

# ชุดทดลองออกแบบวงจรถิจิตอล



โดย

นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์

นายจรัญ เกลั่นพรัตน์

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2532



ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2532

เรื่อง ชุดทดลองออกแบบวางจรวดจรวด

ผู้จัดทำ

1 นายเจษฎา ยิ้มชูทรัพย์

2 นายจรัญ เกตุพรรัตน์

.....อาจารย์ที่ปรึกษา

(นายสนิท ทวีสุวรรณ)



## ซุกทกลองออกแบบวงจรจิกิจอล

เจษฎา ยิ้มชูดทรัพย์

จรัญ เกตุานพรรัตน์

อ.ธนิตย์ ตรีสุวรรณวัฒน์ ที่ปรึกษา

### บทคัดย่อ

จะเห็นว่าเครื่องมือเครื่องใช้ที่มนุษย์ต้องใช้ ในการดำเนินชีวิตประจำวันในปัจจุบัน อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก อาจเป็นเพราะเทคโนโลยีทางด้านนี้ มีความเจริญรุดหน้าไปอย่างมาก ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีทางด้านนี้ จะเติบโตอย่างรวดเร็วเพียงใดก็ตาม แต่ในประเทศไทย เทคโนโลยีทางด้านนี้ต่ำกว่าประเทศอื่นมาก ปัญหาใหญ่ที่เทคโนโลยีเจริญเติบโตช้า ก็เพราะขาดบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ทางด้านนี้ และอีกประการหนึ่งก็คือ ขาดเครื่องมือในการที่จะใช้ศึกษาเรียนรู้ อย่างพอเพียง ซุกทกลองที่ใช้กันอยู่ในประเทศส่วนใหญ่ นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งราคาแพงมาก แม้จะมีการสร้างซุกทกลองในประเทศออกมาจำหน่ายก็ตาม แต่ราคาก็ยังสูงอยู่ ซุกทกลองเหล่านี้ ยังคงมีใช้กันอยู่ตามสถาบันการศึกษาเท่านั้น คนทั่วไปที่สนใจศึกษาทางด้านนี้ ก็ไม่มีโอกาสที่จะมีไว้ใช้ ซุกทกลองการออกแบบวงจรจิกิจอลเครื่องนี้ เป็นเครื่องที่สร้างได้ง่าย และมีราคาถูกมาก สามารถใช้ทดลองได้ ทั้งวงจรรอนาฬิกา และวงจรจิกิจอล สามารถใช้ทดลองตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นออกแบบ เพราะมีวงจร ที่จะช่วยในการทดลองครบสมบูรณ์

026961

สารบัญ

	7.17
บทที่ 1 บทนำ	
- ความ เป็นมาของปัญหา	
วัตถุประสงค์ สาระ และขอบ เขตของโครงการ	
บทที่ 2 โวลต์ เต็ม เร็กกูเลเตอร์	๘
หลักการ ออกแบบแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง	13
การป้องกันไดโอดเบี่ยงกระแส	๕1
บทที่ 3 ทฤษฎี เกี่ยวกับ ไอซี ๗๘๐๕	75
บทที่ 4 ภาคแสดงผลในวงจรจริง	77
บทที่ 5 วงจร มินิเทร็คเกอร์	๗๘
บทที่ 6 รายละเอียดของวงจร	
โวลต์ เต็ม เร็กกูเลเตอร์ปรับค่าได้ 1.25 ถึง ๖0 โวลต์	97
โวลต์ เต็ม เร็กกูเลเตอร์คงที่ ๕ โวลต์	๑๑
ชุดกำเนิดสัญญาณนาฬิกา	103
ชุดเพาเวอร์แอมป์	104
ชุดแสดงผลพหุคูณ	107
ชุดลอจิกสวิทช์	111
ชุดดีเบบวาทสวิทช์	111
บทที่ 7 การสร้าง	113
- การปรับแต่งและการทดสอบใช้งาน	117
การประกอบกล่อง	117

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ความเป็นมาของปัญหา

ชุดทดลองดิจิทัลนั้นเป็นเครื่องที่สำหรับและจำเป็นอย่างหนึ่งสำหรับงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะเหมาะสำหรับนักศึกษาที่ใช้ในการทดลองวงจรต่างๆ และการเรียนวิชาดิจิทัล ดังนั้นรายละเอียดต่างๆ ของชุดทดลองนั้นจะต้องมีระบบป้องกันการลัดวงจรของโหนดภายนอก สำหรับวงจรต่างๆ ที่อาจจะเสียหายได้ เช่น ชุดจ่ายไฟ 1.25 - 30 โวลต์ และ 0 - 5 โวลต์ นอกเหนืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบวงจรจะต้องมีความทนทานเปลี่ยนได้ง่ายถ้าชำรุด ปัจจุบันชุดทดลองดิจิทัล มีจำนวนไม่พอเพียงกับนักศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้จะช่วยให้สถานศึกษาประหยัดเงินงบประมาณในการซื้อเครื่อง

## วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ

### ก. วัตถุประสงค์

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น โครงการนี้จึงมีจุดประสงค์ที่จะศึกษาและออกแบบสร้างชุดทดลองดิจิทัล ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ วงจรเพาเวอร์แอมป์, ลอจิกสวิตช์, สัญญาณนาฬิกา, แหล่งจ่ายไฟ, ดีเบซีสวิตช์, วงจรแสดงผลเป็นตัวเลข, ภาควงจรแสดงผล ซึ่งชุดทดลองนี้ใช้ในการทดลองวงจรต่างๆ รวมทั้งเป็นสื่อในการเรียนวิชาดิจิทัล ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจและยังทำให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่งในการทดลองนั้นใช้ได้ทั้งวงจรดิจิทัลและวงจรรอนาลอก เช่น ทดลองเกี่ยวกับออปแอมป์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการออกแบบวงจรต่างๆ ได้อีกด้วย

### ข. ขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้จะเริ่มศึกษาและออกแบบวงจรที่สำคัญในการทดลองดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันได้ดิจิทัลเป็นที่ใช้กันแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ต้องมีด้านดิจิทัลมาเกี่ยวข้องแทบทั้งสิ้น ซึ่งวงจรที่เกี่ยวข้องนั้นมียรายละเอียดเฉพาะของเครื่องดังนี้

1. แหล่งจ่ายไฟสามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 1.25 - 30 โวลต์ โดยมีปุ่มปรับละเอียด
2. สัญญาณนาฬิกา ซึ่งมีค่าความถี่ปรับค่าได้ตั้งแต่ 1 เฮิรตซ์ ถึง 100 กิโลเฮิรตซ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. ดีเบอซ์สวีทซ์ ซึ่งจะปราศจากสัญญาณรบกวนเหมือนสวีทซ์ทางกล
4. ลอจิกสวีทซ์ ซึ่งเป็นสวีทซ์แสดงสถานะได้ 2 สถานะ คือ "H" และ "L"
5. 7SEGMENT มีอยู่ 2 แบบ คือ 1.7 SEGMENT ซึ่งต่ออนุกรมกันโดย COMMON นั้นจะปล่อยไว้

#### 2.7 SEGMENT ที่ต่อกับความต้านทาน

6. DISPLAY เป็นตัวบอกสถานะของวงจรที่ใช้ทดลอง
7. SOUND AMP เป็นตัวบอกสถานะถึงการทำงานของวงจร

#### ค). ลำดับขั้นการดำเนินการ

1. รวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ
2. ออกแบบโครงสร้างของชุดทดลอง
3. ออกแบบวงจรพร้อมทดสอบและทดลองวงจร
4. ถ่ายแบบสกรีนวงจรและหน้าปัด
5. ตรวจสอบความถูกต้องของวงจร
6. ประกอบส่วนต่าง ๆ ของวงจร
7. สร้างกล่องชุดทดลองดิจิทัล

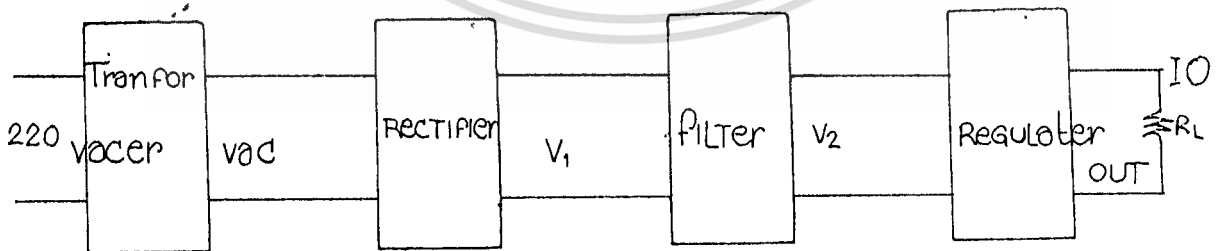
#### ง. ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้

1. ใช้ในการออกแบบวงจรต่าง ๆ
2. ใช้ประกอบในการเรียนวิชาดิจิทัล
3. ใช้ในการศึกษาวงจรต่าง ๆ ในวงการอิเล็กทรอนิกส์

วงจรแรงดันคงที่

คำว่าเรกูเลเตอร์ REGULATOR ในทางอิเล็กทรอนิกส์หมายถึง วงจรที่ทำให้ระดับศักดาหรือกระแส มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามสภาวะของโหลด ในความเข้าใจโดยทั่วไปเมื่อเรากล่าวถึงเรกูเลเตอร์มักจะหมายถึงวงจรที่ทำให้ศักดามีค่าคงที่ หรือโวลต์เตจเรกูเลเตอร์ (VOLTAGE REGULATOR) สำหรับกรณีของวงจรที่ทำให้กระแสคงที่มักจะถูกเรียกเจาะจงลงไป ว่าวงจรจ่ายกระแสคงที่ (CONSTANT CURRENT CIRCUIT) ไอซีที่ใช้ทำหน้าที่เรกูเลเตอร์ที่เรารู้จักกันแพร่หลาย เบอร์แรกก็คงจะเป็น A 723 ของแฟร์ไชลด์ (FAIRCHILD) และเมื่อเรกูเลเตอร์ 3 ขา ในตระกูล LM 340 ของเอ็นเอส (NATIONAL SEMI CONDUCTER) ได้ออกมาสู่ตลาด วงจรเรกูเลเตอร์ทั้งหลายก็ถูกปฏิบัติโดยเรกูเลเตอร์ 3 ขานี้ โดยสิ้นเชิง ในปัจจุบันมีไอซีโมโนลิธิค ที่ทำหน้าที่เป็นเรกูเลเตอร์จ่ายกระแสได้สูงถึง 5 แอมป์ โดยไม่จำเป็นต้องมีวงจรภายนอกเพิ่มเลย เพาเวอร์ซัพพลายประกอบด้วยอะไรบ้าง

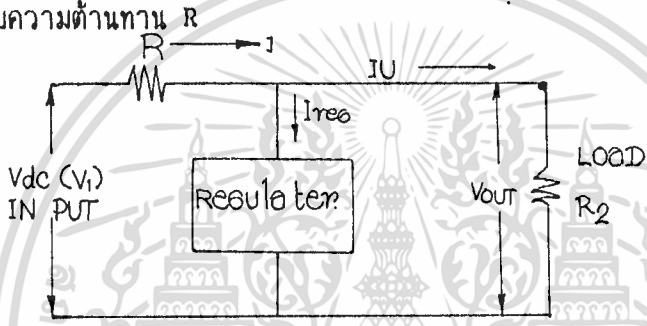
ในรูปที่ 1 แสดงบล็อกไดอะแกรมของเพาเวอร์ซัพพลาย โวลต์จะถูกป้อนเข้ามายังทรานส์ฟอร์มเมอร์ เพื่อเปลี่ยนขนาดของแรงดันไฟฟ้าให้พอเหมาะกับความต้องการของโหลดหลังจากนั้นก็จะผ่านไปสู่อะดิคเตอ์ไฟร์ (RECTIFIER) เปลี่ยนโวลต์ให้เป็นไฟตรง ไฟตรงที่ได้จากการอะดิคเตอ์ไฟร์นั้นยังไม่สามารถที่จะนำไปจ่ายให้กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพราะยังมีการกระเพื่อมหรือมีริปลึ้ม (RIPPLE) ไฟตรงที่มีริปลึ้มนี้จะถูกส่งไปฟิลเตอร์ให้ได้ไฟตรงที่เรียบขึ้น คุณสมบัติของเพาเวอร์ซัพพลาย ที่ดีนั้นจะต้องสามารถจ่ายไฟตรงที่มีริปลึ้มเป็นน้อย ๆ และค่าของแรงดันไฟที่เข้าที่พุดจะต้องมีส่วนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของโหลด ซึ่งส่วนของวงจรเรกูเลเตอร์จะทำหน้าที่ลดริปลึ้มและเป็นตัวรักษาแรงดันไปที่เข้าที่พุดให้คงที่ วงจรในส่วนของอะดิคเตอ์ไฟร์และฟิลเตอร์จะประกอบด้วยไดโอดและคาปาซิเตอร์



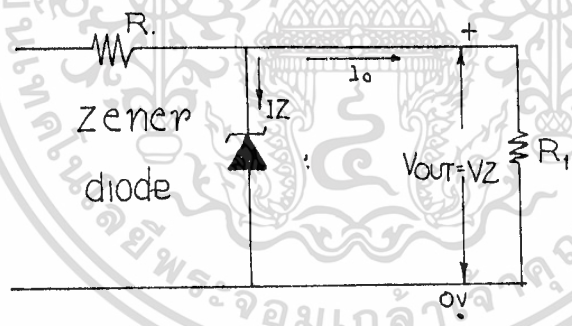
รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของเพาเวอร์ซัพพลาย



เราอาจแบ่งเรื่อกุเลเตอรวีถึตามบักณะของการควบคุมได้ 2 แบบ คือเรื่อกุเลเตอรวีถึแบบขนาน (SHUNT REGULATER) และเรื่อกุเลเตอรวีถึแบบอนุกรม (SERIES REGULATER) ในรูปที่ 2 ก เป็นบล็อดไดอะแกรมแบบขนานสามารถจะพิจารณาการทำงานอย่างง่าย ๆ เมื่อกระแส IO ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงไป กระแสที่ไหลเข้าเรื่อกุเลเตอรวีถึ REG จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ศักดาคร่อมโหลด VOUT มีค่าคงที่กล่าวคือ เมื่อโหลดดิ่งกระแส IO น้อยลง กระแสที่ไหลเข้าสู่เรื่อกุเลเตอรวีถึ REG จะมากขึ้นถ้าโหลดเบิดวงจรกระแสที่ไหลเข้าสู่เรื่อกุเลเตอรวีถึทั้งหมด และเมื่อโหลดดิ่งกระแส IO มากขึ้น กระแสที่ไหลเข้าสู่เรื่อกุเลเตอรวีถึ TREG จะน้อยลง นั่นคือเรื่อกุเลเตอรวีถึแบบขนานนี้จะควบคุมแรงดันเอาพุตให้คงที่โดยการเปลี่ยนแปลงกระแสที่ไหลผ่านตัวมัน เรื่อกุเลเตอรวีถึแบบขนานอย่างง่ายคือ การใช้ซีเนอร์ไดโอดรวมกับความต้านทาน R



ก. บล็อดไดอะแกรม



ข. ตัวอย่างวงจรอย่างง่าย

รูปที่ 2 เรื่อกุเลเตอรวีถึ

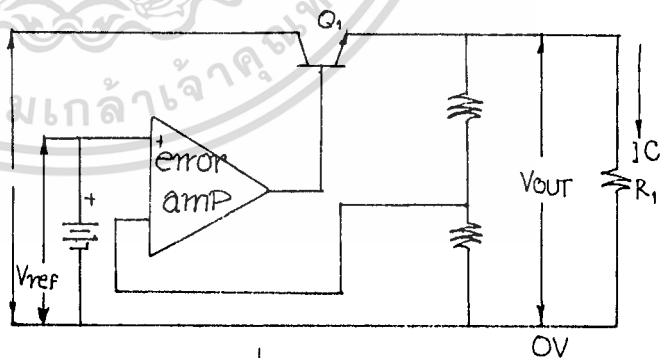
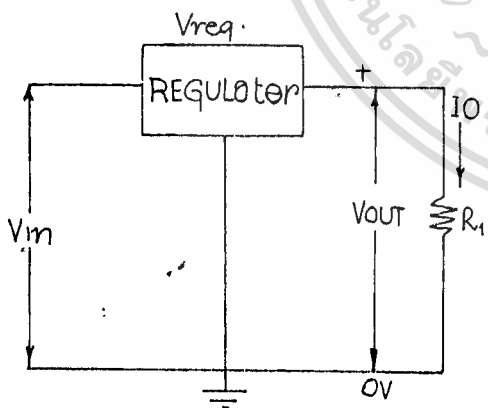
ในรูปที่ 3 เป็นบล็อดไดอะแกรมของเรื่อกุเลเตอรวีถึแบบอนุกรม กระแสที่ไหลต้องการจะไหลผ่านเรื่อกุเลเตอรวีถึทั้งหมด หลักการทำงานโดยสรุปจะเป็นดังนี้ หักดาที่ตักคร่อมเรื่อกุเลเตอรวีถึ VREG จะเปลี่ยนแปลงสภาวะของโหลด IO เพื่อที่จะทำให้ศักดาคร่อมโหลด VOUT ให้คงที่ ในรูป 3 ข ERROR AMPLIFIER ทำหน้าที่เสมือนเป็นสมองของวงจร R1 และ R2 จะทำการสุ่มแรงดันที่เอาที่พุตและนำไปเปรียบเทียบกับแรงดันอ้างอิง VREF ซึ่งเป็นแรงดันที่มีค่าคงที่ เมื่อศักดาที่เอาที่พุตมีค่าลดลง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้ง 026961

ERROR AMPLIFIER ก็จะได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และจะควบคุมทรานซิสเตอร์ Q1 ให้นำกระแสมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามถ้าศักดาที่เอาท์พุทเพิ่มขึ้น Q1 จะนำกระแสลดลง เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรีคูเลเตอร์แบบขนานหรือแบบอนุกรมก็ดี ตัวเรีคูเลเตอร์จะทำตัวเสมือนเป็นความต้านทานที่ปรับค่าได้ ซึ่งการแปรค่าความต้านทานนี้จะได้เป็นไปตามสภาวะของโหลดเพื่อที่จะรักษาให้ศักดาซึ่งตกคร่อมโหลดขณะนั้นเมีค่าคงที่ ในตารางที่ 1 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างเรีคูเลเตอร์แบบขนานและอนุกรม

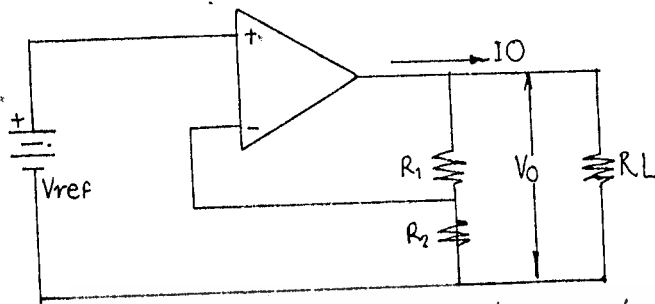
เรีคูเลเตอร์แบบขนาน	เรีคูเลเตอร์แบบอนุกรม
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เหมาะสมสำหรับใช้งานกับโหลดที่ใช้กระแสต่าง ๆ และโหลดที่มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสที่ต้องการไม่มากนัก ถ้าโหลดมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสมาก จะทำให้มีการสูญเสียมาก</li> <li>2. เรีคูเลเตอร์มีความสามารถป้องกันตัวเองได้ในกรณีที่มีการลัดวงจรที่โหลด</li> <li>3. โดยทั่วไปวงจรจะไม่ยุ่งยากซับซ้อน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สามารถใช้งานได้กับโหลดทุกแบบ</li> <li>2. ถ้ามีการลัดวงจรที่โหลดจะทำให้ตัวเรีคูเลเตอร์เสียหาย จะต้องมีวงจรไว้ป้องกันหรือวงจรจำกัดกระแสเข้าช่วย</li> <li>3. วงจรจะยุ่งยากซับซ้อนกว่าเรีคูเลเตอร์แบบขนาน</li> </ol>



รูปที่ 3 เรีคูเลเตอร์แบบอนุกรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำหรับไอซีเรีคูเลเกนนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเรีคูเลเตอรแบบอนุกรม เราจะมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกับโวลต์เดจเรีคูเลเตอรแบบอนุกรมที่ใช้อปแอมป์ดังวงจรในรูปที่ 4



รูปที่ 4 วงจรอย่างง่ายของเรีคูเลเตอรแบบอนุกรมที่ใช้อปแอมป์

ในรูปที่ 4 เป็นการนำหลักการทางงานของวงจรขยายชิตเดไม่กลับเฟสของอปแอมป์มาใช้เป็นโวลเดจเรีคูเลเตอร ค่าของคักดาเข้าที่พุดที่คร่อมโหลด  $V_{OUT}$  จะมีค่าดังสมการที่หนึ่ง

$$V_{OUT} = V_{REF}(1+R1) \dots\dots\dots 1$$

\*\*\*\*\*

สมการที่ 1 จะเห็นได้ว่าคักดาที่คร่อมโหลด  $V_{OUT}$  มีค่าไม่ขึ้นอยู่กักระแสที่ไหลไปยังโหลด  $I_O$  เลยค่าของคักดาคร่อมโหลด  $V_{OUT}$  จะคงที่ที่ดักก็ต่อเมื่อค่าของคักดาอ้างอิง  $V_{REF}$  มีเสถียรภาพที่ดี โดยทั่วไปนิยมใช้ซีเนอร์ไดโอดเป็นตัวก่าเนิดคักดาอ้างอิง  $V_{REF}$  และจากสมการที่ 1 นี้เราจะพบอีกว่า ค่าของคักดาเข้าที่พุด  $V_{OUT}$  ไม่มีทางที่จะมีค่าต่ำกว่าคักดาอ้างอิง  $V_{REF}$  ได้เลย ในวงจรเรีคูเลเตอรที่หรับค่าได้ตั้งแต่ค่าของคักดาเข้าที่พุด  $V_{OUT}$  มีค่าเป็นศูนย์โวลท์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จากรูปที่ 4 เขียนให้สมบูรณ์จะได้ดังในรูปที่ 5 ซึ่งสามารถกระแสได้ประมาณ 20 มิลลิแอมป์

เนื่องจากตัวอปแอมป์มีความสามารถในการจ่ายกระแสได้เพียงประมาณ 20 มิลลิแอมป์ ในกรณีที่ต้องการกระแสสูง ๆ นั้นเราจะเพิ่มความสามารถของวงจรได้โดยการเพิ่มทรานซิสเตอร์เข้าไปเพื่อกำหนดำที่ขยายกระแสให้เพียงพอกับความต้องการดังในรูปที่ 6

ในวงจรรูปที่ 6 กระแสที่ได้จากอปแอมป์ประมาณ 20 มิลลิแอมป์จะให้จ่ายกระแสเบส  $I_{B1}$  ของทรานซิสเตอร์ กระแสเข้าที่พุดที่จ่ายให้กับโหลด จะมีค่าเท่ากับกระแสอิมิตเตอร์ของ  $Q1$  ซึ่งจะมีค่ามากกว่ากระแสที่ได้จากอปแอมป์อยู่ B เท่าหรือ

$$I_O = + B \min \quad I_{E1} \dots\dots\dots 2$$

ตัวอย่างเช่น  $Q1$  เป็นทรานซิสเตอร์เบอร์ 2SC 1061 ซึ่งมีค่า B หรือ HFE ต่ำสุดเท่ากับ 35 ออปแอมป์ที่ใช้จ่ายกระแสได้สูงสุด 15 มิลลิแอมป์ จะได้กระแสเข้าที่พุด  $I_O = 35 \times 15$  เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เท่ากับ 525 มิลลิแอมป์ ส่วนค่าของศักดาเข้าที่พุก  $V_{out}$  ยังคงเป็นไปตามสมการที่ 1

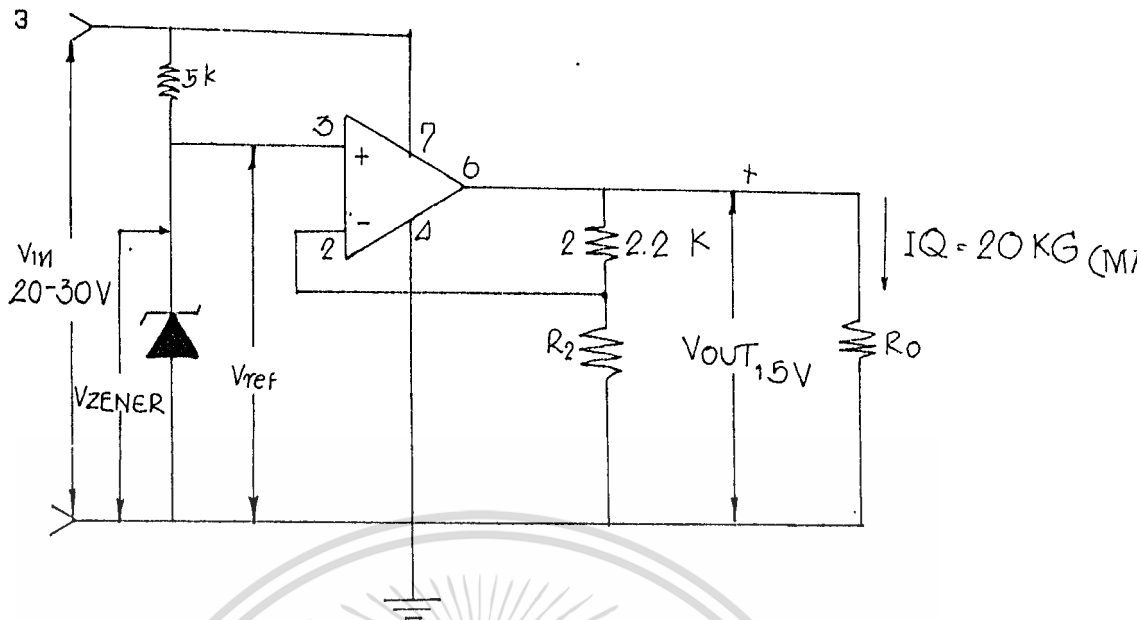
ในกรณีที่ต้องการกระแสมากกว่า 500 มิลลิแอมป์ จะได้กระแสเข้าที่พุก เราสามารถที่จะเพิ่มได้โดยการต่อทรานซิสเตอร์เพิ่มเข้าไปอีกในลักษณะของดาร์ลิงตัน (Darlington) ซึ่งการนำทรานซิสเตอร์มาต่อกันกับดาร์ลิงตันนั้น ผลที่ได้จะเป็นเสมือนทรานซิสเตอร์ตัวเดียว แต่มีค่าของ  $\beta$  หรือ HFE สูงขึ้นคือมีค่า  $\beta$  เท่ากับผลคูณของ  $\beta$  ของทรานซิสเตอร์แต่ละตัวที่ต่อดาร์ลิงตันอยู่ การต่อทรานซิสเตอร์แบบดาร์ลิงตันสามารถทำได้ 2 วิธีคือ การใช้ตัวทรานซิสเตอร์ชนิดเดียวกัน (NPN กับ PNP) หรือ (PNP กับ PNP) ดังรูปที่ 7

ทรานซิสเตอร์ดาร์ลิงตันนี้นิยมใช้กันมากในวงจรที่ต้องการกระแสขับโหลดค่าสูง ๆ เช่น รีเลย์มอเตอร์ วงจรขยายกำลัง วงจรควบคุมมอเตอร์ เป็นต้น และทรานซิสเตอร์บางเบอร์ก็มีโครงสร้างภายในเป็นดาร์ลิงตันทรานซิสเตอร์ ในรูปที่ 8 เป็นตัวอย่างของรีเลย์มอเตอร์ ซึ่งจ่ายกระแสได้สูงถึง 10 แอมป์

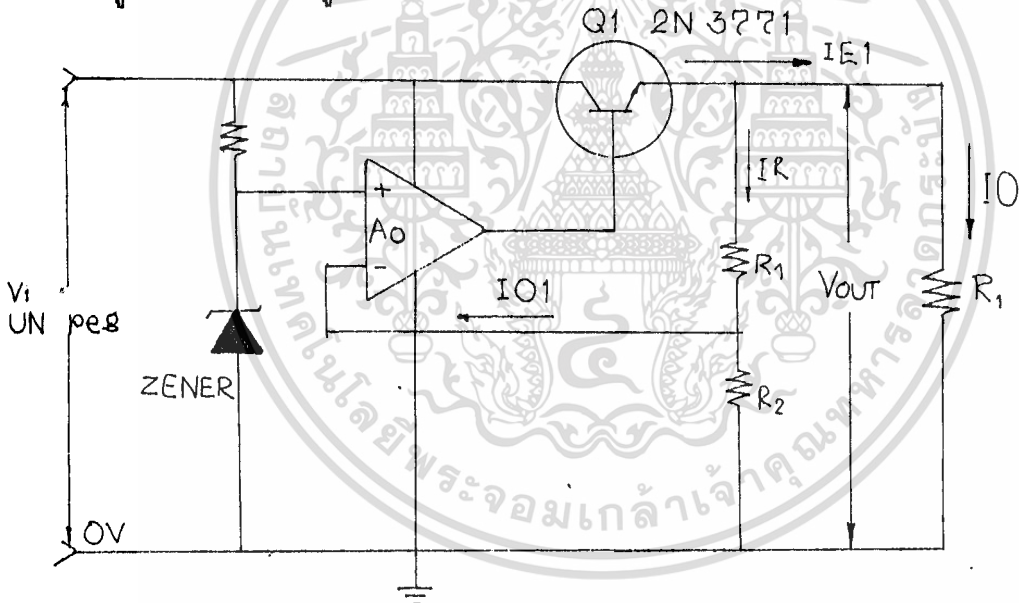
ถ้าโหลดเกิดการลัดวงจรขึ้น มีวิธีป้องกัน วิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้ฟิวส์ และถ้าหากจะให้แน่ใจก็ควรจะมีวงจรจำกัดกระแสเพื่อป้องกันเข้าที่พุกทรานซิสเตอร์ Q1 นี้ ลักษณะของวงจรจำกัดกระแสที่ใช้กันมากจะแสดงในรูปที่ 9 เมื่อมีการลัดวงจรที่เข้าที่พุกจะทำให้มีกระแสไหลผ่าน Q1 และ RSC มากขึ้นจะทำให้ศักดาที่ตกคร่อม RSC มีค่าสูงขึ้น โดยที่เบสของ Q1 จะเป็นบวกกว่าอิมิตเตอร์ เมื่อศักดาที่ตกคร่อม RSC มีค่าประมาณ 0.7 โวลต์ ก็จะทำให้ Q5 นำกระแสการที่ Q5 นำกระแสจะทำให้กระแสเบสของ Q1 ลดลง กระแสคอลเลคเตอร์ของ Q1 จะลดลงปลอดภัยจากการที่เข้าที่พุกลัดวงจร กระแสสูงสุดที่วงจรจะจ่ายได้สามารถกำหนดได้จากค่าของ RSC ดังตาม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สมการที่ 3



รูปที่ 5 วงจรเร็คทูลิเตอร์ 15 โวลท์ 20 มิลลิแอมป์



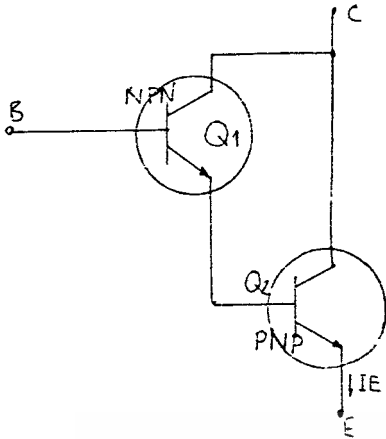
รูปที่ 6 การเพิ่มกระแสเข้าที่พอร์ท IO โดยการใส่ทรานซิสเตอร์เข้าช่วย

$$RSC = 0.07 \dots\dots\dots 3$$

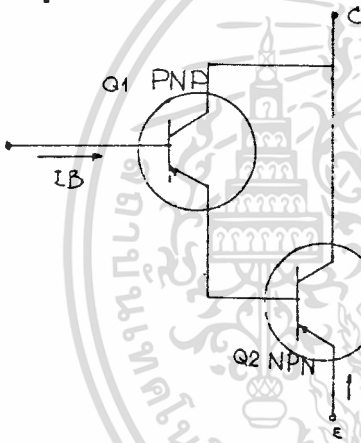
I OUT (MAX)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ก) ทรานซิสเตอร์ Q1 เป็น NPN จะได้ทรานซิสเตอร์



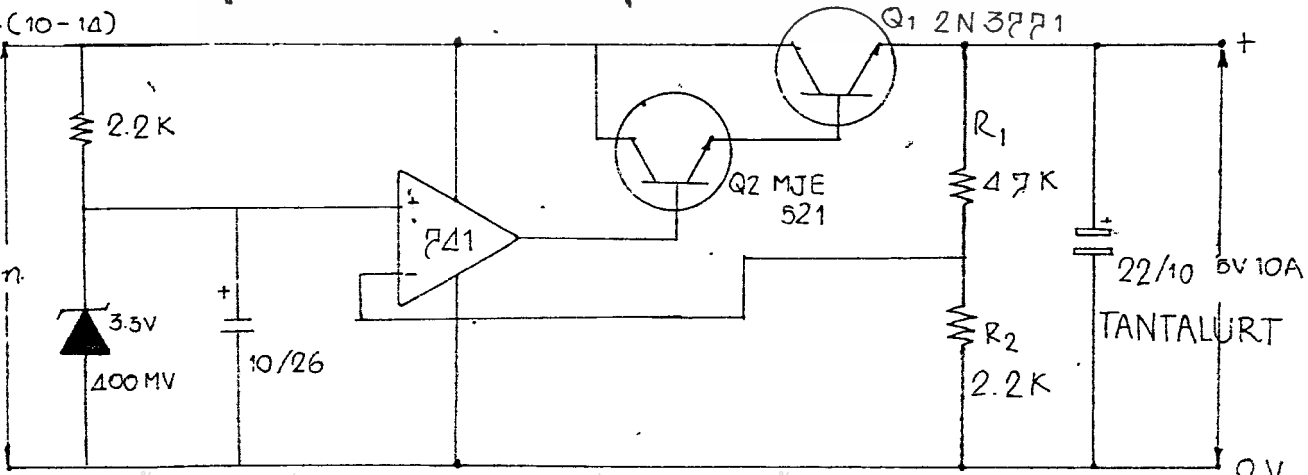
ข) ทรานซิสเตอร์ Q1 เป็น PNP จะได้ทรานซิสเตอร์ดาร์ลิ่งตัน  
รูปที่ 7. การต่อทรานซิสเตอร์ดาร์ลิ่งตัน



รูปที่ 8 5 โวลต์ 10 แอมป์ รั้งคูลเซเตอร์

มีวงจรป้องกันแล้ว แต่ทำไมชอร์ตเมื่อไรก็พังเมื่อนั้น สมมุติว่าทรานซิสเตอร์และค่า RSC

ของวงจรเป็นดังในรูปที่ 9 ก่อนจะอธิบายว่าเมื่อเอาที่พลาต์วงจรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีกรุณาไปใช้

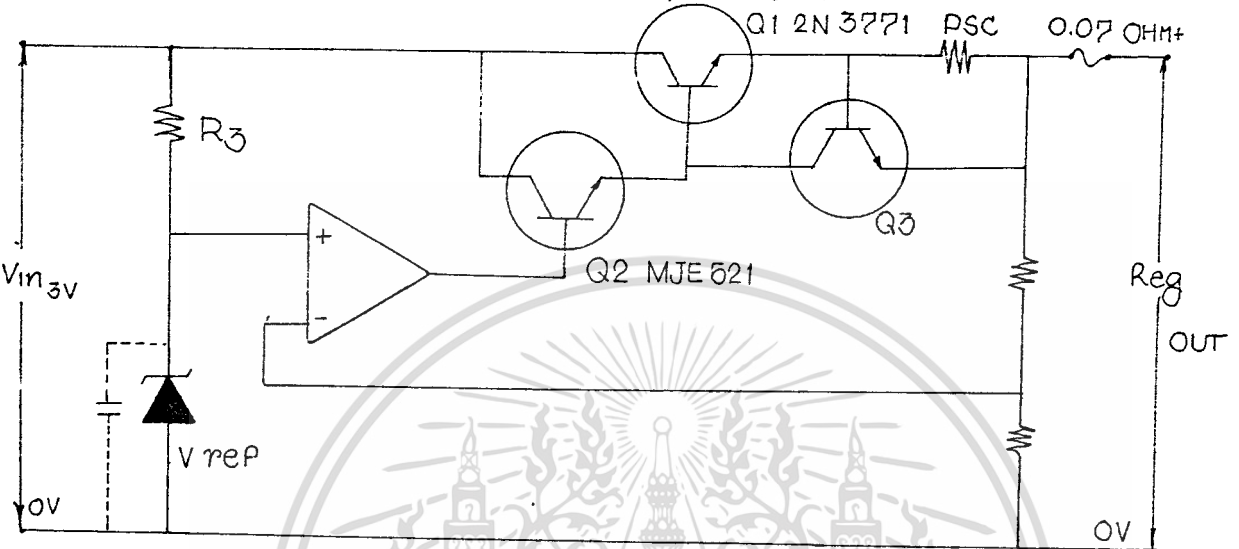
จะขอให้อ่านสมมติข้อ : Q1 นานสองให้รู้ก่อนตั้งชื่อไปนี้

2N 3771

3V ceq 40 โวลท์ ( ศักดาเบรคดาวน์ คอลเลคเตอร์ - อิมิตเตอร์ )

Ic max (cont) 30 แอมป์ ( กระแสคอลเลคเตอร์ต่อเครื่องสูงสุด )

Pd max 150 วัตต์ ( กำลังงานที่ทนได้สูงสุด )



รูปที่ 9 วงจรเร็คทูลเลเตอร์ที่มีวงจรมองกันการลัดวงจรของเอาท์พุท การที่ทรานซิสเตอร์จะนิ่งได้ต่อเมื่อ

1. ศักดาที่ตกคร่อมที่ขาต่างๆ เกินค่าสูงสุดที่มันจะทนได้ เช่น ศักดาาระหว่างคอลเลคเตอร์ อิมิตเตอร์สูงสุดของ 2N 3771 มีค่า 40 โวลท์
2. กระแสคอลเลคเตอร์ที่ไหลผ่านตัวทรานซิสเตอร์ เกินค่าสูงสุดที่จะทนได้ เช่น 30 แอมป์ใน

3. กำลังงานที่เกิดขึ้นที่ตัวทรานซิสเตอร์ เกินค่าสูงสุดที่จะทนได้ กำลังงานที่เกิดขึ้นที่ตัวทรานซิสเตอร์ (TRANSISTER DISSIPATION PD) คือผลคูณของศักดาคอลเลคเตอร์ - อิมิตเตอร์ กับกระแสคอลเลคเตอร์ กำลังงานสูงที่ทรานซิสเตอร์ทนได้นี้จะลดลง เมื่ออุณหภูมิที่รอยต่อสูงขึ้น ในรูปที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ของกำลังงานสูงสุดกับอุณหภูมิที่รอยต่อของ 2N 3771

ในขณะที่มีกระแสไหลผ่านตัวทรานซิสเตอร์ก็จะทำให้อุณหภูมิที่รอยต่อมีค่าสูงขึ้นและจะมีผลทำให้กำลังงานสูงสุดที่ทรานซิสเตอร์จะทนได้มีค่าลดลง เช่น ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 °C 2N 3771 จะทนได้ 150 วัตต์ แต่ที่อุณหภูมิ 100 °C 2N 3771 จะทนเพียง 80 วัตต์ ดังนั้นเราจะต้องหาทางที่จะทำให้อุณหภูมิของรอยต่อภายในทรานซิสเตอร์มีค่าน้อย ๆ (ไม่ต่ำกว่า - 55 °C) ถ้าการระบายความร้อนไม่ดีไม่ดีพอก็จะทำให้ทรานซิสเตอร์เสียหายได้

ถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน 3 ข้อที่กล่าวมาข้างต้นเกิดขึ้นเพียงประการเดียวก็จะทำให้ทรานซิสเตอร์เสียหายได้ และสาเหตุที่ทำให้ทรานซิสเตอร์เสียหายมากที่สุดจะเกิดจาก 3 ข้อ คือ กำลังงานที่เกิดขึ้นที่ตัวทรานซิสเตอร์สูงกว่าค่าที่มันจะทนได้ และกฎ 3 ข้อนี้ครอบคลุมไปถึงสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำทุกชนิด เช่น ไดโอด ไอซี เป็นต้น อะไรเกิดขึ้นมาบ้างในขณะที่เอาท์พุทเกิดลัดวงจร เมื่อเอาท์พุทลัดวงจรก็จะมีกระแสจำนวนมากไหลผ่าน Q1 ค่าของกระแสที่ไหลในขณะที่ลัดวงจรที่สามารถคำนวณได้จากสมการที่ 3 จะได้

$$I_{OUT} \quad (MAX) = 0.7 = 10 \quad \text{แอมป์แปร์}$$

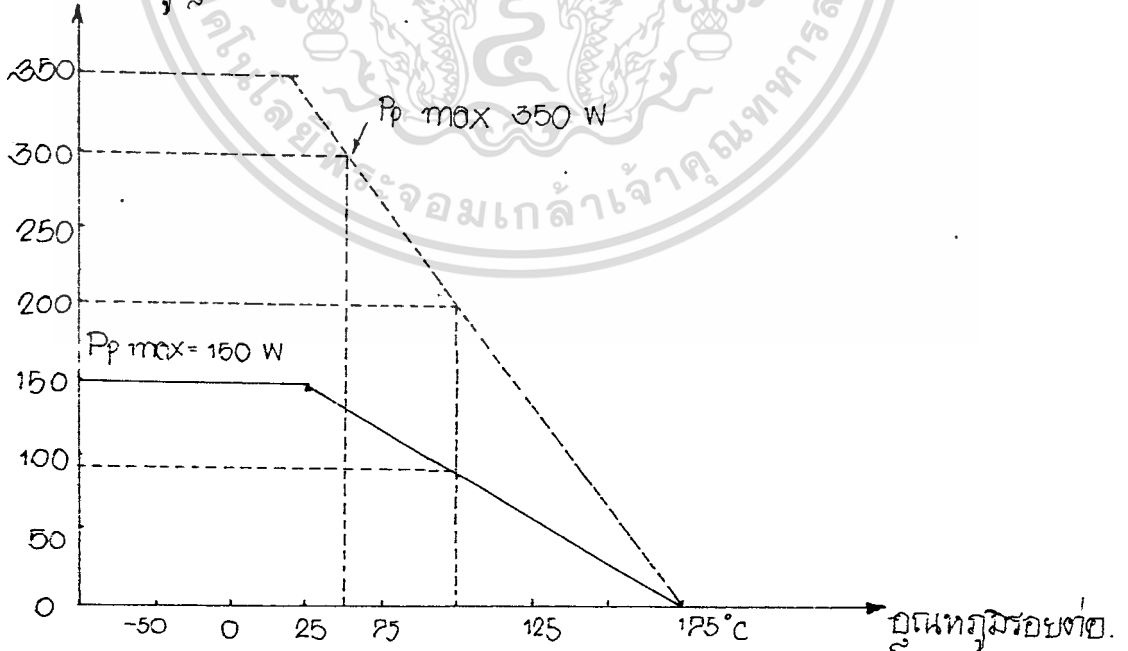
\*\*\*\*\*

ในขณะนี้จะมียิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นกับ Q1 คักคาคอลเลคเตอร์ - อิมิตเตอร์ จะมีค่าเท่ากับ คักคาอินพุท (30 โวลท์) ลบด้วยคักคาตกคร่อม RSC (0.7 โวลท์) และคักคาที่ขาอิมิตเตอร์ (0 โวลท์) เนื่องจากเอาท์พุทลัดวงจร

$$V_{CE}(Q1) = V_{IN} - V_{RSC} - V_{OUT} = 29/3 \text{ VOLTS}$$

ซึ่งไม่เกินค่าสูงสุดที่มันจะทนได้ ดังนั้น Q1 ก็จะไม่พังเนื่องจากสาเหตุในข้อ 1 พิจารณาข้อ 2 ต่อมาก็จะพบว่า 2N 3771 ทนได้ถึง 30 แอมป์ กระแสที่ไหลวงจรขณะนี้ประมาณเพียง 10 แอมป์ดังนั้น Q1 ก็จะพบกันที่ว่าในขณะกำลังของที่เกิดขึ้นที่ Q1 จะสูงถึง 293 วัตต์ (29.3 V / 10 แอมป์แปร์) นั่นคือ กัณฑ์ที่เอาท์พุทลัดวงจรก็จะมีกำลังงานเกิดขึ้นที่ Q1 ถึง 293 วัตต์ ในขณะที่ Q1 นั้นทนได้สูงสุดเพียง 150 วัตต์ ในไม่ว่า Q1 จะมีแผนระบายความร้อนเพียงใดก็ตาม ทรานซิสเตอร์ Q1 ก็จะทำ

(กำลังงานสูงสุด)



รูปที่ 10 คุณสมบัติกำลังงานสูงสุด - อุณหภูมิ ที่รอยต่อของ 2N 3771

เราลองสมมุติต่อไปว่า Q1 สามารถทนกำลังงานได้สูงสุด 350 วัตต์ ดังเส้นประในรูปที่ 10 ถ้าแผ่นระบายความร้อนของ Q1 มีขนาดใหญ่พอที่จะรักษาอุณหภูมิที่มีรอยต่อมิให้เกิน 50 °C Q1 นี้จะมีความสามารถทนกำลังงานได้ 300 วัตต์ Q1 นี้จะปลอดภัย แต่ถ้าแผ่นระบายความร้อนของ Q1 มีขนาดเล็ก เมื่ออุณหภูมิของ Q1 สูงกว่า 50 °C ก็จะทำให้ Q1 ทนกำลังงานสูงสุดได้ต่ำกว่า 300 วัตต์ ในขณะที่มีกำลังงานเกิดขึ้นที่ Q1 ประมาณ 300 วัตต์ ก็จะทำให้ Q1 พัง และสำหรับ Q2 และออปแอมป์ก็มีสิทธิ์ที่จะเสียหายในตัวเองเดียวกันนี้ได้เหมือนกัน ดังนั้นในเร็คกูเลเตอร์หรือเพาเวอร์แอมป์ที่ดี นอกจากจะต้องมีวงจรป้องกันกระแสไหลเกินเมื่อมีลวดวงจรที่เข้าที่พุกแล้ว ก็จะต้องมีวงจรป้องกันอุปกรณ์เสียหายเนื่องจากความร้อนด้วย (THEMING SHUTDOWN)

คุณสมบัติของแหล่งกำเนิดคิกดาอ้างอิง .... สิ่งที่ไม่ควรจะมีมองข้าม จากสมการที่ 1 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า คุณภาพของเข้าที่พุกนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของคิกดาอ้างอิง VREF ถ้าคิกดาอ้างอิง VREF มีการเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้คิกดาที่เข้าที่พุกเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้นแหล่งกำเนิดของคิกดาอ้างอิงที่ดีจะต้อง

- มีความสูงได้แก่ มีริบเบิลและนอยส์ (NOISE) ต่ำ ๆ
- มีเสถียรภาพสูง คือ ไม่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ

ในวงจรเร็คกูเลเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์หรือออปแอมป์ มักนิยมใช้ชิเนอร์ไดโอด ซึ่งทำหน้าที่เป็นคิกดาอ้างอิง VREF คุณสมบัติของชิเนอร์ไดโอดนั้น ขึ้นอยู่กับแถบพลังงานภายในของผลึก (ENERGY BAND GAP) ทำให้เรามองเห็นอย่างชัดเจนว่าค่าของแรงดันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิอย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามในกรณีของเร็คกูเลเตอร์และอนุกรม ซึ่งพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระแสที่ไหลผ่านตัวไดโอดนั้นจะมีค่าไม่มากนักการเปลี่ยนแปลงของแรงดัน เนื่องจากอุณหภูมินั้นอยู่ในขอบเขตที่พอจะยอมรับได้ คุณสมบัติของชิเนอร์ไดโอดอีกประการหนึ่งที่เราควรพิจารณา คือ ในขณะที่ชิเนอร์ไดโอดเบรคดาวน์นั้นจะมีสัญญาณรบกวนขึ้นซึ่งเราเรียกว่า SHOT NOISE ซึ่งจะประกอบด้วยสารกึ่งตัวนำสารพัดความถี่ตั้งแต่ดีซีไปจนถึงย่านไมโครเวทที่เดียว และ SHOT NOISE นี้จะเกิดขึ้นกับสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำทุกชนิดที่มีกระแสไหลข้ามรอยต่อ พี - เอ็น เช่น ไดโอด, ทรานซิสเตอร์ ฯลฯ ดังนั้นในวงจรเร็คกูเลเตอร์ หรือวงจรอื่นใดก็ตามที่มีชิเนอร์อยู่ในวงจร ควรจะมีคาปาซิเตอร์คร่อมตัวชิเนอร์ไดโอดนั้นเพื่อเป็นทางให้รอยสไลลลงกราวด์ไปได้ ดังเส้นประในรูปที่ 9

เมื่อเรารู้หลักการเบื้องต้นของการเร็คกูเลเตอร์แล้ว เราก็มาดูไอซีเลขกุเลข 3 ขา ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เราใช้งานง่ายและราคาถูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนุกรมของ 78 xx และ 79 xx ดังนั้นถ้าจะกล่าวถึง ไอซีเร็คกูเลข 3 ขานี้ คือ ผู้ปฏิบัติโฉมหน้าของวงจรเร็คกูเลเตอร์ในปัจจุบันก็คงจะไม่ผิดความจริงนัก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## หลักการออกแบบแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง

ในการออกแบบแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงชนิดต่าง ๆ โดยเริ่มต้นจากแบบง่าย ๆ ไปถึงแบบที่มีวงจรรักษาระดับแรงดัน ทั้งแบบใช้ทรานซิสเตอร์จนกระทั่งถึงไอซี แหล่งจ่ายมีความสำคัญแค่ไหน ลองพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้ดู เช่น แหล่งจ่ายไฟสำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ ซึ่งจ่ายกระแสได้ไต่กว่าความต้องการทำให้เกิดแรงดันตกต่ำกว่ามาตรฐาน โดยลดลงจากแรงดันจากแรงดันไฟตรง 5 โวลต์ลงเหลือเพียง 4.1 โวลต์ จะส่งผลให้การทำงานของเครื่องผิดพลาดและการโปรแกรมก็พลอยผิดพลาดไปด้วย ในกรณีอื่นอีกเช่นกัน การระบายความร้อนไม่เพียงพอ ทำให้ทรานซิสเตอร์ที่รักษาระดับแรงดันให้คงที่เกิดการรับวงจร จึงเกิดแรงดันไฟตรง + 8 โวลต์ ขึ้นบนสายจ่ายไฟแรงดัน +5 โวลต์ทำให้อุปกรณ์นั้นเกิดความเสียหายขึ้นมาทันทีนอกเหนือจากเรื่องแรงดันขาออก (OUT PUT) แล้วยังจะต้องพิจารณาค่าการจ่ายกระแสความต้านทานภายใน การรักษาค่าแรงดัน (VOLTAGE REGULATION) การส่งผ่านความร้อน ความเชื่อถือของตัวอุปกรณ์และความไวต่อการเสียหาย และบางครั้งอาจจะต้องพิจารณาคูสมบัติในเรื่อง การลดสัญญาณรบกวนทรานเซียนต์ (TRANSIENT) การป้องกันค่าแรงดันเกิน วงจรกำจัดกระแสขาออก และการตรวจจับแรงดันขาออกของแหล่งจ่ายไฟกระแสสูงที่ติดตั้งใกล้ ๆ กับอุปกรณ์ที่ใช้มันอยู่ แบบในระยะไกล (REMOTE SENSING)

### อุปกรณ์ที่ใช้ในแหล่งจ่ายไฟ

อุปกรณ์ที่เป็นหลักใหญ่ในแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงแรงดันต่ำ ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า ตัวเรียงกระแส (RECTIFIER) วงจรกรองกระแส (FILTER) และวงจรเพิ่มเติม เช่น วงจรรักษาระดับแรงดัน วงจรลดทรานเซียนต์ วงจรจำกัดกระแส วงจรป้องกันแรงดันเกิน และหรือตัวแสดงสถานะต่าง ๆ หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นตัวเปลี่ยนแรงดันและกระแส หน้าที่หลักของหม้อแปลงก็คือ การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันสูงตามบ้าน ลงมาเป็นระดับแรงดันที่เหมาะสมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งาน ส่วนหน้าที่อย่างที่สองก็คือ เป็นตัวแยก (ISOLATION) ระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ หม้อแปลงไฟฟ้าประกอบไปด้วย ขดลวด 2 ขดหรือมากกว่า พันอยู่รอบแกนเหล็กผสม (ส่วนใหญ่) แกนเดียวกันในรูปที่ 1 แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบมาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วยขดลวด 2 ขด ขดปฐมภูมิ (PRIMARY) และขดทุติยภูมิ (SECONDARY) ถูกแยกออกจากกันทางไฟฟ้า

ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ของกระแสและแรงดัน ระหว่างขดปฐมภูมิและขดทุติยภูมิมีดังนี้

$$VP / IS = IS / IP \dots\dots\dots (1)$$

ซึ่ง VP เป็นแรงดันที่ป้อนให้กับขดปฐมภูมิ, VS เป็นแรงดันที่ปรากฏขึ้นคร่อมขดทุติยภูมิ, IP เป็นกระแสที่ไหลในขดปฐมภูมิและ IS เป็นกระแสที่ถูกต้องจากขดทุติยภูมิ เราสามารถเขียนสมการที่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. หม้อให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์กว่าดังนี้

$$VP / VS = IS / IP \dots\dots\dots (2)$$

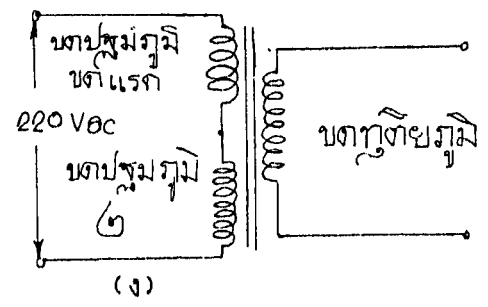
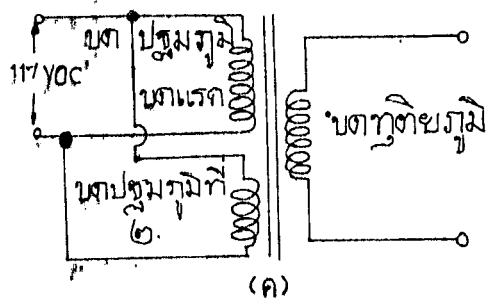
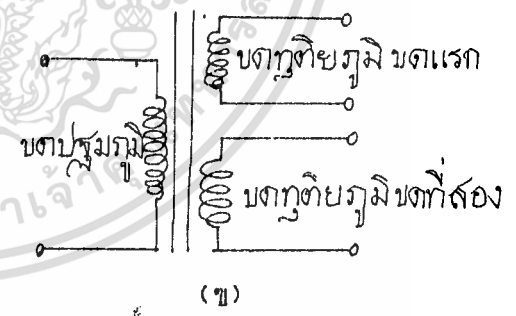
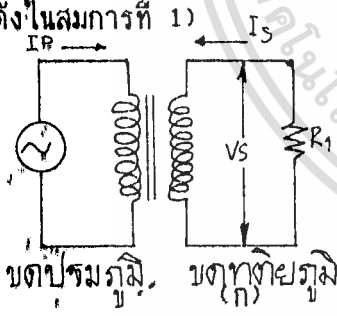
แทนที่เราจะมองถึงความเท่ากันของสมการที่ 1 เราจะพบว่าในสมการที่ 2 นี้ อัตราส่วนระหว่างแรงดันและกระแสเป็นสัดส่วนกับซึ่งกันและกัน อัตราส่วนของแรงดันจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของจำนวนรอบของหม้อแปลงไฟฟ้า โดยมีความสัมพันธ์กันตามสมการข้างล่างนี้

$$VP / VS = NP / NS \dots\dots\dots (3)$$

เมื่อ NP และ NS เป็นจำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิและปฐมภูมิและปฐมภูมิตามลำดับ ส่วน VP และ VS ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ถ้าไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นอัตราค่าแรงดันทางไฟฟ้า จะเป็รค่าเฉลี่ยยกกำลังสองถอดราก (ROOT MEAN = SQUARE; RMS) ดังนั้นหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ 6.3 โวลท์ จะผลิตแรงดันยอด (PEAK) เท่ากับ 1.414 เท่าของค่าแรงดันอาร์เอ็มเอสหรือแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 6.3 โวลท์ จะผลิตแรงดันยอดได้ถึง 8.9 โวลท์

อัตราทนกำลังแบบแรงดันกระแส (VOLT-AMPERE RATING)

อัตราการทนกำลังหลักของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ได้แก่ อัตราทนกำลังแบบแรงดัน - กระแส หรือวีเอ (VA) อัตราทนกำลังวีเอตามพื้นฐานทั่วไปจะบอกให้เราทราบว่ หม้อแปลงไฟฟ้าตัวนี้สามารถจ่ายกำลังได้มากน้อยเพียงใด หม้อแปลงไฟฟ้าจัดว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก (96 - 99 %) ดังนั้นอัตราทนกำลังวีเอทางด้านขดปฐมภูมิจะถูกพิจารณาว่า เท่ากับอัตราทนกำลังวีเอทางด้านขดทุติยภูมิ (ดังในสมการที่ 1)



รูปที่ 1 แสดงถึงวงจรแหล่งจ่ายไฟแบบทั่วไป โดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ คือ

- ก) แบบใช้ขดลวด 2 ขด
- ข) แบบที่มีขดทุติยภูมิหลายขด ใช้ในอุปกรณ์ที่ใช้หลอดสูญญากาศและแหล่งจ่ายไฟที่ต้องการแยกสายเดิน
- ค) แบบที่มีขดปฐมภูมิหลายขด ซึ่งเมื่อต่อขนานกันจะสามารถใช้กับระบบไฟ 117 โวลท์
- ง) เมื่อต่อกันแบบอนุกรม จะสามารถใช้กับระบบไฟ 220 โวลท์
- จ) หม้อแปลงไฟฟ้าแบบขดปฐมภูมิมีแทปแยกออกมาหลายแทป ซึ่งสามารถใช้กับระบบไฟได้หลายระบบ โดยการเลือกต่อขดลวดที่เหมาะสมเข้ากับระบบไฟให้ถูกต้อง

สำหรับกรณีส่วนใหญ่แล้ว อัตราทดกำลังวีเอททางด้านขดปฐมภูมินับว่ามีความสำคัญมากกว่าทั้งนี้เนื่องมาจากขดปฐมภูมิจะอยู่ข้างในสุด และอยู่ใกล้กับแกนมากที่สุด ดังในขอปฐมภูมิจึงได้รับการระบายความร้อนจากสภาพแวดล้อมได้น้อยกว่า จึงไม่เป็นการปลอดภัยที่จะใช้แกนที่อัตราทดกำลังวีเอสูงกว่าขดของปฐมภูมิ หม้อแปลงไฟฟ้า มีคุณลักษณะหลายแบบนอกเหนือจากแบบที่เราที่แสดงในรูปที่ 1 - ก หม้อแปลงไฟฟ้าแบบอื่น ๆ จะแสดงให้เห็นในรูปที่ 1 - ข ถึง 1 - จ

### การเรียงกระแส (RECTIFIERS)

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ทำงานโดยใช้กระแสไหลกลับบ่อยนักโดยมากจะจำกัดให้ใช้งานกับไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้น คุณสมบัติหลักของกระแสตรงคือมีขั้วเดียวแน่นอน นั่นคือกระแสจะไหลในทิศทางเดียวเท่านั้นวงจรเรียงกระแส เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ยอมให้กระแสไหลผ่านตัวมันเพียงทิศทางเดียวเท่านั้น เปรียบเหมือนวงจรเรียงกระแสเป็นตัวปิดเปิดทางเดียว หรือสวิตช์ทางเดียวสำหรับกระแสไฟฟ้า ทั้งหลอดสูญญากาศและไดโอดที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ ถูกใช้เป็นวงจรเรียงกระแส

ในการอธิบายสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เริ่มแรกเราจะกำหนดให้ขั้วหนึ่งของแบตเตอรี่เป็นขั้วบวก ส่วนอีกขั้วหนึ่งเป็นขั้วลบ โดยไม่จำเป็นต้องรู้ถึงนิสสิคส์ของอะตอมและอิเล็กตรอน การเลือกทฤษฎีหนึ่งมาใช้อธิบายจะมีโอกาสถูกและผิดเท่า ๆ กัน เราอาจจะผิดพลาดได้ถ้าหากเราเลือกทฤษฎีผิด โดยที่กระแสจะไหลจากขั้วบวกไปขั้วลบและอิเล็กตรอนจะไหลจากขั้วลบไปขั้วบวกสัญลักษณ์ของไดโอดนั้นด้านหัวลูกศรจะชี้ไปในทิศทางที่กระแสเพียงแต่จำสิ่งนี้ไว้

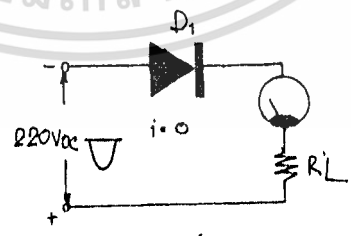
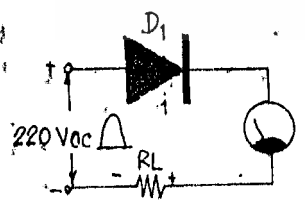
ในรูปที่ 2-ก แสดงวงจรเรียงกระแสด้วยไดโอดอย่างง่าย ๆ เมื่อขั้วของไฟกระแสสลับที่ขั้วแอโนดของตัวเรียงกระแสเป็นบวก (รูปที่ 2-ก) จะทำให้ไดโอดได้รับไบอัสตรง (FORWARD BIAS) ดังนั้นจะมีกระแสไหล สำหรับครึ่งไซเคิลลบของไฟกระแสสลับ ขั้วแอโนดของวงจรเรียงกระแสจะเป็นลบ (รูปที่ 2-ข) ทำให้ไดโอดได้รับไบอัสกลับ (REVERSE VIAS) ภายใต้เงื่อนไขนี้จะไม่มีการไหล เพราะไดโอดจะถูกตัดวงจรออกเปรียบเหมือนวงจรปิด

ผลของการเรียงกระแสโดยไดโอดแสดงให้เห็นในรูป 2-ค เนื่องจากมีเพียงครึ่งไซเคิลของรูปคลื่นไฟกระแสสลับที่ทำให้เกิดกระแสไหล วงจรในรูปที่ 2-ก และ 2-ข เรียกว่า วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น เนื่องจากรูปคลื่นขาออกของวงจรเรียงกระแส ประกอบด้วยพัลส์ของกระแสเพียงทิศทางเดียว ซึ่งเรียกกันว่า ไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระเพื่อม (PULSATING DC) ไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระเพื่อมนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าใดนักในวงจรส่วนใหญ่ มันจะต้องถูกกรองเพื่อให้เกิดแรงดันกระแสตรงที่บริสุทธิ์ (หรือเกือบบริสุทธิ์) ซึ่งจะไหลอย่างสม่ำเสมอ เมื่อวัดด้วยโวลต์มิเตอร์

วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าใดนัก ทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับการกรองกระแสอีกด้วย หม้อแปลงที่ใช้ในวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นโดยทั่วไปแล้ว จะต้องมียูทิลิตี้การทนวิเอทางด้านขดปฐมภูมิ อย่างน้อยสูงกว่า 40 % ของค่าความต่างศักย์ที่แบบอาร์เอ็มเอสที่ป้อนเข้าไป โดยค่าริปเปิล (RIPPLE) หรือระดับความกระเพื่อม หรือความผิดไปจากกระแสตรงบริสุทธิ์เท่ากับ 120 %

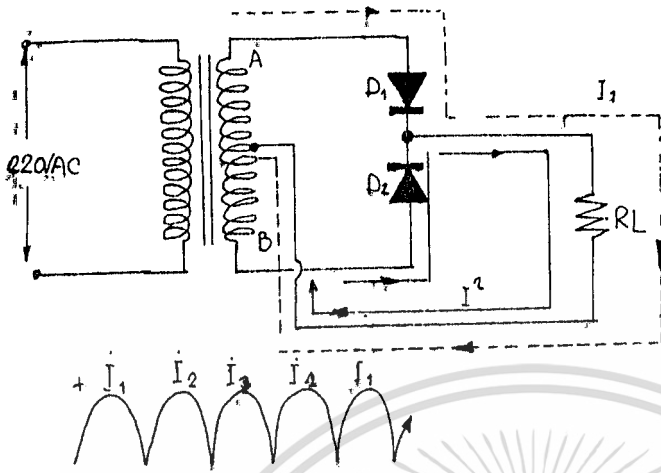
**การเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น (FULL WAVE RECTIFICATION)**

วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นแสดงให้เห็นรูป 3-ก โดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้าแบบพิเศษที่มีแท่งกลาง (CENTER-TAPPED) ของขดทุติยภูมิ เมื่อเริ่มไซเคิลใด ๆ ด้านปลายด้านหนึ่งของขดทุติยภูมิจะเป็นขั้วบวก ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นขั้วลบ ค่าความต่างศักย์ที่แท่งกลางเป็นขั้วร่วมค่าความต่างศักย์ที่จุด A และ B จะมีค่าเท่ากันใน



รูปที่ 3 แสดงลักษณะการทำงานของไดโอดสำหรับ วงจรของระดับไฟกระแสสลับที่ป้อนให้กับวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น โดย

- ก) แสดง เมื่อมีกระแสไหล
- ข) เมื่อกระแสไม่ไหล
- ค) เป็นกราฟแสดงกระแส



รูปที่ 3 เป็นวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น

- ก) แสดง เมื่อกระแสไหลจากทั้งสองครึ่งของระดับแรงดัน ไฟกระแสสลับ
- ข) แสดง รูปคลื่นของกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานที่เป็น โหลด

เรื่องขนาดแต่จะมีขั้วตรงข้าม

สำหรับครึ่งไซเคิลหนึ่งของไฟกระแสสลับที่เข้ามา จุด A จะมีค่าเป็นบวกเมื่อเทียบกับแทปกกลาง ขณะที่จุด B มีค่าเป็นลบ ภายใต้สภาวะนี้ ไดโอด  $D_1$  จะได้รับไบอัสตรง และ  $D_2$  จะได้รับไบอัสกลับ กระแสจะไหลออกจากหม้อแปลงไฟฟ้าจากจุด A ผ่านไดโอด  $D_1$  ตัวต้านทานที่เป็นโหลด  $R_L$  แล้วจึงกลับเข้าสู่หม้อแปลงไฟฟ้าอีกครึ่งทางแทปกกลาง ให้สังเกตถึงทิศทางของกระแสที่ไหลผ่าน  $R_L$  เมื่อไดโอด  $D_2$  นำกระแสสำหรับครึ่งไซเคิลมา

ในครึ่งไซเคิลที่สอง ขั้วของขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้าจะมีขั้วตรงกันข้าม ภายใต้สภาวะไดโอด  $D_2$  จะได้รับไบอัสกลับ และไดโอด  $D_1$  จะได้รับไบอัสตรง กระแสจะไหลออกจากจุด B ผ่านไดโอด  $D_2$  ไปยังตัวต้านทาน  $R_L$  และไหลกลับเข้าสู่ขดลวดทุติยภูมิอีกครั้งทางแทปกกลาง สิ่งสำคัญที่น่าสังเกตก็คือ การแลที่ไหลผ่านตัวต้านทานที่เป็นโหลด  $R_L$  จะไหลในทิศทางเดียวกันกับสำหรับทุกไซเคิลของไฟกระแสสลับซึ่งการกระทำเช่นนี้จะก่อให้เกิดรูปคลื่น ดังแสดงในรูป 3-ข โดยรูปคลื่นของกระแสที่มีส่วนโค้งสูงอันนี้จะง่ายต่อการกรองกระแส และมีประสิทธิภาพดีกว่ารูปคลื่น จากวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น โดยค่ารีปเปิลเท่ากับ 48% ในขณะที่ค่าความถี่รีปเปิลนี้ จะมีค่าเป็น 2 เท่าของความถี่ไฟสลับที่ใช้ ค่าความต่างศักย์เฉลี่ยของไฟออกที่ไม่ได้กรองกระแส จะมีค่าประมาณ 90% ของค่าความต่างศักย์อาร์อาเอ็มเอสที่ป้อนเข้ามา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

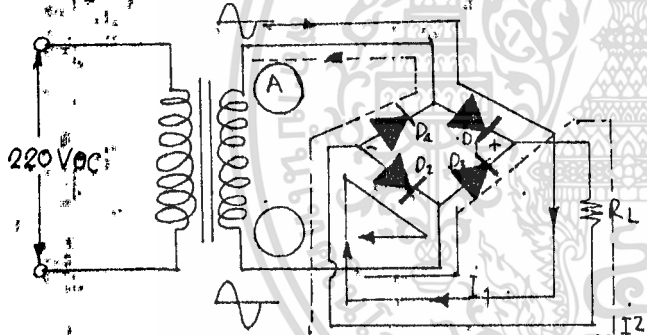
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# การเรียงกระแสแบบบริดจ์ (BRIDGE RECTIFIER)

การจัดวงจรสำหรับวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นในรูปแบบอื่น ๆ แสดงให้เห็นในรูปแบบที่ 4 วงจรนี้ เรียกว่าวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ ซึ่งประกอบด้วยไดโอด 4 ตัว ในวงจรบริดจ์นี้ไม่ต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีขดลวดศูนย์กลาง ซึ่งก็เหมือน ๆ กับหม้อแปลงไฟฟ้าทั่ว ๆ ไป ขั้วของด้านปลายของขดลวดศูนย์กลางจะมีขั้วตรงกันข้ามกันเสมอ ดังนั้นในแต่ละครึ่งไซเคิล ไดโอด 2 ตัวจะได้รับไบอัสกลับหรือออกจะพูดได้ว่าไดโอดทำหน้าที่เป็นแทปกกลาง ในครึ่งไซเคิลแรก แรงดันที่จะ A จะมีค่าเป็นบวก

เมื่อเทียบกับจุด B ดังนั้นไดโอด  $D_1$  และ  $D_2$  จะได้รับไบอัสตรง ในขณะที่ไดโอด  $D_3$  และ  $D_4$  ได้รับไบอัสกลับ กระแสจะไหลออกจากหม้อแปลงไฟฟ้าที่จุด A ผ่านไดโอด  $D_1$  ตัวต้านทานที่เป็นโหลด  $R_L$  ไดโอด  $D_2$  แล้วจึงไหลกลับเข้าสู่ขดลวดศูนย์กลางของหม้อแปลงไฟฟ้าที่จุด B

ในครึ่งไซเคิลที่สอง ขั้วของกระแสไหลกลับจะเปลี่ยนไปเป็นตรงกันข้ามทำให้จุด A มีขั้วเป็นลบ และจุด B มีขั้วเป็นบวก ภายใต้สภาวะนี้ ไดโอด  $D_3$  และ  $D_4$  จะได้รับไบอัสตรง ส่วนไดโอด  $D_1$  และ  $D_2$  จะได้รับไบอัสกลับกระแสจะไหลผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าที่จุด B ผ่านไดโอด  $D_3$ ,  $R_L$  และ  $D_4$



รูปที่ 4 เป็นวงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์ จะให้ลักษณะการเรียงกระแสเช่นเดียวกับในรูปที่ 3 แต่ไม่ต้องการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าแบบที่มีแทปก

แล้วจึงไหลกลับเข้าสู่หม้อแปลงไฟฟ้าทางจุด A และเช่นเดียวกับวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นทั่ว ๆ ไปทิศทางกระแสไหลของกระแสในตัวต้านทานที่เป็นโหลดจะมีทิศทางเดียวกันทั้งสองครึ่งไซเคิลของไฟกระแสกลับ (ดังแสดงในรูปที่ 3 ข) ไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระเพื่อมที่ผลิตได้จากวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์นี้ ยิ่งไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าใดนักในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ ในการผลิตไฟฟ้ากระแสแบบบริสุทธิ์จากไฟฟ้าออกของวงจรเรียงกระแส จะต้องใช้วงจรกรองกระแส วงจรกรองกระแสในรูปแบบที่ง่ายที่สุดได้แก่ การต่อตัวเก็บประจุตัวเดียวขนาดรวมตัวต้านทานที่เป็นโหลด ดังแสดงในรูปที่ 5 การทำงานของวงจรกรองกระแส จะได้กล่าวต่อไปแต่จะรวมอยู่ในที่นี้ด้วย เนื่องจากตัวเก็บประจุที่ใช้ในการกรองกระแส (C1) จะถูกประจุไฟให้มีค่าถึงค่ายอดของรูปคลื่นไฟกระแสสลับ ซึ่งหมายถึงว่า (แรงดันเอาออกของวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ภายใต้สภาวะไม่มีโหลดเท่ากับ 1.414 แรงดัน (อาร์ เอ็ม เอส)

## อัตราณกำลังของวงจรเรียงกระแส (RECTIFIER RATING)

มีคุณสมบัติหลักอยู่ 4 อย่างที่ใช้กับวงจรเรียงกระแส ได้แก่ ค่ากระแสกระชาก (SURGE CURRENT) กระแสรั่วไหล (LEAKAGE CURRENT) กระแสที่ไหลในทิศทางตรง (PEAK INVERSE VOLTAGE) และแรงย้อนกลับสูงสุด (PEAK INVERSE VOLTAGE : PIV) สำหรับคุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้สองอย่าง เป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูง กระแสกระชากเป็นค่ากระแสสูงสุดในช่วงระยะสั้น ๆ โดยทั่วไปจะกำหนดจากไซเคิลของไฟ กระแสกลับ (1/50 วินาที หรือ 20 มิลลิวินาที) กระแสจำนวนนี้จะมีความสูงกว่าและไม่ใช้กระแสในตอนที่ปฏิบัติงาน กระแสรั่วไหล เป็นค่ากระแสที่ไหลเมื่อไดโอดในวงจรเรียงกระแสได้รับไบอัสกลับซึ่งค่านี้โดยทั่วไปแล้วมีค่าน้อยมากเท่าใดก็จะดีมากขึ้น กระแสที่ไหลในทิศทางเดียวกัน เป็นค่ากระแสสูงสุดที่ไดโอดนั้นทนได้โดยไม่เกิดความเสียหาย จากค่าคุณสมบัติที่ระบุในหนังสือแสดงคุณสมบัติของไดโอดค่ากระแสที่กล่าวถึงก็เป็นกระแสที่ไหลในทิศทางตรง ในการเขียนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับกระแสที่ไหลในทิศทางตรงผู้ผลิตบางแห่งจะกำหนดอัตราณกำลังของไดโอด เท่ากับ 1.5 ถึง 2 เท่าของอัตรากระแสที่ใช้งานจริง เนื่องจากใช้งานเป็นช่วง ๆ ภายใต้การกำหนดของไอซีเอเอส (ICASS ; INTERMITTANT COMMERCIAL AND AMATEUR SERVICE CODE) แทนเงื่อนไขการใช้งานแบบต่อเนื่องภายใต้กำหนดของ ซีซีเอส (CCS ; CONTINUOUS COMMERCIAL SERVICE CODE)

โดยทั่ว ๆ ไปมันเป็นการดีที่สุดในการเลือกวงจรเรียงกระแสโดยมีอัตรากระแสที่ไหลในทิศทางตรงเป็นสองเท่าของค่ากระแสเฉลี่ยที่คาดไว้ สำหรับวงจรเรียงกระแสที่ไม่แน่นอนเหล่านี้พวกที่ต้องดูด้วยอัตราณกำลัง (DERATING FACTOR) เข้าอีก 1 ใน 4 ถึง 1 ใน 3

ค่าทวนแรงดันย้อนกลับสูงสุด (PIV) หรือเรียกอีกอย่างว่าค่าแรงดันไบอัสกลับสูงสุด (PEAK-REVERSE VOLTAGE : PRV) เป็นค่าความต่างศักย์ในการไบอัสกลับสูงสุดที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นกับน๊อคเอาท์แบบแหล่งจ่ายไฟ เมื่อใดก็ตามที่แหล่งจ่ายไฟทำให้ไดโอดเสียหายบ่อย ๆ มันก็เป็นการแน่ใจได้ว่าสาเหตุมาจากอัตราการทวนแรงดันย้อนกลับสูงสุดนั้นไม่เพียงพอ

น๊อคเอาท์บางคนลืมนึกถึงค่าแรงดันไบอัสกลับที่เป็นจริง ในวงจรกรองกระแสของแหล่งจ่ายไฟ สำหรับครึ่งไซเคิลหนึ่ง ๆ ไดโอดจะได้รับไบอัสตรงและมีกระแสไหล ในครึ่งไซเคิลในตัวเก็บประจุสำหรับกรองกระแส (C<sub>1</sub> ในรูปที่ 5) จะประจุจนมีระดับแรงดันบวกสูงสุด (เท่ากับ 1.414 \* แรงดันอาร์เอ็มเอส) แรงดันที่ประจุนี้ยังคงอยู่บน C<sub>1</sub> สำหรับครึ่งไซเคิลต่อไประดับแรงดันไฟฟส์กลับกับวงจรเรียงกระแส จนถึงค่าแรงดันที่เป็นลบสูงสุด (เท่ากับ 1.414 \* แรงดันอาร์เอ็มเอส) ระดับความต่างศักย์นี้จะถูกรวบรวมเข้ากับแรงดันจากตัวเก็บประจุ ทำให้ค่าแรงดันย้อนกลับสูงสุดจริง ๆ เป็น 2

ในระหว่างระดับแรงดันขาออกของวงจรเรียงกระแสกำลังเพิ่มขึ้น ตัวเก็บประจุ C<sub>1</sub> จะได้ออกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ทำการแก้ไขทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อที่ 24 และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ฟังก์ชันประจุในรูปที่ 6 หลังจากทีระดับแรงดันสูงสุดได้ผ่านพ้นไปโดยระดับแรงดันที่ผ่านจากการเรียง  
 กระแสเริ่มลดลง และมาถึงจุดที่มีความต่างศักย์ของมีนลดลงต่ำกว่าความต่างศักย์ที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ  
 สำหรับกรองกระแส  $C_1$  ที่ระยะเวลาในประจุที่เก็บไว้ในตัวเก็บประจุจะเริ่มปลดปล่อยเข้าสู่โหลด  $R_L$   
 ซึ่งการกระทำนี้จะมีผลในการเติมเข้าไปในช่องว่างระหว่างยอดคลื่น (ส่วนที่แลเงาในรูปที่ 6) เป็นการ  
 เติมระดับแรงดันเฉลี่ยขาออกให้ใกล้เคียงกับค่าแรงดันสูงสุด (VP) ความลาดชันของการคายประจุตั้ง  
 แสดงในรูปที่ 6 จะแสดงให้เห็นถึงกระแสที่ถูกดึงออกจากตัวเก็บประจุที่ใช้กรองกระแส ในระหว่างที่  
 ระดับแรงดันขาออกของวงจรเรียงกระแสต่ำกว่าระดับแรงดันของตัวเก็บประจุ ความสามารถของวงจร  
 กรองกระแสที่จะทำให้ระดับแรงดันขาออกเรียบ (ลดความลาดชันของเส้นกราฟในแนวระดับในรูปที่ 6)  
 นั้นขึ้นอยู่กับทั้ง  $R_L$  และ  $C_1$  และแสดงค่าให้เห็นโดยตัวประกอบริปลเบิลที่ไม่มีหน่วย (RIPPLE FACTOR:  
 R.F)

$$R.F. = V_{\text{ripple}} / V \dots\dots\dots (4)$$

โดย R.F. เป็นตัวประกอบริปลเบิล (ไม่มีหน่วย) ,  $V_{\text{ripple}}$  เป็นความสูงของค่าริปลเบิลเมื่อ  
 ไม่ได้ต่อ  $C_1$  และ  $V$  เป็นระดับแรงดันขาออกเฉลี่ยเมื่อมี  $C_1$  ในวงจร ในสมการที่ (4) สามารถแทน  
 ที่ด้วยรูปแบบที่เป็นประโยชน์มากกว่าคือ

$$R.F. = 1/3.46 F R_L C_1 \dots\dots\dots (5)$$

เมื่อ  $F$  เป็นความถี่ริปลเบิลมีค่าเป็นเฮิรตซ์,  $R_L$  เป็นค่าความต้านทานของโหลด มีค่าเป็น  
 โอห์ม และ  $C_1$  เป็นค่าความจุมีหน่วยเป็นฟารัด ( $R_L$  หาได้จากระดับแรงดันขาออกหารด้วยกระแสขา  
 ออกหรือ  $VO/IO$ ) สำหรับในเมืองไทยนั้นความถี่ของไฟกระแสสลับตามบ้าน ได้แก่เท่ากับ เฮิรตซ์ ดัง  
 นั้นค่าความถี่ริปลเบิลของแหล่งจ่ายไฟเท่ากับ 50 เฮิรตซ์ เมื่อใช้การเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น และ  
 100 เฮิรตซ์เมื่อใช้การเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น ดังนั้นเราสามารถเขียนรูปแบบทั่ว ๆ ไปของสมการให้  
 อยู่ในรูปแบบเฉพาะดังนี้ สำหรับวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น

$$R.F. = 1/173 R_L C_1 \dots\dots\dots (6)$$

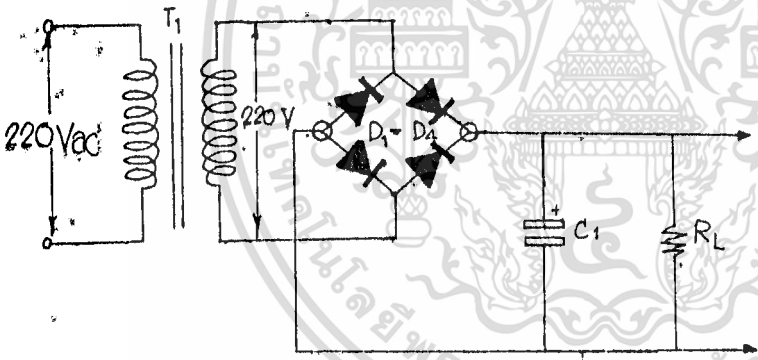
$$\text{สำหรับวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น } R.F. = 1/346 R_L C_1 \dots\dots\dots (7)$$

ตัวอย่างการคำนวณหาค่าตัวประกอบริปลเบิล จงคำนวณค่าตัวประกอบริปลเบิล (% R.F.)  
 ของแหล่งจ่ายไฟตรง แรงดัน 12 โวลท์ 2 แอมป์แปร์ ซึ่งใช้ในวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น และตัว  
 เก็บประจุในวงจรกรองกระแสขนาด 1,000 ไมโครฟารัด (ค่าความถี่ไฟบ้านเท่ากับ 50 เฮิรตซ์) เรา  
 เท่าของค่าแรงดันยอดตามปกติ (เท่ากับ \* 1.414 แรงดันอาร์เอ็มเอส = 2.83 เท่าของแรงดัน  
 อาร์เอ็มเอส) มันเป็นที่เหมาะสมในการใช้ไดโอดที่มีค่าการทนแรงดันย้อนกลับสูงสุด 1000 โวลท์สำหรับ  
 งานทางด้านแรงดันต่ำ (ต่ำกว่า 165 โวลท์) ในย่านกระแสต่ำถึงกลาง 1 ถึง 3 แอมป์ ซึ่งได  
 โอดเบอร์ 1 N4007 มีค่าการทนแรงดันย้อนกลับสูงสุด 100 โวลท์ ที่กระแส 1 แอมป์ เป็นเบอร์ที่มี

ราคาถูกและหาได้ง่าย เมื่อจะติดตั้งแหล่งจ่ายไฟตรงจะต้องแน่ใจว่าได้ติดตั้งวงจรเรียงกระแสไว้ที่มีการระบายอากาศได้ดี วงจรเรียงกระแสจะกำเนิดความร้อนขึ้น จึงต้องการระบายอากาศที่ดี วงจรเรียงกระแสแบบที่ยึดติดกับแผ่นระบายความร้อนมักจะต้องการแผ่ระบายความร้อนที่มีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับวงจรเรียงกระแสแบบที่มีขาออกมาในแนวยาว (AXIAL-LEAD RECTIFIERS) ควรจะติดตั้งห่างจากวงจรพิมพ์และวงจรเรียงกระแสตัวอื่นอย่างต่ำ 1/8 นิ้ว และเว้นระยะขาให้เหลืออยู่บนวงจรแผ่นพิมพ์แต่ละข้าง ๕.4 นิ้ว นอกจากนี้ไม่ควรติดตั้งวงจรเรียงกระแสใกล้เคียงกับอุปกรณ์ที่ไวต่อความร้อน เช่น พากออปแอมป์ วงจรออสซิลเลเตอร์และทรานซิสเตอร์

วงจรเรียงกระแส

หน้าที่ของวงจรกรองกระแสในแหล่งจ่ายไฟคือ ทำให้รูปคลื่นของไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระแสเฟืองในรีเลย์เรียบขึ้น และทำให้ใกล้เคียงกับไฟฟ้ากระแสตรงบริสุทธิ์เท่าที่จะทำได้ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพียงไม่กี่วงจร ที่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องกับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงที่ไม่ผ่านการกรองกระแส วงจรกรองกระแสที่ง่ายที่สุดได้แก่ การต่อตัวเก็บประจุขนานกับทางออกของวงจรเรียงกระแสและโหลด วงจรกรองกระแสแบบนี้เรียกว่า "วงจรกรองกระแสแบบบังคับ" (BRUTE-FORCE FILTER) ตัวอย่างจะแสดงให้เห็นในรูปที่ 5



รูปที่ 5 ตัวเก็บประจุ  $C_1$  จะทำหน้าที่กรองกระแสเพื่อให้แรงดันไฟตกคร่อม  $R_L$  อยู่ตลอดเวลา

จะใช้สมการที่ 7 ในการคำนวณ อย่างไรก็ตาม เราจะต้องคำนวณหาค่าความต้านทานที่เป็นโหลดจาก

$$\begin{aligned}
 R_L &= V_o / I_o \\
 &= 12 / 2 \\
 &= 6
 \end{aligned}$$

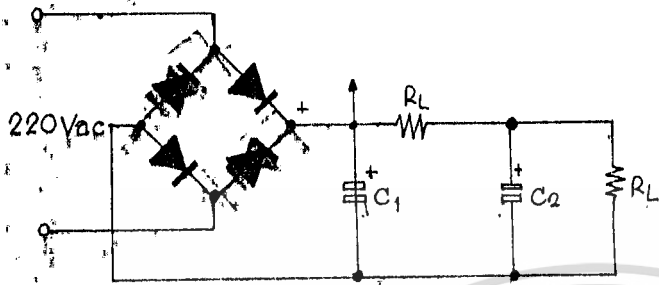
ดังนั้น

$$R.F. = 1 / (346)(6)(1000 \times 10^{-6}) = 0.48$$

วงจรกรองกระแสแบบพายใช้ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ (RC PI-SECTION FILTER)

วงจรกรองกระแสแบบพายแสดงในรูปที่ 7 เป็นการปรับปรุงการกรองกระแสได้ดีขึ้น เนื่องจากเป็นการปรับปรุงเพื่อลดริปเปิ้ลที่ทำให้การรักษาระดับแรงดันไม่คงที่และช่วยจำกัดกระแส โดย  $R_1$

โดยที่  $R_2$  จะช่วยเพิ่มค่าอิมพีแดนซ์ทางด้านขาออกของแหล่งจ่ายไฟ



รูปที่ 7 เป็นวงจรกระแสแบบพาย ที่ใช้ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ เพื่อปรับปรุงการกรองกระแส เป็นการเพิ่มค่าการรักษาระดับแรงดัน ซึ่งวงจรนี้เหมาะสำหรับโหลดที่ดึงกระแสที่ผลกระทบ การขึ้นของการใช้วงจรกรองกระแสแบบพายนี้ อาจจะถูกมองข้ามไป ถ้ามีการลดค่าริปเปิ้ลเป็นตัว หลักที่ต้องคำนึงถึง และกระแสไหลล้นค่อนข้างคงที่ตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งของการใช้งานอันหนึ่งได้แก่ภาคปริ ออมป์ของวงจรขยายเสียง คลาส A เนื่องจากวงจรใช้กำลังงานต่ำ แต่ต้องใช้การกระแสที่เกือบจะคงที่ ในขณะที่เดียวกันวงจรภาคปริ ออมป์นี้ต้องการแหล่งจ่ายไฟที่ปราศจากริปเปิ้ลเพื่อไม่ให้เสียงฮัมที่มาจาก ค่าตัวประกอบริปเปิ้ลทางขาออกของรูปที่ 7 (ที่ตกคร่อม  $R_2$ ) สามารถหาได้จากสมการต่อไปนี้คือ

$$R.F. = K/C_1 C_2 R_1 R_2 \dots\dots\dots (12)$$

โดยที่  $C_1$  และ  $C_2$  มีหน่วยเป็นฟารัด,  $R_1$  และ  $R_2$  มีหน่วยเป็นโอห์ม, K เป็นค่าคงที่ ( $10^{-3}$  สำหรับวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น และ  $2 \times 10^{-3}$  สำหรับวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น) ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างง่าย ๆ ซึ่ให้หาค่าตัวประกอบริปเปิ้ลของแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงขนาด 12 โวลท์ 500 มิลลิแอมป์ ซึ่งมีค่า  $C_1$  เท่ากับ 1,000 ไมโครฟารัด,  $C_2$  เท่ากับ 500 ไมโครฟารัด และ  $R_1$  เท่ากับ 8Ω โอห์ม สมมติว่าเป็นวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นผลลัพธ์จะหาได้ดังนี้

$$\begin{aligned} RF &= 2 \times 10^{-3} / 10^{-3} \times 5 \times 10^{-4} \times 68 \times (12 / 0.5) \\ &= 2 \times 10^{-6} / 8.2 \times 10^{-4} \\ &= 0.002 \end{aligned}$$

ในหลายกรณี แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงในทางปฏิบัติที่คล้ายกับรูปที่ 7 จะมีไฟขาออกอยู่ 2 ที่ โดยไฟขาออกที่มีริปเปิ้ลต่ำที่คร่อม  $C_2$  และไฟที่ขาออกที่สามารถจ่ายกระแสได้สูงที่คร่อม  $C_1$  โดยแต่ละที่ จะมีค่าตัวประกอบริปเปิ้ลแตกต่างกันไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## การเลือกตัวเก็บประจุที่ใช้ในวงจรกรองกระแส

ค่าของตัวเก็บประจุที่ใช้ในวงจรกรองกระแสของแหล่งจ่ายไฟส่วนใหญ่แล้ว จะมีค่าสูงเมื่อเทียบกับค่าของตัวเก็บประจุอื่น ๆ ที่ใช้ในวงจรที่ถูกป้อนโดยแหล่งจ่ายไฟ แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงแรงดันสูง จะใช้ตัวเก็บประจุอยู่ในย่าน 5 ไมโครฟารัด ถึง 100 ไมโครฟารัด (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้แบบ RC หรือ LC) ในขณะที่แหล่งจ่ายไฟแรงดันต่ำจะมีตัวเก็บประจุในวงจรกรองกระแสอยู่ในย่านเกิน 500 ไมโครฟารัด อาจจะมีตัวเก็บประจุที่ใช้กรองกระแสค่า 150,000 ไมโครฟารัด ในแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์บางตัว

ในวงจรแหล่งจ่ายไฟบางแห่งนี้จะซับซ้อนขึ้นโดยใช้อุปกรณ์หลายภาคซึ่งก่อให้เกิดการตัดปลิง (DECOUPLING) ในระหว่างภาค เพื่อที่จะป้องกันการออสซิลเลต อันเนื่องมาจากเส้นทางของการป้อนกลับที่ไม่ต้องการ สมการที่ต้องการใช้ เพื่อที่จะคำนวณหาค่าตัวประกอบปรับเบิ้ลที่ต้องการลดลง แต่อาจจะไม่เพียงพอสำหรับการตัดสัญญาณไฟกระแสสลับความถี่ต่ำ และสัญญาณเสียงใน การคำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ของตัวประกอบปรับเบิ้ลที่ใช้ได้ โดยทั่วไปแล้วก็เป็นเพียงพอ แต่เมื่อการตอบสนองด้านความถี่ต่ำของวงจรขยายเสียง เข้าใกล้ย่านไฟตรง (ดังที่อาจจะ เป็นในระบบเครื่องมือวัดหรือระบบควบคุม) เราอาจจะต้องการคำนวณหาความถี่สูงขึ้นไป เพื่อให้เหมาะสมในการตัดปลิงกฎโดยทั่วไปก็คือ การเลือกค่าตัวเก็บประจุที่ทำให้ (ก) ให้การตอบสนองต่อความถี่ต่ำที่ต่ำองการ หรือ (ข) เพื่อให้เกิดการลดค่าปรับเบิ้ลตามที่ต้องการ เมื่อค่าต่าง ๆ เหล่านี้ไม่เท่ากันก็ให้ เลือกใช้ค่าความจุค่าที่สูงกว่า

มีกฎง่าย ๆ ในการเลือกค่าความจุสำหรับการตัดปลิง ซึ่งจะให้ค่าปรับเบิ้ลเท่ากันหนึ่งในรูปของค่าความต้านทาน ที่ความถี่ต่ำสุดของการทำงานจะได้สมการคือ

$$C = 1/2 F (0.1 R_{\omega}) \dots\dots\dots (13)$$

เมื่อ C เป็นค่าความจุหน่วยเป็นฟารัด, F เป็นจุดหาความการตอบสนองความถี่ต่ำโดยกำลังลดลง - 3DB และ  $R_{\omega}$  เป็นความต้านทานของวงจรแหล่งจ่ายไฟ วิธีการออกแบบที่ถูกต้องก็คือ การคำนวณค่าความจุที่ต่ำที่สุดจากทั้งตัวประกอบปรับเบิ้ล และช่วงการตอบสนองความถี่แล้ว จึงเลือกเอาค่าที่สูงกว่าจากค่าทั้งสองที่คำนวณได้ ค่าความจุค่าสูงๆ สามารถหาได้จากตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันสองชนิดคือ แบบอลูมิเนียมและแทนทาลัม สำหรับงานกรองกระแสแล้วส่วนใหญ่จะใช้แบบอลูมิเนียม

### อัตราทนกำลังและแรงดันใช้งานสูงสุด

อัตราการทำงานกำลังของตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะต้องคำนึงถึง ได้แก่ ค่าความจุและระดับแรงดันใช้งานสูงสุด (DC WORKING VOLTAGE : WVDC) โดยปกติแล้วค่าความจุของตัวเก็บ

ประจักษ์เล็กทรอโลต์แบบอสมมาตร จะมีค่าความคลาดเคลื่อน (TOLERANCE) จาก - 20 เเปอร์เซ็นต์ ถึง 100 เเปอร์เซ็นต์ ถ้าค่าตัวประกอบปรับเบิ้ลหรือการตอบสนองความถี่ใน ค้อนข้างวิกฤตก็ให้เพิ่มค่า ความจุของวงจรกรองกระแสจากที่คำนวณได้อีก 20 ถึง 30 เเปอร์เซ็นต์ โดยปกติไม่มีโทษอะไรในการ ใช้ค่าความจุที่มากเกินไป สำหรับอัตราการทนแรงดันใช้งานสูงสุดนั้น โดยปกติจะยอมให้มีความคลาด เเคลื่อนได้อีก 20 เเปอร์เซ็นต์ เนื่องมาจากการออกแบบที่ไม่รัดกุม จะงานตัวเก็บประจุในวงจรกรอง กระแสที่ค่าความต่างศักย์สูงกว่า 80 เเปอร์เซ็นต์ ของค่าระดับแรงดันใช้งานสูงสุดนอกจากนี้ยังต้องจำไว้ ในใจว่า ค่าความต่างศักย์ในวงจรอาจจะแปรเปลี่ยนไปประมาณ  $\pm 20$  ครั้งจึงควรเลือกอัตราการทน แรงดันใช้งานสูงสุดอย่างน้อยสูงกว่า 40 ของค่าแรงดันที่คลาดว่าจะเป็นจริง ต่อไปนี้จะอ้างถึงการออกแบบที่ผิดพลาดในการใช้อุปกรณ์ ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงกับตัวเก็บประจุที่ใช้ในวงจร กรองกระแส กล่าวคือแหล่งจ่ายไฟตรงขนาด + 200 โวลท์ ที่มีการรักษาระดับค่าแรงดันไว้ ซึ่งในภา คร์รักษาแรงดันในภาคต้น ๆ นั้น ค่าความต่างศักย์ที่ตกคร่อมภาคกรองกระแสโดยปกติเท่ากับ +200 โวลท์ ักถอดแบบได้ใช้ตัวเก็บประจุแบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดทนแรงดันสูงสุด 50 โวลท์ ต่อขนาดกันตัวเก็บ ประจุที่มีอัตราการทนแรงดันสูงสุด 25 โวลท์จะได้อัตราการทนแรงดันสูงสุดของตัวเก็บประจุนี้เท่ากับ 25 โวลท์

การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม

ในรูปที่ 9 จะแสดงให้เห็นถึงตัวเก็บประจุต่อแบบอนุกรมกัน เพื่อที่จะเพิ่มค่าอัตราทนแรงดัน สูงสุดแต่วิธีนี้จะเป็นการลดค่าของความจุตามกฎการต่ออนุกรมกันของตัวเก็บประจุ ส่วนใหญ่แล้วตัวเก็บ ประจุที่ต่ออนุกรมกันที่มีค่าเท่ากับค่าความจุรวมจะเท่ากับ  $C/N$  เมื่อ C เป็นค่าความจุของแต่ละตัวและ N เป็นจำนวนที่ต่ออนุกรมกัน ถ้าตัวเก็บประจุทั้งหมด มีค่าความจุและอัตราการทนแรงดันสูงสุดเท่ากันแล้ว อัตราการทนแรงดันสูงสุดทั้งหมดจะเท่ากับผลรวมของอัตราการทนแรงดันสูงสุดแต่ละตัวรวมกัน ดังนั้นถ้า นำเอาตัวเก็บประจุขนาด 200 ไมโครฟารัด อัตราการทนแรงดันสูงสุด 450 โวลท์ จำนวน 4 ตัวมาต่อ อนุกรมกัน จะได้ค่าความจุรวมเท่ากับ 50 ไมโครฟารัด โดยมีอัตราการทนแรงดันเท่ากับ 1000 โวลท์ ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเห็นตัวเก็บประจุต่ออนุกรมกันในวงจรกำลังงานสูงหลอดสูญญากาศ และวงจรขยาย สัญญาณวิทยุของนักวิทยุสมัครเล่น

การต่อความต้านทานรวม

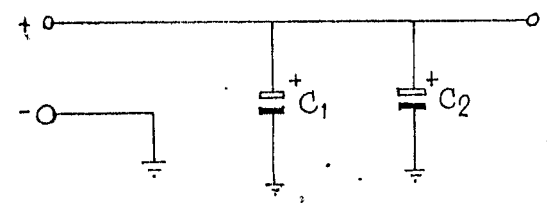
ในบางวงจรจะเห็นมีตัวต้านทานที่ใช้ควบคุมความสมดุลย์ของระดับแรงดัน  $R_1$  และ  $R_2$  (ในรูปที่ 9) โดยการต่อขนานกับตัวเก็บประจุแต่ละตัว ตัวต้านทานเหล่านี้ ควรจะมีค่าความต้านทาน (RO) ประมาณ 100 โอห์มต่อโวลท์ และอัตราการทนกำลังงานสูงกว่า  $V^2C/R$  ยกตัวอย่าง เช่น ตัว

เก็บประจุมีค่าแรงดันใช้งานสูงสุด 450 โวลต์ ดังนั้น  $R = (450 \times 100) = 45,000$  โอห์ม (ใช้มาตรฐาน 47,000 โอห์ม) โดยมีอัตราการทำงานกำลังงานสูงกว่า  $(450^2 / 45,000)$  หรือ 4.5 วัตต์ เราจะเลือกใช้ขนาด 5 วัตต์ก็ได้ แต่ถ้าใช้ขนาด 7 วัตต์หรือ 10 วัตต์จะเหมาะกว่า นักออกแบบบางคนจะเลือกใช้อัตราการทำงานกำลังงานต่ำลงมาเนื่องจากว่าเวลาใช้งาน แรงดันของแหล่งจ่ายไฟจะต่ำกว่าค่าอัตราการทำงานแรงดันสูงสุดเสมอยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราแน่ใจว่าระดับแรงดันจะไม่สูงกว่า 250 โวลต์ ตกคร่อมตัวเก็บประจุแล้ว เราอาจจะเลือกใช้ตัวต้านทานขนาดทนกำลังงาน 2 วัตต์ได้

ยังมีสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุที่มีค่าความจุไม่เท่ากัน โดยปกติแล้วเราสามารถรวมค่าอัตราการทำงานแรงดันสูงสุด แต่ถ้าค่าความจุไม่เท่ากันแล้ว ค่าแรงดันตกคร่อมจะมีค่าไม่เท่ากัน เราจะต้องคำนวณค่ารีแอคแตนซ์ของตัวเก็บประจุแต่ละตัวที่ค่าความถี่ของริบเบิ้ล แล้วจึงคำนวณหาค่าแรงดันที่ตกคร่อมรีแอคแตนซ์แต่ละตัว โดยการคำนวณด้วยสมการของการแบ่งแรงดัน (VOLTAGE DIVIDER) มันอาจเป็นไปได้ที่ตัวเก็บประจุหนึ่งตัวหรือมากกว่าจะได้รับแรงดันตกคร่อมแรงดันใช้งานสูงสุด 350 โวลต์ คุณอาจจะคิดว่ามันถูกต้องแล้วใช่หรือไม่แต่ผิดถนัด ลองพิจารณาเหตุถึงกรณีที่เลวร้ายที่สุดซึ่งค่าการทนแรงดันของตัวประจุ (VC) ต่ำกว่าอัตราการทำงานแรงดันใช้งานสูงสุดเดิม 20 เปอร์เซ็นต์และค่าแรงดันของแหล่งจ่ายไฟ (VPS) สูงขึ้นกว่าเดิม 20 เปอร์เซ็นต์ จากค่าปกติ 280 โวลต์

$$\begin{aligned}
 V_{ps} &= 280 + (0.2 \times 280) \\
 &= 336 \text{ V(dc)} \\
 V_c &= 350 - (0.2 \times 350) \\
 &= 280 \text{ V(dc)}
 \end{aligned}$$

ซึ่งในกรณีที่เลวร้ายที่สุดนี้ เราจะมีตัวเก็บประจุที่ทนแรงดันได้ 200 โวลต์ (ดีซี) ใช้ในวงจรที่มีไฟ 336 โวลต์ (ดีซี) ซึ่งตามความจริงแล้ว กรณีที่เลวร้ายที่สุดนี้ อาจจะไม่ค่อยเกิดขึ้น แต่ตัวเก็บประจุเหล่านี้มักจะเกิดความเค้นได้จนเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้ในอุปกรณ์ที่ค่อนข้างวิกฤต การแก้ไขก็โดยการเปลี่ยนตัวเก็บประจุแบบอิเล็กทรอนิกส์ทรอไลต์ขนาดทนแรงดันใช้งานสูงสุด 350 โวลต์ (ดีซี) ทั้งหมดในวงจรมาเป็นขนาดทนแรงดันได้ 450 โวลต์โดยมีค่าความจุเดิม



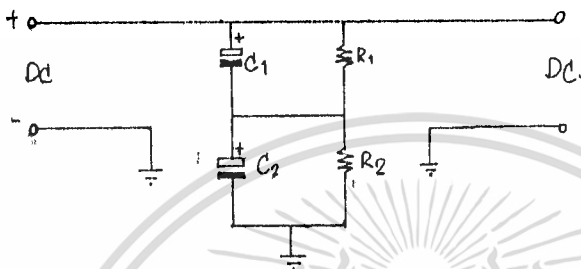
รูปที่ 8. ตัวเก็บประจุที่ใช้กรองกระแสต่อกันแบบขนาน ทำให้ค่าความจุรวมเพิ่มขึ้นเท่ากับผลรวมของค่าความจุแต่ละตัว

## การต่อตัวเก็บประจุแบบขนาน

ในบางกรณีจะเป็นที่จจะรวมค่าตัวเก็บประจุเข้าด้วยกันเพื่อให้ค่าความจุสูงขึ้น เมื่อตัวเก็บประจุสองตัวหรือมากกว่าต่อขนานกัน (ในรูปที่ 8) ค่าความจุรวม  $C_T$  จะหาได้จากสมการตั้งนี้คือ

$$D_T = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

อัตราการทนแรงดันการใช้งานสูงสุดของตัวเก็บประจุที่ต่อขนานกันจะเท่ากับอัตราการทนแรงดันสูงสุดของตัวเก็บประจุที่ต่ำที่สุดในกลุ่ม ยกตัวอย่างเช่น ถ้าตัวเก็บประจุที่มีอัตราการทนแรงดันมากกว่าตัวอื่น ๆ



รูปที่ 9 ตัวเก็บประจุที่ใช้กรองกระแสต่อกันแบบอนุกรมเพื่อเพิ่มค่าระดับแรงดันสูงสุดตัวเก็บประจุบายพาส

ส่วนในรูปที่ 10 มักพบในแหล่งจ่ายไฟของวงจรขยายกำลังสัญญาณความถี่วิทยุโดยตัวเก็บประจุแบบอิเล็กทรอนิกส์ทรานซิสเตอร์จะไม่มีความสามารถในการส่งผ่านความถี่สัญญาณวิทยุหรือความถี่สูง ในงานเหล่านี้



รูปที่ 10 ตัวเก็บประจุแบบอิเล็กทรอนิกส์ทรานซิสเตอร์ไม่สามารถที่จะใช้ส่งผ่านความถี่สูง ๆ ได้ ดังในจึงใช้ตัวเก็บประจุแบบเซรามิกแทน

นั้นเราต้องการตัวเก็บประจุค่าสูง ๆ สำหรับลดค่าริปเปิ้ล และตัวเก็บประจุแบบเซรามิกหรือไมกาสำหรับเหนี่ยวนำความถี่สูงทิ้งไป สำหรับในรูปที่ 10 ตัวเก็บประจุขนาด 2,200 ไมโครฟารัด สำหรับลดค่าริปเปิ้ลในแหล่งจ่ายและตัวเก็บประจุขนาด 0.1 ไมโครฟารัดสำหรับเหนี่ยวนำความถี่สูงทิ้งไป

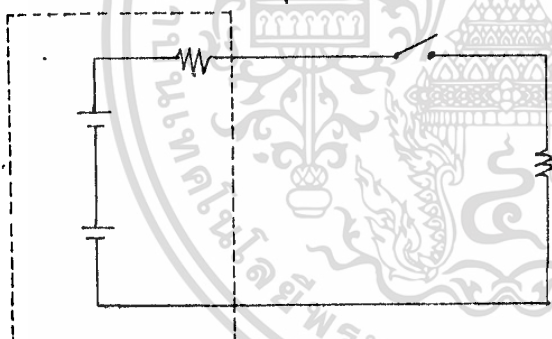
## การรักษาระดับแรงดันให้คงที่

จุดมุ่งหมายของการรักษาระดับแรงดันให้คงที่ ก็คือการรักษาระดับแรงดันเอาต์พุทให้คงที่แม้ว่ากระแสของโหลดเอาต์พุท ระดับแรงดันอินพุทหรือทั้งสองอย่าง มีการเปลี่ยนแปลงไปก็ตามปัญหาเนื่อง

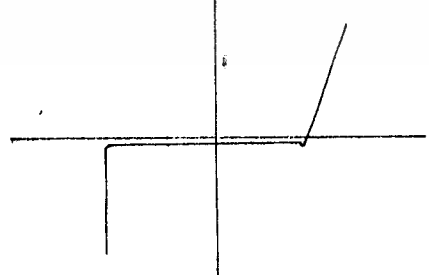
ต้นของการรักษาระดับแรงดันเชิงก่อกำเนิดความยุ่งยากกับอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านซึ่งมีอยู่หลายสาขา เหตุ ปัญหาแรก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงระดับแรงดันของแหล่งจ่ายไฟจากสายตามบ้าน ซึ่งสามารถจะเปลี่ยนแปลงขึ้น ๆ ลง ๆ ได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ หรือในเบตเตอรี่ยรถยนต์ ระดับแรงดันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งโดยปกติจะเปลี่ยนแปลง 20-25 เปอร์เซ็นต์ การเปลี่ยนแปลงแรงดันของเบตเตอรี่ยรถยนต์จะก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น เครื่องเสียงที่ติดตั้งภายในรถยนต์

ส่วนสาเหตุประการที่สองของการเปลี่ยนแปลงระดับแรงดันเอาต์พุต ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของกระแสไหลตรงกลับของปัญหาได้แก่ ไม่มีแหล่งจ่ายไฟใดที่มีคุณสมบัติเหมือนกับไดโอดชนิดเดียวเนื่องจากแหล่งจ่ายไฟทุกชนิดจะมีค่าความต้านทานภายใน บางครั้งเรียกว่าความต้านทานของแหล่งจ่ายไฟทุกชนิดจะมีค่าความต้านทานภายใน บางครั้งเรียกว่าความต้านทานของแหล่งจ่าย ปัญหาในเรื่องค่าความต้านทานภายในนี้ แสดงให้เห็นในรูปที่ 11 โดยจะต่ออนุกรมอยู่กับแหล่งจ่ายแรงดัน เมื่อไม่มีกระแสเอาต์พุตไหลระดับแรงดันเอาต์พุตจะมีค่าเท่ากับ แต่เมื่อเกิดการไหลของกระแสเอาต์พุตก็จะเกิดแรงดัน (เท่ากับ ) ตกคร่อมความต้านทานภายในของแหล่งจ่ายไฟ ภายใต้สภาวะเช่นนี้ ค่าความต่างศักย์ที่เป็นจริงของเอาต์พุต

เราสามารถสรุปได้ว่าการรักษาให้ระดับแรงดันเอาต์พุตเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้



รูปที่ 11 ค่าความต้านทานภายใน (RS) ขนาดต่ำ ๆ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการออกแบบรักษาแรงดันทำได้ดี ภายใต้เงื่อนไขซึ่งค่าของ เปลี่ยนแปลงไปมาก



รูปที่ 12 การรักษาระดับแรงดันของซีเนอร์ไดโอดจะทำในย่านไปอัลสกลับ ภายใต้สภาวะไบอัสตรงก็จะเหมือนกับไดโอดทั่ว ๆ ไป

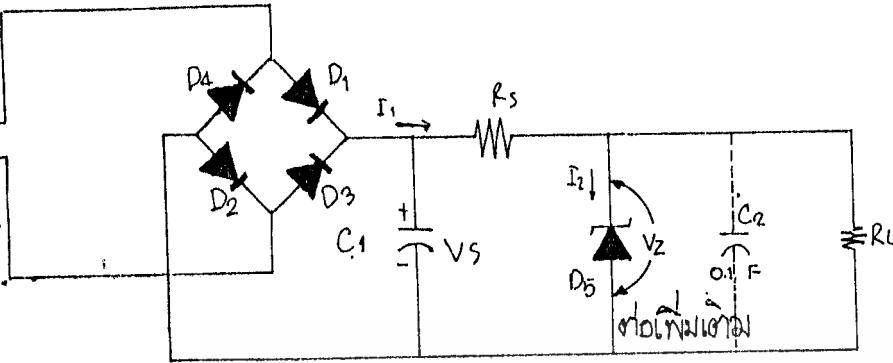
ในเงื่อนไขที่ 3 ให้ค่า  $V_{MIN}$  เช่นเดียวกับเงื่อนไขที่ 1 และใช้ค่า  $I_{SM} \times$  เช่นเดียวกับ

เงื่อนไขที่ 2

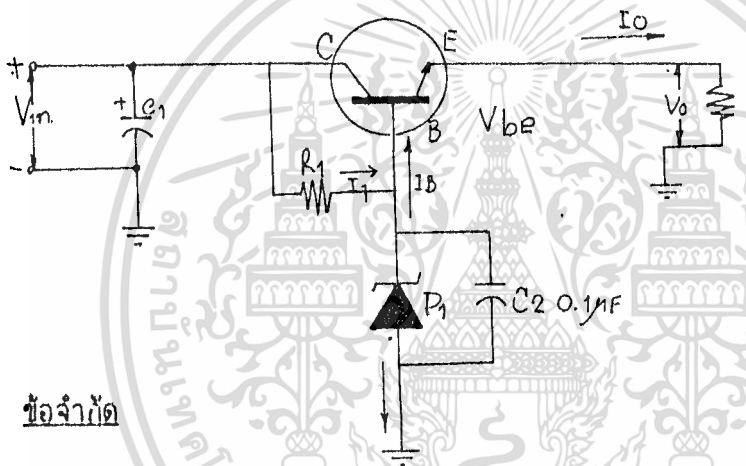
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 13 แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงที่รักษาระดับแรงดันด้วยซีเนอร์ไดโอด เพื่อให้ระดับที่  $R_L$  คงที่ ตัวเก็บประจุ  $C_1$  จะทำหน้าที่กรองกระแสโดยการรักษาระดับ  $V_S$  ให้สูงกว่า  $V_Z$  เสมอ



รูปที่ 14 ค่าความสามารถในการจ่ายกระแสของซีเนอร์ไดโอดสามารถทำให้เพิ่มขึ้นได้ โดยการเพิ่มทรานซิสเตอร์เข้าไปในวงจรแรงดัน  $V_{BE}$  จะรวมกับ  $V_Z$  เพื่อให้ได้ระดับแรงดันเอาต์พุต  $V_O$  คงที่



ข้อจำกัด

บางคนเข้าใจผิดว่า ซีเนอร์ไดโอดเป็นวงจรรักษาระดับแรงดันที่ใช้ได้โดยทั่วไปซึ่งความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น ซึ่งในการใช้งานส่วนใหญ่แล้วมันถูกจำกัดให้ใช้ในวงจรของแหล่งจ่ายไฟที่มีขนาดกระแสที่ต่ำจนถึงปานกลาง แต่ถ้าต้องการกระแสที่สูงขึ้นก็ทำได้ โดยการใช่วงจรที่ใช้ซีเนอร์ไดโอดในการให้ค่าระดับแรงดันอ้างอิง แต่ต้องมีอุปกรณ์ตัวอื่นช่วยในการรับกระแสที่สูงขึ้น

ซีเนอร์ไดโอดนั้น จะได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดของระดับแรงดันอ้างอิงเองมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และนอกจากนี้จากหลักความจริงที่ว่าระดับแรงดันซีเนอร์นั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้มากกว่าที่จะมีค่าคงที่อย่างแน่นอน แต่ก็ยังมีวิธีการในการเอาชนะข้อจำกัดเหล่านี้ แต่ในขณะที่จะต้องระมัดระวังถึงความเที่ยงตรง ความแน่นอน ระดับแรงดันอ้างอิง ซึ่งสามารถพลได้จากไดโอดแบบพิเศษที่ใช้เป็นแรงดันอ้างอิง และในอุปกรณ์ที่เป็นแบบวงจรรวม ซึ่งภายใต้บรรจุซีเนอร์ไดโอดไว้

วงจรรักษาระดับแรงดันที่ใช้ทรานซิสเตอร์ (SERIES PASS TRANSISTOR REGULATOR)

เราสามารถที่จะเพิ่มความสามารถในการจ่ายกระแสของซีเนอร์ไดโอด โดยการใส่ทรานซิสเตอร์เข้าไปในวงจรแรงดัน  $V_{BE}$  จะรวมกับ  $V_Z$  เพื่อให้ได้ระดับแรงดันเอาต์พุต  $V_O$  คงที่

ซิสเตอร์กำลังในการจ่ายกระแสไหลต และใช้ซีเนอร์ไดโอดในการควบคุมรอยต่อระหว่าง D-E ของ ทราวซิสเตอร์

ในรูปที่ 14 จะแสดงให้เห็นถึงวงจรรักษาระดับแรงดัน ซึ่งใช้ทราวซิสเตอร์ต่ออนุกรม (Q1) โดยในรูปที่ 14 นี้ เป็นตัวอย่างของวงจรรักษาระดับแรงดันแบบอนุกรม เนื่องมาจากรอยต่อระหว่างขา C-E ของ Q1 จะต่ออนุกรมอยู่กับโหลด (RL) ตัวเก็บประจุ C1 ในรูปที่ 14 นี้เป็นตัวเก็บประจุที่ใช้กรองกระแสแบบธรรมดา ที่อยู่ตรงเอาต์พุทของวงจรเรียงกระแสตัวเก็บประจุโคโรจจะมีค่าอย่างต่ำ 1000 ไมโครฟารัดต่อกระแสไหลตเอาต์พุทสูงสุด 1 แอมป์แปร์ (IOMAX) ระดับแรงดันเอาต์พุทจะถูกกำหนดโดยค่าความต่างศักย์ของซีเนอร์ ( $V_Z$ ) และมีค่าโดยประมาณเท่ากับ  $V_O = V_Z + V_{BE}$

เมื่อ  $V_{BE}$  มีค่าโดยประมาณ 0.7 โวลท์สำหรับทราวซิสเตอร์แบบซิลิกอน ค่ากระแสไหลตสำหรับซีเนอร์ไดโอดในรูปที่ 14 จะมีกระแสเบส  $I_B$  ของ Q1 เนื่องจากกระแสที่มิแควโมเมท์จะเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับระดับแรงดันอินพุต เราใช้สมการในการออกแบบในเงื่อนไขที่ 3 ดังข้างต้น สำหรับวงจรรักษาระดับแรงดันด้วยซีเนอร์ไดโอด เราจะต้องเลือกทราวซิสเตอร์สำหรับ Q1 ซึ่งจะต้อง (1) สามารถรับค่ากระแสเอาต์พุทสูงสุด ( $I_O$ ) ได้มีค่าระดับแรงดันให้ขาคอลเลคเตอร์อย่างโอเวอร์เท่ากันค่าสูงสุดของ  $V_{IN}$  (3) สามารถกระจายกำลังงาน โดยแทนค่าด้วย  $(V_{IN} - V_O) \times I_O$  และ (4) มีค่าอัตราขยายกระแส (CURRENT GAIN :  $H_{FE}$ ) ที่เพียงพอเมื่อถูกขับด้วย  $I_B$  ที่เหมาะสม

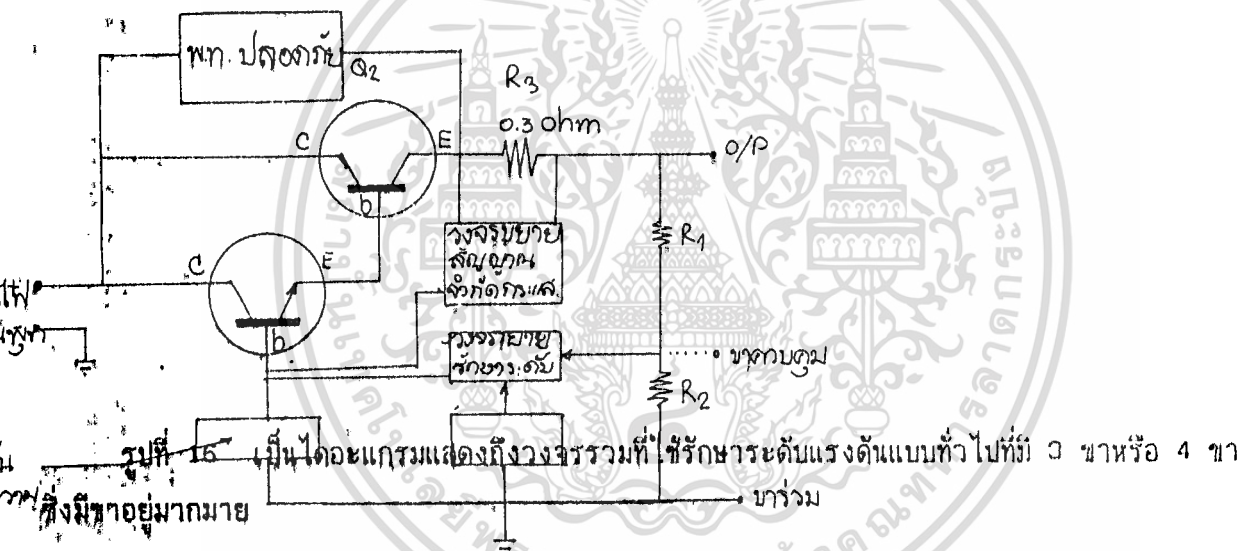
อัตราขยายกระแส (เบต้าหรือ  $H_{FE}$ ) เป็นอัตราส่วนระหว่างกระแสคอลเลคเตอร์ ( $I_C$ ) ต่อกระแสเบส ( $I_B$ )

ทราวซิสเตอร์เลือกมาใช้เป็น Q1 จะต้องมีความสัมพันธ์ตรงตามกฎเกณฑ์ที่ วงจรรักษาระดับแรงดันแบบอนุกรมนี้สามารถดัดแปลงใหม่ดังแสดงในรูปที่ 15 โดยอัตราซิสเตอร์ที่ต่ออนุกรมอยู่กับเมื่อเก็บในรูปที่ 14 แต่วงจรที่ใช้ควบคุมที่ขาเบสของทราวซิสเตอร์ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ในรูปที่ 15 แรงดันที่ใช้ควบคุมขาเบสจะเป็นความต่างศักย์เอาต์พุต ( $V_B$ ) ที่สร้างจากวงจรขยายสัญญาณ A1

วงจรขยายนี้จะต้องมีอินพุตที่เป็นแบบค่าความแตกต่าง (DIFFERENTIAL INPUT) โดยระดับแรงดันอ้างอิง ( $V_{REF}$ ) จะป้อนเข้าสู่ขาอินพุตที่ไม่กลับสัญญาณ (NONINVERTING INPUT) ในขณะที่ระดับความต่างศักย์เอาต์พุตที่เป็นจริงนี้อาจจะป้อนเข้าสู่ขากลับสัญญาณ (INVERTING INPUT) ของ A1 โดยแรงดันเอาต์พุตที่เป็นจริงนี้อาจจะเป็นค่า  $V_O$  ที่แท้จริง หรือเป็นเปอร์เซนต์ของแรงดันเอาต์พุต ( $V_1$ ) หลังจากผ่านวงจรแบ่งระดับแรงดัน ( $R_1$  และ  $R_2$ ) เอาต์พุตของวงจรขยายสัญญาณ A1 นี้จะแปรผันโดยตรงกับ (ก) ค่าความแตกต่างของอัตราขยายแรงดันของ A1 และ (ข) ค่าแรงดันที่แตกต่างกันของ  $V_{REF} - V_1$

รูปที่ 15 ระดับแรงดันนี้ป้อนกลับจากเอาต์พุตจะเปรียบเทียบกับระดับแรงดันอ้างอิงในวงจรขยายสัญญาณ ซึ่งจะควบคุมกระแสที่ไหลผ่านทรานซิสเตอร์ที่ต่ออนุกรมอยู่

วงจรรักษาระดับแรงดันในรูปที่ 15 นี้ บางครั้งเรียกว่า วงจรรักษาระดับแรงดันแบบป้อนกลับ (FEEDBACK VOLTAGE REGULATOR) เนื่องจากมันทำงานโดยการเปรียบเทียบค่าระดับแรงดันเอาต์พุตที่เป็นจริงกับที่ควรจะเป็นจาก  $V_{REF}$  เส้นทางที่ใช้ในการตรวจรับ (SENSE LINE) นั้นจะใช้สำหรับรับเอาตัวอย่างระดับแรงดันในหลาย ๆ กรณี เส้นทางที่ใช้ตรวจรับจะต่อโดยตรงกับขั้วเอาต์พุตของวงจรรักษาระดับแรงดัน ส่วนบางกรณีเส้นทางที่ใช้ในการตรวจรับจะถูกแยกออกไป ดังนั้นมันสามารถที่จะต่อเข้ากับขั้วบวกที่โหลดเลย ซึ่งกรณีนี้จะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเมื่อแหล่งจ่ายไฟกระแสสูงถูกต่อเข้ากับโหลดโดยใช้สายตัวนำที่ยาวมากกว่า 2 - 3 นิ้วขึ้นไป แรงดันตกที่เกิดขึ้นในสายตัวนำอาจมากจนต้องคำนึงถึง และถ้าใช้เส้นทางในการตรวจรับแยกออกไปที่โหลดแล้วจะทำให้วงจรรักษาระดับแรงดันเห็นค่าแรงดันที่ตัวโหลด แทนที่จะไปรับรู้ถึงแรงดันที่เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟเองที่ไม่ถูกต้อง



วงจรรักษาระดับแรงดันที่ใช้ไอซี

มีเพียงไม่กี่คนที่ยังคงออกแบบวงจรรักษาระดับแรงดันแบบใช้อุปกรณ์แยกชิ้น (DISCRETE) เนื่องจากปัจจุบันนี้มีวงจรรักษาระดับแรงดันที่ทำมาจากวงจรรวม หรือ วงจรไฮบริด (HYBRID)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

REGULATOR) ที่มีความเชื่อถือได้สูงจำหน่ายมากมาย อุปกรณ์เหล่านี้ในบางตัวก็เป็นแบบง่าย ๆ ในขณะที่บางชนิดก็มีความสลับซับซ้อนมาก อุปกรณ์เหล่านี้มีขายในย่านกระแสจาก 100 วัตต์แอมป์ ถึง 35 แอมป์ และระดับแรงดันไฟตรงจาก 2 โวลต์ ถึง 24 โวลต์

อุปกรณ์บางตัวจะมีชีวิตเพียง 3 ชั่วโมง (อินพุต เอาต์พุต และความร้อน) และมันจะทำงานให้ระดับแรงดันค่ามาตรฐานออกมาคงที่ ในขณะที่บางตัวจะมีชีวิตมากกว่านี้ และสามารถปรับค่าแรงดันได้ การทรูออพท์ลงในตัวถึงจะเริ่มจากตัวถังของทรานซิสเตอร์แบบ 3 ขา (ประกอบด้วยตัวถังแบบ TO-18, TO-9 และแบบ TO-220) จนกระทั่งถึงตัวถังแบบดินตะขาคาบ (DIP) และตัวถังแบบไอซี จนกระทั่งถึงตัวถังแบบพิเศษที่ทำมาโดยเฉพาะ ในรูปที่ 16 จะแสดงให้เห็นถึงผังการทำงานภายในของวงจรระดับแรงดันแบบทั่วไปที่มีคุณภาพสูง และบรรจุในตัวถังแบบสามขาและสี่ขาของไอซีรักษาระดับแรงดัน ซึ่งโดยแบบทั่วไปแล้วจะบรรจุอยู่ในตัวถังทรานซิสเตอร์แบบมาตรฐาน ส่วนคุณสมบัติในการป้องกันกระแสเกิน จะได้กล่าวในภายหลัง

โดยทั่วไปไอซีรักษาระดับแรงดันแบบ 3 ขาจะทำงานกับระดับแรงดันอินพุตจาก (VOx3 โวลต์) จนถึง 35 หรือ 40 โวลต์ (ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น) บางรุ่นต้องการเพียงความแตกต่างระหว่างแรงดันอินพุตกับเอาต์พุตแค่ 2 โวลต์ (VO/2 โวลต์) สำหรับวงจรรักษาระดับแรงดันขนาด 5 โวลต์ จะต้องการระดับแรงดันทางด้านอินพุตเท่ากับ 7 ถึง 8 โวลต์ ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ไมโครคอมพิวเตอร์แบบ S-100 ใช้ระดับแรงดัน 8 โวลต์ (ยังไม่ได้รักษาระดับแรงดัน) ที่มีสแควร์จายไฟหลัก เนื่องจากหม้อแปลงจุดใส่หลอดขนาด 6.3 โวลต์ อาร์เอ็มเอส จะสามารถจ่ายระดับแรงดันที่ถูกต้อง ถ้าใช้วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์เต็มคลื่น และใช้วงจรกรองกระแสขนาด 1000 ไมโครฟารัด/แอมแปร์

สำหรับไอซีที่ใช้รักษาระดับแรงดันแบบตัวถัง 3 ขา ส่วนใหญ่แล้ว ตัวเลขที่ของซีดีจะบอกเราถึงบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของมัน ยกตัวอย่างเช่น อัตราการทนแรงดันอัตราการทนกระแสโดยประมาณ และให้ระดับแรงดันบวกหรือลบ ตัวเลขที่มีอยู่บนตัวถังแต่ละตัวนั้น จะบอกเราถึงชื่อของแรงดันที่ไอซีนั้นจะให้ มีอยู่ 2 กลุ่มหลัก ๆ คือแบบไฟบวกและแบบไฟลบ โดยจะกำหนดเป็นตัวเลขอยู่

4 แบบคือ

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| แบบให้แรงดันบวก : 78 XX | และ LM340NXX |
| แบบให้แรงดันลบ : 79 XX  | และ LM320NXX |

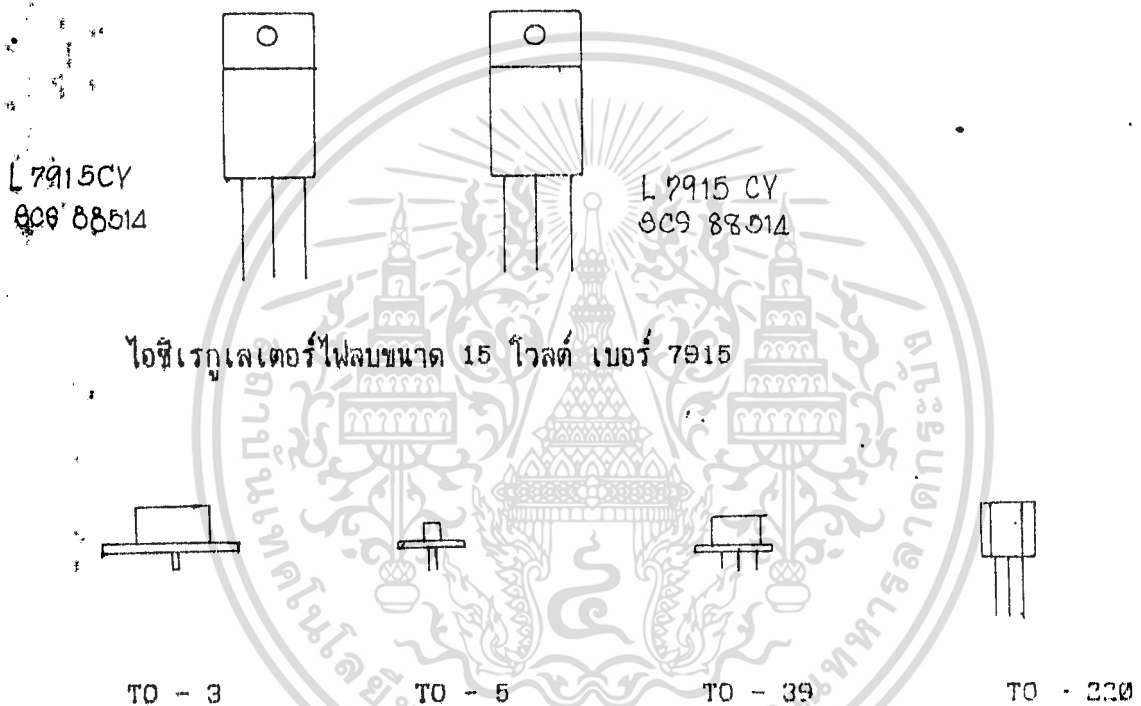
สำหรับทั้ง 4 กรณี ค่า XX จะระบุถึงระดับแรงดันเอาต์พุต ยกตัวอย่างเช่น เบอร์ 7005 และ LM340N05 จะเป็นไอซีรักษาระดับแรงดันขนาด 1.2 โวลต์ ส่วนตัวอักษรนั้นจะระบุถึงแบบของตัวถังที่บรรจุอยู่ และจะบอกโดยอ้อมถึงอัตราการทนกระแสโดยประมาณ โดยชื่อตัวถังที่ตั้งขึ้นมาได้แก่

H จะหมายถึง ตัวถังแบบ TO - 5 จะจ่ายกระแสได้ประมาณ 100 MA

K จะหมายถึง ตัวถังแบบ TO - 3 จะจ่ายกระแสได้ประมาณ 1A

T จะหมายถึง ตัวถังแบบ TO - 220 จะจ่ายกระแสได้ประมาณ MA

หมายเหตุ \* หมายถึง ใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เป็นอากาศ ซึ่งจะจ่ายกระแสได้สูงกว่านี้ โดยใช้แผ่นระบายความร้อนที่เหมาะสม หรือใช้พัดลมเป่า ตัวถังแบบ TO - สามารถมีอัตราทกกำลังได้ 0.5 และ 10 แอมป์ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะทนได้สูงสุด 1 แอมป์ ดังนั้นไดโอดเบอร์ LM340K05 จึงเป็น ไอซีรักษาแรงดันแรงดันบวก ขนาด 5 โวลต์ บรรจุในตัวถังแบบ TO - 3 และสามารถรับค่ากระแสเอาต์พุตขนาด 1 แอมป์ได้อย่างปลอดภัย



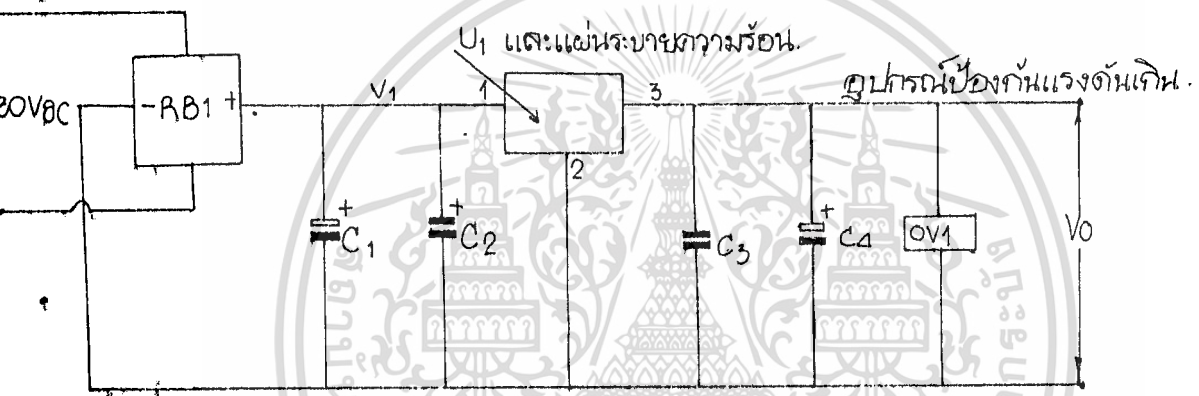
รูปที่ 17 ไอซีรักษาแรงดันแรงดันแบบ 3 ขา หลายชนิดบรรจุอยู่ในตัวถังทรานซิสเตอร์และไอซีทั่วไป ตัวถังแบบที่เห็นกันอยู่บ่อย ๆ แสดงให้เห็นซึ่งกำหนดด้วยตัวเลขบอกลักษณะของตัวถัง ตัวถังแบบ TO - 3 นี้ ตัวถังมันจะเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟเฝ้าด้วย ส่วนตัวถังแบบ TO - 220 จะมีการเจาะสำหรับติดตั้งอยู่ตรงกลางตัวถัง และขากลายจะต่อเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟเฝ้ากับตัวถัง

การรักษาแรงดันด้วยไอซี 3 ขา (THREE - TERMINAL REGULATORS)

วงจรรักษาแรงดันใช้ไอซีแบบ 3 ขานี้เป็นกลุ่มของอุปกรณ์ซึ่งให้ค่าระดับแรงดันเอาต์พุตทั้งที่ บรรจุอยู่ในตัวถังของทรานซิสเตอร์แบบมาตรฐาน (แบบ TO-3, TO-39, TO 22, TO-5, TO-220)

กระแสเอาต์พุตสูงสุดที่จ่ายได้อยู่ในย่านจาก 100 มิลลิแอมป์ ในตัวถังแบบ TO-5 (และ TO-30, TO-92) ไปจนถึง 10 แอมป์แอมป์ ในตัวถังแบบ TO-3 สำหรับตัวถังแบบ TO-3 และ TO 220 นั้น ส่วนใหญ่จะอยู่ในอัตรา 750 มิลลิแอมป์ จนถึง 1 แอมป์

ในรูปที่ 17 แสดงให้เห็นถึงรูปร่างของตัวถังรูปร่างของตัวถังประเภทต่าง ๆ ที่นิยมใช้บรรจุวงจรไอซีรักษาระดับแรงดันแบบ 3 ขา เป็นส่วนใหญ่ จึงสังเกตว่าทุกตัวเป็นตัวถังทรานซิลเดอริเบมาตรฐาน แต่ก็ยังมีบางแบบที่ใช้ตัวถังต่างจากนี้ไป ซึ่งก็ใช้ในอุปกรณ์ซีดีพิเศษและขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตด้วย วงจรมาตรฐานทั่วไปที่นิยมใช้ไอซีรักษาระดับแรงดันแบบ 3 ขา แสดงให้เห็นในรูปที่ 18 อุปกรณ์บางตัวในวงจรก็เป็นแบบเพิ่มเติมเป็นพิเศษ (OPTIONAL) แต่บางตัวก็พบว่าไอซีอยู่เสมอทุกวงจรในรูปที่ 18 นี้ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงหม้อแปลงไฟฟ้าและแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับซึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นวงจรรักษาระดับแรงดัน หรือไม่มีการรักษาระดับแรงดัน หรือไม่มีการรักษาระดับแรงดันก็ตาม



รูปที่ 18 เป็นวงจรรักษาระดับแรงดันโดยใช้ไอซีแบบ 3 ขา ตัวเก็บประจุ C2 และ C3 จะใช้เพื่อลดทรานเซียนต์ที่เป็นสัญญาณรบกวนตัวไอซี วงจรป้องกันแรงดันเกิน (OV1) จะเป็นตัวป้องกันแรงดันที่เอาต์พุตเกินกว่าระดับแรงดันที่กำหนดไว้

ไดโอดเรียงกระแสแบบบริดจ์ BR1 และตัวเก็บประจุ C1 นั้นเหมือนกันหมดสำหรับแหล่งจ่ายไม่ว่า การเลือกใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้กล่าวมาแล้ว มีกฎแบบง่าย ๆ ในการเลือกค่าตัวเก็บประจุ C1 คือมีค่าไม่ต่ำกว่า 1000 ไมโครฟารัดต่อแอมป์ ของกระแสโหลดค่าสูงสุด เช่น ถ้าแหล่งจ่ายไฟขนาด 3 แอมป์ จะใช้ตัวเก็บประจุในการกรองกระแสขนาด 3000 ไมโครฟารัด (หรือมากกว่า)

ตัวเก็บประจุ C2 และ C3 ใช้สำหรับปรับค่าความต้านทานต่อสัญญาณรบกวนให้ดีขึ้นและไว้ค่าอยู่ระหว่าง 0.1 ไมโครฟารัด และ 0.47 ไมโครฟารัด ค่าที่แท้จริงขึ้นอยู่กับ การเลือกใช้ยกเว้นว่า เมื่อออกแบบให้จ่ายกระแสโหลดได้สูงขึ้น ก็จะเลือกค่าความจุสูงขึ้น เราสามารถใช้ค่าความจุ 0.1 ไมโครฟารัด และค่าความจุ 0.33 ไมโครฟารัด หรือ 0.47 ไมโครฟารัด สำหรับกระแสขนาด 3 และ 5 แอมป์ตามลำดับ ซึ่งค่าต่าง ๆ ที่กล่าวมาช่วยเป็นแนวทาง ซึ่งก็เหมาะกับงานส่วนใหญ่

ตำแหน่งของ C2 และ C3 นั้น เป็นสิ่งสำคัญมาก ตัวเก็บประจุเหล่านี้ใช้สำหรับกันแรงดันรบกวนต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยพัลส์ความถี่สูง ๆ ดังในตัวเก็บประจุ C2 และ C3 จะต้องติดตั้งให้ใกล้กับตัวถังของไอซีรักษาระดับแรงดันเท่าที่จะทำได้ บางวงจรจะแนะนำให้ติดตั้ง C2 และ C3 เข้ากับตัวถังของ U1 เลย์ที่เดียว ถ้าตัวเก็บประจุเหล่านี้ถูกติดตั้งห่างจาก U1 มากเกินไป หรือขาดเหลือไว้ยาวเกินไป จะทำให้การทำงานของตัวเก็บประจุประสิทธิภาพลดลงสำหรับตัวเก็บประจุ C4 เป็นตัวที่เพิ่มเติมเข้ามา แต่ก็แนะนำให้มิโดยเฉพาะในวงจรที่มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสไหลดอย่างมากระยะเวลาสั้น ๆ เช่น ในวงจรดิจิตอล ซึ่งในกรณีเช่นนี้เป็นหน้าที่ของตัวเก็บประจุ

หน้าที่ของ C4 ก็คือ ปรับค่าการตอบสนองทางด้านทรานเซียนต์ (TRANSIENT RESPONSE) ของวงจรรักษาระดับแรงดันในตัวเก็บประจุจะทำหน้าที่เป็นแหล่งสะสมประจุไฟฟ้าที่จะป้อนกระแสเข้าสู่โหลดในช่วงเวลาสั้น ๆ ในขณะที่วงจรรักษาระดับแรงดันกำลังปรับตัวเองเพื่อรับกับความต้องการกระแสที่สูงขึ้น

อุปกรณ์ที่ระบุว่าเป็นวงจรป้องกันแรงดันเกิน บางครั้งเรียกว่าวงจร เอลอีอาร์ ไครวบาร์ (SCR CROWBAR) หน้าที่ของ OV1 นี้ก็เพื่อป้องกันวงจรภายนอกที่รับกระแสจากวงจรรักษาระดับแรงดันนี้ ไม่ให้เกิดความเสียหายเมื่อวงจรรักษาระดับแรงดัน U1 เกิดการเสียหายขึ้น

โดยปกติระดับแรงดันอินพุต VI จะสูงกว่าระดับแรงดันเอาต์พุต VO อย่างน้อย 2-3 โวลต์ และมีค่าสูงกว่า VO มากในหลายวงจร ถ้าหาก U1 เกิดเสียหายและทำให้แรงดันอินพุต VI ปรากฏที่เอาต์พุต VO (ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเช่นนี้) ก็จะทำให้อุปกรณ์ที่อยู่ได้รับความเสียหายได้ ยกตัวอย่างเช่น ในวงจรที่แอล ถ้าหาก U1 เกิดเสียหายจะทำให้ปรากฏแรงดัน / 0 โวลต์ ขึ้นที่เอาต์พุตแรงดัน 5 โวลต์ ซึ่งก็จะทำให้ไอซีที่แอลเสียหายขึ้นมาทันที

แผ่นระบายความร้อนสำหรับ U1 นั้น บางครั้งจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาโดยผู้ผลิตบางรายแต่จริง ๆ แล้วขอแนะนำให้ผลิตแผ่นระบายความร้อนให้กับวงจรรักษาระดับแรงดันทุกชนิด เนื่องจาก วงจรรักษาระดับแรงดันเป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่จะกระจายพลังงานออกมา ดังนั้นความเชื่อถือได้จะแปรผันโดยตรงกับค่าอุณหภูมิ สำหรับวงจรที่จ่ายกระแสขนาด 1 แอมแปร์หรือที่น้อยกว่าแผ่นระบายความร้อนแบบเป็นครีบ

### เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันเอาต์พุต

ไอซีรักษาระดับแรงดันแบบ 3 ขา นั้น จะทำมาสำหรับระดับแรงดันคงที่ขนาด 2, 5, 10, 12, 15, 18, และ 24 โวลต์ ถ้าเราต้องการระดับแรงดันที่อยู่ระหว่างระดับมาตรฐานแล้ว เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา 40 จะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จะต้องการใช้วิธีการบางอย่างเข้ามาช่วยในรูปที่ 19 ได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการเปลี่ยนระดับแรงดัน VO โดยใช้ไอซีรักษาระดับแรงดันแบบค่าคงที่ ซึ่งมีอยู่ 2 วิธีคือ

ในรูปที่ 19 (ก) แสดงให้เห็นถึงการใช้ไดโอดเรียงกระแส (เช่นเบอร์ 1N4001-1N4007 หรือเทียบเท่า) ต่อเข้ากับขาร่วมของไอซีรักษาระดับแรงดัน เพื่อที่จะเพิ่มค่าแรงดันเอาต์พุต (VO) คู่ของ VO จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 0.7 โวลต์ สำหรับไดโอดแต่ละตัวที่จะมาต่ออนุกรมกัน ถึงแม้ว่าวิธีนี้จะใช้ได้ แต่ก็ไม่น่าแนะนำให้ทำเพราะว่า ระดับแรงดัน 0.7 โวลต์ที่ตกคร่อมรอยต่อพีเอ็นเอ็็นของไดโอดนั้นจะมีค่าขึ้นกับอุณหภูมิ โดยส่วนใหญ่แล้วจะนิยมใช้วิธีในรูปที่ 19 (ข)

วงจรในรูปที่ 19 (ข) นั้นจะให้ขั้วต่อของขาร่วมของไอซีรักษาระดับแรงดันมีค่าความต่างศักย์สูงขึ้นเป็นสัดส่วนกับระดับแรงดันเอาต์พุตที่ต้องการแทนที่จะต่อลงกราวด์

แต่วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดในการปรับค่าแรงดัน ได้แก่ การใช้วงจรรักษาระดับแรงดันที่ออกแบบมาเฉพาะงาน ไอซีรักษาระดับแรงดันที่ปรับค่าได้ที่มีจำหน่ายได้แก่ เบอร์ LM 317 (1.5 แอมแปร์) เบอร์ LM390 (5 แอมแปร์) และอุปกรณ์ของบริษัทแลมด้าอิเล็กทรอนิกส์ (LAMBDA ELECTRONICS) เบอร์ LASXXX

ไอซีเบอร์ LM 338 เป็นไอซีรักษาระดับแรงดันที่สามารถจ่ายกระแสได้ 5 แอมแปร์ ในตัวถังแบบ TO-3 ซึ่งจะต้องติดตั้งแผ่นระบายความร้อนช่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานะ เมื่อระดับแรงดันอินพุต (VI) สูงกว่าแรงดันเอาต์พุตมาก ซึ่งในสถานะนี้ก็จะเกิดขึ้นใน

1. พยายามรักษาค่า IO ให้คงที่ (ซึ่งเป็นไปไม่ได้ไม่เสมอไป)
2. ลดค่าความต้านทาน RS ให้น้อยที่สุด (ซึ่งเป็นวิธีการที่แพงมากและส่วนใหญ่จะเป็นไปไม่ได้)
3. จัดหาจอร์นรักษาระดับแรงดันซึ่งเป็นวิธีการที่สมเหตุสมผลมากที่สุด

ค่าเปอร์เซ็นต์ของการรักษาระดับแรงดัน (PERCENTAGE OF REGULATION % REG) เป็นวิธีการวัดค่าการรักษาระดับแรงดัน และหาได้จากสมการดังนี้

$$\% \text{ REG} = (100) (V_O - V_{LM \times}) / V_O$$

เมื่อ VO เป็นระดับแรงดันเอาต์พุต เมื่อไม่มีโหลด และ V<sub>LM x</sub> เป็นระดับแรงดันเอาต์พุตเมื่อแหล่งจ่ายไฟจ่ายกระแสออกไปสูงที่สุดเต็มขีดจำกัด

วงจรรักษาระดับแรงดันแบบอนุกรมและแบบขนาน (SERIES VS. PARALLEL REGULATORS)

วงจรรักษาระดับแรงดัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ แบบอนุกรม และ แบบขนาน

วงจรรักษาระดับแรงดันแบบขนานเป็นแบบหนึ่งซึ่งอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รักษาระดับแรงดันจะต่อขนานแบบโพลิต ตัวอย่างได้แก่ วงจรที่ใช้ซีเนอร์ไดโอดเป็นอุปกรณ์ในการรักษาระดับแรงดัน ส่วนวงจรรักษาระดับแรงดันแบบอนุกรมใน อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รักษาระดับแรงดันจะต่ออนุกรมกับโพลิต ดังตัวอย่างได้แก่ วงจรทั้งหมดที่ใช้ทรานซิสเตอร์ต่ออนุกรมเพื่อควบคุมระดับเอาต์พุต

วงจรรักษาระดับแรงดันที่ใช้ซีเนอร์ไดโอด ซีเนอร์ไดโอดเป็นวงจรรักษาระดับแรงดันที่ทำได้ง่ายที่สุดในรูปที่ 12 จะแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ และกราฟแสดงคุณลักษณะระหว่างกระแสตรงของซีเนอร์ไดโอด ซีเนอร์ไดโอดเป็นไดโอดที่ทำจากรอยต่อของสารกึ่งตัวนำชนิดพีเอ็นแอกทิฟ (PN JUNCTION) โดยได้มีการควบคุมและรักษาระดับแรงดันพังทลาย (AVALANCH VOLTAGE :  $V_z$ ) ซึ่งเรียกกันว่า แรงดันซีเนอร์ (ZENER POTENTIAL)

ซีเนอร์ไดโอดจะเหมือนกับไดโอดโดยทั่วไป เมื่อให้ทำงานในย่านที่ได้รับไบแอสตรงดังแสดงในรูปที่ 12 ในช่วงระหว่าง 0 โวลต์ ถึงประมาณ 0.7 โวลต์ (VG) กระแสจะเพิ่มขึ้นจากค่ากระแสรั่วไหลพื้นฐาน ( $I_r$ ) ไปสู่ค่ากระแสที่มีค่าเฉพาะ แต่มีลักษณะที่ไม่เป็นเชิงเส้นที่ระดับแรงดันสูงกว่า VG กระแสจะเพิ่มขึ้นอย่างเป็นเชิงเส้นต่อการเพิ่มขึ้นของระดับแรงดัน ซึ่งเรียกกันว่า เป็นค่าการทํางานตามกฎของโอห์ม (OHM'S LOW REGION OF OPERATION) ซีเนอร์ไดโอดนั้น จะทำงานคล้ายกับกับไดโอดแบบรอยต่อพีเอ็น ในย่านการทำงานแบบไบแอสกลับ ซึ่งระหว่าง 0 โวลต์และแรงดันซีเนอร์ ( $V_z$ ) โดยจะเกิดกระแสไหลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เรียกว่า "กระแสรั่วไหลเมื่อได้รับไบแอสกลับ" ( $I_r$ ) ความแตกต่างระหว่างซีเนอร์ไดโอดกับไดโอดแบบทั่วไปได้แก่ เมื่อได้รับไบแอสกลับถึงจุดซีเนอร์ ( $V_z$ ) ที่ค่าความต่างศักย์นี้ รอยต่อของไดโอดจะเกิดการพังทลาย (AVALANCHES) และกระแสจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ค่าแรงดันที่ตกคร่อมซีเนอร์ไดโอดจะมีค่าคงที่ถึงแม้ว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงของแรงดันที่ป้อนเข้ามา ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้จะทำให้เกิดการรักษาค่าระดับแรงดันโดยซีเนอร์ไดโอด ในรูปที่ 13 เป็นแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงที่รักษาระดับแรงดันด้วยซีเนอร์ไดโอด โดยตัวต้านทาน  $R_z$  จะแทนค่าโพลิตที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟนี้ (เท่ากับ  $V_z/I_z$ ) ตัวเก็บประจุ  $C_1$  เป็นตัวเก็บประจุที่ใช้กรองกระแสแบบธรรมดาค่าที่ความจุของ  $C_1$  ใช้กฎอย่างง่าย ๆ ก็คือไม่ต่ำกว่า 1000 ไมโครฟารัด ต่อค่าไมโครฟารัด ต่อกระแสโพลิต 1 แอมแปร์ หรือ 500 ไมโครฟารัด ต่อกระแส 1 แอมแปร์

ตัวเก็บประจุ  $C_2$  ในรูปที่ 13 ใช้ในการลดสัญญาณรบกวนต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากซีเนอร์ไดโอด ในหลาย ๆ วงจรที่ไม่คำนึงถึงสัญญาณรบกวน ก็อาจตัด  $C_2$  ออกไปจากวงจรได้

ตารางที่ 1 สูตรสำหรับวงจรรักษาระดับแรงดันที่ใช้ซีเนอร์ไดโอด

คำนวณค่าของ  $R_S$  ในหน่วยโอห์ม

$$\text{เงื่อนไขที่ 1 } R_S = V_{MIN} - V_z$$

$$1.1 I_D$$

$$\text{เงื่อนไขที่ 2 } RS = RIN - VZ$$

$$1.1 I_D (\text{MAX})$$

$$\text{เงื่อนไขที่ 3 } RS = VMIN - VZ$$

$$1.1 I_D (\text{MAX})$$

กำลังงานสูญเสียของ D5 หน่วยเป็นวัตต์

$$P_{D5} = (VMIN - VZ)^2 - (I_D VZ)$$

RS

กำลังสูญเสียของ RS หน่วยเป็นวัตต์

$$P_{RS} = (VMAX - VZ)^2$$

หรือ

$$P_{D5} = PDS + I_D VZ$$

การออกแบบวงจรรักษาระดับแรงดันที่ใช้ซีเนอร์ไดโอดดังแสดงให้หาในรูปที่ 13 โดยมีที่  
ตอนที่สำคัญอยู่ 4 ชิ้น คือ

1. นิยามพารามิเตอร์การทำงาน
2. เลือกค่าความต่างศักย์ของซีเนอร์
3. เลือกค่าความต้านทานและอัตราทนกำลังของ RS
4. คำนวณค่ากำลังสูญเสียของซีเนอร์ไดโอด

ซีเนอร์ไดโอดจะต้องทำงานอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อ 3 แต่อันดับแรกจะต้องเลือกเอาเงื่อนไข  
ข้อที่ใกล้เคียงกับวงจรของเราที่สุด เงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ได้แก่

1. ระดับแรงดันไฟป้อน (VS) มีค่าเปลี่ยนแปลง ส่วนกระแสไหลอด ( $I_D$ ) มีค่าคงที่
2. ระดับแรงดันไฟป้อนมีค่าคงที่ ส่วนกระแสไหลอดมีค่าเปลี่ยนแปลง
3. ระดับแรงดันไฟป้อนมีค่าเปลี่ยนแปลง และกระแสไหลอดมีค่าเปลี่ยนแปลง

สมการที่ใช้ในการออกแบบสำหรับทั้ง 3 กรณีนี้ แสดงให้เห็นในตารางที่ 1 และต่อไปนี้จะ  
แสดงให้ที่ขั้นตอนการออกแบบและตัวอย่างสำหรับเงื่อนไขไปแบบที่ 1 ถึงเงื่อนไขแบบที่ 3

### การออกแบบสำหรับเงื่อนไขที่ 1

โดยการทำตามขั้นตอนข้างล่างเพื่อกำหนดตัวแปรของวงจร

1. เลือกค่า VZ จากการใช้งาน

2. เลือกค่ากระแสไหล  $I_g$
3. คำนวณค่า  $R_S$  (ดูจากตารางที่ 1)
4. คำนวณค่ากำลังสูญเสียของซีเนอร์ไดโอด
5. คำนวณค่ากำลังสูญเสียของซีเนอร์ไดโอด และค่าอัตราทนกำลังของซีเนอร์ไดโอด
6. คำนวณค่ากำลังสูญเสียของตัวต้านทาน  $R_S$
7. เลือกอัตราทนกำลังของตัวต้านทาน  $R_S$

ตัวอย่าง .....

จงออกแบบวงจรรักษาระดับแรงดันโดยใช้ซีเนอร์ไดโอด ดังแสดงในรูปที่ 13 เพื่อให้ได้ระดับเอาต์พุตเป็นไฟตรง 6.8 โวลต์ โดยมีกระแสไหล 75 มิลลิแอมป์ แหล่งจ่ายไฟมาจากตัวแบตเตอรี่รถยนต์ ซึ่งปกติแล้วจะมีค่าแรงดันไฟตรงเปลี่ยนแปลงจาก 12 ถึง 15 โวลต์ เนื่องจากความเร็วของเครื่องยนต์จะเปลี่ยนจากตอนเดาเบาไปสู่รอบหมุนสูงขึ้น

ขั้นตอนที่ 1 .. เลือกค่า  $V_Z = 6.8$  โวลต์ดีซี (จากการกำหนดให้มา)

ขั้นตอนที่ 2 .. กำหนดค่ากระแสไหล = 0.075 แอมแปร์ (จากการกำหนดให้มา)

ขั้นตอนที่ 3 ..  $R_S = (V_{MIN} - V_Z) / 1.1 I_g$

ข้อสังเกต .. ใช้ค่า  $1.1 I_g$  เมื่อยอมให้กระแสไหลเป็น  $R_S$  เพิ่มขึ้น 10%

$$R_S = (12 - 6.8) / (1.1 / 0.075)$$

$$R_S = 5.2 (V) / 0.083 (A)$$

$$= 63 \text{ โอห์ม}$$

ขั้นตอนที่ 4 .. คำนวณค่า  $P_{DSS}$

$$P_{DSS} = (V_{MAX} - V_Z)^2 / R_S - (I_g V_Z)$$

$$= (15 - 6.8)^2 / 63 - (0.075 / 6.8)$$

$$= (8.2)^2 / 63 - 0.5$$

$$= (67.2) / 63 - 0.5$$

$$= 1.07 - 0.5$$

$$0.57 \text{ WATT}$$

ขั้นตอนที่ 5 .. เลือกอัตราทนกำลังของ DS เนื่องจากทราบค่า  $P_{DSS}$  เท่ากับ 0.57 วัตต์ เราสามารถใช้ซีเนอร์ขนาด 1 วัตต์ ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไปแล้วเป็นการเผื่อหัดที่ดีที่จะใช้ไดโอดที่มีอัตราการทำกำลังสูงกว่าค่า  $P_{DSS}$  ที่ได้จากการคำนวณ 20 เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่า)

ขั้นตอนที่ .. คำนวณค่า  $P_{DSS} = P_{DSS} + (I_D / V_Z)$

$$= 0.57 + (0.075)(6.8)$$

$$= 0.57 + 0.5$$

$$= 1.00 \text{ WATT}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขั้นตอนที่ 7 .. พิจารณาเลือกอัตราทดกำลังของ RS เนื่องจาก  $P_{out}$  เท่ากับ 1.07 วัตต์ เราเลือกใช้ตัวต้านทาน RS ขนาด 2 วัตต์ ซึ่งเป็นค่ามาตรฐาน ค่าถัดไปที่มี โดยเราใช้หลักเดียวกับอัตราทดกำลังของซีเนอร์ไดโอดคือ เมื่อไว้ 20% หรือมากกว่า

การออกแบบสำหรับเงื่อนไขที่ 2 และ 3

สำหรับเทคนิคในการออกแบบตามเงื่อนไขที่ 2 และ 3 นั้น จะเหมือนกับในเงื่อนไขที่ 1 ทุกอย่างยกเว้น ในเงื่อนไขที่ 2 ใช้ค่า  $I_{out}$  แทนค่า  $I_o$  (เงื่อนไขที่ 2 ใช้แทนค่ากระแสที่เปลี่ยนแปลง) แหล่งจ่ายไฟแบบปรับค่าได้เมื่อ  $V_O$  มีค่าต่ำสุด ในวงจรรูปที่ 20 ใช้ไอซีเบอร์ LM 338



รูปที่ 19 สำหรับขนาดแรงดันที่ไม่เป็นมาตรฐาน สามารถทำได้จากวงจรระดับแรงดัน ซึ่งออกแบบมาให้ผลิตระดับแรงดันที่คงที่ในรูป (ก) ใช้ไดโอดหนึ่งตัวหรือมากกว่า ในการเพิ่มแรงดัน ( $V_O$ ) อีก 0.7 โวลต์ สำหรับไดโอดแต่ละตัวที่ต่ออนุกรมเข้าไป สำหรับตัวต้านทานที่ต่อในรูป (ข) ใช้สำหรับปรับระดับแรงดันเอาต์พุต ซึ่งสามารถเปลี่ยนค่าแรงดัน ( $V_O$ ) ได้

ยกตัวอย่างเช่น ระดับแรงดันเอาต์พุต  $V_O$  จะสามารถปรับแรงดันเอาต์พุตได้จาก 1.2 โวลต์ ถึง 25 โวลต์ที่ระดับแรงดันต่ำ การกระจายกำลังงาน  $P_D$  ที่กระแสไหล 5 แอมแปร์เท่ากับ

$$P_D = (28 - 1.2 \text{ V}) / (5 \text{ A})$$

$$= 104 \text{ วัตต์}$$

ปัญหาจะลดโอเวอร์โหลดที่ค่าสูงสุดของ  $V_O$  โดยจะได้

$$P_D = (V_I - V_O) * (I_{L_{on}})$$

$$= (28 - 25) * (5 \text{ A})$$

$$= 15 \text{ วัตต์}$$

ระดับแรงดันเอาต์พุตของไอซีเบอร์ LM 338 จะถูกกำหนดโดยวงจรแบ่งระดับแรงดัน ( $R_1$  และ  $R_2$ ) ซึ่งอาจจะเป็นไปแทนวีโอมิเตอร์ หรือใช้ตัวต้านทานแบบค่าคงที่และไปแทนวีโอมิเตอร์ร่วมกัน ถ้าต้องการระดับแรงดันเอาต์พุตที่คงที่แล้ว  $R_1$  และ  $R_2$  ควรใช้มีค่าคงที่ทั้งสองตัว ระดับแรงดันเอาต์พุตจะถูกกำหนดโดย

$$V_O = (1.25 \text{ V}) * (R_2 / R_1 + 1)$$

ส่วนมาแล้วค่าของ R1 จะอยู่ระหว่าง 120 โอห์ม ถึง 250 โอห์ม และจะใช้ปรับให้  
ได้ระดับแรงดันที่ต้องการ สมการข้างต้นสามารถเขียนใหม่ให้อยู่ในรูปที่เหมาะสมขึ้น ดังนี้

$$R2 = (VO/1.25-1) \times R1$$

**ตัวอย่าง**

จงออกแบบวงจรรักษาระดับแรงดันที่ใช้ไอซีเบอร์ LM 300 เพื่อให้ได้ระดับแรงดัน  
เอาต์พุตขนาด 13.8 โวลต์ โดยกำหนดให้ค่า R1 = 120 โอห์ม

$$\begin{aligned} R2 &= (VO/1.25-1) \times R1 \\ &= (13.8/1.25-1) \times 120 \\ &= (11.04-1) \times 120 \\ &= 1205 \text{ โอห์ม} \end{aligned}$$

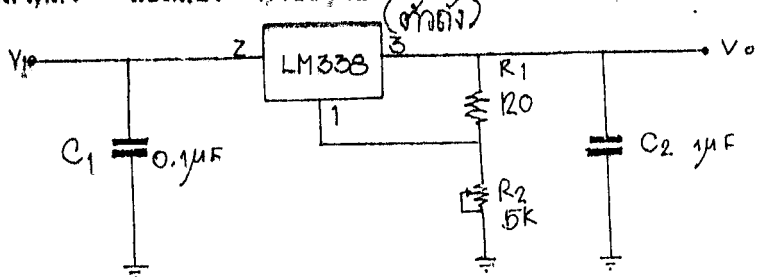
แน่นอนว่าเราไม่สามารถหาตัวต้านทานค่าคงที่ขนาด 1205 โอห์มได้แต่เราสามารถต่อ R2  
โดยใช้ตัวต้านทานค่าคงที่ต่ออนุกรมกับไปเทนซีโอมิเตอร์ยกตัวอย่างเช่น ใช้ตัวต้านทานค่าคงที่ขนาด  
1000 โอห์มและไปเทนซีโอมิเตอร์ขนาด 500 โอห์ม เพื่อปรับให้ได้ค่าแรงดันเอาต์พุตที่ถูกต้อง



ไอซีเรกูเลเตอร์ปรับไฟได้เบอร์ LM 317

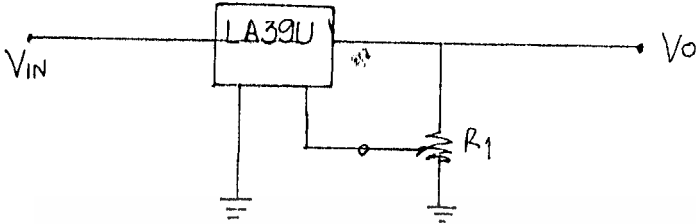
จะต้องจำไว้ให้ต้วว่า ไอซีเบอร์ LM 317 เป็นวงจรรักษาระดับแรงดันที่จ่ายกระแสได้ 5  
แอมป์เปร์ ดังนั้นจึงควรติดตั้งระบายความร้อนแบบมีครีบและใช้จารบีซิลิโคนทาหรือขยต่อที่อุ้งระหว่างวงผิวหน้า  
เพื่อให้การถ่ายเทความร้อนดีขึ้นสำหรับตัวถังแบบ TO-3 นี้ตัวถังจะเป็นเอาต์พุตขาหนึ่ง ดังนั้น จึงต้อง  
แยกตัวถังไม่ได้แตะกับกราวด์ ซึ่งทำได้โดยการแยกตัวแผ่นระบายความร้อนออกจากกราวด์หรือใช้แผ่น  
ไมก้าเป็นฉนวนรองตัวถังของไอซีเบอร์ LM 300

ในรูปที่ 21 ได้แสดงให้เห็นถึงวงจรรักษาระดับแรงดันที่ปรับค่าได้แบบอื่น ๆ โดยใช้ไอซี  
เบอร์ LAS-39 ของแลมด้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอุปกรณ์นี้จะคล้ายคลึงกับไอซีเบอร์ LM 300 แต่สามารถ  
จ่ายกระแสได้ถึง 8 แอมป์เปร์ ค่าของไปเทนซีโอมิเตอร์ที่ใช้ปรับค่าแรงดันเท่ากับ



(ไม่ได้แสดงถึงคานาซีเตอร์กรองกระแส)

รูปที่ 20 วงจรรักษาระดับแรงดันที่ใช้ไอซีเบอร์ LM 388 จะต้องติดตั้งบนแผ่นระบายความร้อน เมื่อระดับแรงดันตกภายในตัวมีค่ามาก ถ้าหาก  $V_I$  มีค่า 20 โวลต์ และ  $V_O$  มีค่าเพียง 1.7 โวลต์ จะทำให้เกิดการกระจายกำลังงานประมาณ 134 โวลต์ ที่กระแสไหล 5 แอมแปร์ ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ถ้าหาก  $V_O$  มีค่า 25 โวลต์ การกระจายกำลังงานก็จะมีเพียง 15 วัตต์เท่านั้น



รูปที่ 21 วงจรรักษาระดับแรงดันแบบปรับค่าได้เบอร์ LA399U เป็นการปรับปรุงวงจรที่ใช้เบอร์ LM388 ในรูปที่ 20 โดยเบอร์ LA399U ต้องการเพียงอุปกรณ์ประกอบภายนอกตัวเดียวเท่านั้น คือ โปเทนชิโอเมเตอร์แบบปรับค่าได้ สำหรับปรับค่าแรงดันเอาต์พุต

### วงจรรักษาระดับแรงดันที่จ่ายกระแสได้สูงขึ้น (HIGHER - CURRENT REGULATORS)

วงจรรักษาระดับแรงดันที่สามารถจ่ายกระแสได้สูงขึ้นมี บางครั้งอาจจำเป็นต้องภายในโครงการทางด้านจัดตั้งเครื่องส่งวิทยุสมัครเล่น และวงจรขยายเสียง เราจึงกำหนดไว้กระแสสูง หมายถึง กระแสที่สูงกว่า 5-8 แอมแปร์ วิธีที่ง่ายที่สุดในการบรรลุถึงความต้องการนี้ ก็โดยการใช้อิทรานซิสเตอร์ตัวหนึ่งหรือหลายตัวต่ออนุกรมเข้าไปช่วย

ในรูปที่ 22 และรูปที่ 23 จะแสดงให้เห็นถึงวิธีเหล่านี้ ข้อได้เปรียบของวงจรเหล่านี้ได้แก่ การออกแบบที่ทำได้ง่ายมาก และเราสามารถใช้อิทรานซิสเตอร์กำลังที่มีค่าอัตราขยาย (B) ต่ำลงได้ เนื่องจากไอซีรักษาระดับแรงดันสามารถจ่ายกระแสได้สูงขึ้น ในวงจรทั้งสองแบบแรงดันเอาต์พุตจะมีค่าโดยประมาณต่ำกว่าอัตราแรงดันเอาต์พุตของไอซีรักษาระดับแรงดันแบบ 3 ขา ประมาณ 0.6 ถึง 0.7 โวลต์ เช่น โดยการใช้อิซีรักษาระดับแรงดันเบอร์ LM317 จะสามารถให้แรงดันเอาต์พุตประมาณ 11.4 โวลต์

ในบางกรณี การจ่ายกระแสที่สูงขึ้นนั้น สามารถทำได้โดยวงจรในรูปที่ 23 วงจรนี้ยังคงสามารถปรับค่าแรงดันเอาต์พุตได้อย่างที่เขียงตรงเช่นกัน โดยหัวใจของวงจรได้แก่ ไอซีรักษาระดับแรงดันแบบปรับค่าได้เบอร์ LM317 (U1) ซึ่งไอซีตัวนี้จะสามารถตั้งค่าแรงดันอ้างอิงให้กับขาเบสของทรานซิสเตอร์ที่ต่ออนุกรมอยู่กับวงจร และยังสามารถจ่ายกระแสให้กับตัวทรานซิสเตอร์ได้ถึง 1.5 แอมแปร์ ถ้าต้องการกระแสเบสมากกว่านี้แล้ว ให้ใช้เบอร์ LM338 (ซึ่งสามารถจ่ายกระแสได้ถึง 5 แอมแปร์) แทนเบอร์ LM317

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

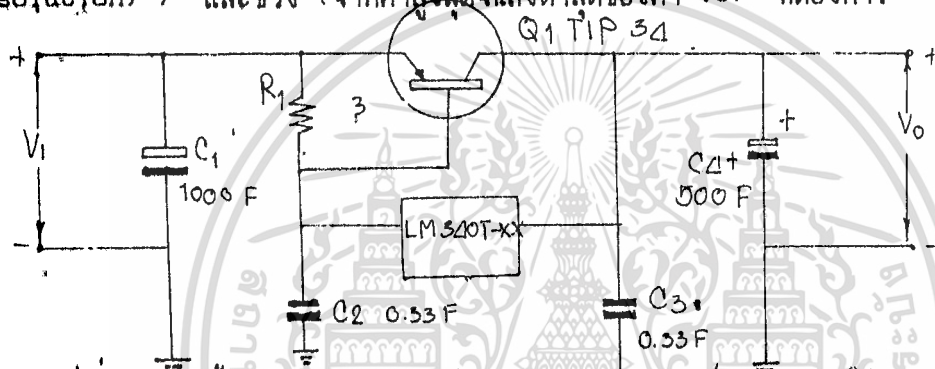
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ระดับแรงดันเอาต์พุต  $V_O$  จะน้อยกว่าระดับแรงดันที่จ่ายออกมาจาก  $V_I$  เท่ากับ 0.7 โวลต์ โดยระดับแรงดันที่จ่ายออกมาจาก  $V_I$  จะสามารถตั้งได้เช่นเดียวกับของไอซีเบอร์ LM330 ที่กล่าวมา แล้ว แต่ในกรณีนี้  $R_2$  จะถูกแทนด้วยตัวต้านทานสองตัว คือ  $R_{2a}$  และ  $R_{2b}$  วงการจะเขียนออกได้เป็น

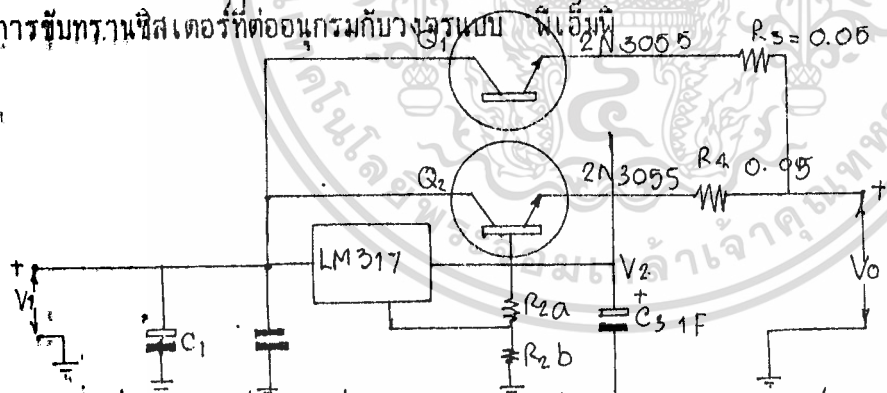
$$V_O = 1.25(R_{2a} + R_{2b})/R_1$$

$$= 1 - 0.7 \text{ V}$$

คุณอาจสังเกตพบว่าสมการนี้ได้ดัดแปลงมาจากสมการที่ใช้กับไดซีเบอร์ LM330 โดยปกติแล้วโพเทนซิโอมิเตอร์  $R_{2b}$  จะมีค่าประมาณจาก 10 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของความต้านทาน  $R_{2a} + R_{2b}$  ความเที่ยงตรงของอัตราส่วนระหว่าง  $R_{2a}$  กับ  $R_{2b}$  ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของการควบคุม (ความละเอียด (resolution) ) และช่วง (จากค่าสูงสุดจนถึงต่ำสุดของค่า  $V_O$ ) ที่ต้องการ



รูปที่ 22 วงจรนี้สามารถจ่ายกระแสได้สูงถึง 6-7 แอมแปร์ โดยการใช้วงจรรักษาแรงดัน การชั้ทรานซิสเตอร์ที่ต่ออนุกรมกับวงจรแบบ พีเอ็มพี



รูปที่ 23 เป็นการเพิ่มค่าความสามารถในการจ่ายกระแสเอาต์พุต โดยวงจรนี้จะปรับปรุงจากวงจรในรูปที่ 22 โดยการต่อทรานซิสเตอร์อนุกรมกับวงจรชานกันหลายตัว เพื่อจ่ายกระแสได้เพิ่มขึ้น วงจรนี้สามารถปรับค่าแรงดันได้

กระแสค่าสูง ๆ นี้ จะถูกรับโดยทรานซิสเตอร์ที่ต่ออนุกรมหนึ่งตัวหรือมากกว่า มีอัตราค่าสูงสุดที่ต้องคำนึงถึงในตอนแรกอยู่ 2 ตัวเมื่อจะเลือกให้ใช้ทรานซิสเตอร์ คือ การกระจายกำลังงานของคอลเลคเตอร์ (COLLECTOR POWER DISSIPATION) และค่ากระแสคอลเลคเตอร์นอกจากนี้แล้วเราขัง

ต้องคำนึงถึงว่าทรานซิสเตอร์แต่ละตัวจะต้องมีค่าอัตราทนแรงดัน  $V_{CE}$  ที่ สูงเพียงพอที่จะรับกับแรงดันเป็น  
ชุดพร้อมตัวมีอยู่

ค่าการกระจายกำลังงานคอลเลคเตอร์ของทรานซิสเตอร์ที่มาต่อแอกเรมนี้ เท่ากับผลคูณของ  
กระแสคอลเลคเตอร์สูงสุดลบแรงดันตกคร่อมระหว่างขา C-E ของแอกเรมกับผลต่างของ  $V_{IC}$   $V_{OC}$  สำหรับ  
วงจรรักษาระดับแรงดันแบบปรับค่าได้ใช้อัตราการกระจายกำลังงานที่แท้จริง ซึ่งทรานซิสเตอร์จะได้รับ  
เท่ากับ

$$P_{D(MAX)} = I_{C(MAX)} (V_{IC(MAX)} - V_{OC(MIN)})$$

เมื่อใช้ทรานซิสเตอร์ 2 ตัวหรือมากกว่าต่อขนาดกัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการจ่าย  
กระแสของวงจรรักษาระดับแรงดัน เราจะต้องใช้ตัวต้านทานต่อแอกเรมกับขาอีมิเตอร์ ( $R3$  และ  $R4$ )  
ของทรานซิสเตอร์แต่ละตัว เนื่องจากว่าค่าอัตราขยายกระแสของทรานซิสเตอร์แต่ละตัว จะมีค่าแตกต่าง  
กันมาก แต่การเปลี่ยนแปลงของโพลไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนัก ภายใต้สถานการณ์นั้น อาจจะปรากฏค่า  
กระแสที่รับโดยทรานซิสเตอร์ตัวหนึ่งมีค่าเกินอัตรา IC สูงสุดของมัน

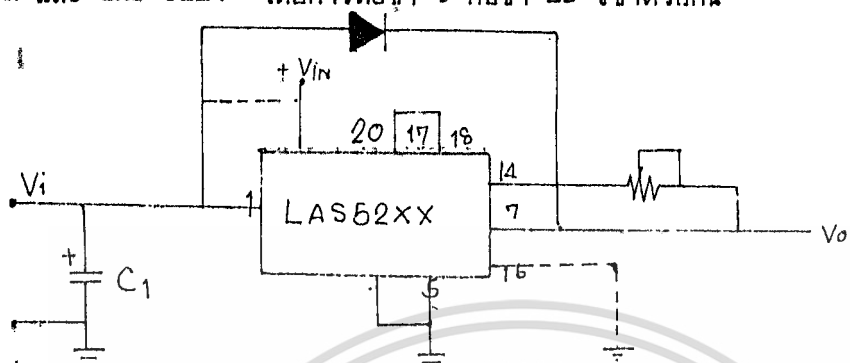
สำหรับการนี้ จะต้องมีการเลือกค่าอัตราขยายของทรานซิสเตอร์ที่จะนำมาใช้อย่างคร่าว ๆ  
ก่อน โดยการใช่วงจรในรูปที่ 23 ทรานซิสเตอร์ Q1 และ Q2 เบอร์ 2N 3055 จะสามารถจ่ายกระแส  
ออกไปได้สูงสุด 15 ถึง 20 แอมแปร์

ทางเลือกอื่นในการออกแบบวงจรรักษาระดับแรงดันแบบจ่ายกระแสได้สูงได้แก่ การใช้  
วงจรวอร์ริด (HYBRID UNIT) ที่ผลิตโดยบริษัทแลมด้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีบริษัทไมซ์อเล็กทริกทางด้น  
การผลิตแหล่งจ่ายไฟแบบตั้งโต๊ะ และยังจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟด้วย ในรูปที่ 24 ได้แสดงให้  
เห็นถึงวงจรรักษาระดับแรงดันแบบไฮบริดที่จ่ายกระแสได้ 20 แอมแปร์ เบอร์ LAS 52XX ตัวอักษร XX  
จะระบุถึงค่าระดับแรงดันเอาต์พุต ซึ่งอาจจะเป็น 5 หรือ 24 โวลต์

ตัวถังที่ใช้บรรจุวงจรรักษาระดับแรงดันนี้ แสดงให้เห็นในรูปที่ 24 (ก) ซึ่งได้รับการออกแบบ  
ด้วยฮีตซิงค์แบบพิเศษ โดยมีแผ่นระบายความร้อนภายนอกอีกที

วงจรถูกใช้งานจริงสำหรับไอซีเบอร์ LAS-52XX จะแสดงไว้ในรูปที่ 24 (ข) ตัวเก็บประจุ  
C1 จะใช้ในการกรองกระแสที่เอาต์พุตของวงจรเรียงกระแส ค่าความจุของตัวเก็บประจุนี้ เท่ากับ  
2000 ไมโคร/แอมแปร์ ดังนั้นสำหรับแหล่งจ่ายไฟขนาด 20 แอมแปร์ จะใช้ตัวเก็บประจุขนาด  
40,000 ไมโครฟารัด

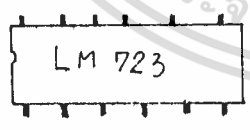
มีขา  $V+$  อยู่ 2 ขั้ว สำหรับไอซีตัวนี้โยธาเบอร์ 1 จะเป็นขา หลักร (กระแสสูง) และใช้ตัวอักษรกำกับว่า  $+VIN$  ขานี้จะต้องเข้ากับทรานซิสเตอร์ที่ใช้ต่ออนุกรมภายใน ขาเบอร์ 20 ซึ่งใช้ตัวอักษรกำกับว่า  $+VIN$  (ขาควบคุม) จะใช้ในการจ่ายกำลังงานให้กับวงจรควบคุมอัตราขยายภายในวงจรที่จ่ายให้กับขา 20 อย่างน้อยที่สุดเท่ากับ 7.5 โวลต์ดีซี ซึ่งความต้องการนี้จะพบได้ในไอซีเบอร์ LAS-5212 และ LAS-5224 โดยการต่อขา 1 กับขา 20 เข้าด้วยกัน



รูปที่ 24 ไอซีเบอร์ LAS52XX เป็นวงจรรักษาระดับแรงดันแบบไฮบริด ซึ่งสามารถจ่ายกระแสได้สูงถึง 20 แอมแปร์ โดยตัวอักษร XX อาจจะเป็น 05 หรือ 24 ซึ่งแสดงถึงระดับแรงดันเอาต์พุต

สำหรับไอซีเบอร์ LAS-5205 นั้นแรงดันของอินพุตอาจอยู่ในช่วง 7-0 โวลต์ ดังนั้นในบางช่วง แรงดันอินพุตอาจจะตกลงมาเหลือต่ำกว่า 7.5 โวลต์ ดังนั้น ถ้าหากใช้แรงดันของ  $V_{IN}$  สำหรับแหล่งจ่ายไฟ +5 โวลต์โดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 6.3 โวลต์แล้ว อาจเกิดปัญหาได้ ดังนั้น จึงควรมหาแหล่งไฟป้อนให้กับขา  $V_{IN}$  ใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันที่ขาไม่ต่ำกว่า 7.5 โวลต์ดีซี

ขาเบอร์ 14 และเบอร์ 16 เป็นขาใช้ตรวจรับ และใช้สำหรับส่งสัญญาณให้กับวงจรขยายสัญญาณอ้างอิงภายในได้รู้ถึงระดับแรงดันใดที่ควรผลิตขึ้นสำหรับ  $V_O$  ถ้าสายที่ต่อออกจากเอาต์พุต



ไอซีเรกูเลเตอร์รับไฟได้เบอร์ 723 ของวงจรรักษาระดับแรงดันไปยังโหลดนี้เส้น และใช้สายขนาดใหญ่แล้ว ขา 14 สามารถต่อเข้ากับขอ 7 โดยผ่าน  $R_1$  และขา 16 สามารถต่อลงกราวด์หรือต่อเข้ากับขา 9 และขา 5 ในหลายกรณีเราจะต่อขาตรวจรับนี้เข้ากับขา  $+V_O$  และ  $-V_O$  ที่โหลดเสีย การต่อเช่นนี้จะทำให้วงจรรักษาระดับแรงดันนั้นสามารถวัดค่า ที่ต้องการจริง ๆ และใช้ลดผลข้างเคียงอันอาจจะเกิดขึ้นจากแรงดันตกที่เกิดขึ้นในสายตัวนำด้วย

ไปแทนชดเชยตัว R1 ใน ใช้สำหรับกำหนดค่า V0 ที่ถูกต้องจริง ๆ ให้ใกล้เคียงกับค่าที่  
ระบุไว้โดย XX ที่เบอร์ของอุปกรณ์ค่าความต้านทานของ R1 กำหนดโดย

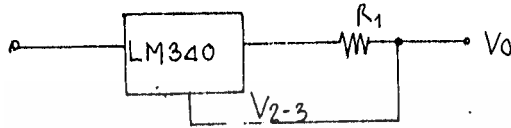
$$R1 = 0.25 V0 * (1000 / V) \dots\dots\dots \text{OHM}$$

สำหรับอุปกรณ์เบอร์ LAS-5205 ขนาดเอาต์พุต 5 โวลต์นั้น เราต้องการความต้านทาน

ที่สูงกว่า

$$R1 = (0.25 * 5V) (1000 \text{ OHM/V}) \dots\dots\dots \text{OHM}$$

$$= 1250 \text{ โอห์ม}$$



รูปที่ 25 เป็นวงจรรักษาระดับแรงดัน ซึ่งต่อโวลต์และจ่ายกระแสตามที่

วงจรจ่ายกระแสคงที่ (CURRENT REGULATORS)

ในรูปที่ 25 ได้แสดงให้เห็นถึงไอซีรักษาระดับแรงดันแบบ 3 ขา ที่ต่อเ็นช่องจ่าย  
กระแสเอาต์พุตจะหาได้อย่างประมาณเท่ากับ

$$I = V_{2-3} / R1 + I_a$$

เมื่อ IO เป็นค่ากระแสเอาต์พุต,  $V_{2-3}$  เป็นระดับแรงดันเอาต์พุต R1 เป็นค่าความ  
ต้านทานในหน่วยโอห์ม และ  $I_a$  เป็นค่ากระแสในสภาวะสงบ (QUIESCENT CURRENT) ของ U1  
(ซึ่งปกติจะอยู่ระหว่าง 1-5 มิลลิแอมป์)

หลักการออกแบบแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง

การเพิ่มประสิทธิภาพ

สู่สายตากันมาแล้วถึง 2 ตอน และคุณก็ได้เข้าถึงหลักการออกแบบที่เกือบจะสมบูรณ์ แต่มีสิ่ง  
หนึ่งที่จะต้องคำนึงถึงคือประสิทธิภาพ ในตอนนี้จึงเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่แหล่งจ่ายไฟตรง  
ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจคือ การป้องกันไดโอดเรียงกระแส การจำกัดกระแสเอาต์พุต การป้องกันแรงดันเกิน  
ความร้อน แหล่งจ่ายไฟแรงดันสูง แหล่งจ่ายไฟแบบไร้หม้อแปลงไฟฟ้า เมื่อระดับแรงดันสูงขึ้นและกำลัง  
งานเพิ่มขึ้น การลดความร้อนที่เกิดขึ้น การรักษาแรงดันแบบลวติ่งที่ใช้ไอซี วงจรอินเวอร์เตอร์

การป้องกันไดโอดเรียงกระแส

วงจรเรียงกระแสในแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงสมัยใหม่ทำมาจากไดโอดแบบรอยต่อ  
พี-เอ็น หรือได้เปรียบของไดโอดเหล่านี้ ได้แก่ มันมีขนาดเล็ก ไม่กินเนื้อที่ แต่ข้อเสียของมันก็คือ ไดโอด

**ผลที่ไม่ควมไวต่อการเสียหายเนื่องจากทรานเซียนต์แรงดันสูง และความเสียหายอันเนื่องมาจากกระแส**  
**กระแสสูง ๗**

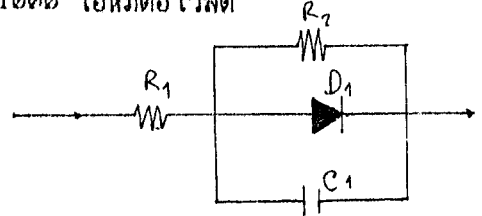
ในรูปที่ 26 ได้แสดงให้เห็นถึงการต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมเมื่อใช้ป้องกันไดโอด ซึ่งไม่ได้ใช้ใน  
 ทุกกรณี แต่ส่วนใหญ่จะนำมาใช้กัน โดยตัวต้านทาน  $R_1$  ที่ต่ออนุกรมนั้นใช้สำหรับจำกัดกระแสกระแสชากโดย  
 ทั่วไปแล้วไดโอดจะมีค่าอัตราทนกระแสชากได้สูง ซึ่งกำหนดว่าทนกระแสเกินได้ 1 ไมโครวินาที เช่นใน  
 ระบบไฟ 500 เฮิรตซ์ จะสามารถทนกระแสเกินได้ 1/50 วินาที หรือน้อยกว่าถ้าหากอัตราทนกระแสเกินมี  
 ระยะเวลายาวนานกว่านี้ จะทำให้อัตราการทนกระแสของไดโอดลดลง

อาจกล่าวได้ว่า การเกิดกระแสเกินที่หนบ่ยที่สุดที่วงจรเรียงกระแสได้รับอนุญาต ๗ ได้แก่  
 การฉัดประจุในตอนเริ่มแรกของตัวเก็บประจุในวงจรกรองกระแส โหลดงานที่ป้อนไฟเข้าแหล่งจ่ายไฟตัว  
 เก็บประจุในวงจรกรองกระแสจะไม่มีประจุอยู่เลย ดังนั้น อัตรากระแสที่ใช้ในการประจุจะสูงมากสำหรับ  
 แหล่งจ่ายไฟกระแสต่ำทั้งหลายจะไม่เกิดปัญหาเหล่านี้ เนื่องจากค่าความจุของตัวเก็บประจุในวงจรกรอง  
 กระแส มีค่าต่ำพอจะทำให้การประจุทำได้อย่างรวดเร็ว

ถ้าหากใช้ตัวเก็บประจุที่มีค่าความจุสูง ๗ กระแสจำกัดเวลาในช่วงของการเปลี่ยนไซเคิล  
 จะยาวนานเพียงพอที่จะทำความเสียหายให้กับวงจรเรียงกระแสได้ หน้าที่ของตัวต้านทาน  $R_1$  ก็เพื่อ  
 จำกัดค่ากระแสให้อยู่ในย่านที่ปลอดภัยในระหว่างช่วงของการเปลี่ยนไซเคิล ค่าของ  $R_1$  อยู่ระหว่าง  
 ๕ ถึง 100 โอห์ม ขึ้นอยู่กับระดับแรงดันที่และกระแส ค่าที่เหมาะสมสามารถหาได้จากการคำนวณจากกฎ  
 ของโอห์ม ( $E/I$ ) โดยใช้ค่าแรงดันที่ป้อนหารด้วยค่ากระแสสูงสุดที่อยู่ในย่านที่ปลอดภัย

วิธีการอื่นในการป้องกันวงจรเรียงกระแสจากความเสียหาย ก็โดยการเพิ่มแรงดันของ  
 แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับให้แก่ไดโอดอย่างช้า ๆ แต่จะกล่าวถึงวิธีการนี้ในตอนหลัง

ตัวต้านทานที่ต่อขนานคร่อมไดโอด ( $R_2$  ในรูปที่ 26) ใช้เพื่อมีการต่อไดโอดเองตัว หรือ  
 มากกว่าอนุกรมกัน ซึ่งวิธีการนี้ใช้สำหรับเพิ่มค่าอัตราการทนแรงดันย้อนกลับสูงสุดของไดโอด (PIV)  
 เนื่องมาจากความแตกต่างของไดโอดแต่ละตัวทำให้แรงดันตกคร่อมไดโอดอาจแตกต่างกันไปบ้าง โดย  
 การใช้ตัวต้านทานค่าเท่ากันขนานกับไดโอดแต่ละตัว จะทำให้แรงดันตกคร่อมไดโอดมีค่าใกล้เคียงกันค่าที่  
 ใช้ตามปกติเท่ากับ 10๓๓ โอห์มต่อโวลต์

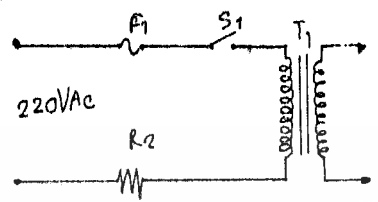


รูปที่ 26 เมื่อเปิดเครื่อง วงจรเรียงกระแสจะถูกตั้งกระแสผ่านจำนวนมาก เนื่องจากตัวเก็บ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ประจําในวงจรกรองกระแสไม่มีประจําอยู่เลย ทำให้เสมือนว่าลัดวงจรในช่วงครึ่งไซ้เกิดแรงหรือมากกว่า

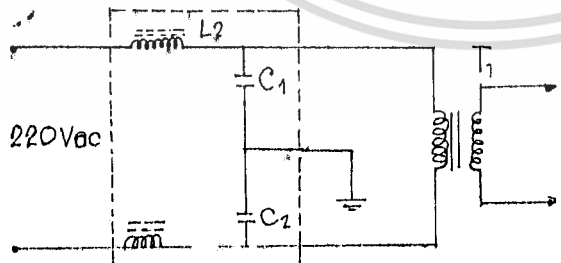
ตัวเก็บประจุ C1 ที่ต่อขนานกับ D1 นั้น ใช้สำหรับลดทรานเซียนต์แรงดันสูงจากสายส่งไฟฟ้า ระดับแรงดันนี้อาจมีค่าสูงถึง 2000 โวลต์ และอาจจะเกิดขึ้นหลายครั้งในหนึ่งวันทรานเซียนต์เหล่านี้สามารถทำลายไดโอดได้ การต่อตัวเก็บประจุขนาด 0.001 ไมโครฟารัด ขนานกับไดโอดจะลดค่าทรานเซียนต์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (เนื่องมาจากประกอบด้วยค่าความถี่สูง) โดยไม่ผ่านกระแสที่ความถี่ 50 เฮิรตซ์ออกไป



รูปที่ 27 วิธีการหนึ่งในการลดกระแสจำนวนมากที่ไหลผ่านไดโอดในระหว่างช่วงแรกเมื่อแหล่งจ่ายไฟโอซีดีของวงจร ก็โดยการลดแรงดันไฟโอซีดีที่ขั้วบ่อแสงจรเรียงกระแสให้มีขนาดลดลง

รูปที่ 27 แสดงให้เห็นถึงวงจรเริ่มจ่ายไฟแบบช้า ๆ (SOFT TURN-ON) ซึ่งความตั้งใจของวงจรนี้ก็เพื่อจำกัดค่ากระแสที่ไหลในช่วงระยะเวลา 2-3 วินาทีแรกจนกระทั่งตัวเก็บประจุทำการอัดประจุถึงระดับแรงดันที่ต้องการ มีวิธีการหลายอย่างในการทำเช่นนี้ สำหรับในรูปที่ 27 โดยการต่อตัวต้านทานอนุกรมกับขดปฐมภูมิของหม้อแปลง หลังจากประจําอย่างช้า ๆ 2-3 วินาที จึงต่อวงจรรีตซ์ S2 เพื่อให้แหล่งจ่ายไฟทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ส่วนวิธีการอื่นก็โดยการแทน R1 ด้วยหลอดไฟหรือบาลลาสต์ (BALLAST) เป็นที่สังเกตว่ามีฟิวส์ F1 ต่ออนุกรมอยู่ที่ขดปฐมภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้า T1 (ในรูปที่ 27) จึงต่อฟิวส์กับแหล่งจ่ายไฟของคุณเสมอ ฟิวส์ควรจะเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ที่สุดกับสายไฟเส้นที่มีไฟ (HOT LINE) เนื่องจากฟิวส์จะเป็นเครื่องป้องกันโดยขาดก่อนที่จะเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ตัวอื่น



รูปที่ 28 วงจรนี้อาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับคุณ เนื่องจากถ้าค่าความจุของตัวเก็บประจุไม่เท่ากัน และปฏิกิริยาของตัวเหนี่ยวนำอาจจะทำให้สายกราวด์มีไฟได้

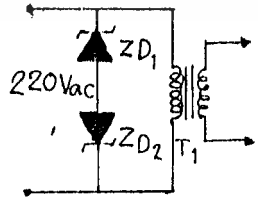
สัญญาณรบกวนความถี่สูงที่เกิดขึ้นในสายส่งไฟฟ้า ซึ่งรวมทั้งถูกรานซึ่งเห็นแต่ที่กล่าวถึงในตอน

แรกแล้ว สามารถทำให้การทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกิดการผิดพลาดขึ้นได้ วิธีการหนึ่งในการลดสัญญาณรบกวนเหล่านี้ก็โดยการต่อวงจรกรองสัญญาณแอลซี ที่วงจรของสายจ่ายไฟก่อนที่จะเข้าสู่อุปกรณ์ กับหม้อแปลงไฟฟ้า ในรูปที่ 28 แสดงถึงวงจรกรองสัญญาณรบกวน แต่สายจากแหล่งจ่ายไฟเอชไอ จะประกอบด้วยส่วนของตัวเหนี่ยวนำ ที่เป็นวงจรกรองความถี่ต่ำผ่าน (LOWPASS FILTER) ซึ่งจะยอมให้สัญญาณความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ผ่านไปได้อย่างดีแต่จะไม่ยอมให้ความถี่สูงและทรานเซียนต์ต่าง ๆ ผ่านไปได้

วงจรกรองสัญญาณรบกวนเช่นในรูปที่ 27 นี้มีขายทั่วไปในท้องตลาดและแบบที่ติดตั้งกับแท่นเครื่องก็หาได้เช่นกัน ถ้าคุณคิดที่จะต่อวงจรนี้ขึ้นมาเอง ต้องแน่ใจว่าตัวเก็บประจุมีอัตราความต้านทานเพียงพอที่จะใช้กับระบบไฟกระแสสลับ โดยทั่วไปแล้ววงจรกรองสัญญาณรบกวนควรติดตั้งให้ใกล้กับจุดที่ต่อระบบไฟกระแสสลับเข้ากับอุปกรณ์ ซึ่งวิธีการนี้เป็นการป้องกันการเหนี่ยวนำสัญญาณเข้าสู่สายตัวนำอเนกภายในตัวถัง เนื่องจากส่วนของสายที่หุ้มไม่ได้มีการกรองสัญญาณรบกวนออกไป ถ้าเป็นไปได้ ควรจะติดตั้งพร้อมกับวงจรกรองสัญญาณรบกวนที่มีการชิลด์ และควรอยู่ข้างหน้าของวงจรกรองสัญญาณรบกวนแก้คลื่นวงจรเข้ากับแท่นเครื่อง

โดยการใช้วงจรกรองสัญญาณรบกวนจากระบบไฟกระแสสลับ ดังเช่นในรูปที่ 29 จะเป็นการเพิ่มกระแสที่ไหลในสายดินอย่างอัตโนมัติในงานเฉพาะบางอย่าง ค่ากระแสที่เพิ่มขึ้นมาจะไม่สามารถจะละไว้ได้ ยกตัวอย่างเช่น ในเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวนของกระแสในสายดินที่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับค่าของ C1 และ C2 และในบางครั้งการเหนี่ยวนำซึ่งกันและกัน ระหว่างตัวเหนี่ยวนำและ L2 กับแท่นเครื่องสำหรับกรณีเช่นนี้ วงจรกรองสัญญาณรบกวนในระบบไฟกระแสสลับอาจจะใช้ไม่ได้

ดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น ทรานเซียนต์แรงดันสูงในสายจ่ายไฟจะก่อให้เกิดปัญหาในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ไดโอดแล้ว ยังทำกรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อีกด้วย ในวงจรจัดลของคอมพิวเตอร์นั้น จะมีปัญหาอย่างมากในเรื่องของทรานเซียนต์ สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มีอาการอยู่ดี ๆ ก็เสียหายไป บางครั้งจะเกิดความผิดพลาดของข้อมูลที่ป้อนเข้าไปเนื่องจากทรานเซียนต์ สิ่งที่เราทำได้แก่การกำจัดทรานเซียนต์ที่จะเกิดขึ้นก่อนที่มันจะไปทำลายและก่อให้เกิดความเสียหาย



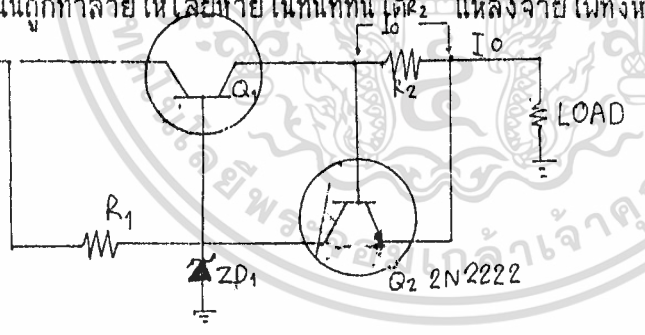
รูปที่ 29 วิธีการ 2 วิธีในการลดความเสียหายในวงจรอันเนื่องมาจากทรานเซียนต์แรงดันสูงที่เกิดขึ้นในสายไฟเอชไอ ในรูป (ก) โดยการใช้ซีเนอร์ไดโอดต่อกันหลังชนกัน โดยวิธีอัตราทานกำลังสูง

เพียงพอเพื่อลดแรงดันที่เกิดขึ้นเกินไป ในรูป (ข) ใช้วาริสเตอร์ที่ทำจากออกไซด์ของโลหะ ซึ่งเป็นตัวต้านทานที่ไวต่อแรงดัน เพื่อใช้ลดแรงดันสูงที่เกิดขึ้น

ในรูปที่ 29 ได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการ 2 วิธีในการตัดสัญญาณทราเวลลิงเวฟในสายจ่ายไฟกระแสสลับ ก่อนที่มันจะเข้าสู่แหล่งจ่ายไฟ ในรูปที่ 29(ก) เราจะเห็นซีเนอร์ไดโอดสองตัวต่อกันหลังกัน แรงดันพ่วงหลาย ( $V_{\text{L}}$ ) ของไดโอดเหล่านี้ ควรจะสูงกว่าระดับแรงดันยอดสูงสุด (MAXIMUM PACK) ของไฟสลับที่คาดว่าจะเป็น อุปกรณ์ส่วนมากแล้วจะทำงานกับแรงดันขนาด 220 V (RMS) ดังนั้นระดับแรงดันยอดสูงสุดเท่ากับ  $1.414 * 220$  หรือ 311 โวลต์ สำหรับทั้ง ZD<sub>1</sub> และ ZD<sub>2</sub>

ส่วนทางเลือกอื่นที่นิยมใช้กันได้แก่การใช้วาริสเตอร์ที่ทำจากออกไซด์ของโลหะ (METAL OXIDE VARISTOR : MOV) ดังแสดงในรูปที่ 29(ข) โดยวาริสเตอร์นี้สามารถกับได้ว่า เหมือนกับซีเนอร์ไดโอดต่อกันหลังกัน แต่จริง ๆ แล้วเป็นตัวต้านทานที่ไวต่อระดับแรงดัน โดยมีแรงไวต่อความต้านทานสูงที่ทุกค่าของความต่างศักย์ที่ต่ำกว่าระดับแรงดันที่รับรู้ (THRESHOLD VOLTAGE) แต่เมื่อกระแสและมีความต้านทานต่ำ เมื่อความต่างศักย์สูงกว่าระดับแรงดันที่รับรู้ ดังนั้นทรานเซียนต์แรงดันสูงจะถูกกำจัดออกไปโดยวาริสเตอร์ ในขณะที่แรงดันไฟกระแสสลับในสายจ่ายไฟจะไม่มีความกระทบกระเทือนการกำจัดกระแสเอาต์พุต

ถ้าหากเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงที่ไม่ได้มีการป้องกันถูกวัดวงจรโดยบังเอิญ ทำให้แหล่งจ่ายไฟนั้นถูกทำลายให้เสียหายในทันทีทันใด แหล่งจ่ายไฟทั้งหมดไม่พร้อมการวัดวงจร เกิดที่ที่เอาต์พุตของมัน



รูปที่ 30 ตัวต้านทานที่ใช้ตรวจสอบอนุกรมนี้จะมิแรงดันตกคร่อมเมื่อกระแสตามต้องการ ทราซิสเตอร์  $Q_2$  จะเป็นตัวจำกัดกระแสที่ไหลผ่าน  $Q_1$

ในรูปที่ 30 แสดงให้เห็นถึงวงจรป้องกันกระแสเกิน หรือการจำกัดวงจรง่าย ๆ โดยทรานซิสเตอร์  $Q_1$  ต่ออนุกรมกับวงจร เหมือนกับที่พบในวงจรรักษาระดับแรงดันแบบทั่วไป โดยระดับแรงดันเอาต์พุตถูกกำหนดโดยค่า  $V_Z$  ของซีเนอร์ไดโอด  $ZD$  และจะมีค่ามากกว่า  $V_Z$  โดยประมาณ 0.6 ถึง 0.7 โวลต์

วงจรป้องกันกระแสเกิน จะประกอบด้วย Q2 และ R2 ตัวต้านทาน R2 จะต่ออนุกรมกับเส้นทางกระแสเอาต์พุตดังนี้จะเกิดแรงดันตกคร่อม R2 เท่ากับ  $10 \times R2$  ซึ่งระดับแรงดันนี้จะเป็โนแอสระหว่างเนลลู-อิมิตเตอร์ สำหรับ Q2 จะนำกระแสทำให้ลัดวงจรระหว่างขาเบสและอิมิตเตอร์ของ Q1 ภายใต้อุณหภูมิเช่นนี้จะทำให้ Q1 หยุดทำงาน

ในแหล่งจ่ายไฟบางแห่ง จะถูกออกแบบเพื่อยอมให้มีการแปรเปลี่ยนของจุดจำกัดกระแสแวลวีธการที่เร็วที่สุดในการทำงานเช่นนี้ ก็โดยการใชตัวต้านทาน R2 แบบปรับค่าได้ และโดยไมล้เก็ถึงว่าจะใช้ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้หรือแบบค่าคงที่ ค่าของ R2 จะหาได้จากกฎของโอห์ม ซึ่งค่าของระดับแรงดันเท่ากับ 0.6 โวลต์

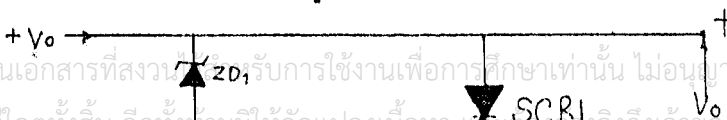
$$R2 = 0.6 / 10 (\text{MAX})$$

เมื่อ R2 มีหน่วยเป็นโอห์ม และ 10 มีหน่วยเป็นแอมแปร์

ในแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงส่วนใหญ่ ค่าของ R2 จะมีค่าต่ำมา เป็นเศษส่วนของโอห์มยกตัวอยู่เช่น แหล่งจ่ายไฟขนาด 10 แอมแปร์ จะต้องการค่าความต้านทานขนาด 0.06 โอห์ม ซึ่งความต้านทานต่ำขนาดนั้น สามารถทำได้โดยการต่อตัวต้านทานขนาดกันหลาย ๆ ตัว (เช่น ใช้ตัวต้านทานขนาด 0.33 โอห์ม ต่อขนานกัน 5 ตัว) หรือจากลวดความต้านทานเฉพาะแบบที่ใช้กับเบดตัวเก็บ การป้องกันแรงดันเกิน

ยังคงมีความแตกต่างระหว่างระดับแรงดันอินพุตและเอาต์พุต สำหรับแหล่งจ่ายไฟแบบรักษา ระดับแรงดันคงที่ โดยทั่วไปแล้ว จะคงความแตกต่างอย่างน้อย 2 โวลต์ และอาจสูงถึง 75 โวลต์ ถ้ามีบางสิ่งเกิดขึ้นทำให้ระดับแรงดันอินพุตปรากฏขึ้นที่เอาต์พุต จะทำให้วงจรที่ต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟเกิดความเสียหายขึ้น ในวงจรดีจิตอลแบบที่ทีแอลมาตรฐานนั้น ทำงานด้วยระดับแรงดันคงที่ ขนาด + 5 โวลต์ ที่รับจากแหล่งจ่ายไฟที่ไม่ได้รักษา ระดับแรงดันขนาด + 8 โวลต์ ถ้าหากทรานซิสเตอร์ที่ต่ออนุกรมอยู่ใน วงจรเกิดลัดวงจรขึ้นมา หรือซีเอนอร์ไดโอดเกิดเปิดวงจรขึ้นมาแล้ว จะทำให้ระดับแรงดันขนาด + 0 โวลต์ ปรากฏขึ้นที่เอาต์พุตของวงจรรักษา ระดับแรงดัน ซึ่งแรงดันขนาดนี้จะทำลายไอซีที่ทีแอลทำให้เสียหายทันที ซึ่งกล่าวได้ว่าการผิดพลาดขึ้นเนียงจุดเดียวในแหล่งจ่ายไฟสามารถทำลาย วงจรดีจิตอลจำนวน มากขึ้นทันที

การแก้ปัญหาที่ทำได้โดยการใช่วงจรป้องกันแรงดันเกินแบบเอสซีอาร์โครบาร์ (SCR CROBAR) ซึ่งตัวอย่างได้แสดงให้เห็นในรูปที่ 31 วงจรเอสซีอาร์โครบาร์นี้ เป็นวงจรที่ใช้ป้องกันปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้ดีที่สุดในเมื่อวงจรตรวจรับสภาวะของแรงดันเกิดเกิดขึ้น ก็จะทำการลัดวงจรของเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟเพื่อทำให้นิวส์ที่ต่ออยู่ขาดไป



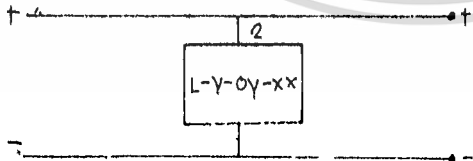
รูปที่ 31 การตัดการทำงานของวงจรถอง ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีระดับแรงดันเกิน โดยเอสซีอาร์ จะถูกจุดชนวน ทำให้มีค่าของวงจรถองไป

เอสซีอาร์นี้ จะแสดงค่าอิมพีแดนซ์สูงระหว่างแคโทดและแอโนด จนกว่าจะมีการสไลโพลเข้าสู่ขาคู เมื่อมีการสไลโพลเข้าสู่ขาคูแล้ว เอสซีอาร์จะทำตัวเหมือนกับไดโอดแบบปกติ แทนที่จะไปโดยฟิล์มเพียงชนิดเดียวที่ป้อนเข้าสู่ขาคูจะทำให้เอสซีอาร์นำกระแสและจะนำกระแสตลอดไป ถึงแม้กระแสที่เกตจะหมดไปแล้วก็ตาม เอสซีอาร์จะนำกระแสอยู่จนกระทั่งกระแสแคโทดและแอโนดจะลดลงต่ำกว่าระดับกระแสยึด (HOLD) จึงจะหยุดทำงาน

ในรูปที่ 31 เอสซีอาร์โครวบารี่นี้จะต่อคร่อมเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟโดยวงจร โดยเอสซีอาร์จะยังคงไม่ทำงานจนกว่าซีเนอร์ไดโอด ZD1 เริ่มทำงาน จะทำให้กระแสเกิดไหลผ่าน R7 โดยระดับแรงดันซีเนอร์ของ ZD1 นี้ จะถูกเลือกให้มีค่าสูงกว่า VO แต่ต่ำกว่าระดับแรงดัน VI ที่ไอออนเข้าสู่อานูตของวงจรรักษาในระดับแรงดันสำหรับแหล่งจ่ายไฟขนาด + 5 โวลต์จะเสียดำ VZ สำหรับ ZD1 เท่ากับ 6.2 โวลต์ หรือ 6.8 โวลต์

บริษัท แลมด้าอิเล็กทรอนิกส์ ได้สร้างโมดูลสำหรับป้องกันแรงดันเกิน ซึ่งใช้ในวงจรเอสซีอาร์โครวบารี่อยู่ในรูปตัวถังแบบ 2 ขา (ในรูปที่ 32) โดยโมดูลเหล่านี้จะถูกบรรจุอยู่ในตัวถังแบบ TO-66 และ TO-3 ของตัวถังทรานซิสเตอร์ (ในขนาดกระแสต่ำถึงกระแสปานกลาง) และในตัวถังแบบพิเศษ (สำหรับกระแสสูง) โดยมีหลายแบบในระดับแรงดันที่นิยมใช้กัน ที่ระดับกระแสขนาด 2 แอมป์ จนถึง 35 แอมป์

วิธีการในการทำให้โมดูลของแลมด้าขนาดกระแสต่ำ (2 แอมป์) ใช้งานกับกระแสสูงนั้นทำได้โดยใช้โมดูลขนาดกระแสต่ำในการตรวจรับสภาวะการเกิดแรงดันเกิน แล้วจึงไปกระแสสไลโพลเข้าสู่เอสซีอาร์อีกที ซึ่งวิธีการนี้จะคล้ายคลึงกับวงจรในรูปที่ 31 มาก แต่ใช้โมดูลป้องกันแรงดันเกินที่ไอออนแทนที่ซีเนอร์ไดโอด และวงจรนี้จะสามารถใช้ร่วมกับเอสซีอาร์ในขาคูกระแสขนาด 50 ถึง 100 แอมป์



รูปที่ 32 วงจรทั้งหมดในรูปที่ 31 ถูกบรรจุไว้ในตัวถังแบบ 2 ขา เพื่อให้ป้องกันแรงดันเกิน ซึ่งโมดูลเหล่านี้สามารถเลือกค่าระดับแรงดันที่ต้องการได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ความร้อน

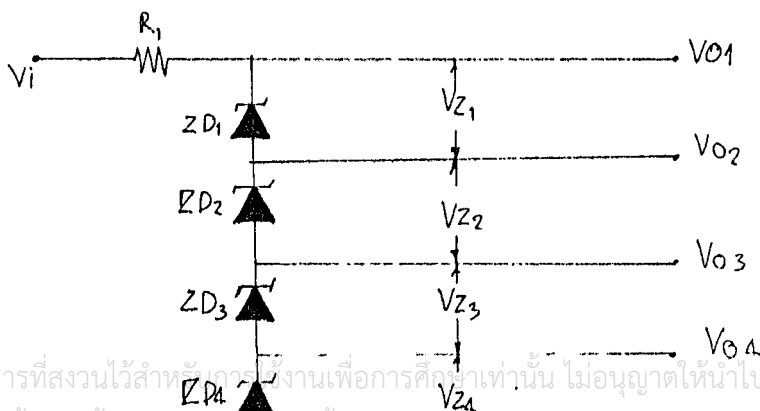
สาเหตุเดียวที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งเป็นสาเหตุของความเสียหายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้แก่เรื่องความร้อน โดยการศึกษาในสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับทรานซิสเตอร์กำลัง วงจรรักษาระดับแรงดัน วงจรเรียงกระแส และวงจรขยายกำลังตลอดจนไอซี

ไม่มีแหล่งจ่ายไฟแบบรักษาระดับแรงดันใด ๆ ที่จะสามารถทำงานได้โดยปราศจากแผ่นระบายความร้อน ถ้าคุณใช้อุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ในตัวถังแบบ (TO - 5) แล้วก็ให้ใช้แผ่นระบายความร้อนแบบครอบขุ่นตัว (HEAT TYPE) แต่ถ้าหากตัวถังที่บรรจุเป็นแบบ TO - 66 , TO - 220 หรือแบบ TO - 3 ก็ให้ติดตั้งอุปกรณ์เหล่านั้นลงบนแผ่นระบายความร้อนแบบมีครีบ สำหรับวงจรรักษาระดับแรงดันที่จ่ายกระแสมากกว่า 5 แอมป์ จะต้องมีพัดลมเป่าตัวแผ่นระบายความร้อนด้วยโดยการให้ความระมัดระวังในเรื่องความร้อนที่จะเพิ่มสูงขึ้น จะทำให้วงจรของคุณเพิ่มความถี่ได้สูงขึ้น

## แหล่งจ่ายไฟแรงดันสูง

ในยุคของชิปไอซีและโมดูลแบบโซลิดสเตต (SOLID STATE) ในปัจจุบันนี้ แทนการยากที่จะกล่าวถึงแหล่งจ่ายไฟ และวงจรรักษาระดับแรงดันขนาดสูงกว่า ๑๐ โวลต์ขึ้นไป สำหรับแหล่งจ่ายไฟเหล่านี้ เราจัดมันไว้ในระดับแรงดันสูง ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันว่าในย่านแรงดันจาก ๑๐ โวลต์จนถึงหลายพันโวลต์ ในขณะที่เทคนิคที่ใช้กับกระแสระดับแรงดันขนาดนี้แตกต่างกันไปเล็กน้อย

ย่านระดับแรงดันสูงนี้ สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็นระดับแรงดันต่ำกว่า ๑๐๐ โวลต์ ในย่านแรงดันต่ำกว่า ๑๐๐ โวลต์ เราสามารถใช้เทคนิคที่เหมือนกับแหล่งจ่ายไฟแรงดันต่ำที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น สิ่งที่เราต้องทำก็โดยการแทนหม้อแปลงไฟฟ้า วงจรเรียงกระแส และตัวเก็บประจุกรองกระแสให้มีอัตราการทำงานกำลังที่สูงขึ้น สำหรับแหล่งจ่ายไฟแบบรักษาระดับแรงดัน เราต้องการทรานซิสเตอร์ที่ต่ออนุกรมที่มีอัตราการทำงานกำลังงานของคอลเลคเตอร์ที่เพียงพอ ที่ระดับแรงดันเคอพิลเลคเตอร์ อิมิตเตอร์ ( $V_{CE}$ ) ที่คาดไว้ ซีเนอร์ไดโอดที่มีอัตราการทำงานกำลังที่ถูกต้องจะถูกเลือกใช้อาจจะเป็นแบบตัวเดียว (ที่มีอัตราแรงดันสูงกว่า 2๐๐ โวลต์ ก็หาซื้อได้ทั่วไป) หรือโดยการต่อซีเนอร์ไดโอดแรงดันต่ำอนุกรมกันหลายตัว



รูปที่ 33 ซีเนอร์ไดโอดสามารถต่ออนุกรมกันหลายตัว เพื่อให้ระดับแรงดันซีเนอร์สูงขึ้นได้ แต่จะต้องคำนึงถึงอัตราทนกำลังงานด้วย

ในรูปที่ 33 จะแสดงให้เห็นชุดของซีเนอร์ไดโอด 4 ตัวต่ออนุกรมกันเมื่อให้กาแรงดันสูง  $V_{O1}$  โดยระดับแรงดันสูงสุดจากชุดนี้เท่ากับ

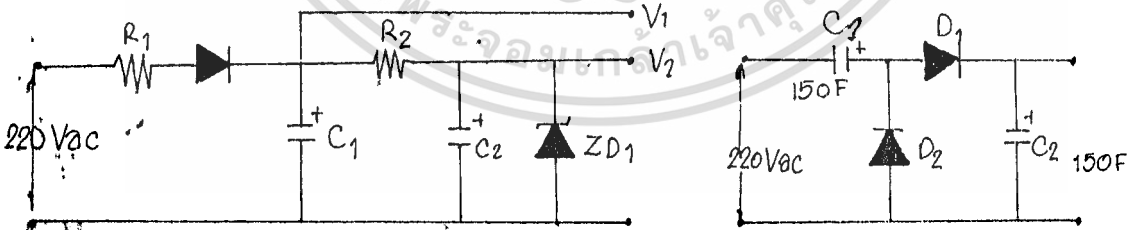
$$V_{O1} = V_{Z1} + V_{Z2} + V_{Z3} + V_{Z4}$$

สำหรับประโยชน์ข้างเคียงของวงจรนี้ ก็ได้แก่ เราสามารถแยกระดับแรงดันซีเนอร์ไดโอดแต่ละตัวได้ เพื่อให้ได้ค่าแรงดันต่ำตามที่ต้องการ ซึ่งวิธีการนี้มีข้อจำกัดในกรณีที่ระดับแรงดันที่ต่ำกว่านี้จะถูกดึงไปใช้ในงานไม่มากนัก

ซีเนอร์ไดโอดที่ใช้ในรูปที่ 33 นี้จะต้องเลือกค่าอัตราทนกำลังงาน ซึ่งต้องคำนึงถึงระดับแรงดัน  $V_Z$  แต่ละตัว ถ้าซีเนอร์ไดโอดแต่ละตัวมีอัตรา  $V_Z$  ต่างกันมาก ๆ แล้ว มันเป็นไปได้ที่อัตราทนกำลังงานสำหรับซีเนอร์ไดโอดตัวหนึ่งหรือมากกว่าจะมีค่าเกินขึ้นมา ถึงแม้ว่าบางตัวจะทำงานอยู่ในย่านที่กำหนด บางคนนิยมใช้ซีเนอร์ไดโอดที่มีระดับแรงดันเท่ากัน (หรือเกือบเท่ากัน) และอัตราทนกำลังงาน (วัตต์) ที่เท่ากัน

แหล่งจ่ายไฟแบบไร้หม้อแปลงไฟฟ้า

มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่หลายชนิดที่ใช้แหล่งจ่ายไฟแบบไร้หม้อแปลงไฟฟ้า เมื่อที่งหมดค่าใช้จ่าย (ซึ่งโดยทั่วไปหม้อแปลงไฟฟ้าค่อนข้างมีราคาแพง) ในรูปที่ 34 แสดงให้เห็นถึงแหล่งจ่ายไฟแบบไร้หม้อแปลงไฟฟ้า 2 แบบที่แตกต่างกัน



รูปที่ 34 เป็นแหล่งจ่ายไฟแบบไร้หม้อแปลงไฟฟ้าโดยในรูป (ก) เป็นวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นซึ่งใช้กันส่วนใหญ่ในหลอดสุญญากาศที่ต่อกันหลาย ๆ หลอด ในรูป (ข) เป็นวงจรที่แรงดันเองเท่า ซึ่งใช้ตัวเก็บประจุขนาดเท่ากันสองตัว เพื่อผลิตแรงดันของวงจรในรูป (ก) เป็นสองเท่า

แหล่งจ่ายไฟแบบไร้หม้อแปลงไฟฟ้าที่แสดงในรูปที่ 34 (ก) จะใช้วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นจ่าย ๆ ซึ่งทำงานโดยตรงจากแรงดันไฟสลับขนาด 220 โวลต์ วงจรเรียงกระแสต่ออนุกรมอยู่

กับสายมีไฟของแหล่งจ่ายไฟสลับ ในขณะที่ขาร่วมต่ออยู่ทางสายนิวทรัล ระดับแรงดันเอาต์พุตที่มีค่าสูงมีค่าโดยโดยประมาณเท่ากับระดับแรงดันเยอดของไฟสลับ เนื่องจากระดับแรงดันไฟสลับแบบ 3 เฟส อาจเปลี่ยนแปลงได้ระหว่าง 198 และ 242 โวลต์ ดังนั้น V1 อาจเปลี่ยนแปลงได้จาก 200 ถึง 342 โวลต์ซึ่งระดับแรงดันที่ต่ำกว่า (V2) ทำได้โดยใช้ตัวต้านทานต่ออนุกรมเมื่อเกิดแรงดัน (V2) ร่วมกับซีเนอร์ไดโอด (ZD1) ส่วนตัวต้านทาน R1 จะไม่ค่อยได้ใช้ โดยที่เหตุที่เป็นเช่นนี้เกิดมาจากแรงดันและฟิวส์ เพื่อป้องกันวงจรเรียงกระแส (D1)

ในรูปที่ 34 (ข) จะแสดงให้เห็นแหล่งจ่ายไฟที่ทวีแรงดันสองเท่า (VOLTAGE DUBLER) ซึ่งใช้การเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นเช่นกัน โดยเอาจุดศูนย์กลางของแหล่งจ่ายไฟไปเชื่อมกับสายนิวทรัล ในวงจรรูปที่ 34 (ก) เล็กน้อย ขอแนะนำให้ใช้ C1 และ C2 ที่มีค่าความจุและชนิดตามที่ระบุไว้

### ข้อควรระวัง

แหล่งจ่ายไฟแบบไร้หม้อแปลงนี้จะแผ่รังสีด้วยอันตรารายที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของระดับแรงดันสามารถทำอันตรารายได้ ถ้าหากว่าใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ระวัง แหล่งจ่ายไฟนี้จะระงับไม่ได้ถ้าหากเกิดเกิดการสลับกันระหว่างสายที่มีไฟกับสายนิวทรัลแล้ว เมื่อแหล่งจ่ายไฟทำงาน สายรวมจะกลายเป็นสายมีไฟจากแหล่งจ่ายไฟสลับ ถ้าหากไปแตะถูกสายรวม (ซึ่งสนใจวงจรรูปที่ 34 (ก) และ 34 (ข) จะมีอันตรารายอย่างยิ่งในกรณีนี้) ถ้าหากแหล่งจ่ายไฟใช้สายร่วมต่อลงแทนเพื่อเชื่อม แทนเครื่องทั้งหมดจะต้องแยกจากกันทางไฟฟ้ากันตัวตุ๊กตาแยก

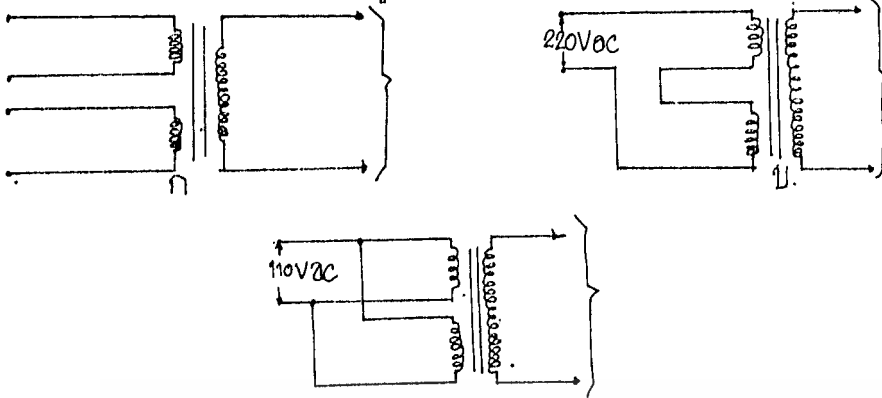
ในกรณีนี้จะต้องระมัดระวังอันตรารายที่ซ่อนอยู่ ซึ่งจะเข้าไปสู่แทนเครื่องที่มีแรงดันจลนสมที่มีไฟ โดยผ่านสกรูที่ทำกาวยึด ปุ่มหมุนซึ่งทาสีที่มีส่วนผสมของโลหะ สายสัณฐานร่วม หรือทางเดินของสายอากาศ แหล่งจ่ายไฟแบบไร้หม้อแปลงนี้ ควรจะใช้งานโดยการใช้อุปกรณ์ไฟแบบที่มีแรงดันสูง (POLARIZED AC LINE CORD) ซึ่งจะทำให้เสียบเข้ากับเต้าเสียบได้เพียงทิศทางเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นไปได้แหล่งจ่ายไฟแบบไร้หม้อแปลงนี้ ซึ่งโดยทั่วไปเรียกชื่อกันว่า แหล่งจ่ายไฟ เซลล์/ดีซี จะไม่แนะนำให้ใช้สำหรับโครงการต่าง ๆ

### เมื่อระดับแรงดันสูงขึ้นและกำลังงานเพิ่มขึ้น

แหล่งจ่ายไฟแรงดันสูงที่นิยมใช้สำหรับเครื่องขยายเสียงขนาด 500 โวลต์วีเอ็มเอทที่ใช้หลอดสูญญากาศนั้นจะเป็นแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงขนาด + 800 โวลต์ จนถึง + 5000 โวลต์ มีกระแสขนาดสูงถึง 1 แอมแปร์ ส่วนแหล่งจ่ายไฟแรงดันสูงโดยทั่วไปก็ใช้สำหรับวงจรขยายสัญญาณ เสียงเชิงเส้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขนาด 1 กิโลวัตต์ อาจจะใช้แรงดันสูงถึงขนาด 2700 โวลต์ ที่กระแส 500 มิลลิแอมป์



รูปที่ 35 ขดลวดปฐมภูมิสองขดในหม้อแปลงไฟฟ้าจะทำให้สามารถเพิ่มแรงดันที่ขดทุติยภูมิเป็นสองเท่าได้ หม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าพลังงานสูงหรือแรงดันสูง จะมีขดปฐมภูมิต่ออีก 2 ขดเสมอ (ดังในรูปที่ 35 ก) การจัดขดลวดไว้เช่นนี้จะสามารถให้ผู้ใช้เลือกให้หม้อแปลงมีแรงดันเป็น 110 โวลต์ หรือ 220 โวลต์ ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะชอบใช้แรงดันขนาด 220 โวลต์ สำหรับงานกำลังสูง เนื่องจากต้องการกระแสต่ำกว่า สำหรับวงจรขยายสัญญาณความถี่ 2 กิโลวัตต์ อาจจะใช้หม้อแปลง 10 แอมแปร์ที่แรงดัน 220 โวลต์ หรือ 20 แอมแปร์ที่แรงดัน 110 โวลต์ การต่อขดลวดของหม้อแปลงสำหรับแรงดัน 220 โวลต์และ 110 โวลต์ แสดงให้เห็นในรูป 35 (ข) และ 35 (ค) ตามลำดับ

ถ้าออกแบบวงจรส่วนใหญ่ คงจะไม่ค่อยได้พบกับไดโอดที่ใช้กับแรงดันสูง ๆ เลยสักโหล่น สำหรับใช้เป็นวงจรเรียงกระแสในแหล่งจ่ายไฟฟ้าพลังงานสูงและแรงดันสูง วงจรที่พบได้มักเป็นโดย การต่อไดโอดหลาย ๆ ตัวอนุกรมกันเพื่อทำเป็นวงจรเรียงกระแส (ดังแสดงในรูปที่ 36) เมื่อพิจารณา ความทรงจำอัตราทนแรงดันย้อนกลับสูงสุดของไดโอดจะต้องเท่ากับ  $2.02$  เท่าของแรงดันโวลต์ที่ป้อนเข้ามา ถ้าหม้อแปลงไฟฟ้าของเราจ่ายแรงดันได้สูงถึง 2000 โวลต์ เวกเตอร์เอ็มเอส ดังในวงจรทนแรงดันย้อนกลับสูงสุดของไดโอดที่ใช้ในวงจรเรียงกระแสจะเท่ากับ  $2000 * 2.02$  หรือเท่ากับ 4040 โวลต์ เมื่อเมื่อค่าความถี่ของหลอดควรจะใช้ไดโอดที่มีอัตราทนแรงดันย้อนกลับสูงสุด (PIV) เท่ากับ 6 กิโลโวลต์ หรือ 7 กิโลโวลต์ สำหรับวงจรเรียงกระแสขนาด 7 กิโลโวลต์ สามารถใช้เวกเตอร์เอ็มเอสได้โดย การทำไดโอดที่มีอัตราทนแรงดันสูงสุดขนาด 1000 โวลต์อนุกรมกัน 7 ตัวดังแสดงในรูปที่ 36 โวลต์อัตราทนแรงดันย้อนกลับสูงสุดรวมจะเท่ากับ ผลรวมของอัตราทนแรงดันย้อนกลับสูงสุดของโวลต์ของแต่ละหลอดที่ ขาดอคเลเตอร์สองจะทำหน้าที่เป็นเข้ากลางที่สับไปมา ซึ่งคล้ายกับเวกเตอร์เอ็มเอสของทรานซิสเตอร์จะสวิตซ์ด้าน A ลงกราวด์ก่อนแล้วจึงเป็นด้าน B ของหม้อแปลง T ซึ่งคล้ายกับกรณีของแรงดันไฟตรงอิมพัลส์จะถูกป้อนเข้าสู่แท่งกลางของขดปฐมภูมิ เอาต์พุตของไอซีเบอร์ LAS-3000 EA และ EB จะใช้สำหรับขับทรานซิสเตอร์ Q1 และ Q2 ให้แผลแตกต่างกัน ตัวต้านทานที่ใช้ต่อวงจรหม้อแปลง EC จะต่อเพื่อใช้กำจัดกระแสแฉกความถี่อินพุตที่เลื่อนไปของไอซีเบอร์ LAS-3000

ทรานซิสเตอร์ที่ใช้แบบทรานซิสเตอร์กำลัง มีนควรวัดค่าการกระจายกำลังงานของหลอด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

มอเตอร์ที่สูงเพียงพอ และอัตราการทำงานแรงดันและการกระแทกที่สูงเพียงพอสำหรับโหลด โดยที่อัตราการทำงานและกำลังงานสามารถเห็นได้ง่ายแต่อัตราการทำงานแรงดันอาจจะเป็นปัญหา ส่วนที่มีควมจำเป็นที่จะต้องก่อให้เกิดรูปคลื่นสี่เหลี่ยมที่รวมขดปฐมภูมิของหม้อแปลงซึ่งเป็นโหลดแบบตัวเหนี่ยวนำ เนื่องจากค่ากระแสในหม้อแปลงจะมีอัตราการทำงานเปลี่ยนแปลงที่สูง และโหลดที่เป็นแบบตัวเหนี่ยวนำ จะมีความถี่ (VOLTAGE SPIKE) จะมีค่าสูง และแรงเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะเท่ากับ

$$V = L(dI/dT)$$

ตัวเหนี่ยวนำซึ่งในกรณีนี้เป็นค่าความเหนี่ยวนำของขดปฐมภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งไม่ต้องการค่าที่สูงเพื่อที่จะสร้างแรงดันสูง เนื่องจากอัตราการทำงานเปลี่ยนแปลงของกระแสเหนี่ยวนำเท่ากับ  $(I / T)$  มีค่าสูง

ในบางครั้ง ผู้ออกแบบวงจรจะต้องวงจรอาร์วีลันเบอร์ คอมมิตดปฐมภูมิหรือตัวเหนี่ยวนำของเลคเตอร์ของ Q1 และขาคอลเลคเตอร์ของ Q2 วงจรสับเบอร์ที้ประกอบขดตัวเหนี่ยวนำ ๑๕.๓๓1 ไมโครฟารัด (ที่ 10๐๐ โวลต์ หรือมากกว่า) ต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน 100 โอห์ม ของความถี่ 5 ถึง 10 วัตต์) การรักษาระดับแรงดันโดยใช้วงจรสวิตซ์ จะมีการสูงเสียดสลับระหว่างที่เหนี่ยวนำจะขึ้นอินพุต เอาต์พุตแตกต่างกันน้อย ตัวเหนี่ยวนำสามารถผลิตแหล่งจ่ายแรงดันแบบสวิตซ์ได้โดยใช้ทรานซิสเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ทั่ว ๆ ไป (SERIES PASS TRANSISTOR)

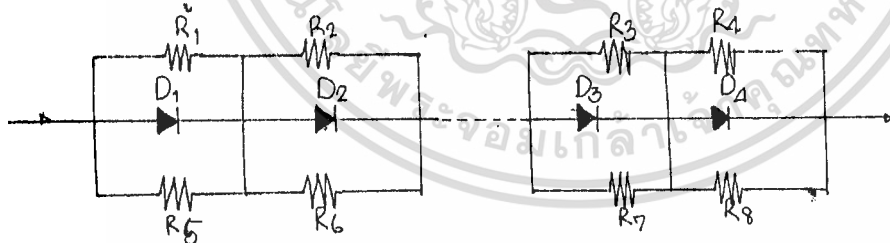
จากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นการแนะนำถึงวงจรรักษาระดับแรงดันประเภทหนึ่ง ซึ่งลักษณะแบบก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป รวมทั้งข้อดีและข้อเสียที่ต่างกันไป คงทำให้รู้ถึงหลักการในการออกแบบแหล่งจ่ายไฟประเภทต่างๆ ได้พอสมควร หลังจากจะเป็นประโยชน์ในโครงการ ๗ ท้า จะมีการนำเสนอได้และครับ

ปัญหาของการต่อไดโอดอนุกรมกันนั้น ได้แก่ ถ้าไดโอดแต่ละตัวมีแรงดันเบรคไม่เหมือนกันแล้ว ก็จะทำให้เกิดปัญหาแรงดันตกคร่อมที่ไดโอดแต่ละตัวไม่เท่ากัน ความแตกต่างกันนี้ จะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นภายหลัง วิธีการแก้ปัญหาก็โดยการต่อตัวต้านทานที่มีค่าเท่ากัน ขนานกับไดโอดแต่ละตัว (R1 ถึง R4 ในรูปที่ ๑6) ตัวต้านทานเหล่านี้โดยทั่วไปจะใช้ขนาด 1 วัตต์ และมีค่าเท่ากับ 500 ถึง 1๐๐๐ โอห์มต่อ 1 โวลต์ของอัตราการทำงานแรงดันย้อนกลับสูงสุด ดังนั้นสำหรับไดโอดที่มีอัตราการทำงานเบรคย้อนกลับสูงสุด 1๐๐๐ โวลต์ จะใช้ตัวต้านทานค่า 5๐๐,๐๐๐ ถึง 1 เมกะโอห์ม ขนาด 1 วัตต์ สิ่งสำคัญ ของ การของความต้านทานจะต้องเท่ากันทุกตัว มิฉะนั้นแล้วคุณสมบัติของการทำให้ระดับแรงดันเท่ากับจะเสียไป ถ้าหากพบว่าตัวต้านทานตัวหนึ่งเกิดเปลี่ยนสีไปอย่างรวดเร็ว ในระหว่างการใช้งานในแหล่งจ่ายไฟ นี้เอง ๓ นามิแรก ก็แสดงว่าตัวต้านทานตัวนั้นหรือไดโอดที่ตัวต้านทานนั้นต่อขนานอยู่เสียคุณสมบัติไป

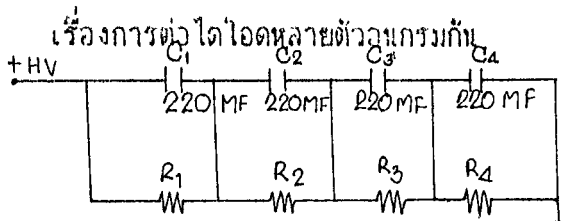
ตัวเก็บประจุถูกใช้ในการป้องกันไดโอดในวงจรเรียงกระแส จากทรานเซียนส์แรงดันสูงที่เข้ามาในสายไฟบ้านในงานส่วนใหญ่แล้วตัวเก็บประจุแต่ละตัวจะมีค่าเท่ากับ ๑.๐๑ ไมโครฟารัด และเป็นชนิดเซรามิกแบบจาน 5 (DISC CERAMIC TYPE) อัตราการทนแรงดันเช่นเดียวกับตัวเก็บประจุไดโอด และควรจะมีค่ามากกว่าเล็กน้อย แต่ไม่เหมาะที่จะใช้ตัวเก็บประจุชนิดเซรามิกแบบวงกลม เพราะตัวเก็บประจุไดโอดที่มีอัตราการทนแรงดันย้อนกลับสูงสุดเพียง กิโลวัตต์ ไดโอดแบบอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในวงจรรูปที่ ๑6 ต้องติดตั้งให้แยกกันระหว่างแรงดันสูงกับแท่นเครื่อง วิธีการทั่วไปก็โดยการใช้วงจรเรียงกระแสบนแผ่นเดิน วงจรที่ทำด้วยเบกาเลต (BAKALITE) ฟีนอลิก (PHENOLIC) หรือไฟเบอร์กลาส (FIBREGLASS) แผ่นเดินวงจรนั้นจะต้องติดตั้งบนแท่นฉนวนที่ทำจากเซรามิกหรือลูไซต์ (LUCITE) ซึ่ง

จุดต่อที่ใช้ในแหล่งจ่ายไฟแบบแรงดันสูงจะต้องกลมและเรียบ และต้องไม่มีจุดแหลมหรือคมที่เนื่องจากการคายประจุ "โคโรนา" (HIGH VOLTAGE CORONA DISCHARGE)

ส่วนของวงจรกรองกระแสของแหล่งจ่ายไฟ แรงดันสูงมีอยู่หลายแบบ เช่น กรองด้วยตัวเก็บประจุเพียงอย่างเดียว วงจรกรองกระแสแบบบังคับ (BRUTE FORCE FILTER) เช่นเดียวกับวงจรกรองกระแสที่เอาแคปซูลเข้ามาแล้ว ซึ่งประกอบด้วยตัวเก็บประจุตัวเดียวหรือเอาตัวเก็บประจุตัวเดียวมาต่อเข้ากับโหลดอย่างน้อย 2 ทางสำหรับตัวเก็บประจุในแหล่งจ่ายไฟแรงดันสูง ชนิดนี้ใช้ตัวเก็บประจุที่ทนแรงดันสูง โดยมีค่าความจุที่คำนวณจากตัวประกอบปรับแก้ที่ต่อกับ ตัวเก็บประจุเป็นอันดับ 1 มีราคาแพงมาก และบางครั้งก็หาได้ยาก ทางเลือกอื่นก็โดยการ ใช้ตัว เก็บประจุเรียงกันเป็นลำดับอนุกรม (ดัง วงจรในรูปที่ ๑7)

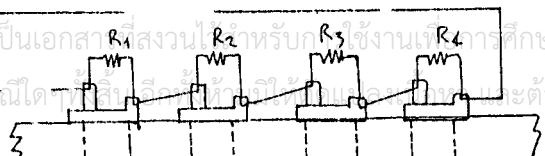


รูปที่ ๑6 เป็นแนวคิดในการเอาชนะปัญหาใน



รูปที่ ๑7 เทคนิคที่สำคัญในการสร้างวงจรกรองกระแสแรงดันสูงที่มีราคาไม่แพงเกินไปในท้องตลาด ในทางปฏิบัติแล้วชิ้นส่วนทุกตัวจะต้องมีค่าและอัตราในการทนแรงดันเท่ากัน

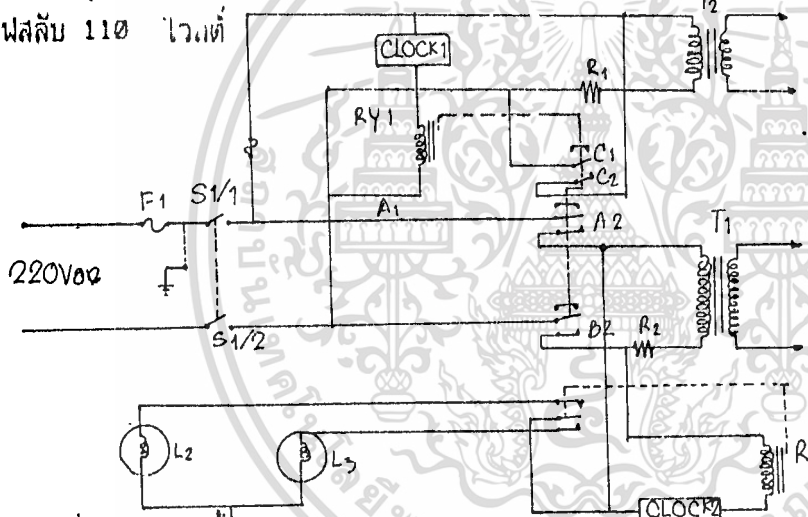
เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้ ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่สืบหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้





รูปที่ 30 แสดงให้เห็นถึงการต่อสายทางชุดปฐมภูมิ สำหรับแหล่งจ่ายไฟแรงดันสูง ซึ่งมีกำลังงานสูงและแรงดันสูง ที่ทำงานมาจากแรงดันไฟสลับ นอกจากนี้ยังมีวงจรป้องกันเพื่อความปลอดภัยอีกหลายตัวในวงจร หรือแปลงไฟฟ้า 2 ตัวถูกนำมาใช้ ถัดมาแหล่งจ่ายไฟให้พลังงานวงจรขยายสัญญาณวิทยุเชิงเส้น ซึ่งวงจรขยายนี้ส่วนใหญ่ใช้หลอดสูญญากาศ ซึ่งต้องมีการเรียงต่อแผงกระแสสูง สำหรับป้องกันให้กับไส้หลอด (T2)

หลอดสูญญากาศจะต้องถูกทำให้มีอุณหภูมิถึงอุณหภูมิที่ใช้งานก่อนที่จะป้อนแรงดันสูงเข้าไปถึง ความต้องการนี้หมายความว่าต้องจุดไส้หลอดก่อนที่คุณจะป้อนแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง แรงดันสูงจนสามารถทำให้สำเร็จไปได้โดยการตัดต่อวงจรดังแสดงในรูปที่ 30 ส่วนที่ 1 ซึ่งเป็นตัวป้องกันที่เชื่อมจ่ายไฟเข้าและจะป้อนไฟเข้าหม้อแปลงจุดไส้หลอดส่วนที่ตัวนี้ตัวแรกจะหม้อแปลงได้สูง ซึ่งหม้อแปลงแรกนี้ของชุดปฐมภูมิของหม้อแปลงทั้ง 2 ตัวได้ กระแสหลัก ได้แก่ กระแสจากหม้อแปลงแรงดันสูง กระแสที่อาจจะมีค่าสูงถึง 20 แอมแปร์ สำหรับวงจรขยายสัญญาณเชิงเส้นขนาด 1 กิโลวัตต์ ที่ใช้หลอดหลอดแรงดันไฟสลับ 110 โวลต์



รูปที่ 30 วงจรนี้ จะควบคุมกับขั้วต่อสำหรับแหล่งจ่ายไฟ แต่วงจรที่ใช้ป้องกันกับวงจรหม้อแปลง เครื่องส่งวิทยุแบบแอมป์ ขนาด 5000 วัตต์ การป้อนแรงดันสูงให้กับหลอดก่อนที่ไส้หลอดจะเย็นลงไว้พร้อมที่จะทำงาน จะทำให้อายุของหลอดลดลงได้ จึงต้องมีวงจรตั้ง เวลาเข้าช่วย

ชุดหลอดปฐมภูมิของหม้อแปลงแรงดันสูง T1 จะถูกควบคุมโดยหนึ่ง เส้นสวิตซ์ A1/A2 และ B1/B2 ของรีเลย์ RY1 หน้าสำเนาเหล่านี้จะเชื่อมวงจร (A1 กับ A2 และ B1 กับ B2) เมื่อคอยล์ของ RY1 ถูกกระตุ้น เมื่อวงจรตั้งเวลาที่ 1 นั้นเวลาครบ ระยะเวลาระยะเวลาของวงจรตั้งเวลาจะหมดได้โดยคำนึงถึงระยะเวลาอุ่นไส้หลอด ในบางกรณีวงจรตั้งเวลาอาจจะเป็นโอเมกาทอมป์ และมันอาจจะแล้วจะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบไฟฟ้า กลศาสตร์ (CLOCK MECHANICAL) ไส้หลอดที่เย็นของหลอดสูญญากาศกำลังจะสูงจะตั้งกระแสเป็นจำนวนแอมป์ เพื่อให้ไส้หลอดจะเย็นลง กระแสจะลดลงจนถึงระดับที่ใช้งานปกติ ซึ่งกระแสพุ่งเข้า (IN RUSH CURRENT) นี้เป็นผลมาจาก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา 53 ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การใช้อุปกรณ์ของหลอดสูญญากาศเส้นลวง เนื่องจากจะพบภาวะแฉกช่วงเข้านี้ จะมีตัวต้านทานต่อกรวดกับกรวด 1 คู่กับ  
กรวดของหม้อแปลงจุดไล่หลอด ซึ่งตัวต้านทานนี้โดยปกติจะมีค่าที่ใช้เลือกแปรปรวนมา 1.5 เท่าของค่าปกติ  
เมื่อวงจรตั้งเวลาตัวที่ 1 ทางบนครบเวลาแล้ว หน้าสัมผัส C1 - C2 ของ RY จะตกลงมาและได้วงจร  
ตัวต้านทานไว้ เมื่อ R1 ถูกผลจวงจรของปฐมภูมิของ T2 จะได้รับแรงดันเต็มที่

ปัญหาเหมือน ๆ กันที่เกิดขึ้นกับด้านแรงดันสูงของแฉกช่วงเข้านี้ ก็คือ การแปรปรวนของแรงดันสูง  
ประจุของตัวเก็บประจุของตัวเก็บประจุในวงจรกรองแรงดันในตอนเริ่มเปิดเครื่องจะยังคงสูงจนกระทั่ง  
จำนวนนี้สามารถทำงานได้อัตโนมัติของวงเรียงกรวดได้ ตัวต้านทาน R2 จะทำหน้าที่จำกัดกระแสในช่วงเวลา  
กับ R2 วงจรตั้งเวลาอีกตัวคือ วงจรตั้งเวลาตัวที่ 2 จะใช้สำหรับระดับตัวเลข RY2 ที่เลือกมาและที่  
ให้ตัวเก็บประจุในวงจรกรองกระแสทำการอีกประจุเพียงพอที่จะเกิดกระแสที่ไหลลง ไปยัง  
เวลาของวงจรตั้งเวลาตัวที่ 2 จะสั้นกว่าเวลาของวงจรตั้งเวลาที่ 1 มาก

หลอดไฟสูญญากาศนี้เพิ่มเข้ามาโดยหลอดไฟ L1 สีเขียว จะติดเมื่อเวลาตัวที่ 1 ในของ  
วงจร L2 เป็นสวิตช์และจะตัดเมื่อวงจรตั้งเวลาตัวที่ 1 ถูกกระตุ้น ส่วนหลอด L2 จะติดเมื่อ  
แรงดันสูงนี้พร้อมที่จะจ่าย แหล่งจ่ายในตัวที่ดังแสดงในรูปที่ 29 นี้ จะต้องใช้เวลา 2 ชั่วโมง  
จำเป็นเนื่องจากความแตกต่างอย่างมากของระดับกำลังงานของหม้อแปลงที่ 2 และ 1 ในตัว  
เพียงตัวเดียวมันจะต้องทนต่อกระแสที่สูง สำหรับจ่ายให้กับหม้อแปลงดังกล่าว ความถี่ของ  
ทางด้านจุดไล่หลอดของแหล่งจ่ายไฟ ซึ่งอาจจะจ่ายแรงดัน T2 เกิดใหม่ไป โหมดการเลือก 1.2 ชั่วโมง  
ในวงจรจะเป็นการป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถป้องกันวงจรได้เป็นอย่างดี

การลดความร้อนที่เกิดขึ้น วงจรรักษาระดับแรงดันทั้งหมดที่กล่าวมาในรูปที่ 29 นี้ จะ  
พบจากข้อบกพร่องหลัก สำหรับอุปกรณ์พวกแอคทีฟ ได้แก่ ทราซิสเตอร์ที่ต่ออนุกรมกับกรวด และกรวด  
กำลังงานจำนวนหนึ่งออกมา เมื่อวงจรต่าง ๆ เหล่านี้ต้องการความแตกต่าง ๆ ของแรงดันกรวด  
อันสุดกับเอาต์พุต (VI - VO) ที่ต่อกรวดตัวต้านทาน ซึ่งจะเป็แหล่งสูญเสียดังกล่าว 1.2 ชั่วโมง  
ที่กระจายออกไปโดยทราซิสเตอร์ที่ต่ออนุกรมจะหาได้จากสมการนี้คือ  $P = IO (VI - VO)$

เมื่อ P คือ กำลังงานที่กระจายเป็นวัตต์ IO คือ กระแสเอาต์พุตเป็นแอมป์ VI คือแรงดัน  
อินพุตเป็นโวลต์และ VO คือแรงดันเอาต์พุตเป็นโวลต์ ถ้าความแตกต่างของระดับแรงดัน (VI - VO)  
มีค่ามากแล้ว กำลังงานที่กระจายออกมาก็จะมีค่ามากที่กระแส แอมป์ วงจรรักษาแรงดันกรวด  
ขนาด 1/5 โวลต์ จะกระจายกำลังงานเพียง 3 วัตต์ ที่ค่าความแตกต่างระหว่าง (VI - VO) เป็น  
ที่สุด แต่สำหรับวงจรรักษาระดับแรงดันซึ่งสามารถทำงานที่ระดับซึ่งสามารถทำงานที่ระดับ  
สามารถทำงานที่ระดับแรงดัน VI สูงถึง 40 โวลต์กำลังงานที่กระจายออกมาจะเท่ากับ  $1/5$  โวลต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

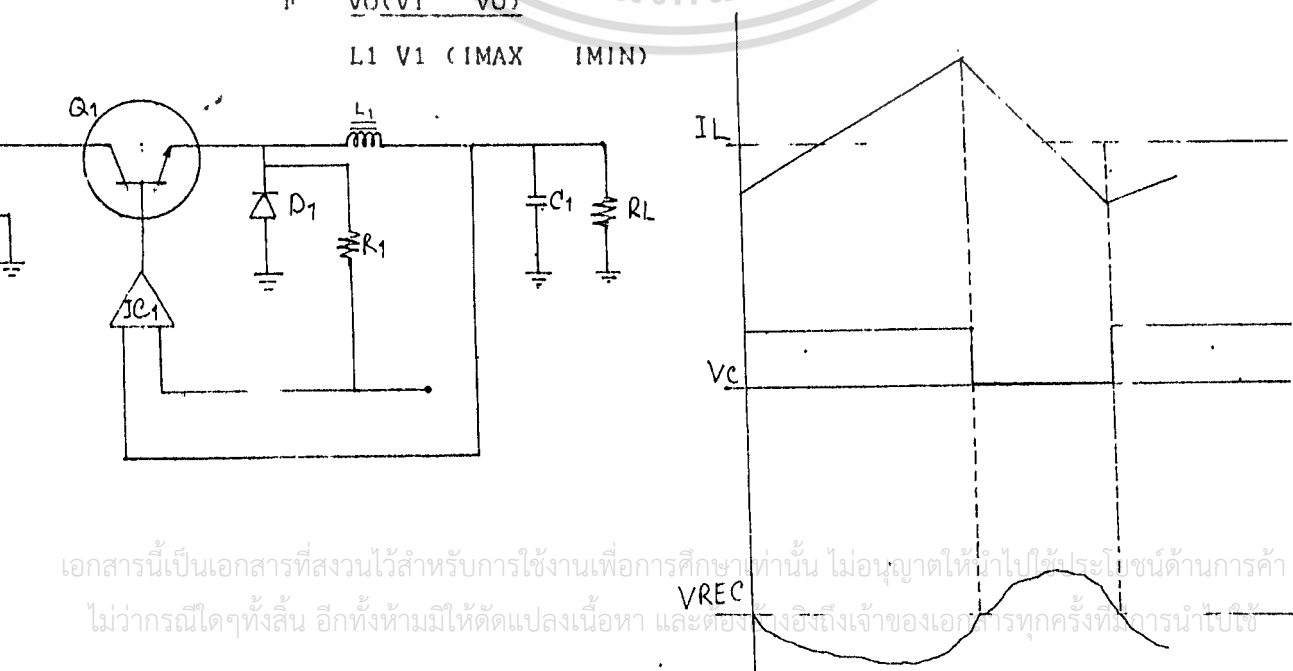
5 โวลต์) / 1 แอมแปร์ หรือ ๑๕ วัตต์ก็ได้เลย เมื่อค่านี้ถึงก เล็งงานที่สูญเสียไปจะ เปลี่ยนรูปไปเป็น ความร้อน และความร้อนนี้เป็นตัวก่อให้เกิดความเสียหายหลักให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทั้งหมดซึ่งจะกระจายออกมามองกลายเป็นความร้อน ดังนั้นเราอาจจะกล่าวได้ว่าวงจรหม้อแปลงจะเป็นตัวที่สร้างความร้อนที่สำคัญ การแก้ปัญหาที่แก้ได้แก่ วงจรรักษาแรงดันแบบสวิทช์ (SWITCHING VOLTAGE REGULATOR) ในรูปที่ 4๑ (ก) แสดงให้เห็นแผงผังวงจรการทำงานของวงจรหม้อแปลงแรงดันแบบสวิทช์ ซึ่ง ในขณะที่รูปที่ 4๑ (ก) แสดงถึงรูปคลื่นทรานส์เซียนเตอร์ Q1 ในโมไซ์เป็น วงจรสวิทช์ ที่ต่ออนุกรมกับวงจร ดังเช่น ใช้ในวงจรรักษาแรงดันแบบทั่วไปแต่มีเป็นสวิทช์ขับเคลื่อนโดย ขาเบสของ Q1 มีค่าเป็นบวก ความต้านทานระหว่างคอลเลคเตอร์กับอีเล็กทอนเมื่อเปิดเบสจะมีค่าลดลงเหลือเพียงเล็กน้อย แรงดันตกคร่อมระหว่าง Q1 ภายใต้อุปกรณ์ที่เก็บมีค่า LOW VCE (SAT) ซึ่งค่าเบสของ Q1 มีค่าเป็นศูนย์ หรือลบ มันก็จะเลิกทำงาน ดังนั้นแรงดันตกคร่อมระหว่าง คอลเลคเตอร์กับอีเลคเตอร์ จึงมีค่าสูงมาก

วงจรขยายสัญญาณ IC1 ในรูปที่ 4๑ (ก) ใช้เป็นวงจรเปรียบเทียบ ขณะเมื่อสวิทช์ เปิดขึ้น อันเนื่องเข้าสู่วงจรเปรียบเทียบให้ขยับแรงดัน ถ้าหากแรงดันที่ป้อนเข้าสู่ขาอินพุตของวงจรเปรียบเทียบแรงดันเท่ากันแล้ว ระดับแรงดันเอาต์พุตจะเป็นศูนย์ ถ้าระดับแรงดันที่ขาอินพุตมีค่ามากกว่าระดับแรงดันเอาต์พุตแล้ว ระดับแรงดันเอาต์พุตจะเพิ่มขึ้นจนกว่าจะเท่ากับอินพุตแล้ว เอาต์พุตจะมีค่าเป็นลบ แต่ถ้าอินพุตมีค่าต่ำกว่าอินพุตแล้ว เอาต์พุตจะมีค่าเป็นบวก เอาต์พุตของวงจรเปรียบเทียบที่ขยับแรงดัน IC1 จะใช้ขยับเบสของสวิทช์ทรานส์เซียนเตอร์ Q1 เมื่อขาเบสของ Q1 มีค่าสูง กระแส  $I_L$  จะไหลใน วงจรอินเหนียวเข้า L และในตัวต้านทานที่เป็นโหลด  $R_L$  ระดับแรงดันที่ปรากฏที่หรือผ่านตัวเก็บประจุ  $C_1$  จะขยับให้ยาวเข้า  $L_1$  ซึ่งหาได้จากสมการ

$$V = LI \cdot IL / DT$$

วงจรนี้จะออกขั้วเสตที่ความถี่ระหว่าง ๑ และ ๑๐ กิโลเฮิรตซ์ ซึ่งหาได้ จากสมการ

$$f = \frac{VO(VI - VO)}{L1 V1 (IMAX - IMIN)}$$

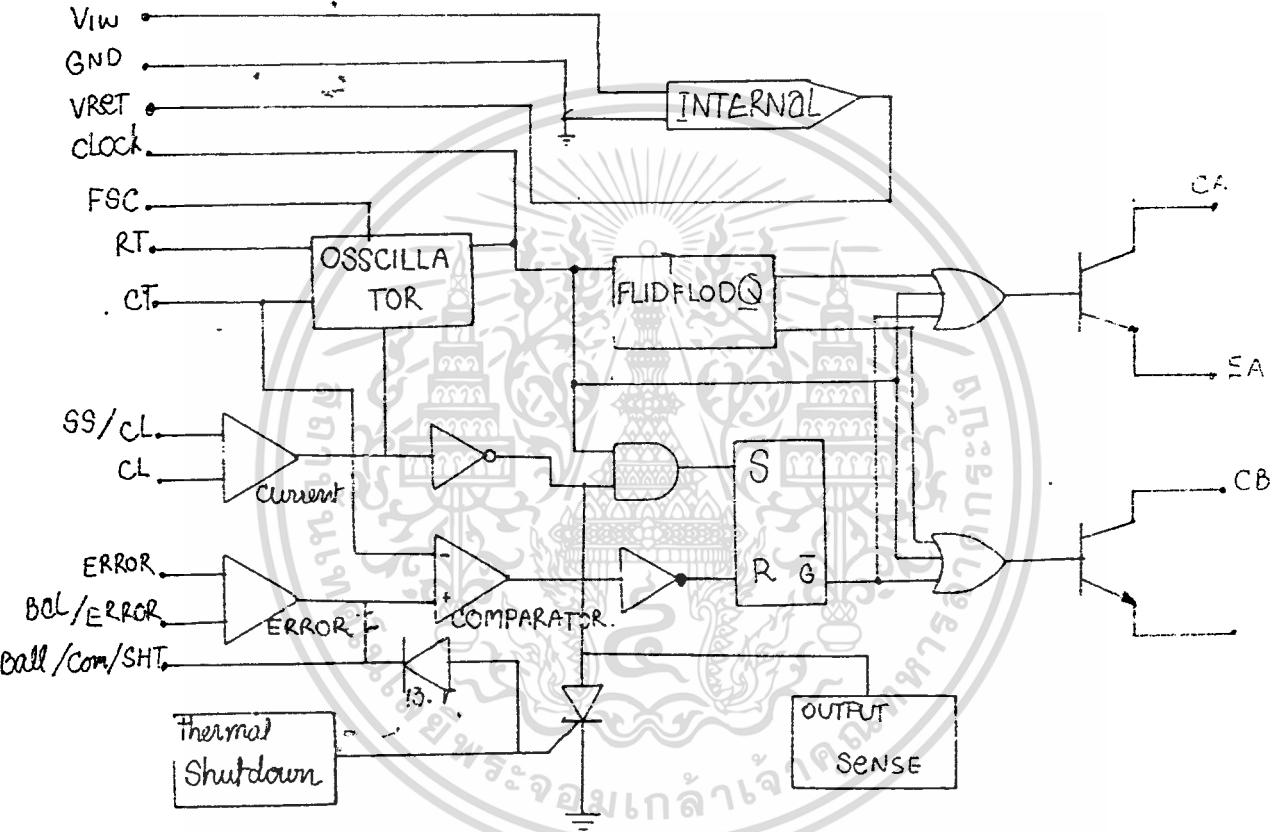


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 VREC  
 ไม่ว่าจะผิดใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้





ตัน / 5 โวลต์ จากอินพุตลิซีขนาด 12 ถึง 24 โวลต์ กระแสไหลลงเอาต์พุตสูงสุดเท่ากับ 500 มิลลิแอม-แปร์ ดังนั้นจึงจ่ายกำลังงานได้ 2.5 วัตต์ การรักษาระดับแรงดันเช่นเดียวกับวงจรในรูป 43 (ก) สำหรับแบบลดแรงดันลงนี้ จะประกอบด้วยอุปกรณ์ ซึ่งไม่ได้ใช้ในแบบเพิ่มแรงดันขึ้น อุปกรณ์เบอร์ L2 - CV6 เป็นไอซีไอโองกันแรงดันเกิน โดยไอซีเบอร์ L2 - CV6 เป็นวงจรเรสซิอาร์ท โดยขนาด 2 แอมแปร์ 6 โวลต์ ถ้าหากวงจรรักษาระดับแรงดันแบบสวิตช์ซึ่งนี้ทำงานผิดพลาดและให้แรงดัน VI ผิดปรกติที่ VO แล้วอุปกรณ์เบอร์ L2 - CV6 จะเบรคความ และลัดวงจรเอาต์พุตเข้าด้วยกัน ในทั้ง 2 กรณีเรสซิอาร์ทเอาต์พุตที่เป็นวงจะสามารถปรับได้ โดยการใช้ตัวลวดของแรงดันเรสซิอาร์ท-ไอซีไอโองกันแบบ ไอโองกันเรสซิอาร์ทที่รวมเอาเอาต์พุต

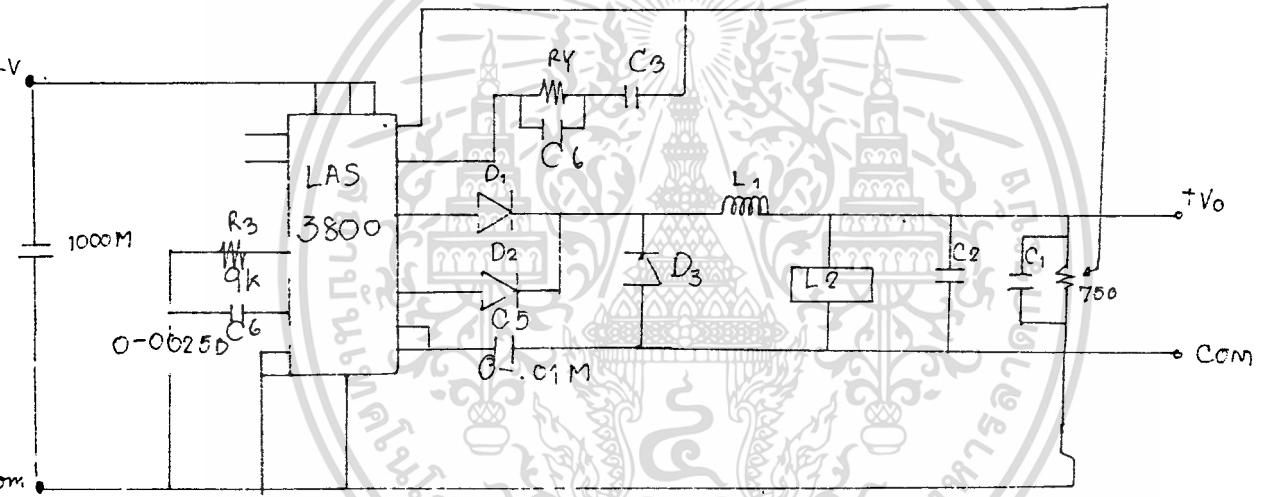
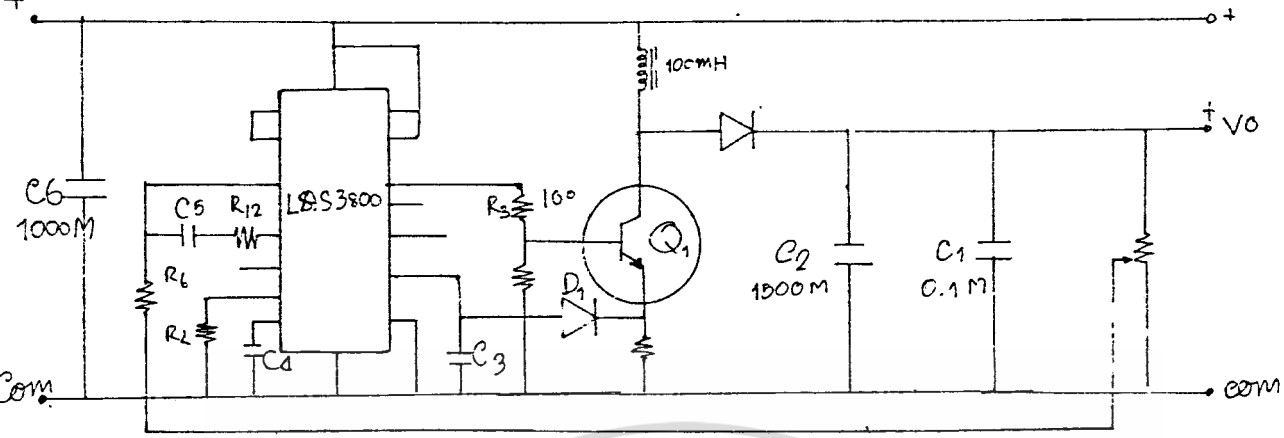


รูปที่ 42 เป็นไอซีที่ออกแบบมาทำหน้าที่เฉพาะในรูป (ก) เป็นหนึ่งสองวงจรภายในของไอซีเบอร์ LAS - 3809 ของบริษัทแลนด้าอิเล็กทรอนิกส์ ตัวดังภายในประกอบลวดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมหาศาลที่ใช้งานในแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตช์ซึ่งการต่อธา แสดงอยู่ทางมุมบนขวาของภาพ (ข)

วงจรอินเวอร์เตอร์ วงจรอินเวอร์เตอร์ เป็นแหล่งจ่ายไฟชนิดนิโคแคดเมียมชนิดหนึ่ง ซึ่งจะผลิตเอาต์พุตซึ่งเป็นไฟกระแสสลับ รูปคลื่นเอาต์พุตที่แท้จริงจะเหมือนกับคลื่นรูปสี่เหลี่ยมมากกว่าคลื่นรูปไซน์ แต่มันสามารถจ่ายกำลังงานให้กับระบบแสงสว่างและอุปกรณ์ที่ไม่เป็นโหลดแบบความเหนี่ยวนำ และความถี่ (โดยมีค่าความเหนี่ยวนำหรือความถี่เพียงเล็กน้อย อินเวอร์เตอร์นี้เป็นตัวพื้นฐานของวงจรแปลงสัญญาณไม่ตรงเป็นไม่ตรง (DC TO DC CONVETOR) โดยวงจรเหล่านี้ บางครั้งใช้ผลิตแรงดันไฟตรงที่มี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ระดับแรงดันแตกต่างกันไปจากระดับแรงดันที่กำหนดไว้ ในขณะที่บางตัวใช้เป็นตัวลงจลที่ทำงานที่ขั้ว  
ทางใส่สัญญาณของวงจรไฟกระพริบ ซึ่งในกรณีหลังนี้ใช้โมดูลเครื่องแพทย์เลือกความถี่ด้วย  
สองขั้วได้





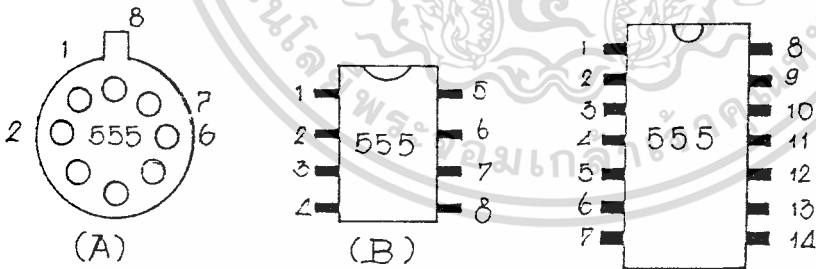
บทที่ 3

หัวข้อ ๓ ไปเกี่ยวกับไอซี 555

มารู้จักไอซี 555 กันก่อน ก่อนที่จะทำโครงการเกี่ยวกับไอซีไทม์เมอร์ 555 เรามาทำความรู้จักกับตัวไอซี 555 กันก่อนเล็กน้อย เพื่อเอาไว้พิจารณาเวลามีปัญหาในการทำโครงการ จะได้ตรวจสอบเช็คแก้ไขได้ถูกต้อง ซิกเนติกส์ เป็นบริษัทแรกที่ผลิตไอซี 555 ออกมาขายเป็นแบบดิว (DIP) 8 ขา ต่อมาบริษัทอื่น ๆ จึงได้ผลิตไอซีเบอร์นี้ออกมาขายมากมาย ซึ่งก็มีเยอร์และสัญลักษณ์แตกต่างกันไป ดังสรุปไว้ในตารางที่ 1 นอกจากนี้ยังได้มีการสร้างไอซีเบอร์ใหม่คือ 556

บริษัท	สัญลักษณ์และเบอร์ที่ใช้
ซิกเนติกส์	WE 555 และ SE 555
เอ็นแอล	LM 555 และ LM 555 C
อินเตอร์ซีส	NE 555 และ SE 555
อาร์ซีเอ	ca 555 และ CA 555 C
แฟร์ชาย	NE 555
โมโตโรล่า	MC 1455 และ MC 1555
เท็กซัส	SN 52555 และ SN 72555

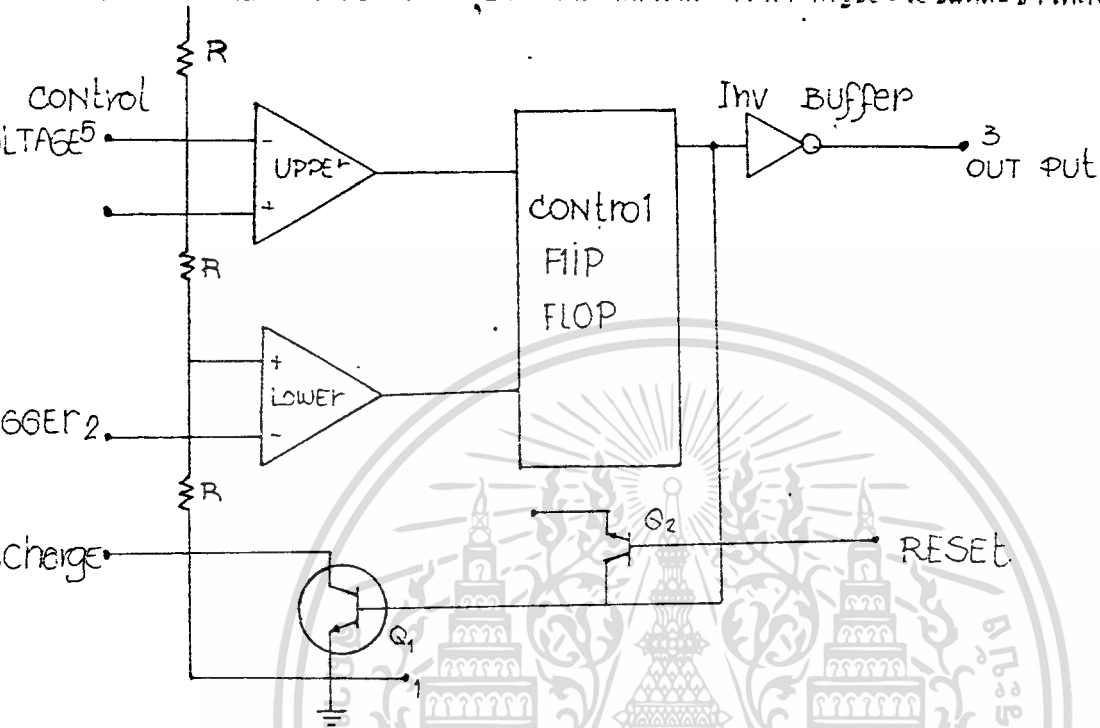
ตารางที่ 1 แสดงบริษัทต่าง ๆ ที่ผลิตไอซี 555



รูปที่ 1 การเก็บบรรจุไอซี 555 ก. แบบตัวถังโลหะ 8 ขา ข. แบบดิว 8 ขา ค. แบบดิว 14 ขา

ปัจจุบันไอซี 555 มีการเก็บบรรจุอยู่ 3 แบบ คือ แบบตัวถังโลหะ 8 ขา, ตัวถังพลาสติกแบบดิว 8 ขา และแบบดิว 14 ขา (แบบนี้ไม่ค่อยมีใช้เพราะตัวใหญ่มีขามากเกินความจำเป็นทำให้ไม่สะดวกในการทำงาน) แบบตัวถังโลหะจะทนอุณหภูมิได้สูงกว่าตัวถังพลาสติกแบบดิว แต่ใช้งานออกแบบติดตั้งบนแผงปริ้นท์ไม่ค่อยสะดวก จึงนิยมใช้แบบดิว 8 ขากันมากกว่า

ภายในตัวไอซี 555 จะประกอบไปด้วยวงจรเปรียบเทียบแรงดันหรือที่เรียกว่าคอมพาราเรเตอร์ (COMPARATOR) วงจรควบคุมฟลิปฟล็อป (CONTROL FLIP FLOP) วงจรรับไฟเฟ้อร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลับสัญญาณด้วย (INVERTER BUFFER) รวมทั้งวงจรลิกซ์ซึ่งต่าง ๆ อีก จากลักษณะการทำงานของวงจรภายในตัวไอซี พอจะสรุปให้เห็นถึงหน้าที่และความสำคัญของไอซีแต่ละขาได้ดังนี้



รูปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมการทำงานของวงจรภายในตัวไอซี 555

ขา 1 เป็นขากราวด์ (GROUND)

ขา 2 เป็นขาทริกเกอร์ (TRIGGER) เมื่อแรงดันไฟฟ้าที่ขาทริกเกอร์ลดต่ำกว่า  $1/3$  ของแหล่งจ่ายแรงดัน จะทำให้วงจรฟลิปฟล็อปภายในตัวไอซีทำงาน และได้เอาต์พุตที่ขา 3 อยู่ในภาวะแรงดันสูง

ขา 3 เป็นเอาต์พุต (OUT PUT) แรงดันที่ ขาเอาต์พุตจะ เปลี่ยนแปลงอยู่ในภาวะแรงดันต่ำหรือสูงได้ตามการทำงานของวงภายใน และสามารถจ่ายหรือดึงกระแสได้ประมาณ 200 มิลลิแอมป์

ขา 4 เป็นขารีเซ็ต (RESET) ถ้าแรงดันไฟฟ้าขา 4 นี้ต่ำกว่า 0.4 โวลต์วงจรภายในตัวไอซีจะไม่สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะมีการกระตุ้นอย่างไรก็ตาม

ขา 5 เป็นขาควบคุมแรงดัน (CONTROL VOLTAGE) เป็นขาที่ต่ออยู่กับจุดเปรียบเทียบแรงดันของวงจรเปรียบเทียบแรงดัน (วงจรคอมพาราเรเตอร์) ภายในตัวไอซีจึงสามารถใช้ตัวต้านทานต่อที่ขา 5 นี้เพื่อให้แรงดันไฟฟ้าที่จุดเปรียบเทียบเปลี่ยนแปลงไป เมื่อไม่ใช้ขา 5 นี้ควรวางคาปาซิเตอร์ที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.1 เพื่อช่วยลดสัญญาณรบกวนความถี่สูงที่เข้าที่ทางแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า

ขา 6 เป็นขาเทรลโวล (THRESHOLD) ถ้าแรงดันที่ขา 6 นี้สูงกว่า  $2/3$  ของแหล่งจ่ายแรงดัน วงจรฟลิปฟล็อปภายในตัวไอซีจะรีเซ็ตทำให้ที่เอาต์พุตของไอซีอยู่ในภาวะแรงดันต่ำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขา 7 เป็นขาคิสรชาร์จ (DISCHARGE) ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของทรานซิสเตอร์ภายในตัวไอซีให้อยู่ในภาวะปิดหรือเปิด ซึ่งจะทำให้แรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตเริ่มเปลี่ยนแปลงอยู่ในภาวะแรงดันสูงหรือต่ำตามการทำงานของทรานซิสเตอร์ด้วย ปกติขา 7 นี้จะมีคาปาซิเตอร์ด้วยจะต่ออยู่เพื่อใช้ในการคิสรชาร์จของคาปาซิเตอร์ไปควบคุมการทำงานของทรานซิสเตอร์

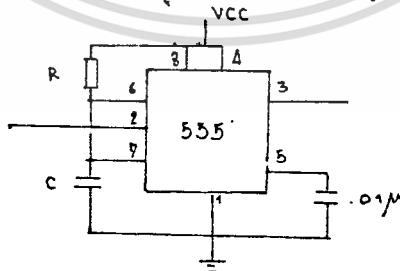
ขา 8 เป็นขาแหล่งจ่ายแรงดัน (SUPPLY) ที่สามารถป้องกันแรงดันผ่านขา 8 นี้ได้ตั้งแต่ 4.5 ถึง 16 โวลต์ วงจรภายในตัวไอซีจึงจะสามารถทำงานได้

การใช้งานไอซี 555 เมื่อนำไอซี 555 มาใช้งานจะมีการต่อวงจรเป็นแบบโมโนสเตเบิล (NONSTABLE) หรือแอสเตเบิล (ASTABLE) ใดๆหรืออย่างหนึ่ง วงจรทั้งสองต่างก็มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน

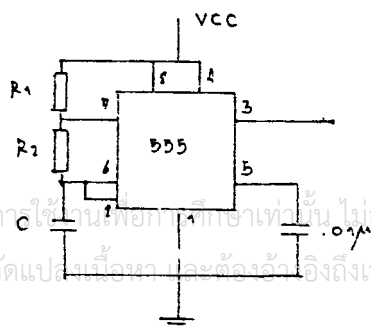
วงจรโมโนสเตเบิล เป็นวงจรที่ให้คลื่นสี่เหลี่ยมออกมาที่เอาต์พุตในแต่ละครั้งที่มีการกระตุ้นด้วยสัญญาณจากภายนอกสัญญาณกระตุ้นจะป้อนขา 2 ซึ่งเป็นขาทริกเกอร์ เมื่อแรงดันไฟฟ้าของสัญญาณที่ขา 2 ลดลงต่ำกว่าหนึ่งในสามของแหล่งจ่ายแรงดัน ( $1/3$ ) จะทำให้ที่ขา 3 ซึ่งเป็นขาเอาต์พุตมีแรงดันไฟฟ้าสูงเกือบเท่ากับแหล่งจ่ายแรงดัน ช่วงความกว้างของคลื่นสี่เหลี่ยมที่ได้ทางเอาต์พุตจะขึ้นอยู่กับค่า R และ C โดยมีสูตรความสัมพันธ์กันดังนี้

$$T = 1.1 RC$$

เมื่อ T คือ ช่วงความกว้างของคลื่นสี่เหลี่ยมทางเอาต์พุต มีหน่วยเป็นวินาทีนอกจากนี้สัญญาณที่นำมากกระตุ้นแต่ละสัญญาณจะต้องมีช่วงความกว้างของคลื่นห่างกันไม่น้อยกว่าช่วงความกว้างของคลื่นสี่เหลี่ยมที่ได้ทางเอาต์พุต เพราะคลื่นที่เข้ามากกระตุ้นใหม่จะมีผลต่อแรงดันทางเอาต์พุต เพราะเอาต์พุตเองก็มีภาวะแรงสูงอยู่แล้ว



รูปที่ 3 วงจรโมโนสเตเบิล โดยใช้ไอซี 555



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานที่ถูกต้องเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องแจ้งถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 4 วงจรออสเตเบิ้ลโดยใช้ไอซี 555

วงจรโมโนสเตเบิลนี้ส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ประโยชน์เป็นวงจรตั้งเวลาในรูปแบบต่าง ๆ วงจรออสเตเบิ้ลกำเนิดสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้การกระตุ้นจากการชาร์จของคาปาซิเตอร์ที่ขา 2 ดังนั้นวงจรนี้ไม่ต้องใช้สัญญาณจากภายนอกมากกระตุ้น การกระตุ้นจะเกิดจากการชาร์จของคาปาซิเตอร์ C ผ่าน R เมื่อแรงดันที่ตกคร่อมคาปาซิเตอร์ที่มีค่าถึงสองในสามของแหล่งจ่ายแรงดัน  $2/3 VCC$  จะทำให้วงจรเปรียบเทียบแรงดันชุดบน (UPPER COMP) ทำงานไปกระตุ้นให้วงจรควบคุมพลิก-ฟลอป ทำงานอีกต่อหนึ่งเป็นผลให้คาปาซิเตอร์คายประจุผ่าน R และขา 7 (ผ่าน 01 ในไอซี) ลงกราวด์ ช่วงนี้เอาต์พุตที่ขา 3 จะมีแรงดันไฟฟ้าต่ำ เมื่อแรงดันไฟฟ้าที่คาปาซิเตอร์ลดลงมาถึงหนึ่งในสามของแหล่งจ่ายแรงดัน ( $1/3 VCC$ ) ก็จะไปกระตุ้นให้วงจรเปรียบเทียบแรงดันชุดส่วนล่าง (LOWER COMP) ทำงานไปกระตุ้นวงจรควบคุมพลิกฟลอปอีก ทำให้แรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตมีค่าสูง (เหมือนกับการทำงานของโมโนสเตเบิล) และคาปาซิเตอร์จึงเริ่มชาร์จใหม่อีกจนแรงดันไฟฟ้ามาถึง  $2/3 VCC$  ก็จะเริ่มการทำงานแบบเดิมอีก ช่วงที่คาปาซิเตอร์ชาร์จขึ้นแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตจะมีค่าสูงอยู่ จนกว่าคาปาซิเตอร์จะคายประจุแรงดันที่เอาต์พุตจึงจะมีค่าต่ำลง ซึ่งพิจารณาได้จากไดอะแกรมเวลาในรูปที่ 4

จากลักษณะการทำงานของวงจรออสเตเบิลนี้ จะเห็นได้ว่าช่วงความกว้างของคลื่นสี่เหลี่ยมที่ได้ทางเอาต์พุตจะขึ้นอยู่กับการเก็บประจุ (การเก็บประจุ) และคูลชาร์จ (การคายประจุ) ของคาปาซิเตอร์ C เนื่องจากคาปาซิเตอร์ C ต้องชาร์จผ่าน R และคูลชาร์จผ่าน R และคูลชาร์จผ่าน R อย่างเดียว จึงได้สูตรความสัมพันธ์ของ T (ช่วงชาร์จ) และ T กับค่า R และ C ออกมาดังนี้

$$T1 = 0.693 (R1 + R2) C$$

$$T2 = 0.693 RC$$

$$F = \frac{1}{T1 + T2}$$

เราสามารถกำหนดช่วงเวลา T1 และ T2 ได้จาก R และ C เมื่อต้องการทราบความถี่ของคลื่นที่ได้จากวงจรออสเตเบิลก็นำช่วงเวลา T1 และ T2 มารวมกันและนำไปหาร เลขหนึ่งก็จะได้ความถี่ F ของคลื่นออกมาตามสมการข้างบน

วงจรออสเตเบิลนี้จะถูกนำไปใช้ประโยชน์เป็นวงจรสร้างสัญญาณนาฬิกาไปควบคุมการทำงานของวงจรหรืออุปกรณ์อื่น ๆ รวมทั้งยังสามารถนำไปเป็นวงจรตรวจจับ (DETECTOR CIRCUIT) ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับต่าง ๆ ได้อีกด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 4

### ภาคแสดงผลในวงจรดิจิทัล

เมื่อก่อนนี้การแสดงผลหรือความหมายทางด้านดิจิทัลเรามักใช้หลอดไฟไส้ ข้อเสียที่เด่นชัดในการแสดงด้วยหลอดไฟไส้เห็นจะได้แก่การสูญเสียพลังงานมากไปหรือหลอดไฟไส้กินกระแสมากเกินไป แต่หลังจากเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น การแสดงผลเราอาจต้องการให้แสดงผลลัพธ์ในสิ่งที่เราจะทราบความหมายได้ทันทีคือ เป็นตัวเลข ตัวอักษร ฯลฯ เทคโนโลยีทางภาคแสดงก็เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเช่นกัน ภาคแสดงก็ใช้จึงเปลี่ยนโฉมหน้ามาเป็น แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DISPLAY)

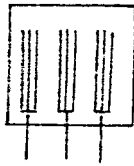
แผงแสดงผลมีมากมายหลายแบบ แต่อย่างไรก็ตามเรามักจะเห็นใช้กันมากเพียงไม่กี่ชนิด สำหรับในที่นี้เราจะได้กล่าวถึงแผงแสดงชนิดต่าง ๆ และวิธีการใช้งานแผงแสดงในวงจรทางดิจิทัล

หลอดนิกซี เป็นแผงแสดงอิเล็กทรอนิกส์แบบแรกที่ประสบความสำเร็จดีกว่าหลอดนิกซี (NIXIE TUBE) เป็นชื่อเครื่องหมายการค้าของบริษัทเบอร์โรห์แห่งสหรัฐอเมริกาโดยลักษณะพื้นฐานแล้วหลอดนิกซีได้แนวการทำงานมาจากหลอดนีออนซึ่งมีขั้วโลหะ 2 ขั้วขั้วหนึ่งขั้วอยู่ในหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซนีออน เมื่อป้อนแรงดันไฟตรงประมาณ 75 โวลต์ ให้แก่ขั้วโลหะทั้งสองก๊าซนีออนที่อยู่ในหลอดก็จะแตกตัวเป็นนีออน และเรืองแสงออกมาทันที

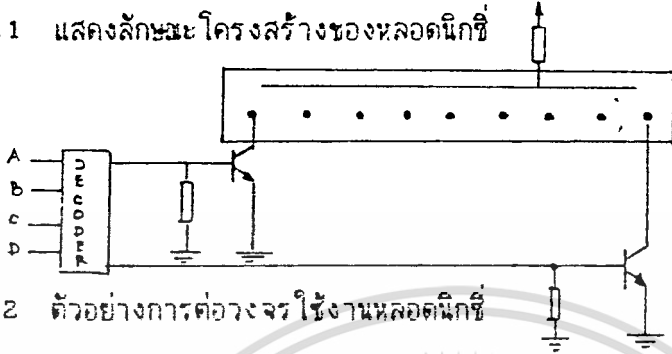
หลอดนิกซีก็ทำงานคล้าย ๆ กัน แต่แทนที่จะมีเพียงคาโทดอันเดียว ก็มีคาโทด 10 อันวางซ้อนกันอยู่ คาโทดเหล่านี้ถูกตัดเป็นรูปตัวเลขต่าง ๆ ตั้งแต่เลข 0 ถึง 9 แล้วมีอานอดซึ่งตะแกรงลวดวางซ้อนอยู่ข้างหน้าอีกทีหนึ่ง ถ้าต้องการให้คาโทดอันใดสว่างก็ซ้อนแรงดันให้อานอดและคาโทดขั้วนั้น ก๊าซนีออนในบริเวณใกล้คาโทดนั้นก็เรืองแสง และปรากฏตัวเลขขึ้นมา จะเห็นว่าเราสามารถตัดคาโทดเป็นตัวอักษรอย่างไรก็ได้ ขนาดแรงดันเริ่มต้นที่จะทำให้ก๊าซนีออนเรืองแสงขึ้นมา มักจะไม่น้อยกว่า 120 โวลต์ และเมื่อตัดตัวเรืองแสงขึ้นมาแล้ว ขนาดแรงดันที่ยังทำให้เรืองแสงต่อไปก็จะลดลงเหลือเพียง 70 โวลต์

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ยุคกัน ๆ จะใช้หลอดนิกซีเป็นแผงแสดงกันแทบทั้งนั้น ข้อเสียที่เห็นกันก็คือ มีคาโทดวางซ้อนอยู่ถึง 10 ชั้น ทำให้คาโทดตัวหน้า ๆ ยังแสงจากคาโทดตัวหลังการอ่านตัวเลขจึงไม่สะดวกนักและแรงดันไฟใช้สูงมากกว่าที่แหล่งจ่ายไฟทั่วไปจะป้อนให้ได้ ทรานซิสเตอร์ก็จะป้อนสัญญาณแก่หลอดนิกซีก็จะต้องเป็นแรงดันสูง ข้อบกพร่องเหล่านี้ทำให้หลอดนิกซีเสียเปรียบแข่งแสดงแบบอื่น ๆ ในปัจจุบันอยู่มาก จนแทบไม่มีโอกาสแทรกตัวเข้ามาได้เลย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา 77 จะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



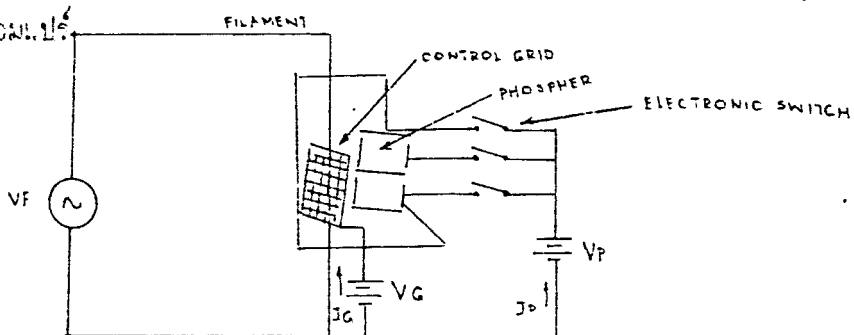
รูปที่ 4.1 แสดงลักษณะโครงสร้างของหลอดนิกซี่



รูปที่ 4.2 ตัวอย่างการต่อวงจรใช้งานหลอดนิกซี่

แผงแสดงอิเล็กทรอนิกส์อีกแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหม้อน้ำออกแบบชาวญี่ปุ่นคือ แผงแสดงแบบฟลูออเรสเซนต์ FLUORESCENT DISPLAY หลักการก็คล้าย ๆ กับหลอดตาแมวที่ใช้ในเครื่องรับวิทยุรุ่นคุณปู่หรืออาจจะเอียบได้กับ หลอดภาพที่ใช้ในโทรทัศน์ขนาดจิ๋ว กล่าวคือ สร้างความร้อนให้เกิดขึ้นในไส้หลอดซึ่งทำหน้าที่เป็นคาโทดในตัวด้วยไฟฟ้า แรงดันที่ป้อนให้แก่ไส้หลอดมีประมาณ 1 โวลต์ ถึง 3 โวลต์ อาจจะเป็นไฟสลับหรือไฟตรงก็ได้ ไส้หลอดตั้งกระแสประมาณ 40 MA ความร้อนที่เกิดขึ้นในไส้หลอด จะทำให้อิเล็กตรอนสามารถหลุดออกจากไส้หลอดได้แต่ไม่มากนักที่จะทำให้ไส้หลอดเปล่งแสงออกมาได้

ถัดจากไส้หลอดเข้าไปเป็นอาโนดซึ่งมีรูปร่างเป็นส่วน ๆ 7 ส่วน วางอยู่เป็นรูปเลข 8 ที่ผิวของอาโนดฉาบสารฟอสฟอรัสสาคไว้ซึ่งจะเปล่งแสงสีเขียวอมฟ้าออกมาถ้ามีอิเล็กตรอนวิ่งมาชนผิวของมัน ถ้าต้องการให้อาโนดสว่างขึ้นมากก็เพียงแต่ป้อนแรงดันไฟบวก (เมื่อเทียบกับคาโทด) ให้แก่อาโนดซึ่งใน ไฟบวกจะดูดอิเล็กตรอนให้พุ่งเข้าชนผิวได้แรงพอที่จะเปล่งออกมาได้ แรงดันไฟบวกที่แผงแสดงแบบฟลูออเรสเซนต์ ต้องการจะอยู่ราว ๆ 20 ถึง 25 โวลต์ แต่บางรุ่นก็ต้องการสูง 55 โวลต์ ซึ่งก็อยู่ในขีดจำกัดที่ไอทีทางดิจิทัลแบบ MOS จะป้อนให้ได้ส่วนกระแสที่อาโนดต้องการก็อยู่ในช่วงไม่กี่สิมถึงไม่กี่ร้อยไมโครแอมแปร์



รูปที่ 4.3 โครงสร้างภายในของแผงแสดงแบบฟลูออเรสเซนต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเฉพาะเท่านั้น มิอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

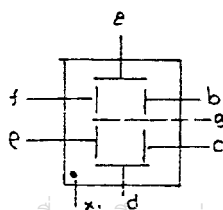
แผงฟลูออเรสเซนต์บางที่อาจจะมิตะแกรงโลหะสองชั้นอยู่ระหว่างไส้หลอด (หรือคาโอด) กับอาโนด ตะแกรงนี้เรียกว่า คอนโทรลกริด ทำหน้าที่เป็นตัวปิดแผงแสดงทั้งหมด เมื่อได้รับแรงดันลบมากพอที่จะหยุดอิเล็กตรอนที่จะวิ่งไปหาอาโนด จุดอ่อนของแผงแบบฟลูออเรสเซนต์อยู่ตรงที่ว่าต้องมีแหล่งจ่ายไฟอีกชุดหนึ่งป้อนแรงดันให้แก่ไส้หลอดตลอดเวลา และเนื่องจากมีไส้หลอดทำให้ไม่สามารถทนการสั่นสะเทือนได้มากนัก

แผงแสดงแบบผลึกเหลว (LCD) แผงแสดงทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นแบบที่ให้ความสว่างพอสมควร แต่ก็มิชอบเหมือนก ๗ กันคือ จะจางลงถ้าแสงภายนอกสว่างขึ้น การอ่านตัวเลขก็ยากขึ้น ถ้าต้องให้อ่านง่ายขึ้นก็ต้องพยายามทำให้มันสว่างขึ้น แต่แผงแบบผลึกเหลว (LIQUID CRYSTAL DISPLAY) กลับตรงกันข้ามจะใช้แสงสว่างจากภายนอกมาเป็นตัวทำให้สว่างดังนั้นยิ่งแสงภายนอกสว่างมากขึ้นเท่าไรก็จะอ่านตัวเลขได้ชัดเจนขึ้นเท่านั้น

ผลึกเหลวมีอยู่หลายชนิดขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารว่าหลังจากถูกสนามไฟฟ้าแล้วแล้วจัดเรียงตัวอย่างไร ชนิดที่นิยมใช้กันอยู่ 2 ชนิดคือ ไดนามิกส์แคทเทอร์ริง (DYNAMIC SCATTERING) และชนิดฟิลด์เอฟเฟค (FIELD EFFECT) สำหรับชนิดไดนามิกส์แคทเทอร์ริงโมเลกุลของผลึกเหลวภาวะปกติจะเรียงตัวเป็นระเบียบมองแล้วจะเห็นใส แต่เมื่อป้อนสนามไฟฟ้าโมเลกุลของผลึกเหลวภาวะจะกระจัดกระจายมองเห็นเป็นสีเทา ส่วนชนิดฟิลด์เอฟเฟคใช้หลักการโพลาไรเซชัน ส่วนที่ได้รับสนามไฟฟ้าก็จะหันเหทิศทางของขั้วปรากฏเป็นส่วนที่มีอบริเวนนอกนั้นจะสว่าง

ทั้งสองชนิดยังแบ่งออกได้ 2 แบบ คือแบบส่งผ่าน (TRANSMISSIVE) และ แบบสะท้อน (REFLECTIVE) LCD แบบส่งผ่านทำหน้าที่เป็นแผ่นกรองแสงจากด้านหลัง ส่วน LCD แบบสะท้อนทำหน้าที่เป็นแผ่นสะท้อนแสงจากด้านหลัง จะกรองได้ก็ต่อเมื่อมีสนามไฟฟ้าป้อนให้มัน โครงสร้างทั่วไปจะเป็นแผ่นกระจกสองแผ่นประกบกันมีผลึกเหลวอยู่ตรงกลาง

ข้อเด่นของแผงแบบ LCD คือต้องการแรงดันมาเพียงเพื่อสร้างสนามไฟฟ้าเพื่อให้โมเลกุลเรียงตัวตามต้องการ ดังนั้นจึงสิ้นกระแสไฟน้อยมาก ถ้าพลังงานที่ถึงเมื่อทุกส่วนทำงานมักจะน้อยกว่า 25 mW ข้อเสียของแบบนี้ก็คือต้องมีแสงจากภายนอก และ ใช้งานที่ช่วงอุณหภูมิแคบ ๆ ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า ๕ °C ผลึกเหลวจะทำงานช้าลงกว่าปกติมาก ถ้าอุณหภูมิสูงกว่าประมาณ ๕๐ °C ผลึกเหลวจะเปลี่ยนรูปเป็นของเหลว การทำงานก็จะผิดพลาดไปจากที่ควรจะเป็น



รูปที่ 4.4 ลักษณะโครงสร้างของแผงแสดงแบบผลึกเหลวชนิดไดนามิกส์แคทเทอร์ริงแบบสะท้อนแสง ไม่มีการฉีดทั้งสีอื่น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แอลอีดี, LED คือ ไดโอดชนิดหนึ่งที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ให้สามารถเปล่งแสงออกมาได้ขณะที่ถูกไบแอสตรง สัญลักษณ์ของ แอลอีดี ก็เหมือนไดโอดธรรมดา เพียงแต่มีแสงเปล่งออกมาเท่านั้น ดังรูปที่ 4.5 ดังนั้นถ้า ขอลอีดี ถูกไบแอสตรงและมีกระแสไหลผ่านตัวมันมากพอ ก็จะเปล่งแสงออกมาได้ และเมื่อถูกไบแอสกลับจะไม่ยอมให้กระแสไหลผ่าน จึงเปล่งแสงออกมาไม่ได้ขอให้ดูรูปที่ 4.6 จะช่วยให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับแอลอีดี ต้องการแรงดันไบแอสตรงมากกว่าไดโอดธรรมดา คือจะอยู่ระหว่าง 1.0 โวลต์ ขึ้นอยู่กับสารที่ใช้ทำ แอลอีดี และขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสที่ไหลผ่าน ถ้ากระแสไหลผ่านมาก แรงดันไบแอสตรงคร่อมตัวมัน ( $V_{LED}$ ) ก็จะมีค่ามากขึ้น และแสงจะสว่างมากขึ้น แสงที่แอลอีดี จะเปล่งออกมาไม่ได้หลายสี แต่ละสีก็ใช้สารต่างกันไป และก็ให้ควมสว่างต่างกันไปด้วย สีที่นิยมใช้กัน คือ แดง เขียว และ เหลือง สีอื่นนอกจากนี้ให้ความสว่างน้อยเกินไป และมีราคาแพงมากจึงไม่เป็นที่นิยมใช้ แสงที่กล่าวถึงนี้เป็นแสงที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แอลอีดียังสามารถที่จะเปล่งแสงอินฟราเรดซึ่งเรามองไม่เห็นออกมาได้ถ้าเลือกสารที่ใช้ให้ถูกต้อง สารที่นิยมใช้ทำแอลอีดีมีอยู่ 3 ชนิดคือ แกลเลียมอาร์เซไนด์ (GASP) แกลเลียมฟอสไฟด์ (GAP) และแกลเลียมอาร์เซไนด์ฟอสไฟด์ (GAASP) ซึ่งแยกแยะคุณสมบัติได้ดังนี้

1. แกลเลียมอาร์เซไนด์ นิยมใช้ทำแอลอีดีที่เปล่งแสงอินฟราเรด มีประสิทธิภาพ ในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงอินฟราเรดได้สูงมาก คือสูงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจึงใช้แรงดันไบแอสตรงไม่มากนักเพียง 1.2 – 1.3 โวลต์ เท่านั้น

2. แกลเลียมฟอสไฟด์ นิยมใช้ทำแอลอีดีที่เปล่งแสงสีเขียวและสีเหลือง มีประสิทธิภาพ ในการเปลี่ยนรูปพลังงานต่ำมาก จึงต้องใช้แรงดันไบแอสตรงสูงมาก มักจะต้องการไม่น้อยกว่า 2 โวลต์ โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 2.0 ถึง 4.5 โวลต์

3. แกลเลียมอาร์เซไนด์ฟอสไฟด์ นิยมใช้ทำแอลอีดีที่เปล่งแสงสีแดง มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนรูปพลังงานปานกลาง (ประมาณ 10%) จึงใช้แรงดันไบแอสตรงปานกลาง คือ อยู่ระหว่าง 1.2 – 2.0 โวลต์

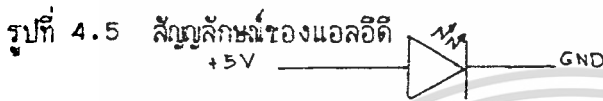
ข้อแตกต่างอีกประการหนึ่งระหว่างแอลอีดี กับไดโอดธรรมดา คือแอลอีดี ขานแรงดันไบแอสกลับ (V<sub>R</sub>) ได้้น้อยมาก โดยทั่วไปจะทนได้ประมาณ 3 – 10 โวลต์ ส่วนไดโอดธรรมดักจะทนได้มากกว่า 50 โวลต์ ดังนั้นถ้าแอลอีดีถูกไบแอสกลับด้วยแรงดันมากกว่า 3 โวลต์ ก็อาจจะยอมให้กระแสไหลผ่านจนเกิดผลกรของตัวมันเอง และทำให้เกิดแสงสว่างได้ ดังตัวอย่างในรูปที่ 4.6 ซึ่งถ้าไม่มีการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิใช่เพื่อเผยแพร่ไปใช้จริงโดยไม่ผ่านการคัด

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ห้ามนำไปดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

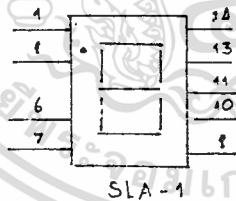
ป้องกันให้ดี กระแสจะไหลย้อนทางได้มาก แอลอีดีก็จะเสียหายในทันที จึงเป็นเหตุการณ์ที่เราจะต้องหาทางหลีกเลี่ยง

หากความนิยมนำแอลอีดีไปแทนหลอดไฟ เพราะกินกระแสต่ำกว่าหลอดไฟมาก กล่าวคือ แอลอีดีใช้ประมาณ 5 mA ถึง 20 mA ขณะที่หลอดไฟส่องหน้าปัดมีใช้ประมาณกว่า 100 mA และแอลอีดีใช้งานได้คงทนกว่า จึงมักเรียกแอลอีดีว่าเป็นหลอดไฟโซลิดสเตท (SOLID - STATE LAMP)



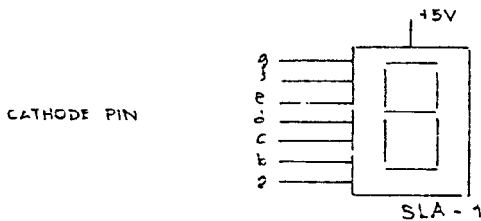
รูปที่ 4.6 แสดงลักษณะการไบแอสที่จะทำให้แอลอีดีเปล่งแสง

การใช้งานแผงแสดงแอลอีดี ตัวอย่างแรกที่จะอธิบายเป็นแผงตัวเลข แอลอีดี 7 ส่วน ตัวเดียว สีแดง มีขายในคนเป็นขาร่วม เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัททอปโคเบอร์ SLA-1 มีจุด 2 จุด อยู่ทางด้านซ้ายมือ ทำหน้าที่เป็นจุดทศนิยม (DECIMAL POINT) ซึ่งเขียนอักษรย่อว่า DP หมายถึงเลขที่ใช้เมื่อมองดูจากด้านบนของแผงแสดงในรูปที่ 4.7



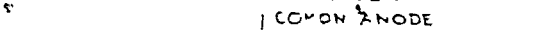
รูปที่ 4.7 ลักษณะการอ่านเขา และหมายเลขขาที่ใช้เมื่อมองจากด้านบน SLA - 1

แต่เมื่อเขียนแผงตัวเลขลงในวงจร นิยมเขียนดังรูปที่ 4.8



รูปที่ 4.8 สัญญลักษณ์การเขียนแผงตัวเลขลงในวงจร

จะเขียนออกมาให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เต็มตัวได้ ดังรูปที่ 4.9



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับการใช้งานที่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีข้อผิดพลาดและต้องอ้างอิงถึงเลขของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

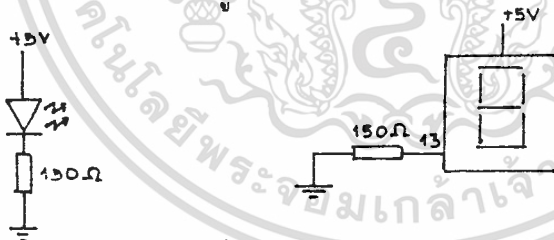
## รูปที่ 4.9 สัญลักษณ์ภายในของแผงตัวเลข

จากสัญลักษณ์ภายในรูปที่ 4.9 สรุปได้ดังนี้

1. ขาที่ไม่ใช้คือขา 3, 4, 5, 9 และ 12 (แผงตัวเลขเป็นแบบ DIP 14 ขา)
2. ขาอินพุตรวมของแอลอีดีทุกตัวคือขา 14 ซึ่งต้องนำไปต่อกับแรงดัน + 5V
3. มีขาโอดอยู่ทั้งหมด 8 ขา 7 ขาสำหรับส่วน a, b, c, d, e และ f อีกขาหนึ่งสำหรับจุดทศนิยม (DP)
4. ไม่มีขาเอาต์พุตออกจากแผงตัวเลข มีแต่ขาอินพุต เอาต์พุตที่ได้จากแต่ละส่วนคือ แสงที่เปล่งออกมาเท่านั้น

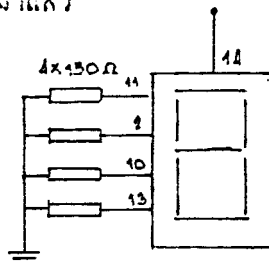
ต่อไปนี้จะแสดงวิธีการจุดให้แอลอีดีแต่ละส่วนสว่าง วิธีจุดให้แอลอีดีสว่างได้เป็นเลข 0 ถึง 9 ด้วย BCD โดยใช้ไอซีเบอร์ 7447

1. วิธีจะให้แต่ละส่วนสว่าง เมื่อเราต้องการให้แอลอีดีส่วนใดสว่างก็ให้ป้อน + 5V เข้าที่ขาอินพุตรวมและต่อขาคาโอดของส่วนนั้นลงกราวนด์ โดยผ่านตัวต้านทานจำกัดกระแส จากการทดลองพบว่า ถ้าตัวต้านทานเป็น 100 กระแสผ่านส่วนนั้นจะเป็น 22 mA ถ้าตัวต้านทานเป็น 150 mA และถ้าใช้ตัวต้านทาน 330 กระแสจะลดลงอีกเป็น 8 mA ซึ่งค่า 330 นี้ แสงสว่างลดลงไปมาก อย่างไรก็ตามค่าตัวต้านทานทั้งสามก็ให้ส่วนนั้นสว่างพอมองเห็นได้ชัดเจน ในที่นี้จะเลือกใช้ค่า 150 สมมติว่าต้องการให้แอลอีดีส่วน b สว่างก็ให้ต่อตามรูปที่ 4.10



รูปที่ 4.10 แสดงการต่อสายเมื่อต้องการจุดส่วน ให้สว่าง

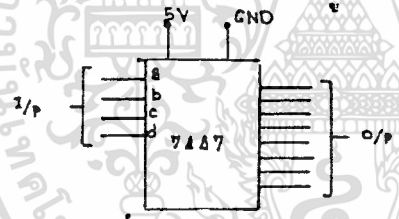
2. วิธีจุดให้สว่างพร้อม ๆ กันหลายส่วน วิธีนี้ก็ทำเช่นเดียวกับข้อ 1. สมมติว่าเราต้องการให้แอลอีดีสว่างเป็นรูปเลข 4 ก็ต้องจุดให้ส่วน c, d, e และ f สว่าง ดังรูปที่ 4.11 ขอใช้สิ่งเถิดว่า วิธีการต่อสายเหมือนกับที่ได้อธิบายมาแล้ว



รูปที่ 4.11 แสดงการต่อสายเมื่อต้องการจุดให้สว่างเป็นตัวเลข 4.

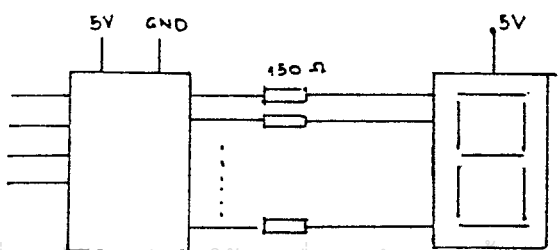
3. วิธิจุดให้สว่างเป็นตัวเลข 0 ถึง 9 ด้วย BCD การใช้งานแผงตัวเลขจริง ๆ แล้ว ไม่ใช่ว่าต้องการตัวเลขอะไรก็มาคอยต่อสายดังวิธีที่กล่าวมาแล้ว สายทุกสายของแอลอีดีจะถูกต่อหมด แล้วใช้วงจรอิเลกทรอนิกส์มาเป็นตัวออกคำสั่งว่าจะให้คาโอดของแอลอีดีส่วนใดต่อลงกราวด์. โดยผ่านตัวต้านทานจำกัดกระแสตามปกติสัญญาณในวงจรดิจิทัลจะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่เรียกว่า BCD (BINARY-CODED DEECIMAL) คือแทนด้วยตัวเลขปกติที่เราใช้กันแต่ละตัวด้วยตัวเลข 4 หลักในระบบฐานสองซึ่งมีแค่เลข 0 กับ 1 ตัวอย่างเช่นเลข 8 ในระบบปกติ (ฐานสิบ) จะถูกแทนเป็นรหัสในรูปของฐานสองเป็น 1000 เลข 4 (ฐานสิบ) จะถูกเปลี่ยนเป็น 0100 (ฐานสอง) เป็นต้น ดังนั้นตัวเลขในฐานสิบตั้งแต่ 0 ถึง 9 จะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในตัวเลข 4 หลักที่เรียกว่า BCD นี้

เมื่อเราจะเปลี่ยนเลข BCD ให้ออกมาเป็นเลขฐานสิบโดยแสดงบนแผงตัวเลขเราจะต้องมีวงจรถอดรหัส (DECODER) และวงจรขับ (DRIVER) เพื่อทำหน้าที่จ่ายกระแสได้มากเท่าที่แอลอีดีต้องการ ในปัจจุบันได้สร้างวงจรถอดรหัส และวงจรขับลงบนไอซีตัวเดียวกัน และเรียกชื่อไอซีตัวนั้นตามหน้าที่การทำงานว่า BCD-TO-7-SEGMENT DECODER/DRIVER ซึ่งหมายความว่าทำหน้าที่ถอดรหัสจาก BCD ให้อยู่ในรูปที่ใช้กับแผงเขียนในวงจรได้ง่าย ๆ เป็นดังรูปที่ 4.12



รูปที่ 4.12 ลักษณะการเขียน 7 4 4 7 ลงในวงจร

จะเห็นได้ว่าขั้วอินพุตของ 7447 มี 4 ขั้ว เขียนว่า DCBA ซึ่งตัวอักษรแต่ละตัวจะแทนอินพุตสำหรับเลข BCD แต่ละหลัก ตัวอย่างเช่น เลข BCD เป็น 1011 หมายความว่าขั้วอินพุตของ 7447 จะได้รับสัญญาณที่ขั้ว D, C, B และ A เป็นลอจิก 1, 0, 1 และ 1 ตามลำดับส่วนเอาต์พุตจะเขียนอักษรกำกับไว้ ซึ่งหมายความว่าให้ต่อเอาต์พุตไม่เข้าขั้วอินพุตของแอลอีดี แต่ละส่วนที่มีอักษรกำกับตรง ดังรูปที่ 4.13 ไอซีเบอร์นี้ได้รับการออกแบบมาให้กับแผงตัวเลข 7 ส่วนที่มีชื่อว่าในคร่วมกัน ซึ่งจะสังเกตได้จากตารางตรรก (TRUTH TABLE) ของไอซีเบอร์นี้ในตารางที่ 4.1



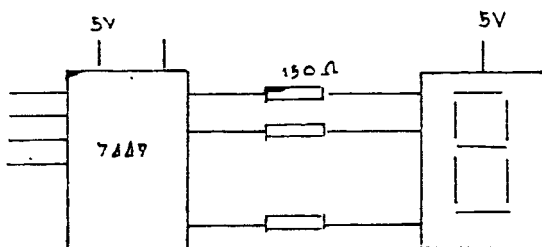
รูปที่ 4.13 การต่อไอซีเบอร์ 7447 เข้ากับแผงตัวเลข 7 ส่วน

ตารางที่ 4.1

ตัวเลขฐานสิบ	INPUT				OUTPUT						
	D	C	B	A	A	B	C	D	E	F	G
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
5	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
6	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
7	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

ตารางตรรกะนี้คือ ตารางที่แสดงการทำงานของไอซีให้เรารู้ว่าเมื่ออินพุตเป็นดังนี้แล้ว เราจะได้ลิจิกอะไรออกที่เอาต์พุต จะลองยกตัวอย่างให้ดู เมื่ออินพุตเป็น 0011 ซึ่งแทนเลข 3 (ในฐานสิบ) เอาต์พุตที่จะแสดง "ลิจิก 1" ที่เอาต์พุตหมายถึงว่าเอาต์พุตนั้นให้แรงดันเป็น + 5 โวลต์และ "ลิจิก" หมายถึงว่าแรงดันที่เอาต์พุตจะเท่ากับ 0 โวลต์ ดังนั้นแวลลิจิส่วน e และ f จะต่อเข้ากับ + 5 โวลต์ ซึ่งแรงดันอีกปลายหนึ่งที่ขั้วขาในอีกต่อกับ + 5V ดังนั้นแวลลิจิส่วน e และ f จึงไม่มีกระแสไหล และไม่เปล่งแสงออกมา ส่วนแวลลิจิในส่วนอื่นจะเปล่งแสงออกมา และแสดงให้เห็นเป็นเลข 3 ตรงกับเลขฐานสิบก่อนที่จะใส่รหัสในช่องซ้ายมือ ของตารางที่ 1 ดังแสดงในรูปที่ 4.14

สำหรับขาคาโอดของแวลลิจิ ส่วนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม (DP) ของ SLA-1 ขอละเว้นที่จะไม่กล่าวถึงในที่นี้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 4.14 แสดงตัวเลขที่ปรากฏบนแผงตัวเลข เมื่ออินพุตเข้าไอซีเป็น ๑๐11

บทสรุป ภาพแสดงผลในวงจรดิจิทัลมีความสำคัญมากส่วนหนึ่งของทั้งระบบ เพราะการใช้งานวงจรถิฉิทอลส่วนใหญ่มักให้เอาต์พุตเป็นค่าหรือเป็นความหมายตามข้อมูล เช่น เครื่องคิดเลขดิจิทัล มัลติมิเตอร์ ในปัจจุบัน ตัวแสดงผลก็มีด้วยกันหลายชนิดหลายขนาดแตกต่างกันออกไป การเลือกใช้งานจึงต้องพิจารณาถึงเหตุผลต่าง ๆ ตามที่กล่าวแล้วในบทนี้ แต่อย่างไรก็ตามเราจะต้องมาพิจารณาข้อมูลของอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตกำหนดมาให้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อนด้วย

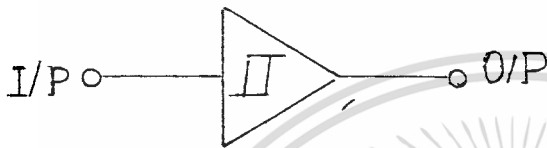


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

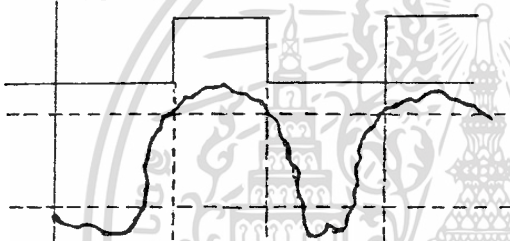
บทที่ 5

วงจรมิตซ์ทริกเกอร์

มิตซ์ทริกเกอร์ เป็นวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ทางดิจิทัลชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับเปลี่ยนหรือเกลาสัญญาณ (WAVE SHAPPING CIRCUIT) ที่ไม่เป็นพัลส์ให้พัลส์ เช่นทำสัญญาณไซน์ (SINE WAVE) ให้เป็นพัลส์เวลา (CLOCK PULSE) หรือสัญญาณสี่เหลี่ยม (SQUARE WAVE) และใช้เวลาเกลาสัญญาณพัลส์ที่มีสิ่งรบกวน (NOISE) ให้มีรูปร่างดีขึ้น โดยแอมแกรมและการทำงานของมิตซ์ทริกเกอร์มีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 1



ก. สัญญลักษณ์

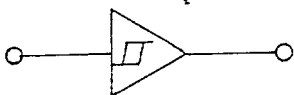


ข. ลักษณะการทำงาน

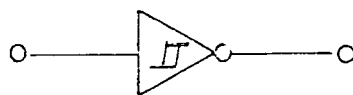
รูปที่ 1 โดยแอมแกรมและการทำงานของมิตซ์ทริกเกอร์

สัญญาณในรูปที่ 5.1 ข) เป็นสัญญาณที่ไม่สามารถนำมาใช้ในระบบดิจิทัลได้ เพราะการเปลี่ยนระดับลอจิกไม่เป็นไปในทันทีทันใด โดยอาศัยคุณสมบัติของวงจรมิตซ์ทริกเกอร์ คือสัญญาณเอาต์พุตจะอยู่ที่ระดับลอจิก ถ้าสัญญาณนั้นยังขึ้นไม่ถึงระดับ  $S_1$  และจะอยู่ที่ระดับลอจิก 1 ตลอดไปจนกว่าสัญญาณนี้จะลดลงมาถึงระดับหนึ่ง คือ  $S_0$  เอาต์พุตจะเปลี่ยนกันมาเป็นระดับลอจิก 0 ทันที และจะคงอยู่ที่ระดับลอจิก 0 ตลอดไป จนกว่าสัญญาณนั้นจะขึ้นถึงระดับ  $S_1$  ใหม่อีกครั้งหนึ่ง

วงจรมิตซ์ทริกเกอร์นี้โดยมากมักใช้ทำเป็นอินพุตของเกทต่าง ๆ ที่ใช้ในสัญญาณอินพุตของเกทนั้น ๆ มีรูปร่างไม่เป็นพัลส์ที่สมบูรณ์ การเขียนลอจิกโดยแอมแกรมของเกทที่มีวงจรมิตซ์ทริกเกอร์อยู่ด้วย มีลักษณะเหมือนเกททั่ว ๆ ไปนั่นเอง เพียงแต่เขียนเครื่องหมายพิเศษ (II) เพิ่มเข้าไปในเกทนั้น ๆ ดังแสดงในรูปที่ 2



ก) ไดรเวอร์ (DRIVE)



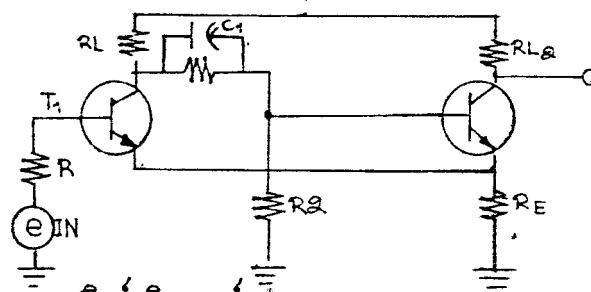
ข) อินเวอร์เตอร์ (INVERTER)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามทำซ้ำหรือดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงที่มาของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

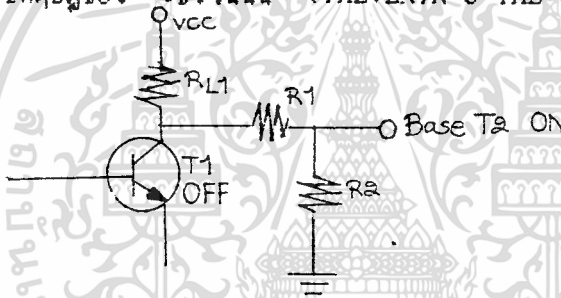


ดังนั้นจะเห็นว่า วงจรนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงสถานะการทำงานตั้งเดิมคกร่วม R2 จะมีค่ากับ แรงดันตกคร่อม  $R_E$  ในขณะที่ทรานซิสเตอร์ T1 ทำงาน ( $V_{E1}$ )



รูปที่ 5.4 แสดงวงจรชนิดที่ทริกเกอร์

การกำหนดค่า U.T.P. ค่าของ U.T.P. (UPPER TRIGGER POTENTIAL) ของวงจร ในรูปที่ 5.4 อาจกำหนดได้ดังนี้ สมมติว่าขณะที่ไม่มีแรงดันอินพุตใด ๆ เข้ามา ทรานซิสเตอร์ T1 จะมีสถานะเป็น OFF และทรานซิสเตอร์ T2 จะมีสถานะเป็น ON วงจรไบอัสของทรานซิสเตอร์เขียนเป็น วงจรเสมือนได้โดยใช้ทฤษฎีของ "เทเวนิน" (THEVENIN'S THE OREM) ดังในรูปที่ 5.5



รูปที่ 5.5

โดยการสมมติว่า แรงดันที่ตกคร่อมรอยต่อในทรานซิสเตอร์ ไม่ต้องนำมาพิจารณาด้วย

ดังนั้น

$$E_{OC} = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2 + R_{L1}}$$

$$Z_0 = \frac{R_2 (R_1 + R_{L1})}{R_1 + R_2 + R_{L1}}$$

และเมื่อนำค่า  $E_{OC}$  และ  $Z_0$  ไปแทนลงในวงจรจึงอาจเขียนได้ดังแสดงในรูปที่ 5.6 จากกฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ (KIRCHOFF'S VOLTAGE LAW) จะได้ว่า

$$V_{E2} + E_{Z_0} = E_{OC}$$

$$V_{E2} = E_{OC} - I_2 Z_0$$

ค) แนนด์เกต (NAND GATE)

ง) นอร์เกต (NOR GATE)

รูปที่ 2 ตัวอย่างรูปสัญลักษณ์ของเกตที่มีวงจรมิตท์ทริกเกอร์ด้วย

วงจรมิตท์ทริกเกอร์ (SCHMITT TRIGGER CIRCUIT) จัดได้ว่าเป็นวงจรไบสเตเบิล มีลติไวเบรเตอร์แบบอิมิตเตอร์คัปเปิลชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถสร้างพัลส์จัตุรัสหรือพัลส์รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ จากการป้อนสัญญาณอินพุตลักษณะรูปไซน์ ลักษณะของพัลส์ที่เอาต์พุตซึ่งสร้างขึ้นมานี้สามารถถูกควบคุมและกำหนดได้ ดังจะได้กล่าวถึงรายละเอียดต่อไป

การทำงานของวงจรมิตท์ทริกเกอร์ พิจารณารูปที่ 5.4 ซึ่งเป็นวงจรมิตท์ทริกเกอร์แบบง่าย ๆ ในขณะที่ไม่มีความแรงดันอินพุตใด ๆ ทรานซิสเตอร์  $T_1$  จะมีสถานะเป็น OFF และทรานซิสเตอร์  $T_2$  จะมีสถานะเป็น ON ขณะที่ทรานซิสเตอร์  $T_2$  ทำงานอยู่ในภาวะอิ่มตัว จะทำให้เกิดมีแรงดันตกคร่อม  $R_E$  ซึ่งจะสมมติให้มีค่า ดังนั้นแรงดันที่เอาต์พุตช่วงเวลา  $T_1$  ก็คือ  $(V_{E2} + V_{EC(sT)})$  และก่อนที่ทรานซิสเตอร์  $T_1$  จะทำงาน แรงดันอินพุตจะต้องมีค่ามากกว่า  $V_{E2}$  ขนาดของแรงดันอินพุตที่จะทำให้ทรานซิสเตอร์  $T_1$  ทำงานได้นี้ถูกเรียกว่า "ศักดาทริกเกอร์ระดับสูง" (UPPER TRIGGER POTENTIAL)

หรือต่อไปจะเรียกย่อ ๆ ว่า U.T.P

ดังนั้น 
$$U.P.T. = V_{E2} + V_E$$

โดยที่  $V_{E2}$  คือแรงดันตกคร่อม  $R_E$  ขณะที่ทรานซิสเตอร์  $T_2$  ทำงานในภาวะอิ่มตัว  $V_{BEA}$  คือ ขนาดของแรงดันไบอัสตรง ที่จะทำให้ทรานซิสเตอร์ทำงานในย่านแอคทีฟ (ACTIVE REGION) ซึ่งสำหรับทรานซิสเตอร์แบบซิลิกอนจะมีค่าราว 0.5 โวลต์

ขณะที่ทรานซิสเตอร์  $T_1$  เริ่มทำงานศักดาที่คอลเลคเตอร์ ( $V_{C1}$ ) ก็จะลดลงจากค่าการที่ค่า  $V_{CC}$  ลดลงนี้ จะทำให้ทรานซิสเตอร์  $V_{C1}$  นำไปเข้าได้น้อยลง นั่นคือทรานซิสเตอร์ทั้งสองตัวจะมีจุด A อยู่ในย่านแอคทีฟ และในที่สุดทรานซิสเตอร์  $T_1$  ก็จะหยุดทำงานโดยสมบูรณ์ตั้งแต่นั้นเวลาที่  $T_1$  แรงดันเอาต์พุตจะมีค่า  $V_{CC}$  และทรานซิสเตอร์  $T_1$  จะทำงานในภาวะอิ่มตัว ทรานซิสเตอร์  $T_2$  จะอยู่ในภาวะ OFF ต่อไปจนกว่าแรงดันอินพุตจะมีขนาดลดลงและน้อยกว่าค่า U.P.T. และเมื่อนั้นทรานซิสเตอร์  $T_2$  จะกลับสู่สถานะทำงานอีกครั้งหนึ่ง ขนาดของแรงดันอินพุตที่จะทำให้ทรานซิสเตอร์  $T_2$  กลับมา มีสถานะเป็น ON และอยู่ในภาวะอิ่มตัวได้อีกครั้งหนึ่งนี้จะถูกเรียกว่า "ศักดาทริกเกอร์ระดับต่ำ" (LOWER TRIGGER POTENTIAL) หรืออาจเรียกย่อ ๆ ว่า L.P.T.

$$I_{E2} = (H_{FE} + 1) I_{B2}$$

$$I_{C2} = H_{FE} I_{B2}$$

รูปที่ 5.6

แทนค่า  $E_{ocB}$  และ  $Z_{oB}$

ดังนั้น

$$V_{E2} = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2 + R_{L1}} - \frac{I_{B2}(R_2 + R_{L1})}{R_1 + R_2 + R_{L1}}$$

แต่

$$V_{E2} = I_{E2} \cdot R_E$$

และ

$$I_{E2} = (H_{FE} + 1) I_{B2}$$

ดังนั้น

$$V_{E2} = (H_{FE} + 1) I_{B2} \cdot R_E$$

$$I_{B2} = \frac{R_2 V_{CC} - I_{B2} \cdot R_2 (R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_{L1}}$$

$$I_{B2} = \frac{R_2 V_{CC} - V_{E2} R_2 (R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_{L1}}$$

$$I_{B2} = \frac{R_2 V_{CC} - V_{E2} R_2 (R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_{L1}}$$

$$I_{B2} = \frac{R_2 V_{CC} - V_{E2} R_2 (R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_{L1}}$$

$$I_{B2} = \frac{R_2 V_{CC} - V_{E2} R_2 (R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_{L1}}$$

$$I_{B2} = \frac{R_2 V_{CC} - V_{E2} R_2 (R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_{L1}}$$

$$I_{B2} = \frac{R_2 V_{CC} - V_{E2} R_2 (R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_{L1}}$$

$$I_{B2} = \frac{R_2 V_{CC} - V_{E2} R_2 (R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_{L1}}$$

และ โดยไม่ต้องนำค่าแรงดันตกคร่อมรอยต่อของทรานซิสเตอร์มาพิจารณา ดังนั้น

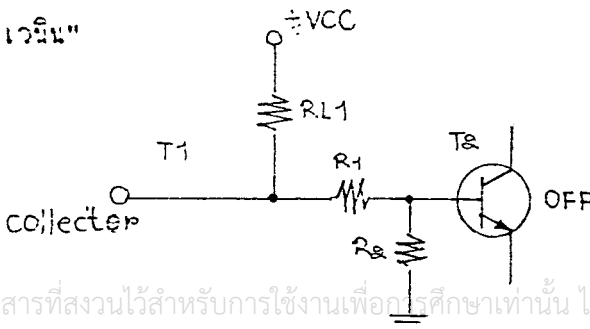
$$U.P.T. = V_{E2}$$

นั่นคือ

$$U.P.T. = \frac{V_{CC}}{\frac{R_1 + R_2 + R_{L1}}{R_2} + \frac{R_1 + R_{L1}}{R_E (H_{FE} + 1)}} \quad (5.4)$$

การกำหนดค่า L.P.T. ค่าของ (LOWER TRIGGER POTENTIAL)

ของวงจรในรูปที่ 5.4 ซึ่งจะทำให้ทรานซิสเตอร์ T2 หยุดทำงาน อาจกำหนดได้โดยพิจารณาจาก วงจรในรูปที่ 5.7 ซึ่งเป็นวงจรเสมือนของวงจรทางต้านคอลเลคเตอร์ของทรานซิสเตอร์ T1 โดยการใส่กฎของ "เวเนิน"



รูปที่ 5.7

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

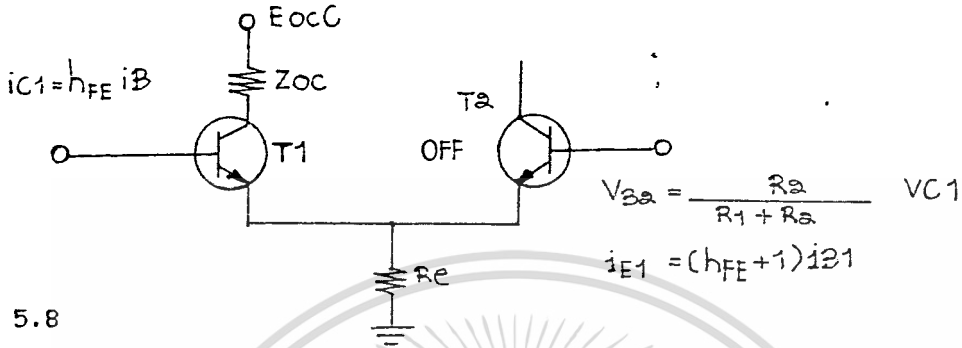
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ดังนั้น

$$E_{OC} = \frac{(R1+R2) V_{CC}}{R1+R2+RL1}$$

$$Z_{OC} = \frac{RL1(R1+R2)}{R1+R2+RL1}$$

และเมื่อนำค่า  $E_{OC}$  และ  $Z_{OC}$  ไปแทนลงในวงจรที่ 5.4 จึงอาจเขียนแสดงได้ดังในรูปที่ 5.8



รูปที่ 5.8

และจากรูปที่ 5.8 โดยใช้กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ (KIRCHOFF'S VOLTAGE LAW) จะได้ว่า

$$E_{OC} = V_{C1} + E_{ZOC}$$

$$E_{OC} = V_{C1} + h_{FE} I_{B1} Z_{OC}$$

แต่

$$I_{E1} = \frac{V_{E1}}{R_E}$$

$$I_{E1} = V_{E1}$$

$$I_{B1} = \frac{V_{E1}}{R_E(h_{FE} + 1)}$$

$$E_{OC} = V_{C1} + h_{FE} \frac{V_{E1}}{R_E(h_{FE} + 1)} Z_{OC}$$

แต่

$$E_{OC} = \frac{(R1 + R2) V_{CC}}{R1+R2+RL1}$$

และ

$$Z_{OC} = \frac{RL1 (R1 + R2)}{R1+R2+RL1}$$

ดังนั้น

$$\frac{(R1+R2) V_{CC}}{R1+R2+RL1} = \frac{h_{FE}}{R1 + R2 + RL1} \frac{V_{E1} RL1 (R1+R2)}{R_E(h_{FE} + 1)} + V_{C1}$$

แต่

$$V_{E1} = \left( \frac{R2}{R1+R2} \right) V_{C1}$$

แทนค่า  $V_{C1}$  ลงไป

ดังนั้น

$$(R1+R2) V_{CC} = V_{E1}(R1+R2)$$

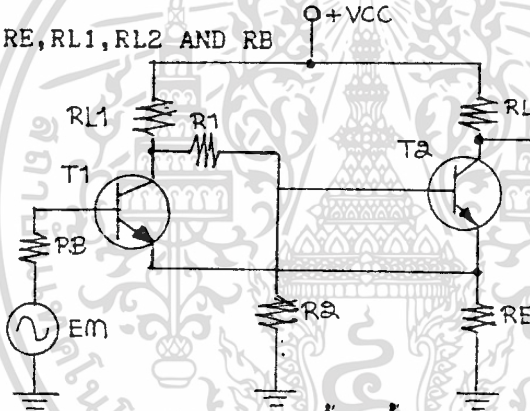
$$R1+R2+RL1 \qquad R2$$

$$V_{E1} = \frac{R_E R_2 (HFE+1) V_{CC}}{R_E (HFE+1) (R1+R2+RL1)}$$

$$= \frac{V_{CC}}{\frac{R1 + R2 + RL1}{R2} + \frac{HFE RL1}{RE (HFE+1)}}$$

$$= \frac{V_{CC}}{\frac{R1 + R2 + RL1}{R2} + \frac{HFE RL1}{RE (HFE+1)}}$$

การออกแบบวงจร ในตอนนี้จะพิจารณาการออกแบบวงจรซิมิลาร์ทริกเกอร์ โดยพิจารณาจากรูปที่ 5.9 ซึ่งกำหนดให้และทรานซิสเตอร์ที่ใช้เป็นซิลิกอนชนิด NPN ซึ่งมี  $FE_{MIN} = 20$  แหล่งจ่ายศักดา (กระแสตรง) มีค่า + 15 โวลต์ และสมมติว่าแรงดันที่ตกคร่อมมีทรานซิสเตอร์มีค่าน้อยมาก ไม่ต้องนำมาพิจารณา และ  $I_Z = 10 \%$  ของ  $I_{C2}$ ,  $I_{CBO} = 0$  ค่าต่าง ๆ ที่ต้องการหาเพื่อการออกแบบวงจรก็คือ  $R1, R2, RE, RL1, RL2$  AND  $R_B$



รูปที่ 5.9

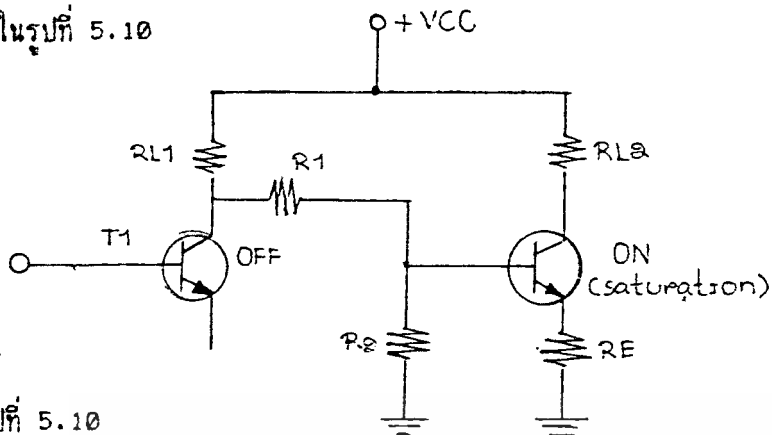
วิธีการพิจารณาและออกแบบตามลำดับขั้นดังนี้

1. โดยการใช้อนุกรมโอห์ม หาค่าของ  $(RL2 + RE)$  เมื่อทรานซิสเตอร์อยู่ในภาวะ ON และอิมิตัวโดยที่ไม่มีแรงดันอินพุตใด ๆ เข้ามา
2. เมื่อไม่ต้องพิจารณาค่าแรงดันตกคร่อมรอยต่อ  $V_{E2} = U.P.T.$  โดยค่าของ  $VE, RL2$  AND  $V_{CC}$
3. ค่าของ  $RL2$  หาได้จากผลของข้อ 1 และ 2
4. ค่าของ  $VE1 = L.P.T.$  โดยค่าของ  $VE1$  อาจแสดงอยู่ในเทอม  $RE, RL$  และ  $V_{CC}$
5. หาค่าของ  $R2$  โดยสมมติว่า กระแสซึ่งไหลผ่าน  $R_2$  มีค่าเป็น  $10$  เปอร์เซ็นต์ของค่ากระแสคอลเลกเตอร์ซึ่งไหลผ่านทรานซิสเตอร์  $T2$  ขณะทำงานในภาวะอิมิตัว และการที่ทรานซิสเตอร์  $T2$  จะเปลี่ยนสถานะจาก OFF ที่เวลา  $T_{-}$  ไปเป็นสถานะ ON ที่เวลา  $T_{+}$ , ค่าของแรงดันตกคร่อมรอยต่ออิมิตเตอร์ และเบสจะต้องมีค่าเป็น 0 โดยที่  $VE1 = L.P.T.$  และ  $ER2=ER1 = L.P.T.$  ดังนั้นอาจใช้กฎของโอห์มของ  $R2$  ได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สแกนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6. หาค่าของ R1 จากสมการกระแสโหนด (CURRENT-NODE EQUATION) ของวงจร ดังแสดงในรูปที่ 5.10



รูปที่ 5.10

7. เนื่องจากทรานซิสเตอร์ T1 ไม่จำเป็นต้องทำงานในภาวะอิ่มตัว ดังนั้นค่าของ RB จึงอาจมีค่าน้อยกว่า  $H_{FE} RE$  ได้

จากลำดับขั้นตอนดังกล่าวข้างบน สามารถเขียนได้ดังนี้

สมมติว่า

$$I_{C2} = I_{E2}$$

$$(R_{L2} + R_E) = \frac{V_{CC}}{I_{C2}} = \frac{15}{5\text{mA}} = 3\text{K}$$

$$U.P.T = V_{E2} = 5\text{V}$$

$$V_{E2} = \frac{R_E}{R_{L2} + R_E} V_{CC}$$

$$(R_{L2} + R_E)$$

$$R_E = \frac{V_{E2}}{V_{CC}} (R_{L2} + R_E) = \frac{5}{15} (3\text{K})$$

$$= 1\text{K}$$

$$R_{L2} = (R_{L2} + R_E) - R_E = 3\text{K} - 1\text{K}$$

$$= 2\text{K}$$

$$L.P.T. = V_{E1} = 3\text{V}$$

$$V_{E1} = \frac{R_E}{R_E + R_{L1}} V_{CC}$$

$$R_E + R_{L1}$$

$$R_{L1} = \frac{R_E}{V_{E1}} V_{CC} - R_E$$

$$= \frac{V_{E1}}{V_{E1}}$$

$$= \frac{(1\text{K} * 15)}{3} - 1\text{K}$$

$$= 5 - 1$$

$$= 4\text{K}$$

$$= 4\text{K}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ซึ่งสามารถใช้ตัวความต้านทานที่วางขายมีค่า 3.9 K แทน

และ  $I_2 = 10\% \quad I_{C2} = (10\%)(5 \text{ mA}) = 0.5 \text{ mA}$

$R_2 = E_{R2} = V_{E1} = L.P.T. = 3$

$I_2 \quad I_2 \quad I_2 \quad 0.5 \text{ mA}$

ซึ่งสามารถใช้ตัวความต้านทานที่วางขายมีค่า  $R_2 = 6 \text{ K}$  แทน  
จากรูปที่ 5.10

$I_1 = I_2 + I_{B2}$

$\frac{E_{R1} + E_{R1}}{R_1 + R_{L1}} = \frac{E_{R2} + I_{B2}}{R_2}$

$V_{CC} - U.P.T. = U.P.T. + I_{B2}$

$I_{B2} = \frac{I_{C2}}{HFE} = \frac{5 \text{ mA}}{20} = 0.25 \text{ mA}$

$HFE \text{ MIN } 20$

$\frac{15 - 5}{3.9 \text{ K} + R_1} = \frac{5}{5.6 \text{ K}} + 0.25 \text{ mA}$

$\frac{10}{3.9 \text{ K} + R_1} = 0.892 \text{ mA} + 0.25 \text{ mA}$

$\frac{10}{3.9 \text{ K} + R_1} = 1.142 \text{ mA}$

$R_1 = \frac{5.55}{1.142} = 4.87 \text{ K}$

ซึ่งเราใช้ค่า 4.7 K แทน เนื่องจากมีขายในท้องตลาด

$R_B = \frac{HFE \cdot R_E}{10} = \frac{20 * 1 \text{ K}}{10} = 2 \text{ K}$

ดังนั้นสรุปได้ว่า

ค่า  $R_1 = 4.7 \text{ K}$

$R_2 = 5.6 \text{ K}$

$R_E = 1 \text{ K}$

$R_{L1} = 4 \text{ K}$

$R_{L2} = 2 \text{ K}$

$R_B = 2 \text{ K}$

## บทที่ 6

โวลต์เตจเร็คกูเลเตอร์ปรับค่าได้ - + 1.25 V ถึง -+ 30 โวลต์

### พร้อมระบบป้องกัน

#### คุณสมบัติของเครื่อง

1. สามารถจ่ายกระแสได้สูงถึง 2 Amp (จะให้สูงกว่านี้ก็ได้ โดยเพิ่มขนาดของหม้อแปลงและเพิ่มอุปกรณ์บางตัว)
2. มีวงจรป้องกันกระแสเกิน คือ ถ้าไหลถึงกระแสเกินที่กำหนดไว้ เครื่องจะป้องกันตนเองโดยตัดตัวเองออกจากระบบหรือไหล
3. ทันทีที่ตัดตัวเองออกจากระบบภายในเครื่องจะมีออเด็ตเอน
4. สามารถจ่ายไฟได้ทั้งแบบคงที่ คือ +5V, +9V, +12V, +5V และแบบปรับค่าต่อเนื่อง +, - 1.2 TO +, - 3.0 V

หลักการทำงาน ภาคเร็คตีไฟเออร์ จากวงจรในรูปที่ 1 ภาคนี้จะใช้ไดโอดแบบบริดจ์เร็คตีไฟเออร์ไฟเอซี 24 โวลต์จากหม้อแปลง แล้วฟิลเตอร์ด้วยตัวเก็บประจุ C1 และ C2 ได้เป็นไฟดีซี +33.94 โวลต์ VDC = 24  $\sqrt{2}$  = 33.94 โวลต์ เพื่อป้อนให้กับวงจรเร็คกูเลเตอร์ภาคต่อไป (รูปที่ 3) ในส่วนของวงจรนี้เราจะเพิ่มเต้าตัวเมียสำหรับจ่ายไฟ 220 V ออกไปใช้งานไว้ด้านหลังของตัวเครื่อง เต้า 220 V นี้ควรต่อกับสวิตช์และฟิวส์ ส่วนสวิตช์เพาเวอร์นั้นควรใช้แบบที่มี LED อยู่ในตัวเมื่อเวลาเปิดเครื่องจะได้รู้ว่ามิไฟจ่ายเข้าเครื่องแล้ว

หลักการทำงาน ภาคป้องกัน (PROTECTION) จากวงจรในรูปที่ 2 เราใช้ตัวต้านทานเป็นตัวจำกัดกระแส ในที่นี้จำกัดกระแสไว้ที่ 2 Amp เนื่องจากจังก์ชันของทรานซิสเตอร์ชนิดซิลิกอนจะมีค่าประมาณ 0.6 โวลต์ ดังนั้นค่าตัวต้านทานที่ใช้จึงมีค่าเท่ากับ  $R = \frac{V}{I} = \frac{0.6}{2} = 0.3$  กำลังวัตต์ของตัวต้านทานแยกได้ดังนี้

$$R = I^2 R = (2^2 \times 0.3 = 1.2 \text{ วัตต์})$$

เพื่อให้ประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่ ในที่นี้ให้ใช้ขนาด 5 W วงจรป้องกันกระแสเกินได้แสดงไว้แล้วในรูปที่ 2 พิจารณา Q1 เมื่อกระแสไหลผ่าน R 0.3 เกิน 2 Amp ทรานซิสเตอร์ Q1 จะนำกระแสทำให้ D1 ถูกไบอัสแบบตรง (FORWARD BIAS) SCR จึงถูกทริกทำให้นำกระแสได้ ออดที่ต่อไว้กับรีเลย์จะทำงาน ค่าตัวต้านทานที่ใช้จำกัดกระแสผ่านรีเลย์นั้นหาได้เมื่อเราทราบกระแสที่ทำให้รีเลย์ทำงาน จากการทดลองเพิ่มโวลต์ให้รีเลย์ ในขณะที่เยียวกันวัดกระแสที่ผ่านตัวมันได้ประมาณ 120 มิลลิแอมป์ ดังนั้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

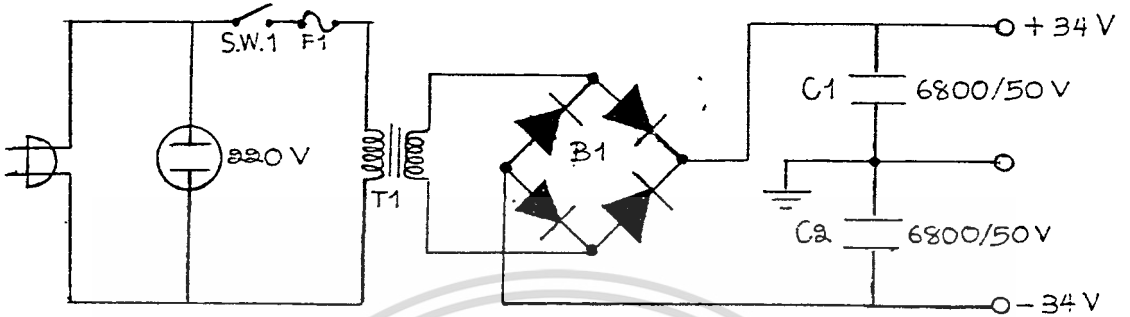
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$R = 33.94 -$  วัตต์ที่ตกคร่อม SCR

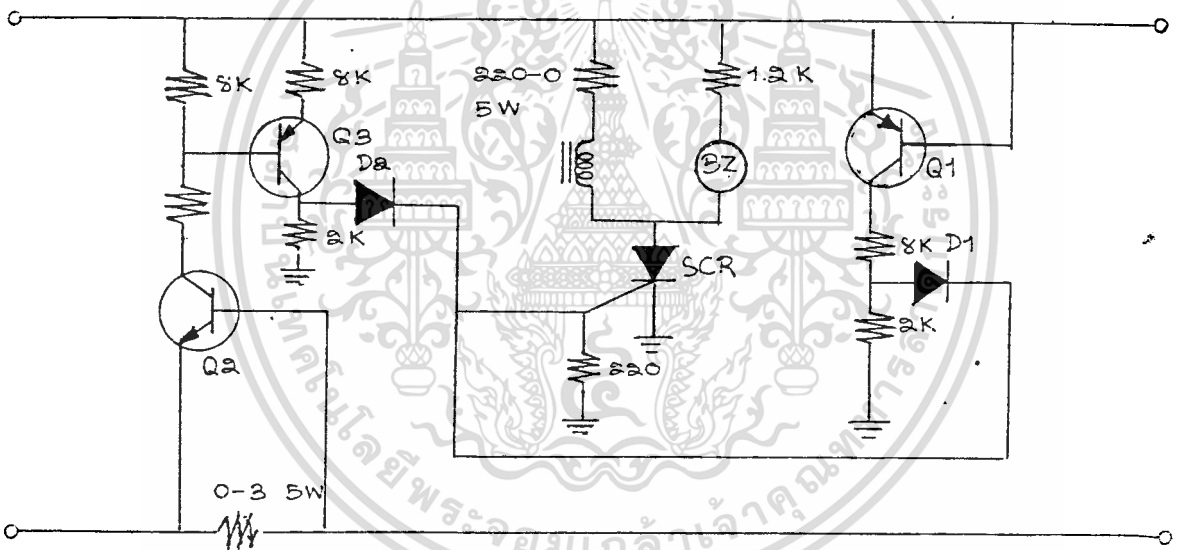
120

$= 220$  กำลังวัตต์ที่ใช้  $I^2R = (120)^2$

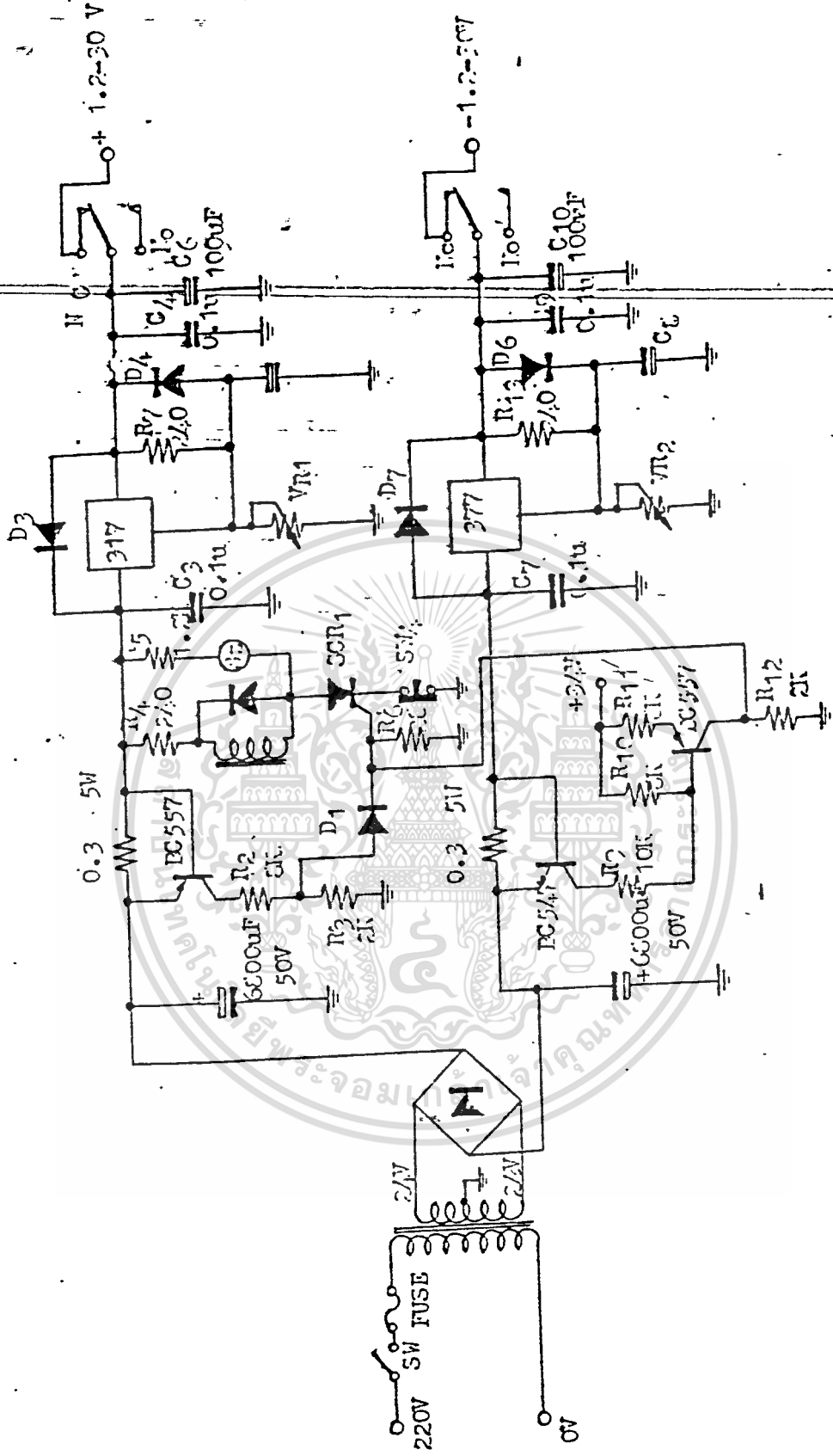
220 3.168 วัตต์ ในที่นี้ให้ใช้ 220 5 W



รูปที่ 1 แสดงภาพเร็คไฟเออร์



รูปที่ 2 แสดงวงจรบล็อกรวมทั้งไฟบวกและไฟลบ



เอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งาน 94 การศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ในส่วนใดก็ตาม อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำหรับทางด้านโพลบนั้น เราจำเป็นต้องใช้ทรานซิสเตอร์ 2 ตัว มีหลักการทำงานดังนี้ เมื่อกระแสที่ไหลผ่าน R Q.3 เกิน 2 Amp จะทำให้ทรานซิสเตอร์ Q2 นำกระแส ในขณะที่เดียวกันเมื่อ Q2 นำกระแสจะเป็นการไบอัส Q3 ทำให้ Q3 นำกระแสด้วย D2 จะถูกไบอัสแบบตรง (FORWARD BIAS) ส่งสัญญาณไปทริก SCR ทำให้ SCR ทำงาน

สำหรับการทำงานของ SCR นั้นพอจะกล่าวคร่าว ๆ ได้ดังนี้ โดยปกติ SCR จะอยู่สถานะใดสถานะหนึ่งเท่านั้นคือ นำกระแสและไม่นำกระแสโดยกระแสจะไหลจากขั้วแอนโอดไปยังคาโทด และต้องมีการจำกัดกระแสที่ไหลผ่านตัวมันไม่ให้เกินอัตราที่กำหนดไว้ในการเปลี่ยนสถานะจากไม่นำกระแสเป็นนำกระแส นั่นทำได้โดยจ่ายกระแสกระตุ้นที่เกทของ SCR เพียงเล็กน้อย และแม้จะเอากระแสที่เกทออกไปแล้ว SCR ก็ยังอยู่ในสภาวะนำกระแสต่อไปจนกว่าจะมีการลดกระแสที่ไหลผ่านตัวมันจะมีระดับต่ำกว่ากระแสยึดเหนี่ยว (THRESHOLD CURRENT) มันจึงจะหลุดจะมีค่าแตกต่างกันไปแล้วแต่ SCR แต่ละเบอร์

ภาคเร็คกูเลเตอร์ เราจะใช้ไอซีเร็คกูเลเตอร์เบอร์ LM 317 T และ LM 337 T เป็นตัวเร็คกูเลตไฟบวกและโพลบตามลำดับ วงจรที่สมบูรณ์ดังแสดงไว้ในรูปที่ 3 เนื่องจากว่าอินพุตของไอซี LM 317 T และ LM 337 T ใช้ไฟถึง  $\pm 34$  โวลต์ตามลำดับ ดังนั้นขณะที่เอาต์พุตของ LM 317 T และ LM 337 T มีค่าเล็กน้อย โวลต์เตจจึงตกคร่อมไอซีทั้งสองมาก จึงเป็นเหตุให้จ่ายกระแสได้น้อยในขณะที่เอาต์พุต มีโวลต์ต่ำ เพื่อให้จ่ายกระแสได้สูงเราจึงใช้ LM 317 T และ LM 337 T มีค่าเล็กน้อย โวลต์เตจจึงตกคร่อมไอซีทั้งสองมาก จึงเป็นเหตุให้จ่ายกระแสได้น้อยในขณะที่เอาต์พุต มีโวลต์ต่ำ เพื่อให้จ่ายกระแสได้สูงเราจึงใช้ LM 317 T และ LM 337 T สองตัวต่อขนานกันและจากการทดลองที่  $\pm 5$  โวลต์ สามารถจ่ายกระแสได้ถึง 2 แอมป์ตามที่ต้องการ

D4 จะช่วยป้องกัน LM 317 T ในกรณีที่ตัวเก็บประจุ C5 (10 MF) ตีสวาร์ท ส่วน D3 จะช่วยป้องกัน LM 317 T ในกรณีที่ตัวเก็บประจุที่เอาต์พุตตีสวาร์ท เพราะถ้าไม่มีไดโอดทั้งสองตัวนี้ โอกาสที่ LM 317 T จะเล็กลงง่าย โดยเฉพาะกรณีที่เรื่อต่อขนานกัน 2 ตัว ถ้าโวลต์ไม่เท่ากันอาจทำให้ตัวหนึ่งตัวให้พังได้

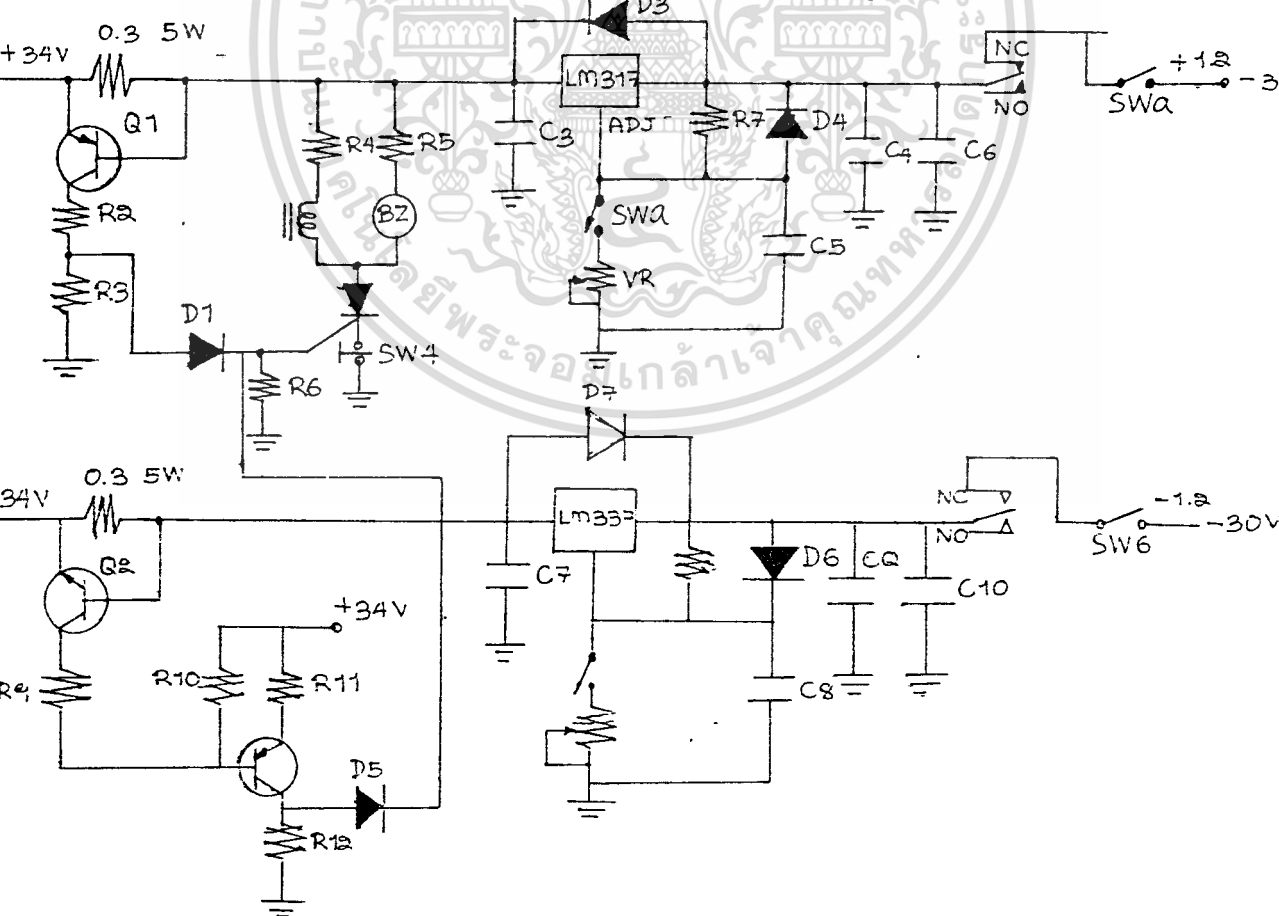
สำหรับทางโพลบนี้ D5 และ D6 ก็ใช้งานในลักษณะเดียวกัน มีขา ADJUST ของไอซีทั้งสองตัวจะพบว่า มีตัวต้านทานปรับค่าได้ต่อเอาไว้โดยผ่านทางสวิทช์ SW 2 อยู่ถึงข้างละ 5 ตัว ทั้งนี้เพราะเราต้องการให้เครื่องจ่ายไฟตรงนี้ สามารถถูกเลือกให้ใช้งานแบบใดก็ได้คือ แบบคงที่  $\pm 5, \pm 9, \pm 12, \pm 15$  โวลต์ และแบบปรับค่าได้  $\pm 1.2$  ถึง  $\pm 30$  โวลต์ การเลือกใช้งานแบบใดนั้นเลือกโดยการหมุนซีเล็คเตอร์สวิทช์ D3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### รูปที่ 3 แสดงวงจรสมบูรณของโวลต์เตจเร็กกูเลเตอร์

การสร้างประกอบ ข้อควรระวังในการประกอบคือ ขั้วของตัวเก็บประจุทุก ๆ ตัวที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ โวลต์ดีคัล โดยเฉพาะตัวใหญ่สุด C1 และ C2 (6300 MF) ส่วนทรานซิสเตอร์และ SCR ได้เขียนรูปให้ดูอย่างละเอียดแล้วจะให้ทรานซิสเตอร์เบอร์อื่นก็ได้ แต่ต้องเป็นชนิดเดียวกันและขั้วที่ใส่ลงแผ่นปริ้นท์ต้องให้ตำแหน่งขาคตรงกันด้วย สำหรับอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังคือ ขั้วของตัวไดโอดที่ใช้เป็นตัวป้องกันไอซี ทั้งสองเบอร์คือ D3 , D4 และ D5 , D6

สำหรับรีเลย์ และ ออก (BUZZER) นั้น ให้ประกอบลงบนแผ่นปริ้นท์ได้เลย โดยการติดตั้งออกนั้น ให้ใช้นอตตัวเล็ก ๆ ยึด การเจาะรูปริ้นท์ของรีเลย์ต้องกะวางขนาดของดอกสว่านที่ใช้ อาจทำให้สายปริ้นท์หลุดหมดได้ ส่วนการเจาะรูปริ้นท์ของตัวเก็บประจุนั้น ให้ใช้ดอกสว่านขนาดเล็กเจาะตามเส้นก่อนแล้วจึงใช้ตะไบให้ข้อยใหญ่ขึ้น เวลาบัดกรีให้ตัดเก็บประจุก่อนหรือจะตัดเลยก็ได้ ส่วนสายที่จะโยงจากตัวต้านทานแบบเกือกม้ากับ LED (MONITOR) ไปยังซีล็คเตอร์สวิทช์นั้น ควรใช้สายแพร (เพื่อความเบ้ระเบียบเรียบร้อย) สำหรับไอซี LM 377 T และ LM 317 T ให้ติดบนแผ่นอีทซิงค์ โดยมีแผ่นไม้ก้ำขนาดเล็กรองด้วย เมื่อติดตั้ง LM 377 T และ LM 317 T บนไม้ก้ำเสร็จแล้วนั้นควรใช้มิเตอร์ตรวจดูว่าเกิดการช้อตขึ้นให้ถอดแล้วค่อย ๆ ประกอบใหม่ ตรวจสอบดูจนแน่ใจว่าไม่มีกาช้อต



การปรับแต่งวงจร เมื่อประกอบเสร็จแล้วเดินสายทุกอย่างถูกต้องแล้ว ต่อไปก็เพียงแต่นำ  
ไขควงเล็ก ๆ ปรับ R เกือบมาโดยวัดเอาต์พุตให้ได้โวลต์ตามที่ต้องการคือ +5, +9, +12,  
และ +15 โวลต์ตามลำดับ

หมายเหตุ หลังจากประกอบเสร็จแล้วลองช้อตเอาต์พุตทั้งบวกและลบดู ถ้าได้ยินเสียงริ  
เลย์ ๗ทำงานและออกคิ่ง แสดงว่าทุกอย่างสมบูรณ์แล้ว แต่ถ้าริเลย์ทำงานแต่บัสเซอร์ไม่ทำงานให้ลอง  
ชั้บบัสเซอร์หรือขันน็อตให้แน่นพอเหมาะใหม่แล้วทดลองใหม่ บางท่านที่ไม่ชอบเสียงออกจะใช้ LED เป็น  
ตัวแสดงแทนเสียงออกก็ได้ โดยต่อแทนตำแหน่งออกให้ขั้วคาโอดต่อกับ SCR ส่วนขั้วอานินดต่อกับ R5  
เมื่อมีการช้อตทางเอาต์พุต LED ก็จะมีติดแสงสว่าง

### รายการอุปกรณ์

ตัวต้านทาน 1/4 วัตต์ 5% (นอกจากระบุ)

R1 , R8	0.3	5W
R2 , R10 , R11		6K
R3 , R12		2K
R4		220 5W
R5		1.2 K
R6		200
R7 , R13		240
R9		10K

### ไฟเพนซ์ไอมีเตอร์

VR1 ถึง VR4	เกือบมาแบบตั้งขนาด
VR5 ถึง VR9	กลาง
VR5, VR10	5% (B) โวลลุ่ม

### ตัวเก็บประจุ

C1 , C2	6800M	50 V	อีเล็กโตรลิติก
C3 , C4 , C7 , C	0.1 M	50 V	ไมลาร์, เซรามิก
C5 , C8	10 M	50 V	อีเล็กโตรลิติก
C6 , C10	100M	50 V	อีเล็กโตรลิติก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

Q1 , Q3	BC 557	PNP	ทรานซิสเตอร์
Q2	BC 547	PNP	ทรานซิสเตอร์
IC1, IC2	LM 317	T	เร็กคูลเลเตอร์ไฟบวกปรับค่าได้
IC3, IC4	LM 337	T	เร็กคูลเลเตอร์ไฟลบปรับค่าได้
SCR	EC 103	D	เอสซีอาร์
P1 - P7	IN 4002		
B1	3A 100V		ปริคต์รีคตีไฟเออร์

## อื่น ๆ

หม้อแปลงขนาด 24-0-24 V 2 Amp

รีเลย์ขนาด 12 V 5 Amp คอนแทค 2 ชุด

ออก 12 V

SW1 สวิตช์เพาเวอร์ชนิดมี LED ในตัว

SW2 ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบ 5 ทาง 2 ชั้น

SW3 สวิตช์เลื่อนหรือโยก 2 ทาง

SW4 สวิตช์กดดับปล่อยติด

ซีทซิงค์ขนาดกลาง 2 แผ่น, แผ่นไมก้านพร้อมแหวนดนาสติก 4 ชุด สายแพรขนาด 10 เส้น สาย AC ลูกยางรองสาย, เต้าเสียบตัวเมีย ลูกบิด, ฝิวส์พร้อมกระบอกฝิวส์, เทอร์มินอลแผ่นปรินท์, หนีบ, สกรู ฯลฯ

โวลต์เตจเร็กคูลเลเตอร์ 5 โวลต์

นวัตรระบบป้องกัน

## คุณสมบัติของเครื่อง

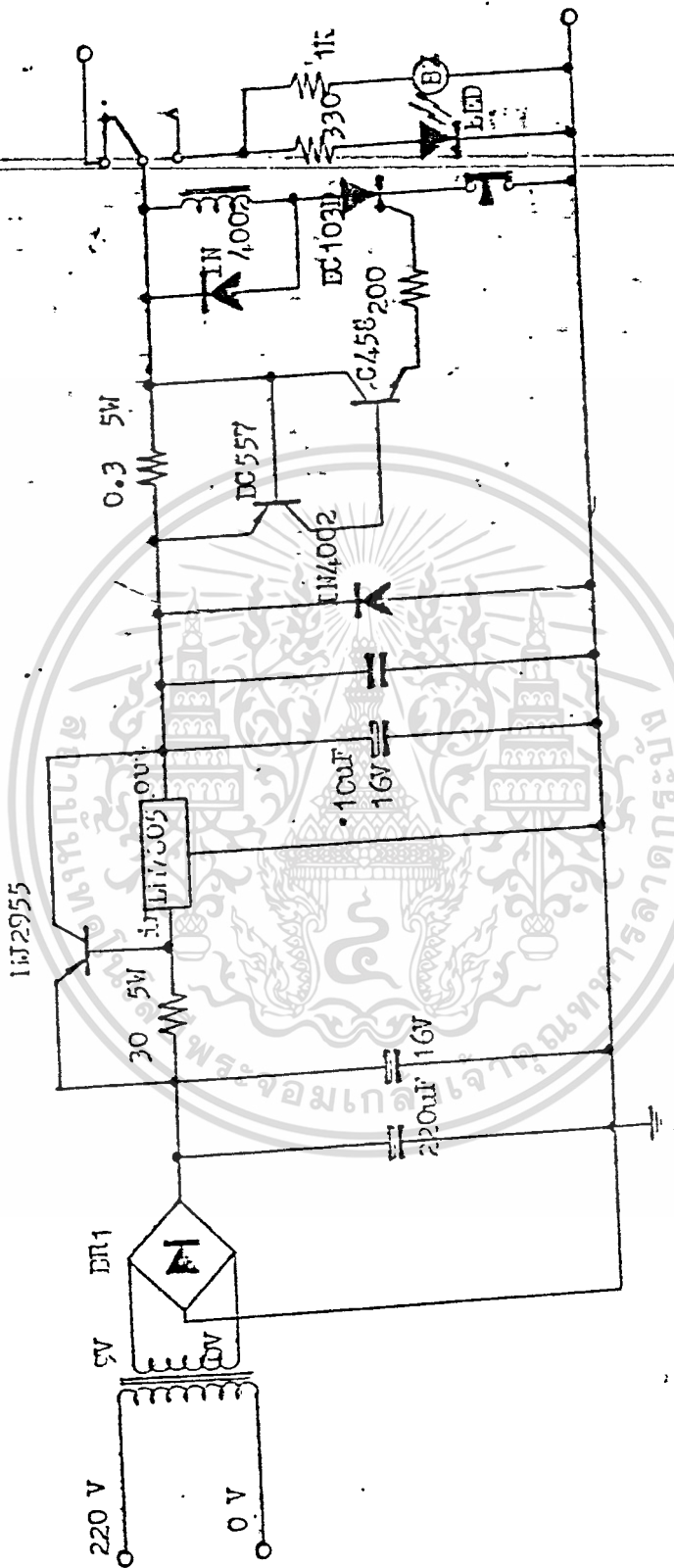
1. สามารถจ่ายกระแสได้สูงถึง 1 แอมป์ (จะให้สูงกว่านี้ก็ได้โดยเพิ่มอุปกรณ์บางตัว)
2. มีวงจรป้องกันกระแสเกิน คือ ถ้าโหลดดึงกระแสเกินที่กำหนดไว้ เครื่องจะป้องกันตนเองโดยตัดตัวเองออกจากระบบหรือโหลด
3. ทันทีที่ตัดตัวเองออกจากระบบภายในเครื่องจะมีออกเตือน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อเรื่อง และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## หลักการทำงาน

การทำงานของภาคจ่ายไฟสำหรับ ทิทานอล 5 โวลต์ ก็ใช้หลักการเดียวกัน เพียงแต่แรงดันที่ต้องการคงที่ 5 โวลต์ ตลอดเริ่มตันจากบริดจ์ ทำหน้าที่เรกติไฟร์โดยมี คาปาซิเตอร์สองตัว ทำหน้าที่ฟิลเตอร์ แรงดันดิซีที่ได้ประมาณ 12 โวลต์ จ่ายให้ไอซีเรกูเลเตอร์ 3 ขา เบอร์ 7805 ทำหน้าที่เรกติคูเตอร์ แรงดันคั่นที่ 5 โวลต์ จ่ายกระแสได้ไม่เกิน 1 แอมป์ จึงใช้ทรานซิสเตอร์ช่วยในการจ่ายกระแสให้สูงขึ้น โดยอาศัยแรงดันตกคร่อมความต้านทานเป็นไบอัสให้ทรานซิสเตอร์ ถ้าหากเกิดการลัดวงจรทางเอาต์พุต ทำให้กระแสไหลผ่านความต้านทาน 3 โอห์ม 5 วัตต์ มากกว่าปกติทำให้โวลต์เตจที่ขาเบสของ ทรานซิสเตอร์ 557 มีค่าต่ำกว่าขา อิมิตเตอร์ ทำให้ ทรานซิสเตอร์อ่อน และทำให้ทรานซิสเตอร์ 458 อ่อน ด้วย เพราะต่อกันแบบดาร์ลิ่งตันกระแสไหลผ่านความต้านทาน 200 โอห์มเข้าขาเกต ของ เอสซีอา ทำให้อ่อนเมื่อ เอสซีอาอ่อน ทำให้รีเลย์ทำงาน ทำให้หมอลอติ้แสดงโอเวอร์โหลลสว่างและมีเสียงเตือนจากบัลเซอร์ด้วย ถ้าต้องการให้วงจรจ่ายกระแสต่อไปก็ต้องกดสวิทช์เซทโดยตัดราคาโถดของ เอสซีอาร์ออกทำให้ เอสซีอาร์ ทำให้ รีเลย์ กลับมาสภาวะปกติจึงจ่ายกระแสออกทางเอาต์พุตได้ต่อไป





รายการอุปกรณ์

ตัวต้านทาน 1/4 วัตต์

30, 0.3, 200, 330, 1000

โอห์ม

ตัวเก็บประจุ

220 ไมโคร 16 โวลต์ อิเล็กโตรไลต์

10 ไมโคร 16 โวลต์ อิเล็กโตรไลต์

สารกึ่งตัวนำ

บริดจ์เรกติไฟร์

ทรานซิสเตอร์ เบอร์ 2955

" " 557

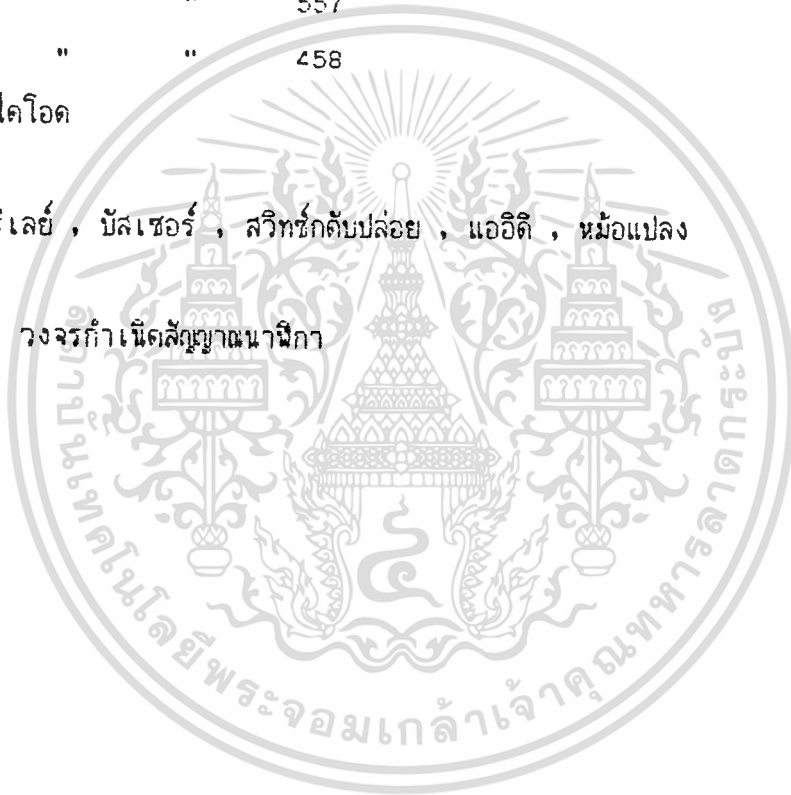
" " 458

ไดโอด

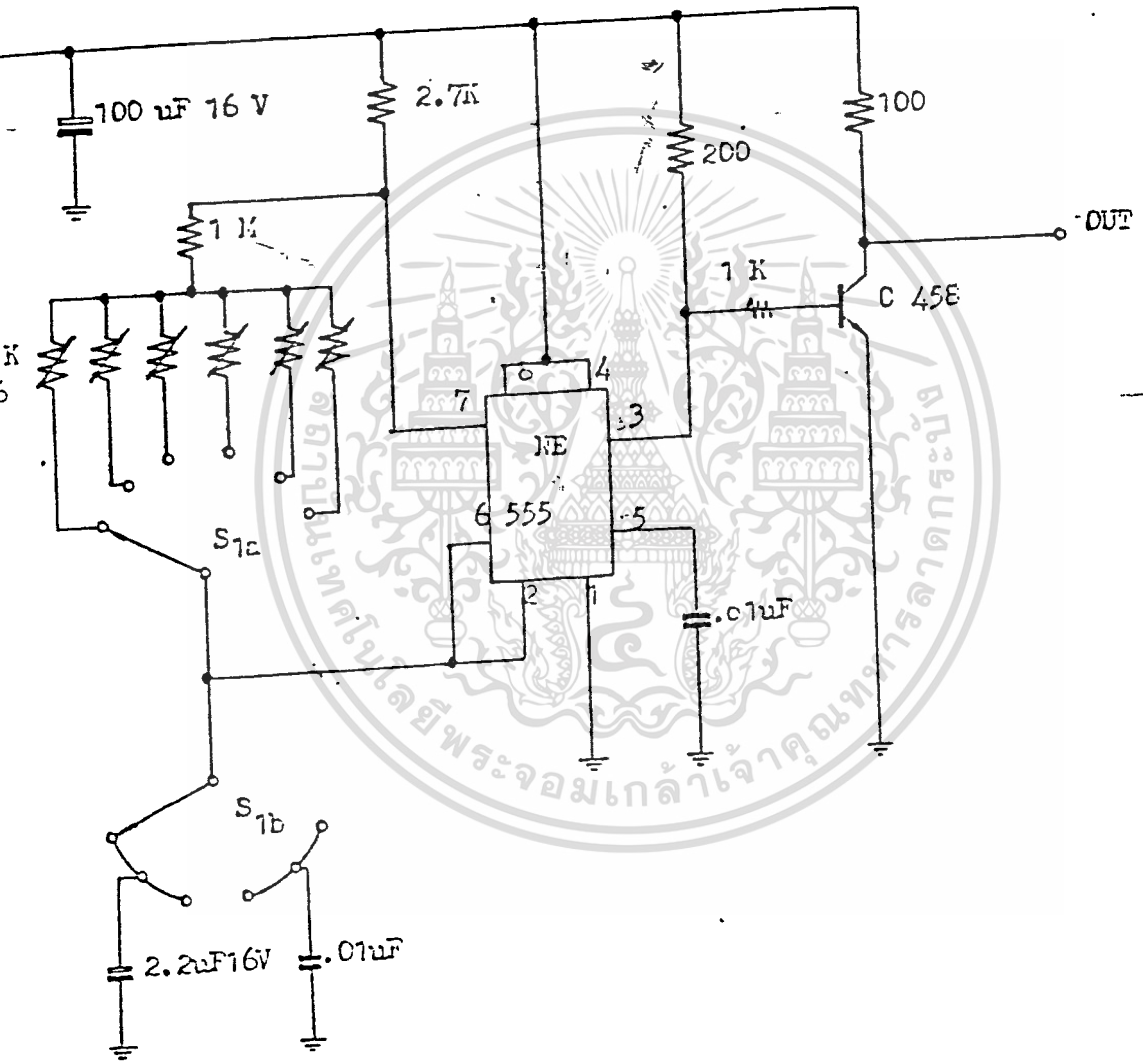
อื่น ๆ

รีเลย์ , บัสเซอร์ , สวิตช์ดับปล่อย , แอวิตติ , หม้อแปลง

รูปที่ 1 วงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกา



รูปที่ 1 วงจรเนกซ์ต์สเตจ



## ชุดกำเนิดความถี่

จากวงจรในรูปที่ 1 IC 3/1 ซึ่งเป็นไอซีอินเวอร์เตอร์แบบซิมิลาร์ทรียูทริคเกอร์ จะให้เอาต์พุตเป็นคลื่นรูปจัตุรัส ความถี่กำหนดด้วย  $R_{1,2}$ ,  $VR_1$ ,  $C_{1,1}$  และ  $C_{1,2}$  ค่าความถี่ขึ้นอยู่กับเวลาที่คาปาซิเตอร์ใช้ในการเก็บประจุ ดังนั้นถ้าหากเพิ่มค่าความต้านทานหรือเพิ่มค่าความจุให้มากขึ้นความถี่ที่เอาต์พุตก็จะลดลง

สวิทช์  $S_1$  สำหรับเลือกความถี่สูง - ต่ำ เมื่อ  $S_1$  อยู่ที่ตำแหน่ง LOW คาปาซิเตอร์  $C_{1,1}$  ถูกต่อขนานกับ  $C_{1,2}$  ทำให้ได้ความถี่เอาต์พุตจาก 10-100 เฮิรตซ์ และเมื่อ  $S_1$  มาอยู่ที่ตำแหน่ง HIGH ในขณะที่จะมี  $C_{1,2}$  ต่ออยู่กับอินพุตของ IC 3/1 เพียงตัวเดียว ทำให้ได้ความถี่เอาต์พุตระหว่าง 1-10 กิโลเฮิรตซ์ ส่วน  $VR_1$  ใช้ปรับค่าความถี่ในช่วง LOW หรือ HIGH

สำหรับสัญญาณคลื่นรูปสามเหลี่ยมได้จากการประจุและคายความประจุของตัวเก็บประจุ ( $C_{1,1}$  และ  $C_{1,2}$ ) และเพื่อไม่ให้เกิดการไหลลัดต่อตัวเก็บประจุ จึงจัดกับฟเอร์ด้วยตัวทรานซิสเตอร์ Q1 ซึ่งต่อแบบคอมมอนคอลเลกเตอร์ เอาต์พุตจะได้จากแรงดันตกคร่อม  $R_{1,7}$  ซึ่งช่วงต่ำที่สุดของรูปคลื่นจะอยู่สูงกว่าระดับแรงดันศูนย์ตามระดับของแหล่งจ่ายแรงดันที่เปลี่ยนไป

เมื่อปรับ  $VR_1$  ความถี่ของคลื่นรูปจัตุรัสและคลื่นรูปสามเหลี่ยมจะเปลี่ยนไปด้วยกันและมีความถี่เท่ากันด้วย

นอกจากนี้ยังมีความถี่คลื่นรูปสามเหลี่ยมด้วย โดยต่อหม้อแปลงทางชดเชยมีระหว่างขั้ว 0 และ 15 โวลต์ ผ่านตัวต้านทาน  $R_1$  เพื่อกำจัดกระแสความถี่ที่ได้เท่ากับความถี่ของไฟบ้านนั่นคือ 50 เฮิรตซ์ ส่วนแอมป์ลิจูดมีค่าประมาณ  $15 \cdot \sqrt{2} \cdot 2 = 42V_{p-p}$  (เนื่องจากแรงดัน 15 โวลต์ที่วัดด้วยมิเตอร์เป็นค่าอาร์เอ็มเอส แต่รูปคลื่นนี้แท้จริงเป็นค่ายอดถึงยอด) เวลาต่อใช้งานถ้าต้องการลดแรงดันลงก็ให้ใช้หลักการของวงจรแบ่งแรงดัน

### รายการอุปกรณ์

ตัวต้านทาน	1/4 วัตต์
100	โอห์ม
10 , 2.7	กิโลโอห์ม
โพเทนโอมิเตอร์	
10	กิโลโอห์ม เกือกม้าแบบฮิน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

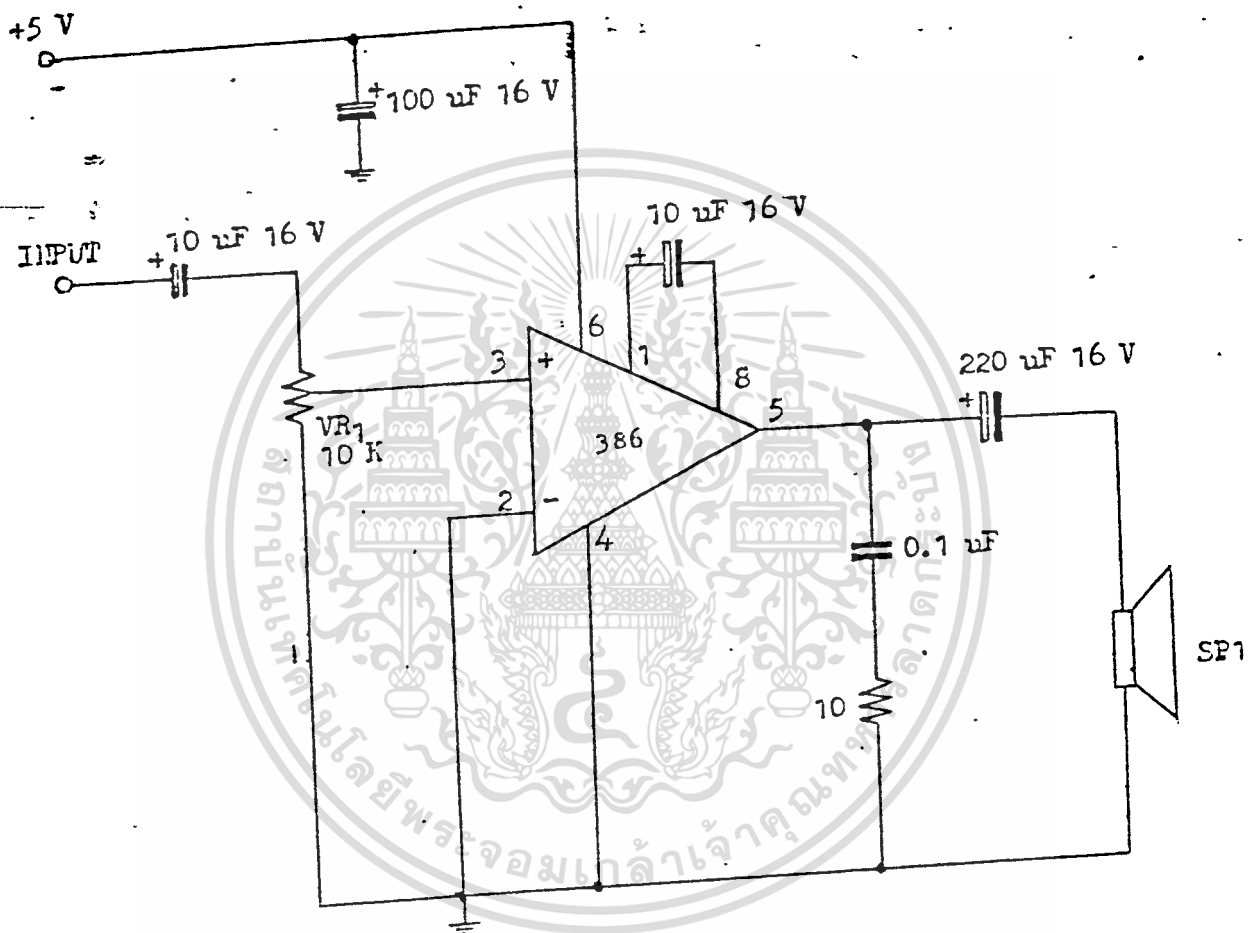
ตัวเก็บประจุ

- ง. 01 ไมโคร 50 โวลต์ ไมลาร์
- 2.2 ไมโคร 16 โวลต์ อิเล็กโตรไล
- 100 ไมโคร 16 โวลต์ อิเล็กโตรไล

อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

ทรานซิสเตอร์	458
ไอซี	555





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## การทำงานของวงจรมหาเวอ์แอมป์

(POWER AMPLIFIER)

จากวงจรในรูปแบบแสดงวงจรมหาเวอ์แอมป์ใช้ไอซีเบอร์ LM 368 มีอัตราขยาย 200 เท่า ข้อดีของไอซีเบอร์นี้คือมีอัตราขยายสูงที่แรงดันต่ำ ๆ ผ่านแรงดันที่ใช้งาน 4 - 12 โวลต์ ความเพี้ยนต่ำ จากวงจรอินพุตป้อนผ่าน C<sub>2</sub> ทำหน้าที่คัปปลิ่งป้อนสัญญาณเข้า VR<sub>1</sub> ทำหน้าที่ปรับความดัง (VOLUME) ปรับขนาดสัญญาณเข้าทางขา 3 ขา 6 เป็นขาไฟเลี้ยงสำหรับวงจรมหาเวอ์แอมป์เลือกใช้ค่า 10  $\mu$ F ทำให้เกนขยายแรงดันของวงจรมหาเวอ์แอมป์เท่ากับ 200 เท่า C<sub>1</sub> และ R<sub>1</sub> ต่ออนุกรมกันต่อไว้เพื่อเป็นวงจรป้องกันการเกิดการออสซิลเลชันภายในตัวไอซีขา 5 เป็นเอาต์พุต C<sub>3</sub> คัปปลิ่งสัญญาณเอาต์พุตไปยังลำโพง

### รายการอุปกรณ์

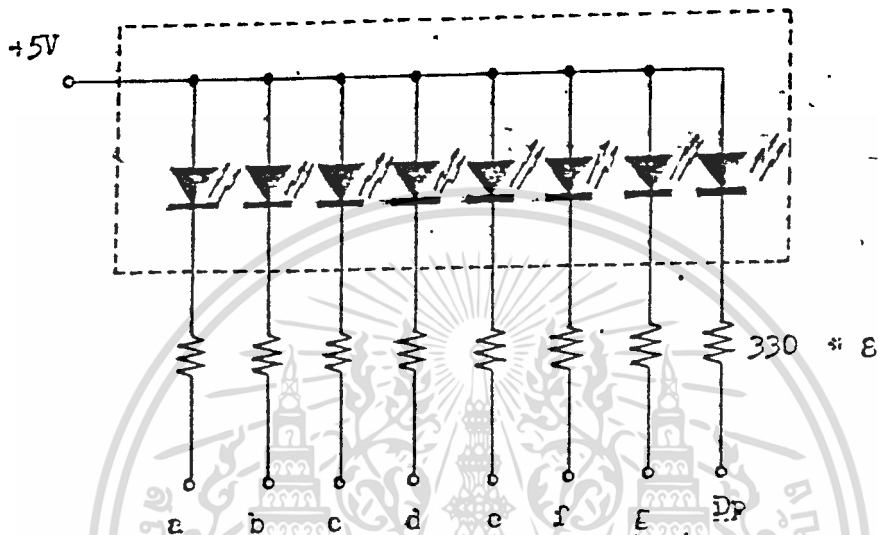
ตัวต้านทาน	1/4	วัตต์	
10			โอห์ม
โพเทนชิโอมิเตอร์			
10	กิโลโอห์ม	วอลลุ่ม	ขึ้นเดียวแกนยาว
ตัวเก็บประจุ			
100	ไมโคร	16	โวลต์ อิเล็กโตรไลต์
10	ไมโคร	16	โวลต์ อิเล็กโตรไลต์
.1	ไมโคร	50	โวลต์ ไมลาร์
220	ไมโคร	16	โวลต์ อิเล็กโตรไลต์
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ			
ไอซี			386
อื่น ๆ			

ลูคัส , ลำโพง

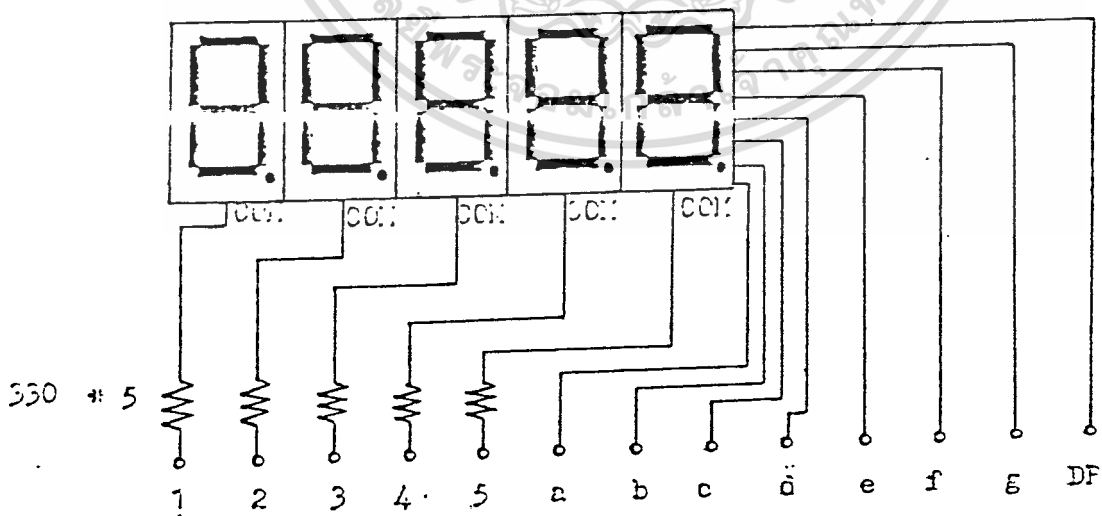
7 - SEGMENT DISPLAY

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

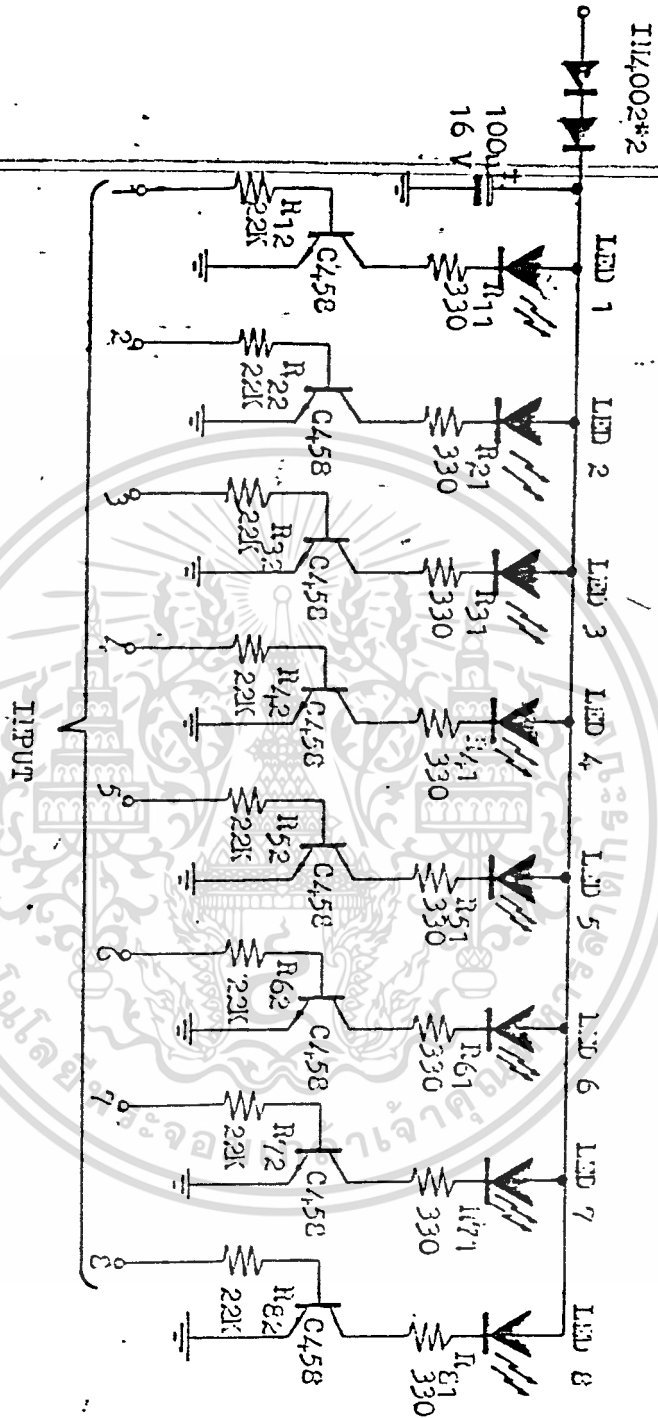
# 7 - SEGMENT DISPLAY



## MULTIDIGIT DISPLAY



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



วงจรแสดงผลทศอิจ

## การทำงานของวงจรแสดงผลลอจิก

(LOGIC MONITOR)

จากรูปเป็นวงจรแสดงผลลอจิกที่เขียนไว้เป็นตัวอย่างเพียง ๑ ชุดที่สมมุติมี ๘ ชุด 1 ชุด ประกอบด้วยตัวแสดงลอจิก "1" และ "๐" คือ LED<sub>1</sub> และ LED<sub>2</sub> โดยมีทรานซิสเตอร์ Q1 และ Q2 เป็นตัวขับ จากวงจรถ้าไม่มีระดับลอจิกเข้ามาทางอินพุตของวงจรทรานซิสเตอร์ Q1 และ Q2 จะมีไบอัสซึ่งได้มาจากกระแส I<sub>E</sub> ของ Q2 ไหลเป็น I<sub>B</sub> ของ Q<sub>1</sub> ผ่าน R<sub>3</sub>' จะป้อนผ่าน R<sub>2</sub> และ R<sub>2</sub> เป็น I<sub>B</sub> ของ Q<sub>1</sub> ดังนั้นทั้ง Q<sub>1</sub> และ Q<sub>2</sub> จะทำงานมีกระแส I<sub>C</sub> ไหลทั้งสองตัว LED<sub>1</sub> และ LED<sub>2</sub> จึงติดสว่าง ถ้าป้อนระดับลอจิกเข้ามาทางอินพุตเป็น "1" หมายถึงมีไฟ + 5V เข้ามาจะต่อต้านการไหลของ I<sub>B</sub> ของ Q<sub>2</sub> ทำให้ Q<sub>2</sub> คัทออฟ LED<sub>2</sub> ระดับแต่ + 5V จะไปเพิ่ม I<sub>B</sub> ของ Q1 ทำให้ Q1 ทำงานต่อไป LED<sub>1</sub> จะยังติดอยู่ ดังนั้นถ้า LED<sub>1</sub> ติด LED<sub>2</sub>ดับ หมายถึง ระดับลอจิกที่ป้อนเข้ามาเป็น "1" ในทางตรงกันข้ามถ้าป้อนระดับลอจิกเข้ามาทางอินพุตเป็น "๐" หรืออินพุตมีศักย์เท่ากับกราวด์ของวงจร I<sub>B</sub> ของ Q<sub>2</sub> จะไหลได้มากขึ้น Q<sub>2</sub> จะทำงาน LED<sub>2</sub> จะติด แต่ I<sub>B</sub> ของ Q1 จะหยุดไหล Q1 จะคัทออฟ LED<sub>1</sub> จะดับ และถ้า LED<sub>2</sub> ติดแต่ LED<sub>1</sub> ดับ หมายถึง ระดับลอจิกที่ป้อนเข้ามาเป็น "๐" ถ้าคิดพร้อมกันทั้งสองดวงหมายถึง เอาต์พุตของวงจรที่ป้อนมาซึ่งอินพุตของวงจรแสดงผลลอจิกเปิดวงจร (HIGH IMPEDANCE) ดังนั้นพอสรุปได้ว่าการแสดงผลลอจิกแบบนี้ให้ผลดีกว่าแบบที่ใช้กันในชุดทดลองทั่วไปที่แสดงผลด้วย LED เป็นตัวเดียว

### รายการอุปกรณ์

ตัวต้านทาน 1/4 วัตต์

330

22

โอห์ม

กิโลโอห์ม

ตัวเก็บประจุ

100 ไมโคร 16 โวลต์ อิเล็กโตรไลต์

สารกึ่งตัวนำ

ไดโอดเปล่งแสง

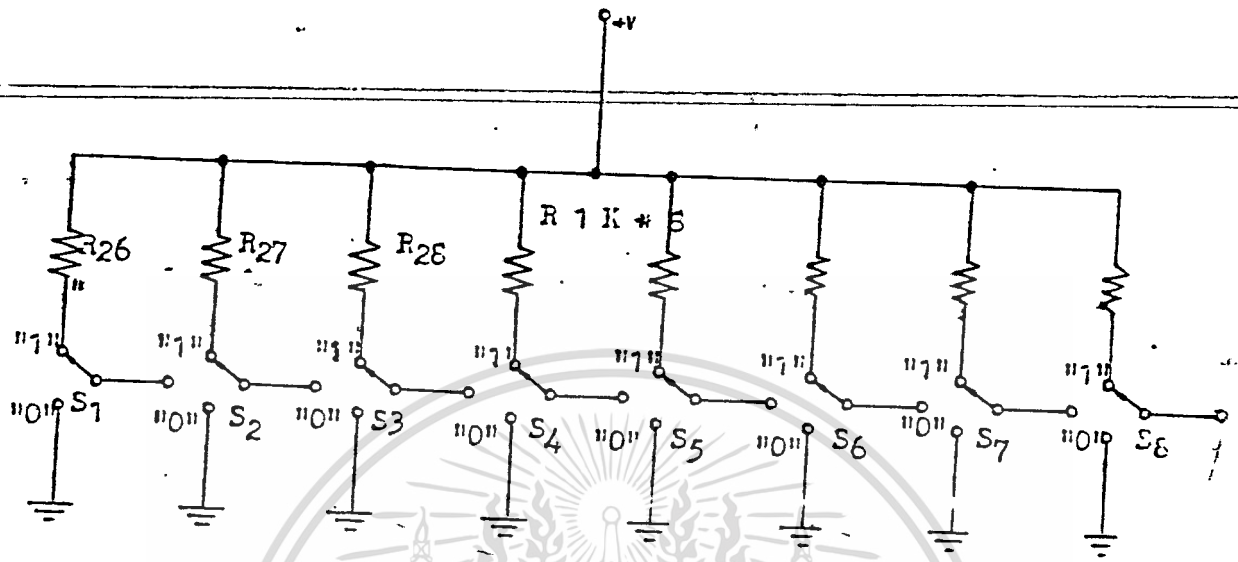
ไดโอด

ทรานซิสเตอร์

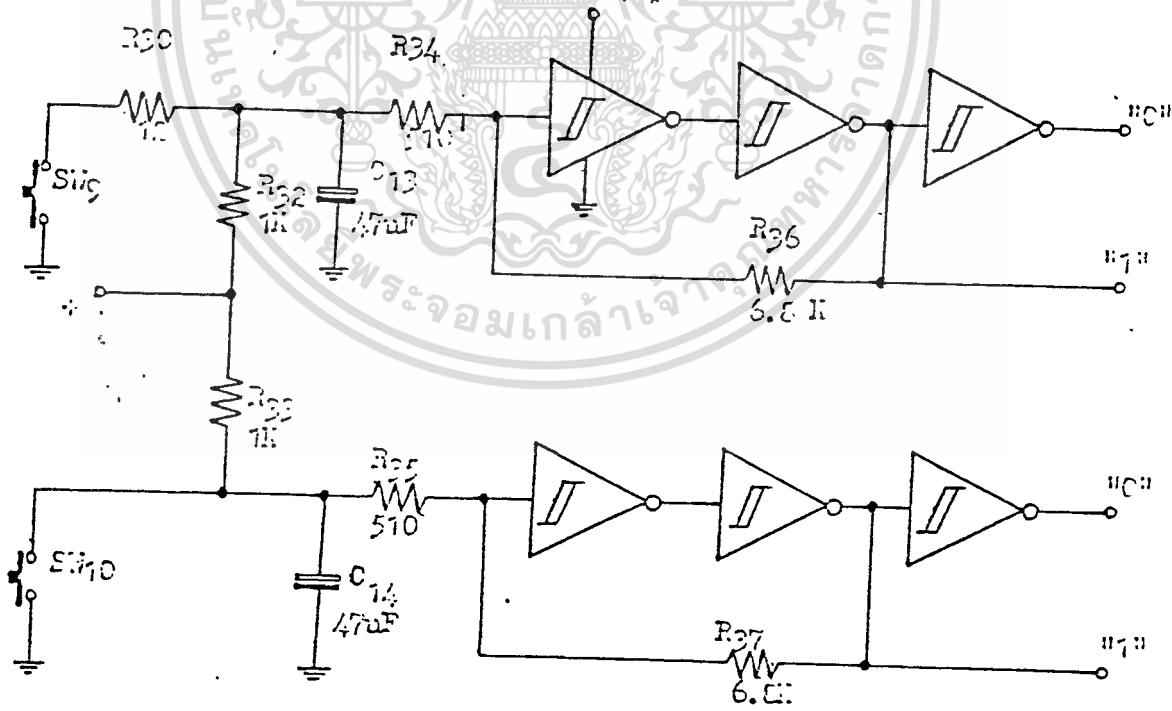
458

### รูปที่ 1 วงจรลอจิกสรีค

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับครูช่างงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 1 วงจรลอจิกสี่ตติ



รูปที่ 2 วงจรทีเขายซ์สวิช

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## รูปที่ 2 วงจรตีเบาสวิตช์

### ลอคจิกสวิตช์

จากวงจรในรูปเป็นการเลือกสถานะลอคจิกด้วยสวิตช์  $S_{๑} - S_{๒}$  ซึ่งเป็นสวิตช์แบบ SPT (SIGNAL POLE DOUBLE THROW) ที่ตำแหน่ง "1" สวิตช์จะต่อไปยังแรงดันบวกผ่านตัวต้านทาน  $R_{๒๑} - R_{๒๒}$  ทำให้ขากลางของสวิตช์มีสถานะ "1" และเมื่อยกสวิตช์ไปยังตำแหน่ง "๒" ขากลางก็จะต่อลงกราวด์โดยตรง ดังนั้นจึงมีสถานะเป็น "๐"

### รายการอุปกรณ์

ตัวต้านทาน 1/4 วัตต์

1 กิโลโอห์ม

อื่น ๆ

สวิตช์โยก 3 ขา

### ตีเบาสวิตช์

ในรูปที่ 1 เป็นวงจรตีเบาสวิตช์ 2 ชุด โดยที่เอาต์พุตของตีเบาสวิตช์จะไม่มีสัญญาณรบกวนเหมือนสวิตช์ทางกล  $R_{๒๑}$  และ  $R_{๒๒}$  ต่อเป็นวงจรแบ่งแรงดันเพื่อให้อินพุตของ IC 4/1 เป็น "1" ดังนั้นเอาต์พุตของ IC4/3 เป็นลอคจิก "๐" เมื่อกดสวิตช์  $S_{๑}$  ให้ต่อวงจรอินพุตของ IC4/1 จะถูกต่อลงกราวด์ ทำให้เอาต์พุตของ IC4/2 เป็น "๐" และเอาต์พุตของ IC4/3 เป็น "1"

สำหรับตีเบาะสวิทช์อีกชุดก็มีหลักการทำงานเช่นเดียวกัน ปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวนจากสวิทช์  $S_{9}$  และ  $S_{10}$  จะถูกกำจัดไปด้วย  $C_{13}$  และ  $IC_{14}$  และด้วยคุณสมบัติของ  $IC_{14}$  ซึ่งเป็นไอซีแบบชนิดที่รีกเกอร์ สถานะลอจิกทางเอาต์พุตจะคงอยู่นานเท่าที่สวิทช์ต่อวงจรอยู่

รายการอุปกรณ์

- ตัวต้านทาน 1/4 วัตต์
- 12 , 510 โอห์ม
- 1 กิโลโอห์ม
- 6.8 กิโลโอห์ม

ตัวเก็บประจุ  
47 ไมโคร 25 โวลต์ อีเล็กโตรไลต์

สารกึ่งตัวนำ  
ไอซี





ที่ชุดลอจิกไบนารี แอลอีดีติดอยู่ 1 ดวง คือ ดวงที่แสดงสถานะที่ไม่ใช่ "0" และ "1" คือดวงกลางนั่นเอง ใช้มีเตอร์วัดแรงดัน 5 โวลต์ ที่แอ็ทอากาศของชุดจ่ายไฟสำหรับ TTL ต้องได้ประมาณ 5 โวลต์ เมื่อได้ตามนี้ให้ย้ายมิเตอร์มาวัดคร่อมที่แอ็ทอากาศของชุดจ่ายไฟแบบปรับค่าได้ ลองปรับที่แรงดัน  $V_{R_2}$  ดูจะต้องมีแรงดันเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 1.2 โวลต์ ถึง 18 โวลต์ทดลองช้อตปลายสายทั้งสองของชุดจ่ายไฟนี้ จะเห็นแอลอีดีแสดงการจำกัดกระแสดีดสว่าง จากนั้นนำตัวต้านทาน 10 โอห์ม 10 วัตต์ต่อคร่อมชุดจ่ายไฟแบบปรับค่าได้นี้ ปรับโวลต์ลุ่มเกือกว่าให้แสดงการจำกัดกระแสดีดสว่างแสดงว่าตอนนี้เราปรับการจำกัดกระแสไว้ที่ 1 แอมป์พอดี เมื่อภาคจ่ายไฟทำงานถูกต้องแล้วก็ทดสอบการทำงานชุดอื่นต่อไปตามขั้นตอนดังนี้

เริ่มต้นทดสอบการทำงานของวงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกา โดยหลักสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง SINGLE กดสวิตช์ป้อนสัญญาณนาฬิกาจะเห็นแอลอีดีแสดงสัญญาณนาฬิกาติดแล้วดับตามการกลจากนั้นหลักสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง MULTI สวิตช์อีกตัวอยู่ที่ตำแหน่ง LOW จะเห็นแอลอีดีแสดงสัญญาณนาฬิกากระพริบทดลองปรับโวลต์ลุ่มปรับความถี่จะเห็นแอลอีดีกระพริบตามความถี่ที่ปรับ หลักสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง HIGH จะเห็นแอลอีดีแสดงสัญญาณนาฬิกากระพริบเร็วมาจากดูเหมือนคลื่นสว่างตลอดเวลา ทดลองใช้ออสซิลโลสโคปวัดเอาต์พุตของสัญญาณนาฬิกาจะต้องได้รูปคลื่นสี่เหลี่ยม ทดลองปรับความถี่ดูจะเห็นความถี่ของสัญญาณนาฬิกาเปลี่ยนแปลงตามการปรับ

การทดลองวงจรแสดงผลลอจิกอาศัยการป้อนสัญญาณนาฬิกาเข้ามาทดสอบโดยต่อสายจากเอาต์พุตของสัญญาณนาฬิกาเข้ามายังอินพุตของวงจรแสดงผลลอจิกที่ละเอียด โดยปรับความถี่สัญญาณนาฬิกาให้ต่ำพอที่จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงระดับลอจิก "1" และ "0" จะเห็นแอลอีดีแสดงสถานะติดคือเมื่อปรับระดับ "1" ดวงที่แสดงผลเป็น "1" จะติดสว่างที่เป็น "0" จะดับและขณะที่เป็นระดับ "0" ดวงที่เป็นระดับ "0" ดวงที่เป็น "0" จะติดและดวงที่เป็น "1" จะติด

การทดสอบวงจรแสดงผลลอจิกสวิตช์โดยใช้มีเตอร์วัดที่เอาต์พุตของชุดสวิตช์ที่เอาต์พุตเมื่อโยกสวิตช์ไปที่ "1" มิเตอร์จะแสดงแรงดัน 5 โวลต์ และเมื่อโยกสวิตช์ไปที่ "0" มิเตอร์จะแสดง 0 โวลต์

การทดสอบวงจรแสดงผลตัวเลขทศนิยมหรือเลขฐานสองเข้ามาทางอินพุต โดยอาศัยลอจิกสวิตช์เป็นตัวป้อนตัวเลข ต่อแสงเป็นตัวเลขฐาน 10 ตามการป้อน การทดสอบลอจิกไบนารี 3 สถานะอาศัยสัญญาณนาฬิกาความถี่ต่ำป้อนเข้ามาทางอินพุต จะเห็นแอลอีดีแสดงผล "0" และ "0" ตามสัญญาณนาฬิกาที่เป็นเข้ามาและสุดท้ายทดสอบการทำงานของนาเวอร์ออมป์ โดยแรงโวลต์ลุ่มไว้สูง ใช้นิ้วแต่อินพุตดูมีเสียง 50 Hz ออกลำโพงหรืออาจใช้สัญญาณนาฬิกาป้อนเข้ามาทางอินพุต ทดลองปรับความถี่สัญญาณนาฬิกา จะได้ยินความถี่ตามการปรับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รายการประกอบกล่องของชุดฝึกตัดไม้

1. ไม้อัดให้ใช้ขนาดความหนา 10 ม.ม. จำนวน 1 แผ่น
2. ไม้อัดให้ใช้ขนาดความหนา 6 ม.ม. จำนวน 1/2 แผ่น
3. แผ่นพลาสติกหนา 0.3 ม.ม. จำนวน 1 แผ่น
4. ตะปูเบอร์ 11 เจอร์สำหรับคอกขนาด 1 นิ้ว จำนวน 0.5 ก.ก.
5. กาวลาเท็กซ์ จำนวน 1 ขวดใหญ่
6. แผ่นไฟเบอร์ลัม 1 แผ่น
7. กาวติดไฟเบอร์ลัม 2 กระป๋อง

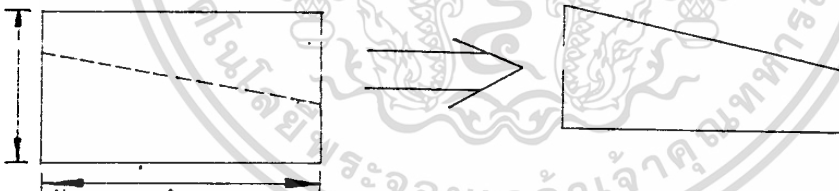
วิธีการตัดไม้

แบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

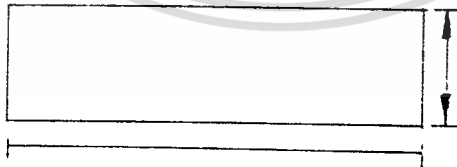
1. แผ่นล่างใช้ทำพื้นรองกล่องขนาดกว้าง 30 ซม. จำนวน 10 แผ่น



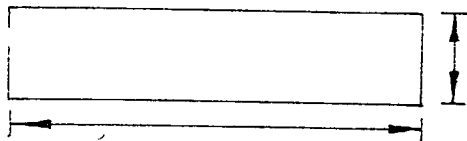
2. ฝาปิดด้านข้างทั้งสองขนาดกว้าง 16 ซม. ยาว 31.2 ซม. จำนวน 10 แผ่น หลังจากนั้นให้ติดตามเส้นประจุดได้ขนาดความกว้างนี้ไม่เท่ากัน คือ ด้านแรกกว้าง 10 ซม. ด้านสองกว้าง 6 ซม. และยาว 31.2 ซม. จำนวน 20 แผ่น



3. ฝาปิดด้านบนหลังขนาดกว้าง 10 ซม. ยาว 43 ซม. จำนวน 10 แผ่น



4. ฝาปิดตัวช่วยหน้าขนาดกว้าง 6 ซม. ยาว 31.2 ซม. จำนวน 10 แผ่น



การประกอบกล่อง

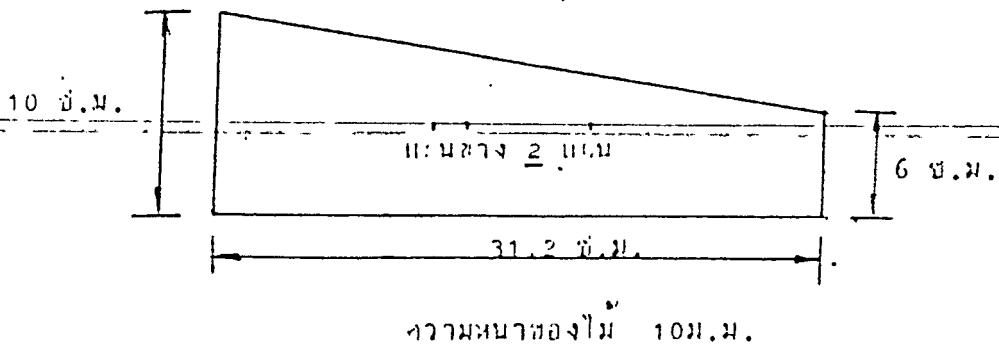
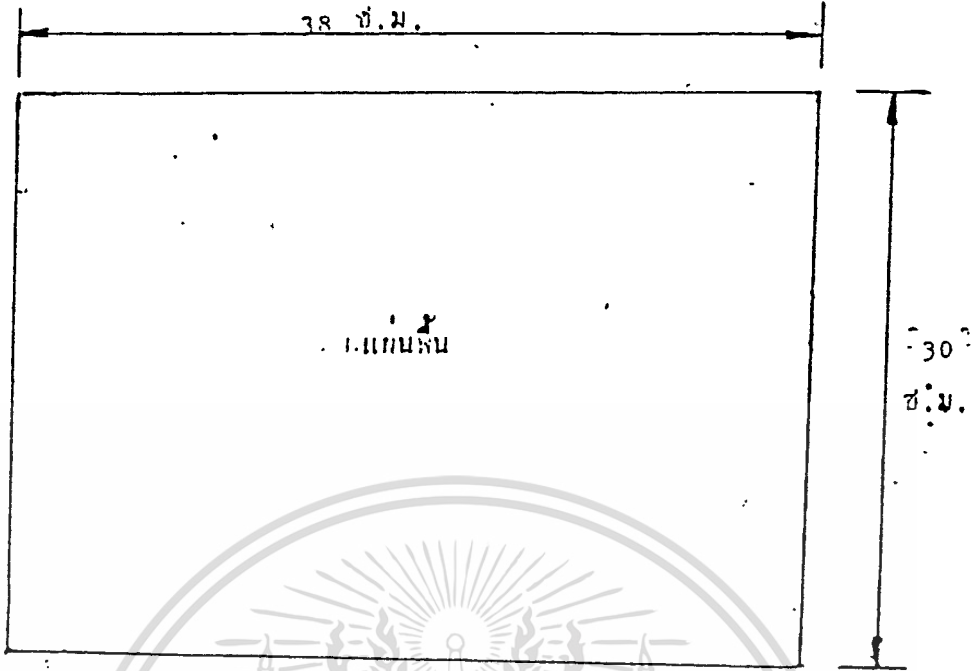
เมื่อตัดไม้เรียบร้อยแล้วให้ใส่ไม้ให้เรียบร้อย หลังจากนั้นทำการประกอบโดยการเข้ามุม 45

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

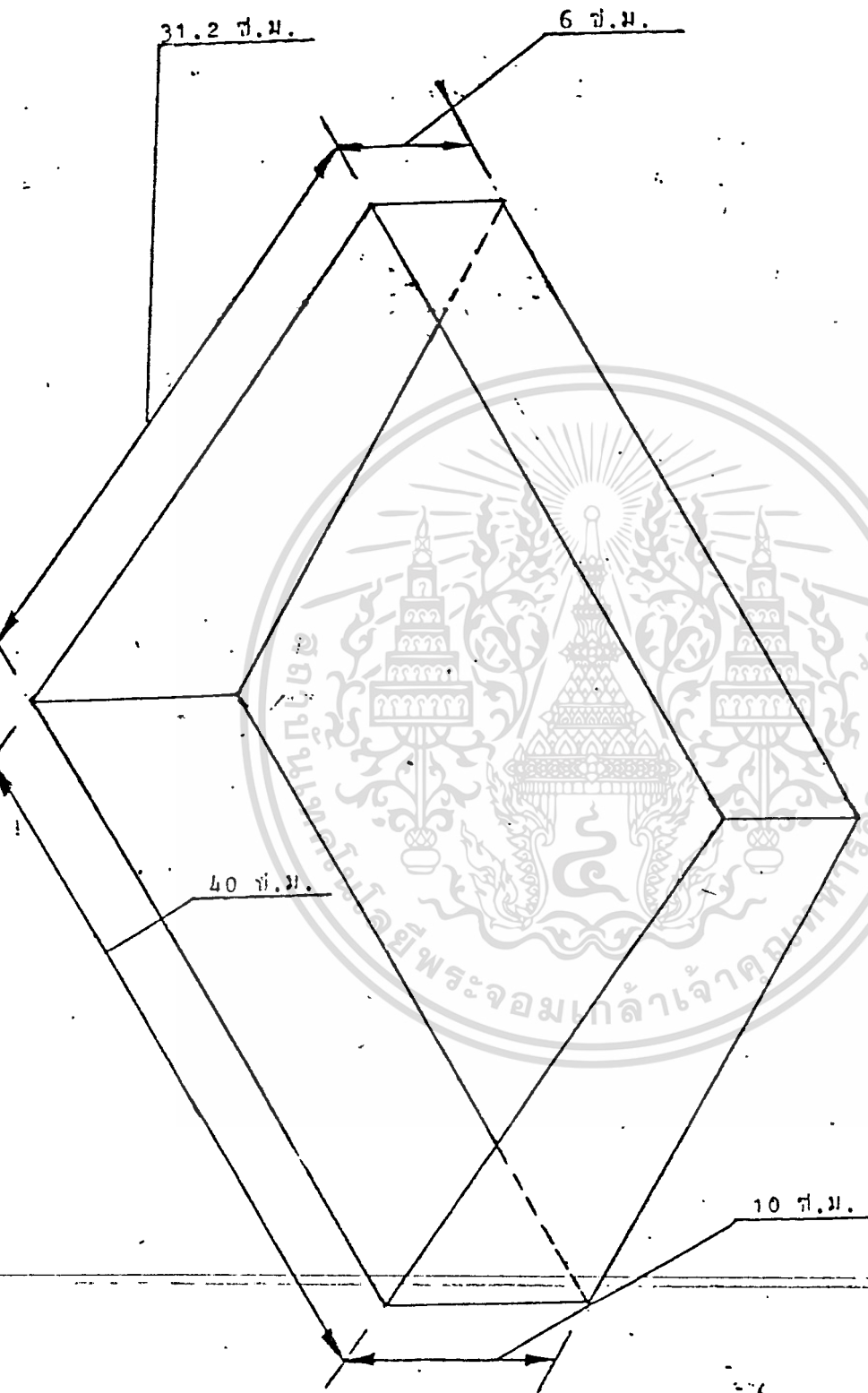
องศาหรือ 90 องศา ถ้าต้องการใส่เครื่องแรงควรรใส่ไม้เคร่าทั้ง 4 ด้าน โดยจะต้องยึดการด้วยเมื่อความแข็งแรงยิ่งขึ้น หลังจากนั้นให้ขีดลัดขยกระดากทรายแล้วทาสีหรือติดไฟเบอร์ก้า

ส่วนการติดพลาสติกนั้นให้ตัดขนาด กว้าง 40.5 ซม. ยาว 31.7 ซม. เพราะจะต้องเพิ่มเนื้อไว้เพื่อความหนาของไฟเบอร์ก้าด้วย และการเจาะรูแผ่นพลาสติกนั้นขอสำคัญควรใช้รอบเร็วการใช้มือยึดแผ่นพลาสติกกับไม้ั้นควรรใช้มือตแบบหัวเทเปอร์ เกลียวปล่อย



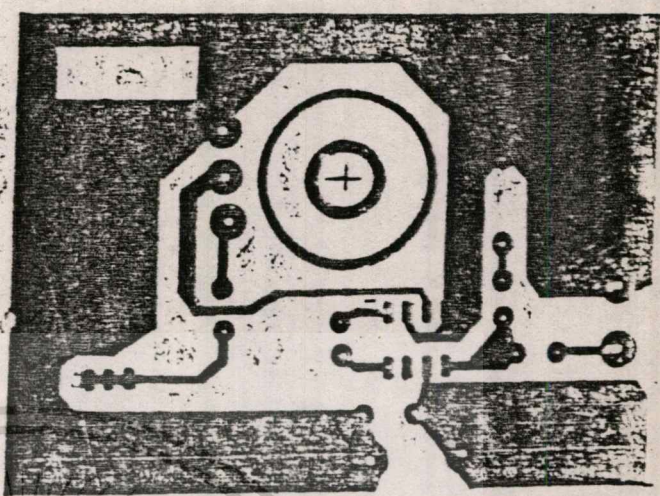
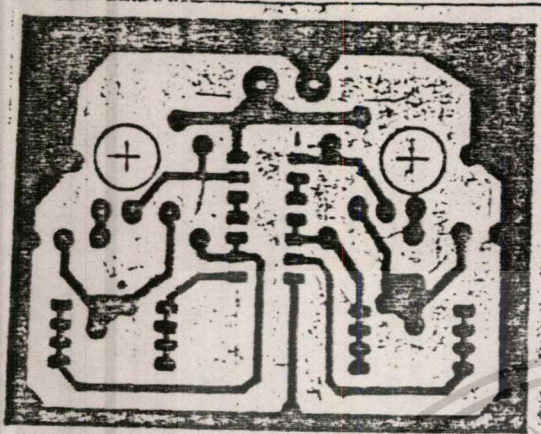


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น วิชาช่างไม้ปีห้าฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



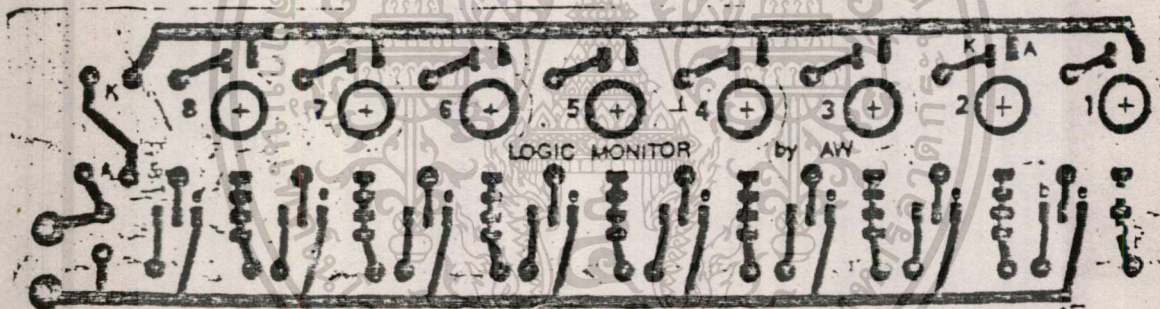
ฉบับทดลองของสถาปัตย์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

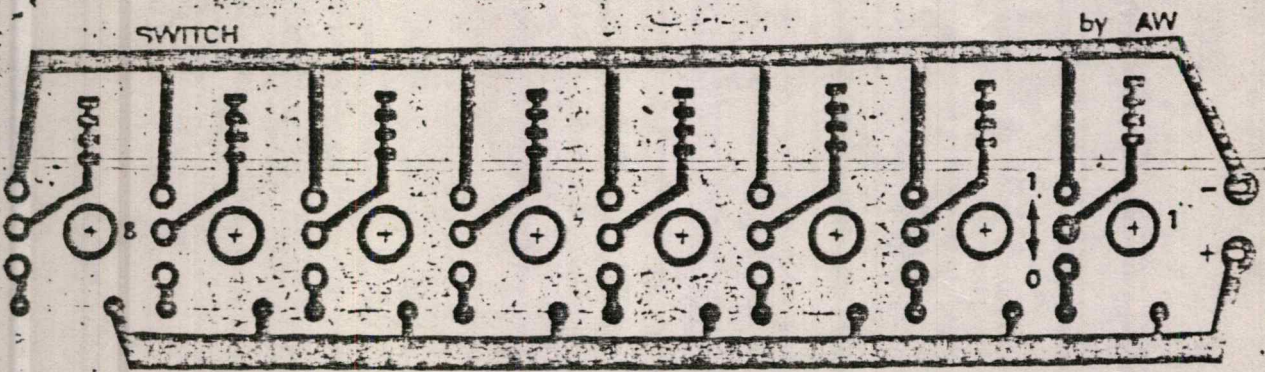


ลายทองแดงของวงจรถ่ายภาพ

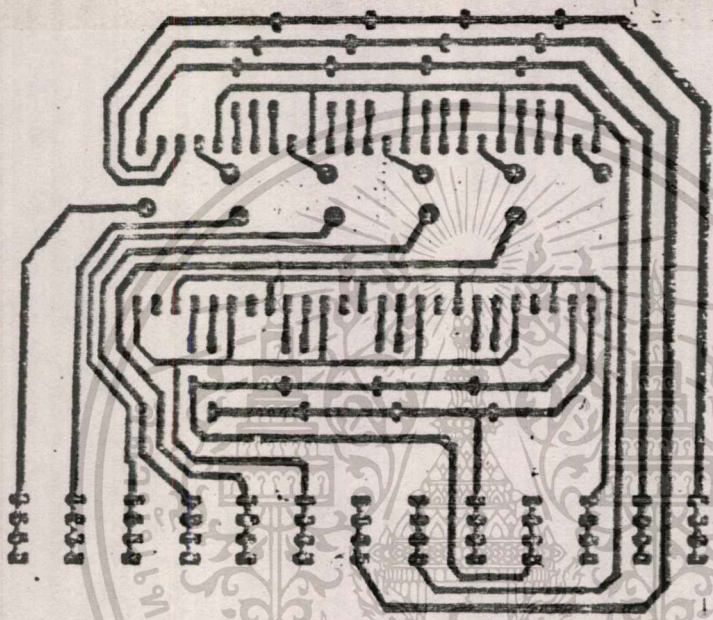
ลายทองแดงของวงจรถ่ายภาพวีเออาร์



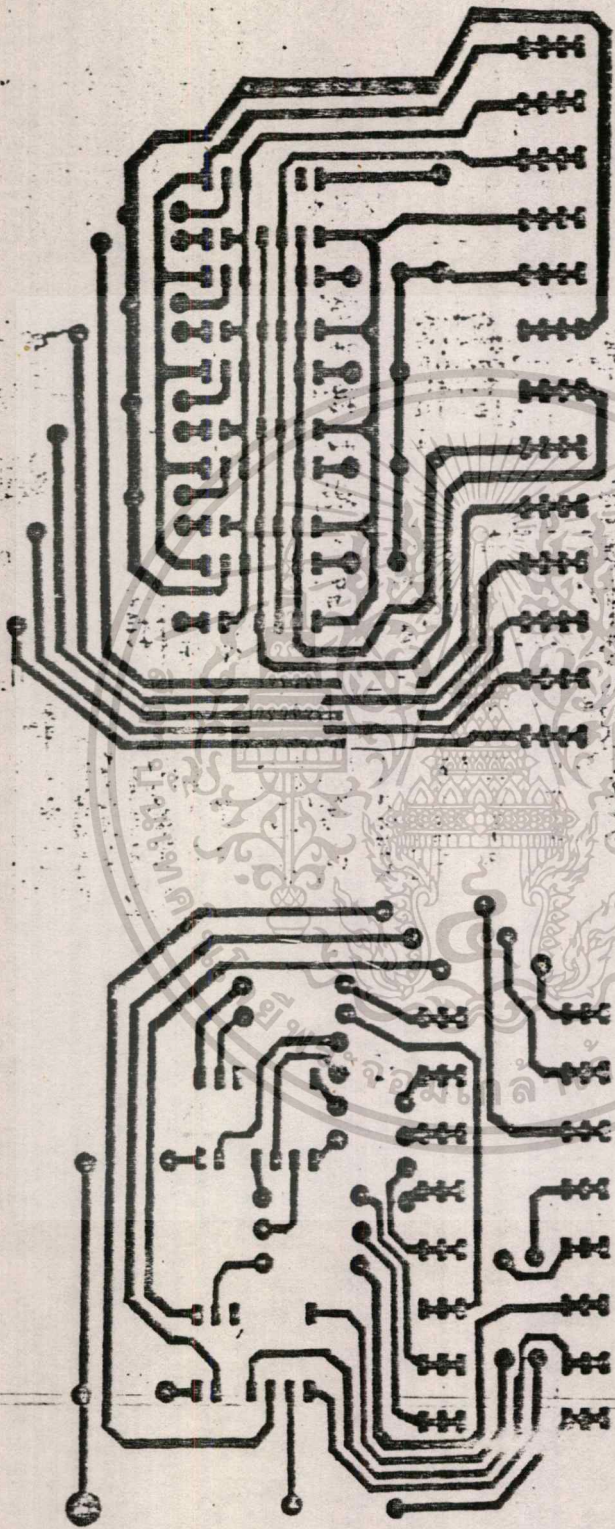
ลายทองแดงของวงจรถ่ายภาพมอนิเตอร์



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษานานาชาติให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 การผลิต การเผยแพร่ การโฆษณา การบริการ หรือการอื่นใดที่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของการสงวนลิขสิทธิ์  
 ไม่ว่าการตีพิมพ์นี้ห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

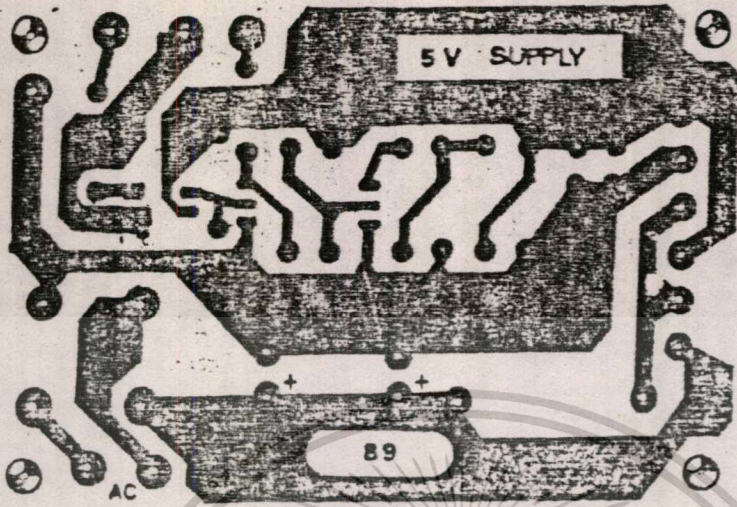


ก. ขอบของแผงทองวงจรแสดงกลายเป็นตัวเศษ

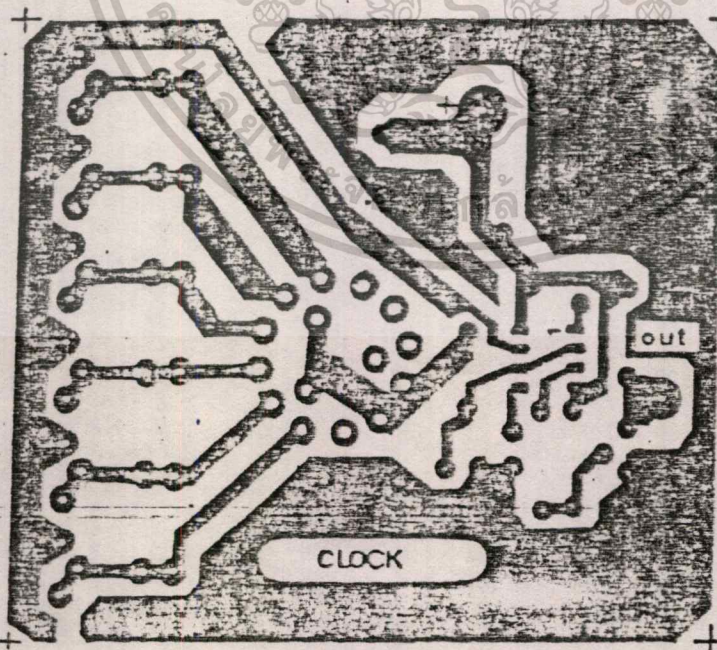


ภาพทองแดงของวงจรแสดงแผงแม่พิมพ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

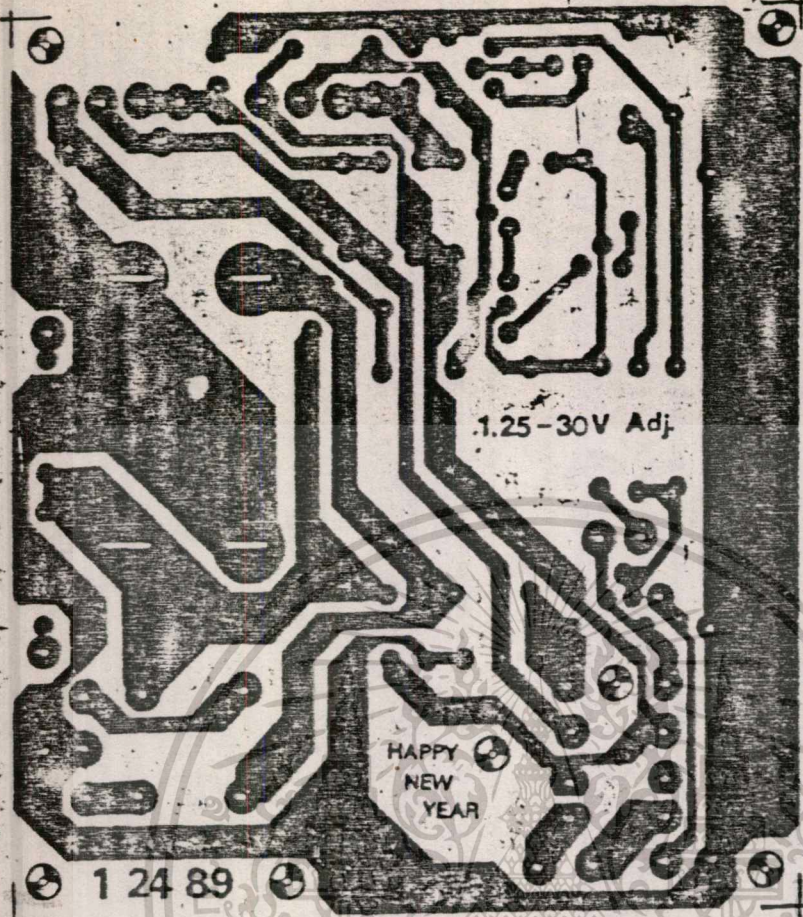


ลายทองแดงของวงจรแหล่งจ่ายไฟ 5 โวลต์

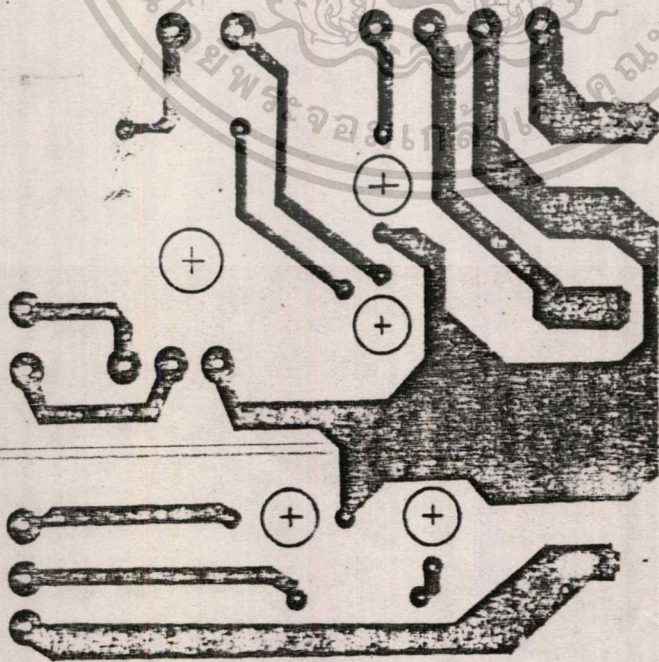


ลายทองแดงของวงจรถ่ายค่าเนกซ์สเตชันนาฬิกา

เอกสารนี้เป็นเอกสารทสงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ทำกรณีใดทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหุ และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

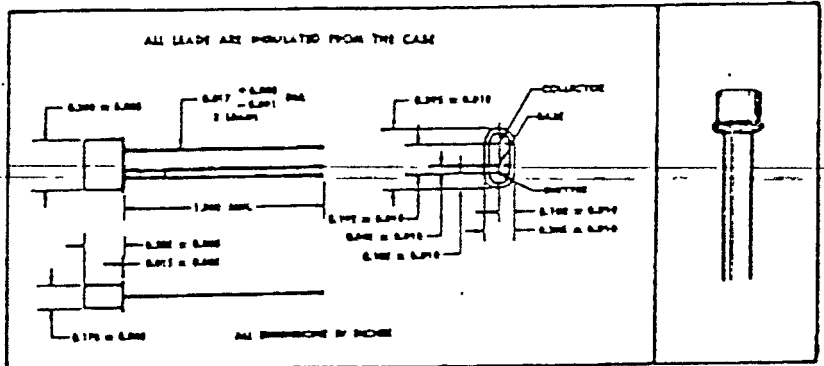
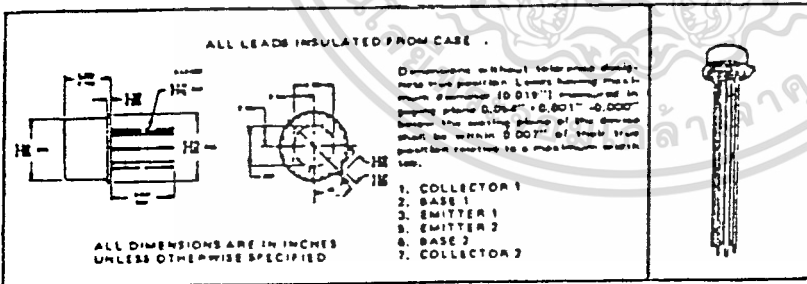
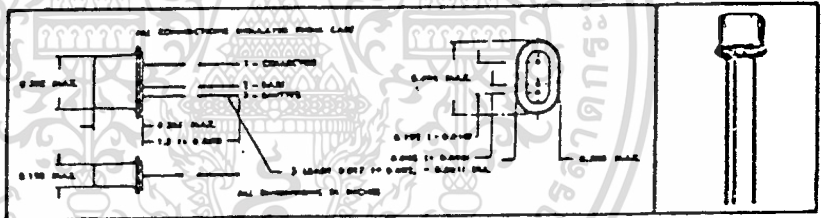
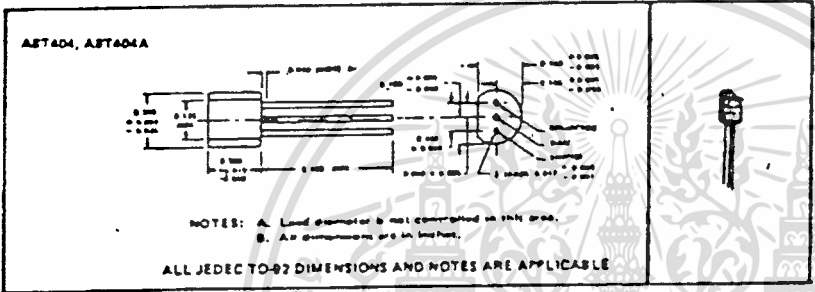
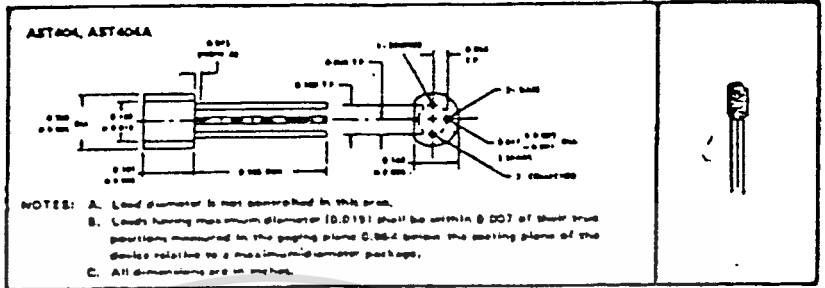
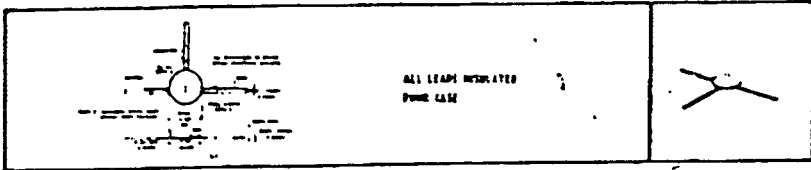


ค่าของแรงดันจะลดลงไป 1.25 - 30 โวลต์



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกรนำมาใช้ทำที่พิมพ์หลังจากนั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ถ้าหากต้องการข้อมูลอื่น ๆ กรุณาติดต่อฝ่ายเทคนิคของศูนย์ฯ  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้





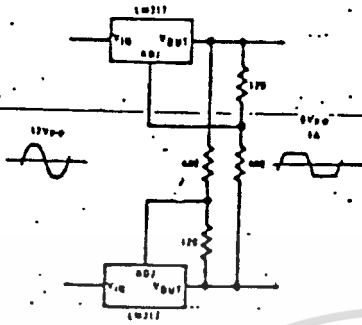
TAMAS/STDA NUMBER	PL DLT	PACI-AGI	LEAD INFO	VCD MAL	VCE MAX	VIB MAX	I C MAX	T J MAX	F P TOT	C MJA	CO MAL	M FE	M FE BIAS	USE	WTR	EUR EDJUV	USA EDJUV	ISS
25C395A/R	NS	101R	101	20V	17V	5V	500MA	175C	300MWT	200M	6P	30/70	10MA	VMS	TOS	DSX70	2A2369	0
25C395A/Y	NS	101R	101	20V	17V	5V	500MA	175C	300MWT	200M	6P	100MA	10MA	VMS	TOS	DSX70	2A2369	0
25C395A/D	NS	101B	101	20V	17V	5V	500MA	175C	300MWT	200M	6P	60/170	10MA	VMS	TOS	DSX70	2A2369	0
25C396	NS	101B	101	40V	20V	5V	200MA	175C	300MWT	225M	6P	200MA	10MA	VMG	ODS	DSX64	2A2222A	0
25C397	NS	101C	106	20V	17V	2V	50MA	180C	200MWT	400M	4P	80TP	10MA	VLA	TOS	BFX73	2A93E	0
25C398	NS	1072	106	20V	20V	3V	20MA	175C	200MWT	250M	0R5	20/200	10MA	VMS	TOS	BF200		0
25C399	NS	1072	106	20V	20V	3V	20MA	175C	200MWT	250M	0R5	20/200	10MA	VMS	TOS	BF200		0
25C400	NS	101R	101	30V	20V	5V	100MA	175C	250MWT	100M	6P	30MA	10MA	ALG	TOS	BC107	A157	0
25C400/C	NS	101B	101	30V	20V	5V	100MA	175C	250MWT	100M	6P	170MA	10MA	ALG	TOS	BC107	A157	0
25C400/R	NS	101B	101	30V	20V	5V	100MA	175C	250MWT	100M	6P	30/70	10MA	ALG	TOS	BC107	A157	0
25C400/T	NS	101R	101	30V	20V	5V	100MA	175C	250MWT	100M	6P	100MA	10MA	ALG	TOS	BC107	A157	0
25C400/D	NS	101B	101	30V	20V	5V	100MA	175C	250MWT	100M	6P	60/120	10MA	ALG	TOS	BC107	A157	0
25C401	NS	X20	142	50V	25V	5V	100MA	125C	100MWT	85M	5P	90TP	1MA	ALG	SOY	BC182L	2A3710	0
25C402	NS	X20	142	50V	25V	3V	100MA	125C	100MWT	85M	5P	90TP	1MA	ALG	SOY	BC182L	2A3710	0
25C402A	NS	X20	142	50V	25V	3V	100MA	125C	180MWT	70M	5P	60TP	1MA	ALG	SOY	BC182L	2A3710	0
25C402B	NS	X20	142	50V	25V	4V	100MA	125C	300MWT	70M	3P3	32MA	1MA	ALG	SOY	BC182L	2A3710	0
25C403	NS	X20	142	50V	25V	3V	100MA	125C	100MWT	85M	5P	60TP	1MA	ALG	SOY	BC182L	2A3710	0
25C403A	NS	X20	142	50V	25V	3V	100MA	125C	180MWT	70M	5P	60TP	1MA	ALG	SOY	BC182L	2A3710	0
25C403B	NS	X20	142	50V	25V	4V	100MA	125C	300MWT	70M	2P1	20MA	1MA	ALG	SOY	BC182L	2A3710	0
25C403C	NS	X20	142	60V	25V	4V	100MA	120C	320MWT	70M	4P	41/715	1MA	ALG	SOY	BC182L	2A5089	2
25C403C5	NS	X20	142	60V	25V	5V	100MA	120C	320MWT	70M	4P	41/715	1MA	ALG	SOY	BC182L	2A5089	0
25C404	NS	X20	142	50V	25V	3V	50MA	125C	100MWT	85M	5P	90TP	1MA	ALG	SOY	BC182L	2A3710	0
25C405	NS	T05	104	30V	18V	6V	200MA	100C	125MWT	4M	25P	60TP	100MA	VMG	ODS	AS729	2A1304	0
25C406	NS	T05	104	30V	18V	8V	200MA	100C	125MWT	4M	25P	120TP	100MA	VMG	ODS	AS729	2A1304	0
25C407	NS	T03	105	150V	100V	4V	10A	150C	100MC	200M	100P	10/30	5A	VHM	SW1	DDY90		0
25C408	NS	T03	105	150V	100V	4V	10A	150C	100MC	200M	100P	20/40	5A	VHM	SW1	DDY90		0
25C409	NS	T03	105	200V	140V	4V	10A	150C	100MC	200M	100P	10/30	5A	VHM	SW1	DDY90		0
25C410	NS	T03	105	200V	140V	4V	10A	150C	100MC	200M	100P	20/40	5A	VHM	SW1	DDY90		0
25C411	NS	T03	105	300V	200V	4V	10A	150C	100MC	200M	100P	10/30	5A	VHM	SW1	DDY90		0
25C412	NS	T03	105	300V	200V	4V	10A	150C	100MC	200M	100P	20/40	5A	VHM	SW1	DDY90		0
25C413	NS	T08	112	60V		5V	1A5	175L	20MC	90M		25MA	150MA	RM5			2A2782	1
25C414	NS	T08	112	90V		5V	1A5	175C	20MC	90M		25MA	150MA	RM5			2A2782	1
25C415	NS	T08	112	120V		5V	1A5	175C	20MC	90M		25MA	150MA	RM5			2A2782	1
25C416	NS	T08	112	90V		5V	1A5	175C	20MC	90M		30MA	400MA	RM5			2A2782	1
25C423	NS	T03D	104	40V		5V	300MA	185C	800MWT	250M	10P	80TP	20MA	VMG	SAA	BS954	2A2219A	0
25C424	NS	T05	104	40V		4V	300MA	175C	200MWT	250M	10P	40MA	20MA	VMG	SAA	BS954	2A2219A	1
25C425	NS	T03F	104	40V		5V	300MA	185C	500MWT	250M	10P	80TP	20MA	VMG	SAA	BS954	2A2219A	0
25C426	NS	T05	104	20V		4V	300MA	175C	200MWT	250M	10P	40MA	20MA	VMG	SAA	BS954	2A2219A	1
25C427	NS	T01R	101	40V		5V	100MA	175C	300MWT	90M		40MA	1MA	R35	ODS	DSX64	2A2222A	1
25C428	NS	T01B	101	25V		5V	100MA	175C	300MWT	90M		40MA	1MA	R35	ODS	DSX64	2A2222A	1
25C429	NS	X37		25V	17V	2V	10MA	150C	100MWT	200M		12MA	1MA	VMS	ATP	BF200		1
25C430	NS	X37		25V	17V	2V	10MA	150C	100MWT	200M		25MA	1MA	VMS	ATP	BF200		1
25C431	NS	X87	105	150V	100V	4V	30A	150C	200MC	100M		10MA	10A	RHE	SW1	BUX21		2
25C432	NS	X87	105	150V	100V	4V	30A	150C	200MC	100M		20MA	10A	RHE	SW1	BUX21		2
25C433	NS	X87	105	200V	140V	4V	30A	150C	200MC	100M		10MA	10A	RHE	SW1	BUX21		2
25C434	NS	X87	105	200V	140V	4V	30A	150C	200MC	100M		20MA	10A	RHE	SW1	BUX21		2
25C435	NS	X87	105	300V	200V	4V	30A	150C	200MC	100M		10MA	10A	RHE	SW1	BUX21		2
25C436	NS	T0F	112	100V	60V	5V	2A	175C	130C	100M		20MA	350MA	VHM	ODS		2A2782	0
25C436	NS	T0E	112	75V	60V	5V	2A	175C	130C	100M		20MA	350MA	VHM	ODS		2A2782	0
25C439	NS	T05	104	25V		5V	100MA	200C	800MWT	200M		25MA	100MA	ALG	ODS	BS954	2A2219A	1
25C440	NS	T05	104	25V	15V	5V	100MA	175C	500MWT	200M	7P	50TP	100MA	VMG	ODS	BS954	2A2219A	0
25C441	NS	T05	104	25V	15V	5V	100MA	175C	500MWT	200M	7P	50TP	100MA	VMG	ODS	BS954	2A2219A	0
25C442	NS	T05	104	25V	15V	5V	100MA	175C	500MWT	200M	7P	50TP	100MA	VMG	ODS	BS954	2A2219A	0
25C443	NS	T05	104	25V	40V	3V	500MA	200C	800MWT	70M	20P	20TP	100MA	VMG	ODS	BF150	2A2257	0
25C444	NS	T05	104	60V	45V	4V	500MA	200C	800MWT	140M	20P	25TP	100MA	VMG	ODS	BS954	2A2219A	0
25C445	NS	T05	104	80V	60V	5V	500MA	200C	800MWT	140M	20P	30TP	100MA	VMG	ODS	BS954	2A2219A	0
25C446	NS	T05	104	60V		7V	500MA	200C	800MWT	100M		12MA	100MA	VMG	ODS	BS954	2A2219A	1
25C447	NS	T060	161	75V		4V	2A	175C	5RT	105M		10MA	250MA	VMG	ODS	BL128		1
25C448	NS	T060	161	100V		5V	2A	175C	5RT	95M		10MA	250MA	VMG	ODS	BL128		1
25C449	NS	T060	161	75V		5V	2A	175C	5RT	95M		10MA	350MA	VMG	ODS	BL128		1
25C450	NS	T060	161	60V		4V	2A	175C	5RT	105M		10MA	350MA	VMG	ODS	BL128		1
25C451	NS	T060	161	100V		4V	1A2	200C	250C	90M		15MA	350MA	VMG	ODS	BL128		1
25C452	NS	T060	161	100V		4V	1A2	200C	250C	90M		15MA	350MA	VMG	ODS	BL128		1
25C453	NS	T060	161	80V		4V	1A2	200C	250C	85M		15MA	350MA	VMG	ODS	BL128		1
25C454	NS	X21	145	30V	30V	5V	100MA	125C	200MWT	115M	4P	60MA	2MA	ALG	H1J	DC182L	2A3710	0
25C454A	NS	X21	145	30V	30V	5V	100MA	125C	200MWT	115M	4P	60MA	2MA	ALG	H1J	DC182L	2A3710	0
25C455	NS	X21	145	30V	30V	5V	100MA	125C	200MWT	115M	4P	30MA	2MA	ALG	H1J	DC182L	2A3710	1
25C456	NS	T05	104	50V	30V	5V	600MA	175C	750MWT	100M		10MA	80MA	VMG	ODS	BS954	2A2219A	1
25C456	NS	X21	145	30V	30V	5V	100MA	125C	200MWT	115M	4P	60MA	2MA	ALG	H1J	DC182L	2A3710	0
25C458A	NS	T052	114	30V	30V	5V	100MA	125C	200MWT	100M	4P	300MWT	10MA	R35	H1J	DC347A	2A3904	2
25C458L	NS	X21	145	30V	30V	5V	100MA	125C	200MWT	115M	4P	150TP	2MA	ALG	H1J	DC184L	2A3707	0
25C458C	NS	X21	145	30V	30V	5V	100MA	125C	200MWT	115M	4P	60MA	2MA	ALG	H1J	DC184L	2A3707	0
25C459	NS	X21	145	30V	30V	5V	100MA	125C	200MWT	115M	4P	60MA	2MA	ALG	H1J	DC184L	2A3707	0
25C460	NS	X21	145	30V	30V	5V	100MA	125C	200MWT	115M	3P	35MA	2MA	ALG	H1J	DC182L	2A3710	1

TRANSISTOR NUMBER	PN DA LT	PACK-AGE	LEAD INFO	VCD MAX	VCE MAX	VEB MAX	I C MAX	T J MAX	P TOT	F T MHZ	C OB MAX	M FE	N FE BIAS	USE MFR	EUR EQUIV	USA EQUIV	ISS	
2SC395A/R	NS	TO18	L01	20V	12V	5V	500MA	175C	300mW	200M	6P	30/70	10MA	VMS	T05	BSX20	2K2369	0
2SC395A/Y	NS	TO18	L01	20V	12V	5V	500MA	175C	300mW	200M	6P	100MH	10MA	VMS	T05	BSX20	2K2369	0
2SC395A/O	NS	TO18	L01	20V	12V	5V	500MA	175C	300mW	200M	6P	60/120	10MA	VMS	T05	BSX20	2K2369	0
2SC398	NS	TO18	L01	40V	20V	5V	200MA	175C	300mW	225M	6P	200MH	10MA	PMG	T05	BS864	2K2222A	0
2SC397	NS	TO72	L06	20V	12V	2V	50MA	180C	200mW	400M	4P	80TP	BMA	VLA	T05	DFX73	2K918	0
2SC398	NS	TO72	L06	20V	20V	3V	20MA	175C	200mW	250M	0A5	20MH	4MA	FVG	T05	BF200		0
2SC399	NS	TO72	L06	20V	20V	3V	20MA	175C	200mW	250M	0A5	20/200	4MA	FVG	T05	DF200		0
2SC400	NS	TO18	L01	30V	20V	5V	100MA	175C	250mW	100M	6P	30MH	10MA	ALG	T05	BC107	A157	0
2SC400/G	NS	TO18	L01	30V	20V	5V	100MA	175C	250mW	100M	6P	170MH	10MA	ALG	T05	BC109	2K930	0
2SC400/R	NS	TO18	L01	30V	20V	5V	100MA	175C	250mW	100M	6P	30/70	10MA	ALG	T05	DC107	A157	0
2SC400/Y	NS	TO18	L01	30V	20V	5V	100MA	175C	250mW	100M	6P	100MH	10MA	ALG	T05	BC107	A157	0
2SC400/D	NS	TO18	L01	30V	20V	5V	100MA	175C	250mW	100M	6P	60/130	10MA	ALG	T05	BC107	A157	0
2SC401	NS	X20	L42	50V	25V	5V	100MA	125C	100mW	85M	5P	90TP	1MA	ALG	SOY	BC182L	2K3710	0
2SC402	NS	X20	L42	50V	25V	3V	100MA	125C	100mW	85M	5P	90TP	1MA	ALG	SOY	BC182L	2K3710	0
2SC402A	NS	X20	L42	50V	25V	3V	100MA	125C	180mW	70M	5P	60TP	1MA	ALG	SOY	BC182L	2K3710	0
2SC402B	NS	X20	L42	50V	25V	4V	100MA	125C	300mW	70M	3P5	32MH	1MA	ALG	SOY	BC182L	2K3710	0
2SC403	NS	X20	L42	50V	25V	3V	100MA	125C	100mW	85M	5P	80TP	2MA	ALG	SOY	BC182L	2K3710	0
2SC403A	NS	X20	L42	50V	25V	3V	100MA	125C	180mW	70M	5P	60TP	1MA	ALG	SOY	BC182L	2K3710	0
2SC403B	NS	X20	L42	50V	25V	4V	100MA	125C	300mW	70M	2P7	20MH	1MA	ALG	SOY	BC182L	2K3710	0
2SC403C	NS	X20	L42	60V	60V	4V	100MA	120C	320mW	70M	4P	41/175	1MA	ALG	SOY	DC882L	2K5089	2
2SC403CS	NS	X20	L42	60V	60V	5V	100MA	120C	320mW	70M	4P	41/175	1MA	ALG	SOY	DC882L	2K5089	0
2SC404	NS	X20	L42	30V	25V	3V	50MA	125C	100mW	85M	5P	90TP	1MA	ALG	SOY	BC182L	2K3710	0
2SC405	MG	T05	L04	30V	18V	6V	200MA	100C	125mW	4M	25P	60TP	100MA	PMG	ODS	AS729	2K1304	0
2SC406	MG	T05	L04	30V	18V	6V	200MA	100C	125mW	4M	25P	120TP	100MA	PMG	ODS	AS729	2K1304	0
2SC407	NS	T03	L05	150V	100V	4V	10A	150C	100WC	200M	500P	10/30	5A	VHN	SMI	BDY90		0
2SC408	NS	T03	L05	150V	100V	4V	10A	150C	100WC	200M	500P	20/40	5A	VHN	SMI	BDY90		0
2SC409	NS	T03	L05	200V	140V	4V	10A	150C	100WC	200M	500P	10/30	5A	VHN	SMI	BDY90		0
2SC410	NS	T03	L05	200V	140V	4V	10A	150C	100WC	200M	500P	20/40	5A	VHN	SMI	BDY90		0
2SC411	NS	T03	L05	300V	200V	4V	10A	150C	100WC	200M	500P	10/30	5A	VHN	SMI	BDY90		0
2SC412	NS	T03	L05	300V	200V	4V	10A	150C	100WC	200M	500P	20/40	5A	VHN	SMI	BDY90		0
2SC413	NS	T08	L12	60V	5V	1A5	175C	20WC	90M	25MH	150MA	PM5				2K2782	1	
2SC414	NS	T08	L12	90V	5V	1A5	175C	20WC	90M	25MH	150MA	PM5				2K2782	1	
2SC415	NS	T08	L12	120V	5V	1A5	175C	20WC	90M	25MH	150MA	PM5				2K2782	1	
2SC416	NS	T08	L12	90V	5V	1A5	175C	20WC	90M	30MH	400MA	PM5				2K2782	1	
2SC423	NS	TO39	L04	40V	5V	300MA	165C	500mW	250M	10P	80TP	20MA	PMG	SAN	BS854	2K2219A	0	
2SC424	NS	T05	L04	40V	5V	300MA	175C	200mW	250M	10P	40MH	20MA	VMG	SAN	BS854	2K2219A	1	
2SC425	NS	TO39	L04	40V	5V	300MA	165C	500mW	250M	10P	80TP	20MA	PMG	SAN	BS854	2K2219A	0	
2SC426	NS	T05	L04	20V	4V	300MA	175C	200mW	250M	10P	40MH	20MA	VMG	SAN	BS854	2K2219A	1	
2SC427	NS	TO18	L01	40V	5V	100MA	175C	300mW	90M	40MH	1MA	PLS	ODS	BS864	2K2222A	1		
2SC428	NS	TO18	L01	25V	5V	100MA	175C	300mW	90M	40MH	1MA	PLS	ODS	BS864	2K2222A	1		
2SC429	NS	X37		25V	12V	2V	100MA	150C	100mW	200M	12MH	1MA	FVG	H1P	BF200		1	
2SC430	NS	X37		25V	12V	2V	100MA	150C	100mW	200M	12MH	1MA	FVG	H1P	BF200		1	
2SC431	NS	X87	L05	150V	100V	4V	30A	150C	200WC	10MH	10A	RHE	SMI	BUX21		2		
2SC432	NS	X87	L05	150V	100V	4V	30A	150C	200WC	20MH	10A	RHE	SMI	BUX21		2		
2SC433	NS	X87	L05	200V	140V	4V	30A	150C	200WC	10MH	10A	RHE	SMI	BUX21		2		
2SC434	NS	X87	L05	200V	140V	4V	30A	150C	200WC	20MH	10A	RHE	SMI	BUX21		2		
2SC435	NS	X87	L05	300V	200V	4V	30A	150C	200WC	10MH	10A	RHE	SMI	BUX21		2		
2SC436	NS	X87	L05	300V	200V	4V	30A	150C	200WC	10MH	10A	RHE	SMI	BUX21		2		
2SC437	NS	T08	L12	100V	60V	5V	2A	175C	13WC	20MH	350MA	VHN	ODS		2K2782	0		
2SC438	NS	T08	L12	75V	60V	5V	2A	175C	13WC	100M	20MH	350MA	VHN	ODS		2K2782	0	
2SC439	NS	T05	L04	25V	5V	100MA	200C	500mW	200M	7P	25MH	100MA	ALR	ODS	BS854	2K2219A	1	
2SC440	NS	T05	L04	25V	15V	5V	100MA	175C	500mW	200M	7P	50TP	100MA	VMG	ODS	BS854	2K2219A	0
2SC441	NS	T05	L04	25V	15V	5V	100MA	175C	500mW	200M	7P	50TP	100MA	VMG	ODS	BS854	2K2219A	0
2SC442	NS	T05	L04	25V	15V	5V	100MA	175C	500mW	200M	7P	50TP	100MA	VMG	ODS	BS854	2K2219A	0
2SC443	NS	T05	L04	50V	40V	3V	500MA	200C	800mW	70M	20P	20TP	100MA	AMC	ODS	BFY50	2K2287	0
2SC444	NS	T05	L04	60V	47V	4V	500MA	200C	800mW	140M	20P	25TP	100MA	PMG	ODS	BS854	2K2219A	0
2SC445	NS	T05	L04	80V	60V	5V	500MA	200C	800mW	140M	20P	30TP	100MA	PMG	ODS	BS854	2K2219A	0
2SC446	NS	T05	L04	60V	47V	4V	500MA	200C	800mW	100M	12MH	100MA	ALR	ODS	BS854	2K2219A	1	
2SC447	NS	TO60	L81	75V	4V	2A	175C	5WF	125M	10MH	350MA	PMG	ODS		BLY28		1	
2SC448	NS	TO60	L81	100V	5V	2A	175C	5WF	95M	10MH	350MA	PMG	ODS		BLY28		1	
2SC449	NS	TO60	L81	75V	5V	2A	175C	5WF	85M	10MH	350MA	PMG	ODS		BLY28		1	
2SC450	NS	TO60	L81	80V	4V	2A	175C	5WF	105M	10MH	350MA	PMG	ODS		BLY28		1	
2SC451	NS	TO60	L81	100V	4V	1A2	200C	25WC	90M	15MH	350MA	PMG	ODS		BLY28		1	
2SC452	NS	TO60	L81	100V	4V	1A2	200C	25WC	90M	15MH	350MA	PMG	ODS		BLY28		1	
2SC453	NS	TO60	L81	80V	4V	1A2	200C	25WC	85M	15MH	350MA	PMG	ODS		BLY28		1	
2SC454	NS	X21	L45	30V	30V	5V	100MA	125C	200mW	115M	4P	80MH	2MA	ALG	H1J	DC182L	2K3710	0
2SC454L	NS	X21	L45	30V	30V	5V	100MA	125C	200mW	115M	4P	80MH	2MA	ALR	H1J	BC184L	2K3707	0
2SC455	NS	X21	L45	30V	30V	5V	100MA	125C	200mW	115M	4P	30MH	2MA	ALG	H1J	DC182L	2K3710	1
2SC456	NS	T05	L04	50V	20V	5V	800MA	175C	750mW	100M	10MH	80MA	PMG	ODS	BS854	2K2219A	1	
2SC458	NS	X21	L45	30V	30V	5V	100MA	125C	200mW	115M	4P	60MH	2MA	ALG	H1J	DC182L	2K3710	0
2SC458K	NS	TO92	L14	30V	30V	5V	100MA	125C	200mW	100M	4P	32MH	10MA	ALS	H1J	BC347A	2K3904	2
2SC458L	NS	X21	L45	30V	30V	5V	100MA	125C	200mW	115M	4P	150TP	2MA	ALR	H1J	BC184L	2K3707	0
2SC450G	NS	X21	L45	30V	30V	5V	100MA	125C	200mW	115M	4P	60MH	2MA	ALR	H1J	BC184L	2K3707	0
2SC459	NS	X21	L45	30V	30V	5V	100MA	125C	200mW	115M	4P	60MH	2MA	ALG	H1J	BC184L	2K3707	0
2SC460	NS	X21	L45	30V	30V	5V	100MA	125C	200mW	115M	3P	35MH	2MA	ALG	H1J	BC182L	2K3710	1

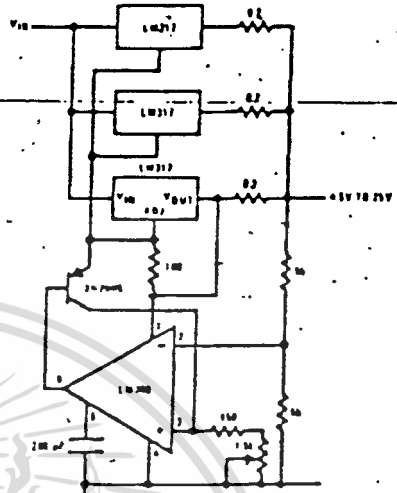
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อี... ทั้งหมดนี้... และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีค่าธรรมเนียม

## Typical Applications (cont'd.)

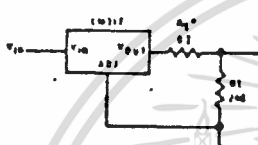
AC Voltage Regulator



Adjustable 4A Regulator



12V Battery Charger

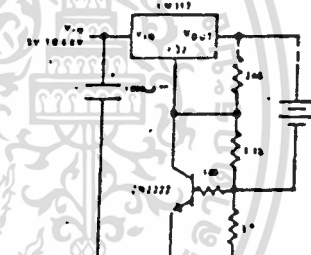


\* $R_2$  sets output impedance of charger  $Z_{OUT} = R_2 \left( 1 - \frac{R_2}{R_1} \right)$   
 Use of  $R_2$  allows low charging rates with fully charged battery.

50 mA Constant Current Battery Charger



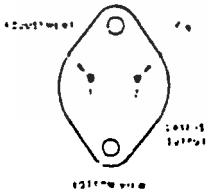
Current Limited 6V Charger



\*Sets bias current 10.6A for 100k  
 \*\*The 1000  $\mu$ F is recommended to filter out input transients

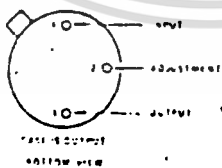
## Connection Diagrams

1TO3 STEEL  
Metal Can Package



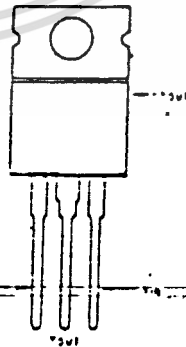
Order Number:  
 LM117K STEEL  
 LM217K STEEL  
 LM317K STEEL  
 See Package KO2A

1TO391  
Metal Can Package



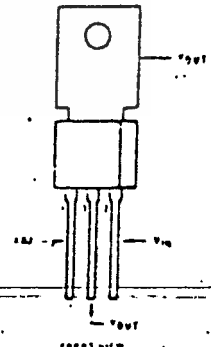
Order Number:  
 LM117H  
 LM217H  
 LM317H  
 See Package MO3A

1TO 2201  
Plastic Package



Order Number:  
 LM317T  
 See Package TD3B

1TO 2021  
Plastic Package

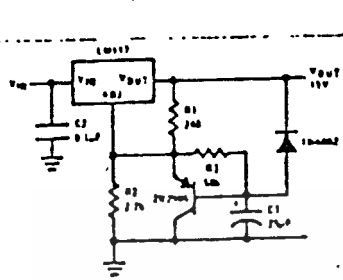


Order Number:  
 LM317MP  
 See Package PD3A  
 Tab Formed Devices  
 LM317MP TB  
 See Package PD3E

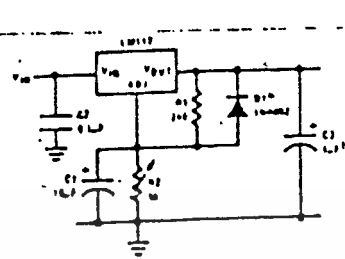


# Typical Applications (cont'd.)

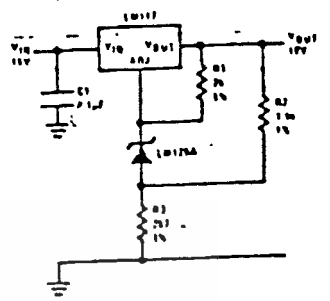
Slow Turn-On 15V Regulator



Adjustable Regulator with Improved Ripple Rejection

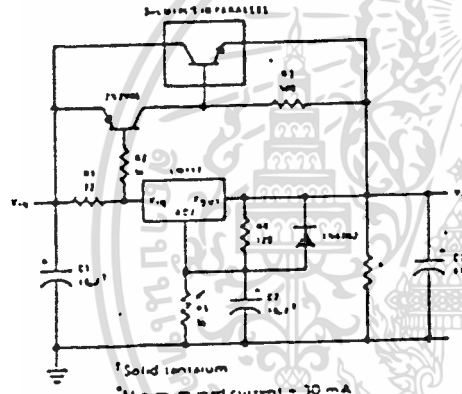


High Stability 10V Regulator



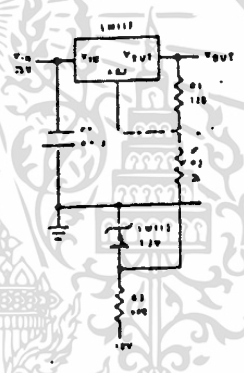
! Solid tantalum  
\* Discharge C1 if output is shorted to ground

High Current Adjustable Regulator

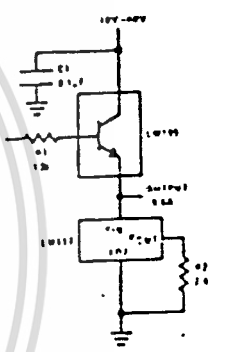


! Solid tantalum  
\* Minimum load current = 30 mA  
! Optional improves ripple rejection

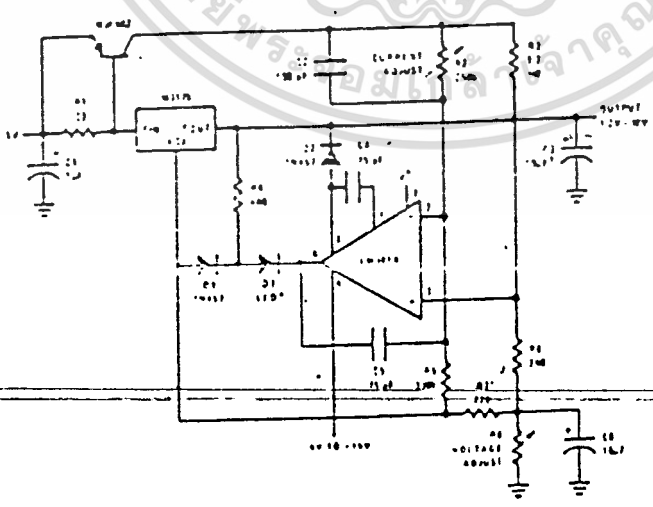
0 to 20V Regulator



Power Follower

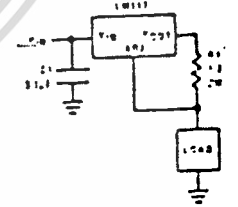


5A Constant Voltage/Constant Current Regulator

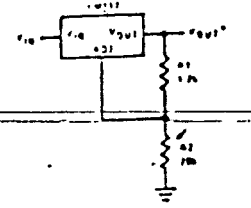


! Solid tantalum  
\* Lights in constant current mode

1A Current Regulator



1.2V-20V Regulator with Minimum Program Current



\* Minimum load current = 4 mA

Application Hints (cont'd.)

current depends on the value of the capacitor, the output voltage of the regulator, and the rate of decrease of  $V_{IN}$ . In the LM117, this discharge path is through a large junction that is able to sustain 15A surge with no problem. This is not true of other types of positive regulators. For output capacitor of 25 $\mu$ F or less, there is no need to use diodes.

occurs when either the input or output is shorted. Internal to the LM117 is a 50 $\Omega$  resistor which limits the peak discharge current. No protection is needed for output voltages of 25V or less and 10 $\mu$ F capacitance. Figure 3 shows an LM117 with protection diodes included for use with outputs greater than 25V and high values of output capacitance.

The bypass capacitor on the adjustment terminal can discharge through a low current junction. Discharge

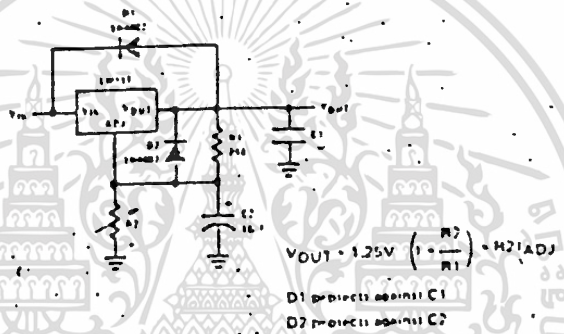
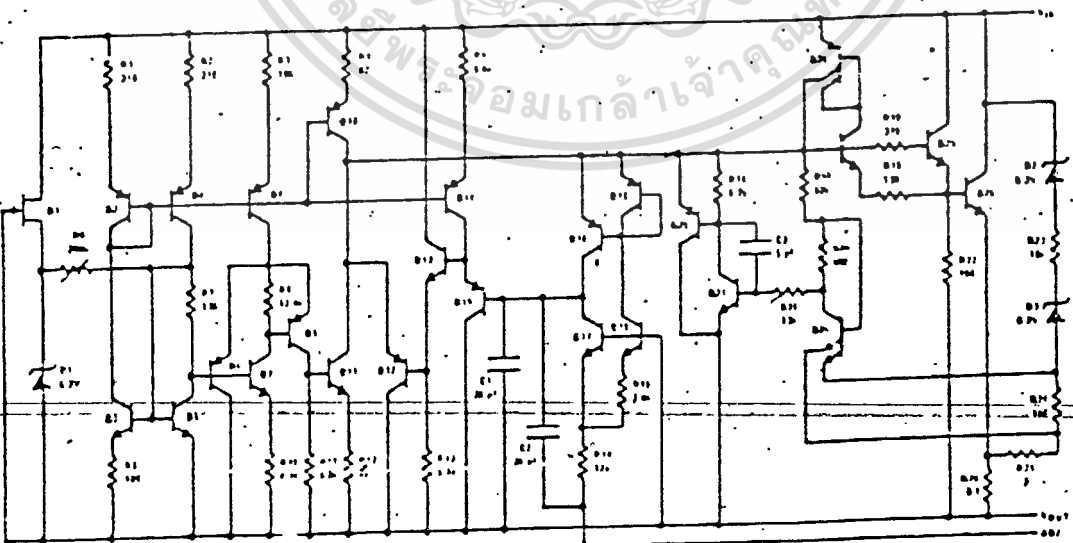


FIGURE 3. Regulator with Protection Diodes

Schematic Diagram



## Application Hints

In operation, the LM117 develops a nominal 1.25V reference voltage,  $V_{REF}$ , between the output and adjustment terminal. The reference voltage is impressed across program resistor  $R_1$  and, since the voltage is constant, a constant current  $I_1$  then flows through the output-set-resistor- $R_2$ , giving an output voltage of

$$V_{OUT} = V_{REF} \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) + I_{ADJ} R_2$$

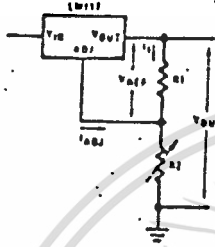


FIGURE 1.

Since the 100 $\mu$ A current from the adjustment terminal represents an error term, the LM117 was designed to minimize  $I_{ADJ}$  and make it very constant with line and load changes. To do this, all quiescent operating current is returned to the output establishing a minimum load current requirement. If there is insufficient load on the output, the output will rise.

### External Capacitors

An input bypass capacitor is recommended. A 0.1 $\mu$ F disc or 1 $\mu$ F solid tantalum on the input is suitable input bypassing for almost all applications. The device is more sensitive to the absence of input bypassing when adjustment or output capacitors are used but the above values will eliminate the possibility of problems.

The adjustment terminal can be bypassed to ground on the LM117 to improve ripple rejection. This bypass capacitor prevents ripple from being amplified as the output voltage is increased. With a 10 $\mu$ F bypass capacitor 40 dB ripple rejection is obtainable at any output level. Increases over 10 $\mu$ F do not appreciably improve the ripple rejection at frequencies above 120 Hz. If the bypass capacitor is used, it is sometimes necessary to include protection diodes to prevent the capacitor from discharging through internal low current paths and damaging the device.

In general, the best type of capacitors to use are solid tantalum. Solid tantalum capacitors have low impedance even at high frequencies. Depending upon capacitor construction, it takes about 25 $\mu$ F in aluminum electrolytic to equal 1 $\mu$ F solid tantalum at high frequencies. Ceramic capacitors are also good at high frequencies; but some types have a large decrease in capacitance at frequencies around 0.5 MHz. For this reason, 0.01 $\mu$ F disc may seem to work better than a 0.1 $\mu$ F disc as a bypass.

Although the LM117 is stable with no output capacitors, like any feedback circuit, certain values of external capacitance can cause excessive ringing. This occurs with values between 500 pF and 5000 pF. A 1 $\mu$ F solid tantalum (or 25 $\mu$ F aluminum electrolytic) on the output swamps this effect and insures stability.

### Load Regulation

The LM117 is capable of providing extremely good load regulation but a few precautions are needed to obtain maximum performance. The current set resistor connected between the adjustment terminal and the output terminal (usually 240 $\Omega$ ) should be tied directly to the output of the regulator rather than near the load. This eliminates line drops from appearing effectively in series with the reference and degrading regulation. For example, a 15V regulator with 0.05 $\Omega$  resistance between the regulator and load will have a load regulation due to line resistance of 0.05 $\Omega \times I_L$ . If the set resistor is connected near the load the effective line resistance will be 0.05 $\Omega (1 + R_2/R_1)$  or in this case, 11.5 times worse.

Figure 2 shows the effect of resistance between the regulator and 240 $\Omega$  set resistor.

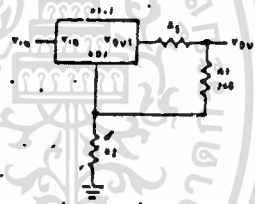


FIGURE 2. Regulator with Line Resistance in Output Load

With the TO-3 package, it is easy to minimize the resistance from the case to the set resistor, by using two separate leads to the case. However, with the TO-5 package, care should be taken to minimize the wire length of the output lead. The ground of  $R_2$  can be returned near the ground of the load to provide remote potential sensing and improve load regulation.

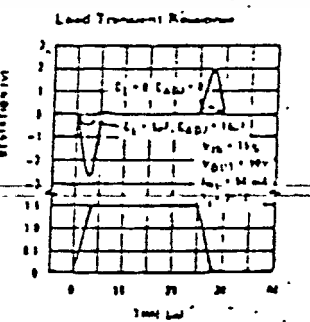
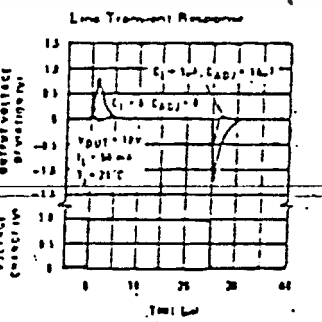
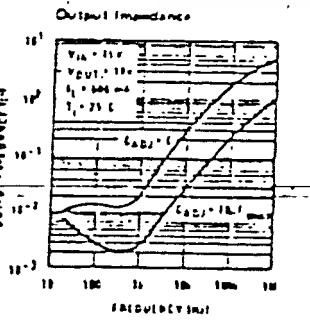
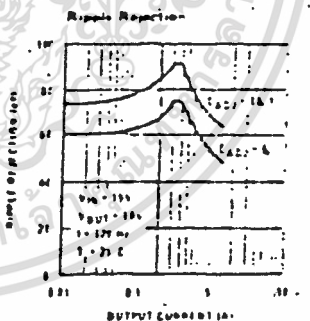
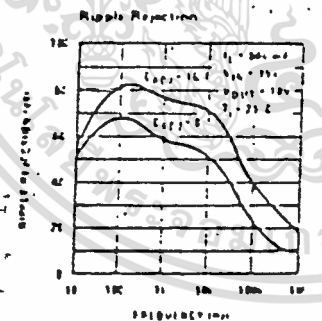
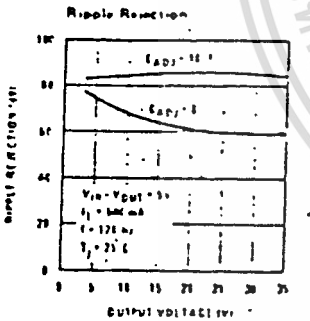
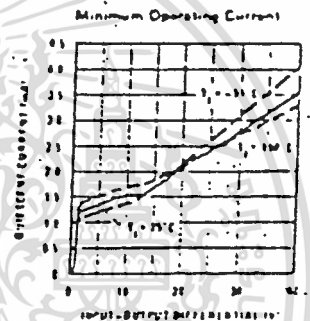
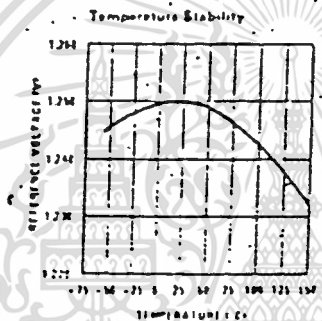
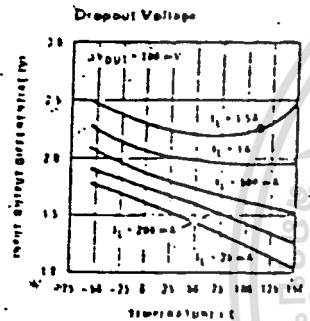
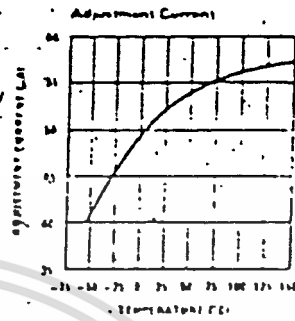
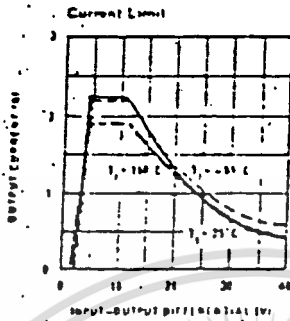
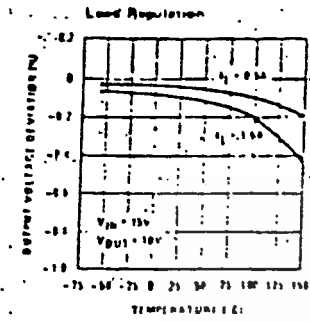
### Protection Diodes

When external capacitors are used with any IC regulator it is sometimes necessary to add protection diodes to prevent the capacitors from discharging through low current points into the regulator. Most 10 $\mu$ F capacitors have low enough internal series resistance to deliver 20A spikes when shorted. Although the surge is short, there is enough energy to damage parts of the IC.

When an output capacitor is connected to a regulator and the input is shorted, the output capacitor will discharge into the output of the regulator. The discharge

# Typical Performance Characteristics (K and T Packages)

Output Capacitor = 0 unless otherwise noted



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งาน 131 การศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## Absolute Maximum Ratings

Power Dissipation	Internally limited
Input-Output Voltage Differential	40V
Operating Junction Temperature Range	-55°C to +150°C
LM117	-25°C to +150°C
LM217	0°C to +125°C
LM317	-65°C to +150°C
Storage Temperature	300°C
Lead Temperature (Soldering, 10 seconds)	300°C

## Preconditioning

Burn-In in Thermal Limit 100% All Devices

## Electrical Characteristics (Note 1)

PARAMETER	CONDITIONS	LM117/217			LM317			UNITS
		MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	
Line Regulation	$T_A = 25^\circ\text{C}$ , $3\text{V} \leq V_{IN} - V_{OUT} \leq 40\text{V}$ (Note 2)		0.01	0.02		0.01	0.04	%/V
Load Regulation	$T_A = 25^\circ\text{C}$ , $10\text{mA} \leq I_{OUT} \leq I_{MAX}$ $V_{OUT} \leq 5\text{V}$ , (Note 2)		5	15		5	25	mV
	$V_{OUT} \geq 5\text{V}$ , (Note 2)		0.1	0.3		0.1	0.5	%
Thermal Regulation	$T_A = 25^\circ\text{C}$ , 20 ms Pulse		0.03	0.07		0.04	0.07	%/W
Adjustment Pin Current			50	100		50	100	$\mu\text{A}$
Adjustment Pin Current Change	$10\text{mA} \leq I_L \leq I_{MAX}$ $3\text{V} \leq (V_{IN} - V_{OUT}) \leq 40\text{V}$		0.2	5		0	0	$\mu\text{A}$
Reference Voltage	$3\text{V} \leq (V_{IN} - V_{OUT}) \leq 40\text{V}$ , (Note 3) $10\text{mA} \leq I_{OUT} \leq I_{MAX}$ , $P \leq P_{MAX}$	1.20	1.25	1.30	1.20	1.25	1.30	V
Line Regulation	$3\text{V} \leq V_{IN} - V_{OUT} \leq 40\text{V}$ , (Note 2)		0.02	0.05		0.02	0.07	%/V
Load Regulation	$10\text{mA} \leq I_{OUT} \leq I_{MAX}$ , (Note 2)		20	50		20	70	mV
	$V_{OUT} = 5\text{V}$		0.3	1		0.3	1.5	%
Temperature Stability	$T_{MIN} \leq T_J \leq T_{MAX}$		1			1		%
	Minimum Load Current		3.5	5		3.5	10	mA
Current Limit	$V_{IN} - V_{OUT} \leq 15\text{V}$ K and T Package	1.5	2.2		1.5	2.2		A
	M and P Package	0.5	0.8		0.5	0.8		A
Short-Circuit Current	$V_{IN} - V_{OUT} = 40\text{V}$ , $T_J = +25^\circ\text{C}$ K and T Package	0.30	0.4		0.15	0.4		A
	M and P Package	0.15	0.07		0.075	0.07		A
THS (Output Noise, $\Delta V_{OUT}$ )	$T_A = 25^\circ\text{C}$ , 10 Hz to 10 kHz		0.003			0.003		$\mu\text{V}$
3-pulse Rejection Ratio	$V_{OUT} = 10\text{V}$ , $f = 120\text{Hz}$ $C_{ADJ} = 10\mu\text{F}$		65			65		dB
			60			60		dB
Long Term Stability	$T_A = 125^\circ\text{C}$		0.3	1		0.3	1	%
	M Package		12	15		12	15	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Thermal Resistance, Junction to Case	K Package		2.3	3		2.3	3	$^\circ\text{C}/\text{W}$
	T Package					4		$^\circ\text{C}/\text{W}$
	P Package		3			12		$^\circ\text{C}/\text{W}$

Note 1. Unless otherwise specified, these specifications apply  $-55^\circ\text{C} \leq T_J \leq +150^\circ\text{C}$  for the LM117,  $-25^\circ\text{C} \leq T_J \leq +150^\circ\text{C}$  for the LM217, and  $0^\circ\text{C} \leq T_J \leq +125^\circ\text{C}$  for the LM317.  $V_{IN} - V_{OUT} = 5\text{V}$ , and  $I_{OUT} = 0.1\text{A}$  for the TO-3 and TO-202 packages and  $I_{OUT} = 0.5\text{A}$  for the TO-3 and TO-220 packages. Although power dissipation is internally limited, these specifications are applicable for power dissipation of 2W for the TO-3 and TO-202, and 20W for the TO-3 and TO-220.  $I_{MAX}$  is 1.5A for the TO-3 and TO-220 packages and 0.5A for the TO-3 and TO-202 packages.

Note 2. Regulation is measured at constant junction temperature, using pulse testing with a low duty cycle. Changes in output voltage due to heating effects are covered under the specification for thermal regulation.

Note 3. Selected devices with tightened tolerance reference voltage available.

### General Description

The LM117/LM217/LM317 are adjustable 3-terminal positive voltage regulators capable of supplying in excess of 1.5A over a 1.2V to 37V output range. They are exceptionally easy to use and require only two external resistors to set the output voltage. Further, both line and load regulation are better than standard fixed regulators. Also, the LM117 is packaged in standard transistor packages which are easily mounted and handled.

In addition to higher performance than fixed regulators, the LM117 series offers full overload protection available only in IC's, included on the chip are current limit, thermal overload protection and safe area protection. All overload protection circuitry remains fully functional even if the adjustment terminal is disconnected.

### Features

- Adjustable output down to 1.2V
- Guaranteed 1.5A output current
- Line regulation typically 0.01% /V
- Load regulation typically 0.1%
- Current limit constant with temperature
- 100% electrical burn-in
- Eliminates the need to stock many voltages
- Standard 3-lead transistor package
- 80 dB ripple rejection

Besides replacing fixed regulators, the LM117 is useful in a wide variety of other applications. Since the regulator is "floating" and sees only the input-to-output differential voltage, supplies of several hundred volts can be regulated as long as the maximum input to output differential is not exceeded.

Also, it makes an especially simple adjustable switch-mode regulator, a programmable output regulator, or by connecting a fixed resistor between the adjustment and output, the LM117 can be used as a precision current regulator. Supplies with electronic shutdown can be achieved by clamping the adjustment terminal to ground which programs the output to 1.2V where most loads draw little current.

The LM117K, LM217K and LM317K are packaged in standard TO-3 transistor packages while the LM117H, LM217H and LM317H are packaged in a solid Kovar base TO-39 transistor package. The LM117 is rated for operation from -55 C to +150 C, the LM217 from -75 C to +150 C and the LM317 from 0 C to +125 C. The LM317T and LM317MP, rated for operation over a 0 C to +125 C range, are available in a TO-220 plastic package and a TO-202 package, respectively.

For applications requiring greater output current in excess of 3A, and 5A, see LM150 series and LM132 series data sheets, respectively. For the negative complement, see LM137 series data sheet.

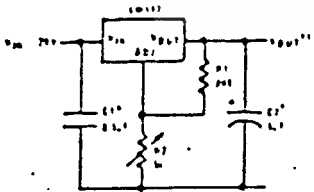
LM117 Series Package and Power Capability

DEVICE	PACKAGE	RATED POWER DISSIPATION	DESIGN LOAD CURRENT
LM117	TO-3	20W	1.5A
LM217	TO-3	20W	0.5A
LM317	TO-220	15W	1.5A
LM317T	TO-202	7.5W	0.5A
LM317MP	TO-202	6.0W	0.1A

Normally, no capacitors are needed unless the device is situated far from the input filter capacitor(s) in which case an input bypass is needed. An optional output capacitor can be added to improve transient response. The adjustment terminal can be bypassed to achieve very high ripple rejection ratios which are difficult to achieve with standard 3-terminal regulators.

### Typical Applications

1.2V-25V Adjustable Regulator

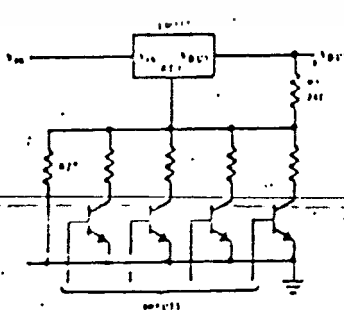


1 Optional—improves transient response. Output capacitors in the range of 1 μF to 1000 μF of electrolytic, tantalum, electrolytic are commonly used to provide improved output impedance and rejection of transients.

\* Needed if device is far from filter capacitor(s).

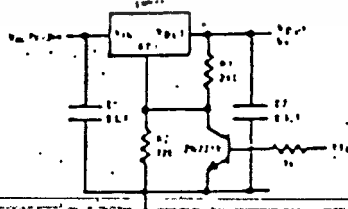
$$V_{OUT} = 1.25V \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

Digitally Selected Outputs



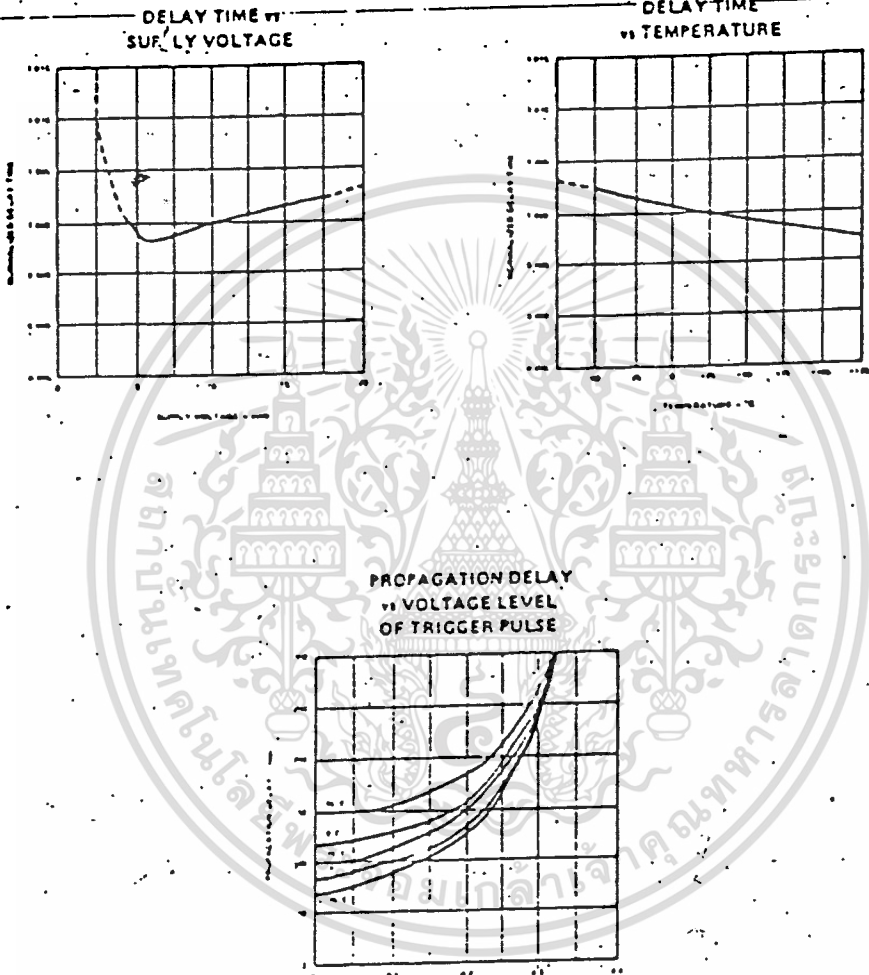
\* Sets maximum V<sub>OUT</sub>

5V Logic Regulator with Electronic Shutdown\*



\* Min output = 1.2V

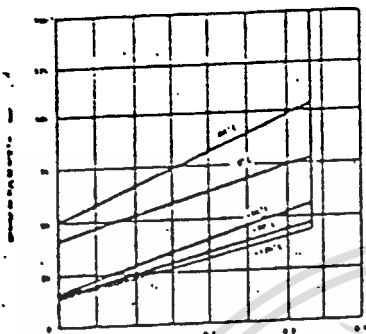
TYPICAL CHARACTERISTICS (Cont'd)



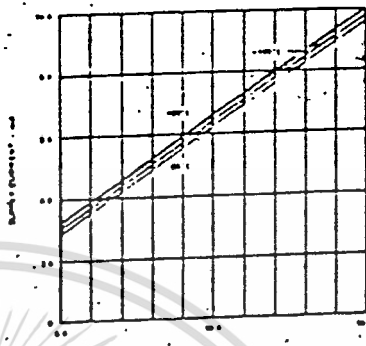
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่จำกัดสิทธิ์ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### TYPICAL CHARACTERISTICS

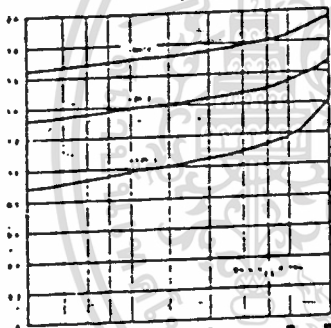
MINIMUM PULSE WIDTH  
REQUIRED FOR TRIGGERING



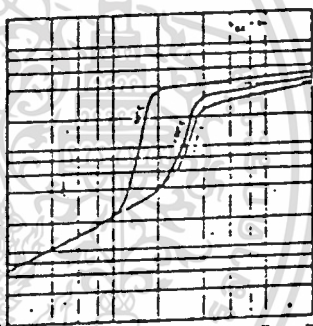
SUPPLY CURRENT  
vs SUPPLY VOLTAGE



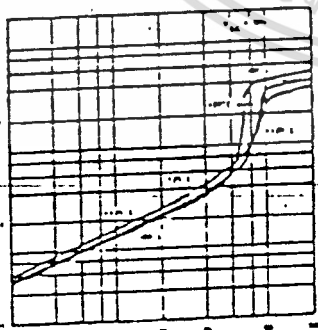
LOW OUTPUT VOLTAGE  
vs OUTPUT SINK CURRENT



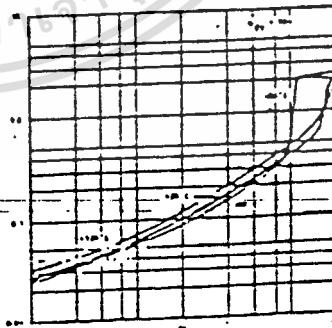
HIGH OUTPUT VOLTAGE  
vs OUTPUT  
SOURCE CURRENT



LOW OUTPUT VOLTAGE  
vs OUTPUT SINK CURRENT



LOW OUTPUT VOLTAGE  
vs OUTPUT SINK CURRENT



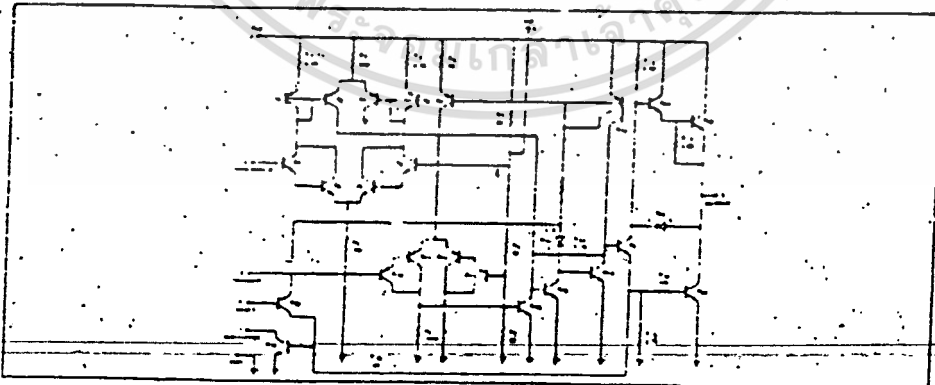
ELECTRICAL CHARACTERISTICS  $T_A = 25^\circ\text{C}$ ,  $V_{CC} = +5\text{V}$  to  $+15$  unless otherwise specified

PARAMETER	TEST CONDITIONS	SE 555			NE 555			UNITS
		MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	
Supply Voltage		4.5		18	4.5		18	V
Supply Current	$V_{CC} = 5\text{V}$ , $R_L = \infty$		3	9		3	6	mA
	$V_{CC} = 15\text{V}$ , $R_L = \infty$ Low State, Note 1		10	12		10	15	mA
Timing Error (Monostable)	$R_A, R_B = 1\text{k}\Omega$ to $100\text{k}\Omega$							
	$C = 0.1\mu\text{F}$ Note 2		0.5	2		1		%
	Initial Accuracy		20	100		50		ppm/°C
	Drift with Temperature		0.05	0.2		0.1		%/V <sub>CC</sub>
Threshold Voltage			2/3			2/3		V
Trigger Voltage	$V_{CC} = 15\text{V}$	4.8	9	8.2		5		V
Timing Error (Astable)	$V_{CC} = 5\text{V}$	1.45	1.87	1.9		1.87		V
Trigger Current			0.5			0.6		mA
Reset Voltage		0.4	0.7	1.0	0.4	0.7	1.0	V
Reset Current			0.1			0.1		mA
Threshold Current	Note 3		0.1	25		0.1	25	mA
Control Voltage Level	$V_{CC} = 15\text{V}$	9.6	10	10.4	9.6	10	11	V
	$V_{CC} = 5\text{V}$	2.9	3.33	3.8	2.9	3.33	4	V
	$V_{CC} = 15\text{V}$							
Output Voltage (Low)	$I_{\text{SINK}} = 10\text{mA}$		0.1	0.15		0.1	25	V
	$I_{\text{SINK}} = 50\text{mA}$		0.4	0.5		0.4	75	V
	$I_{\text{SINK}} = 100\text{mA}$		2.0	2.2		2.0	25	V
	$I_{\text{SINK}} = 200\text{mA}$		2.9			2.5		V
	$V_{CC} = 5\text{V}$							
	$I_{\text{SINK}} = 8\text{mA}$		0.1	0.25				V
Output Voltage Drop (Low)	$I_{\text{SOURCE}} = 200\text{mA}$		12.5			12.5		V
	$V_{CC} = 15\text{V}$							
	$I_{\text{SOURCE}} = 100\text{mA}$		13.0	13.3		12.75	13.3	V
	$V_{CC} = 5\text{V}$		3.0	3.3		2.75	3.3	V
Rise Time of Output		100			100		ns	
Fall Time of Output		100			100		ns	

NOTES

1. Supply Current when output high steady state load.
2. Tested at  $V_{CC} = 5\text{V}$  and  $V_{CC} = 15\text{V}$ .
3. The unit determines the maximum value of  $R_A + R_B$ . For  $15\text{V}$  operation, 100  $\mu\text{s}$  max delay  $R = 20$   $\mu\text{s}$ .

EQUIVALENT CIRCUIT (Shown for One Side Only)



LINEAR INTEGRATED CIRCUITS

DESCRIPTION

The NE/SE 555 monostable timing circuit is a highly stable controller capable of producing accurate time delay or oscillation. Additional terminals are provided for triggering or resetting if desired. In the time delay mode of operation, the time is precisely controlled by one external resistor and capacitor. For a stable operation as an oscillator, the free running frequency and the duty cycle are both accurately controlled with two external resistors and one capacitor. The circuit may be triggered and reset on falling waveforms, and the output structure can source or sink up to 200mA or drive TTL circuits.

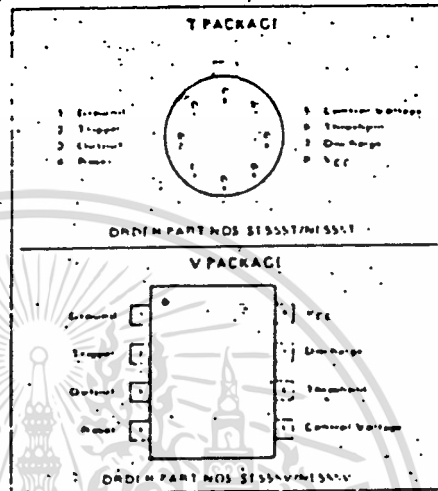
FEATURES

- TIMING FROM MICROSECONDS THROUGH HOURS
- OPERATES IN BOTH ASTABLE AND MONOSTABLE MODES
- ADJUSTABLE DUTY CYCLE
- HIGH CURRENT OUTPUT CAN SOURCE OR SINK 200mA
- OUTPUT CAN DRIVE TTL
- TEMPERATURE STABILITY OF 0.005% PER °C
- NORMALLY ON AND NORMALLY OFF OUTPUT

APPLICATIONS

- PRECISION TIMING
- PULSE GENERATION
- SEQUENTIAL TIMING
- TIME DELAY GENERATION
- PULSE WIDTH MODULATION
- PULSE POSITION MODULATION
- MISSING PULSE DETECTOR

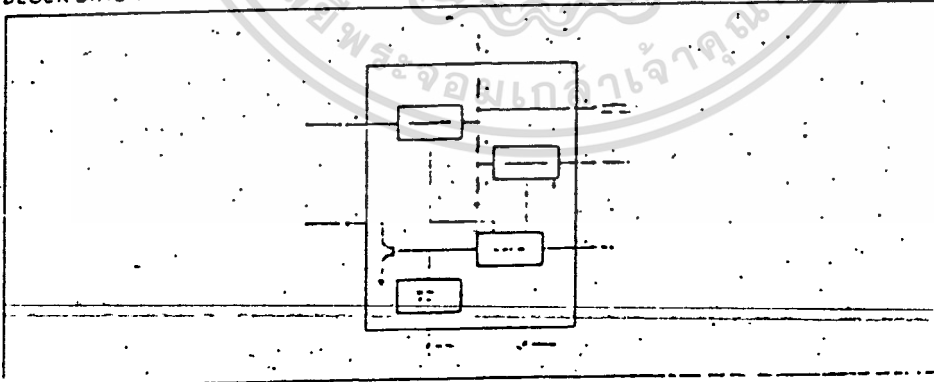
PIN CONFIGURATIONS (Top View)

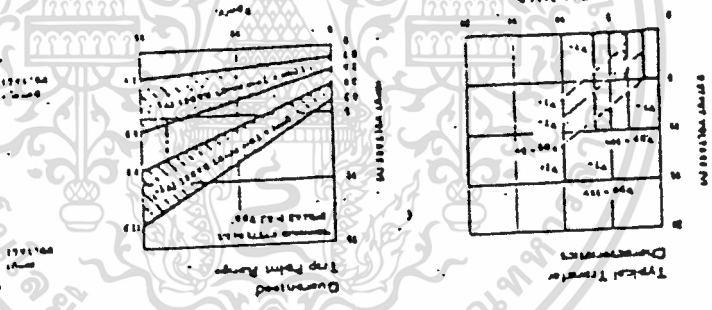
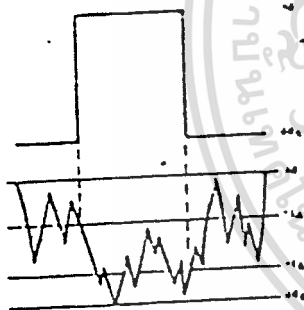
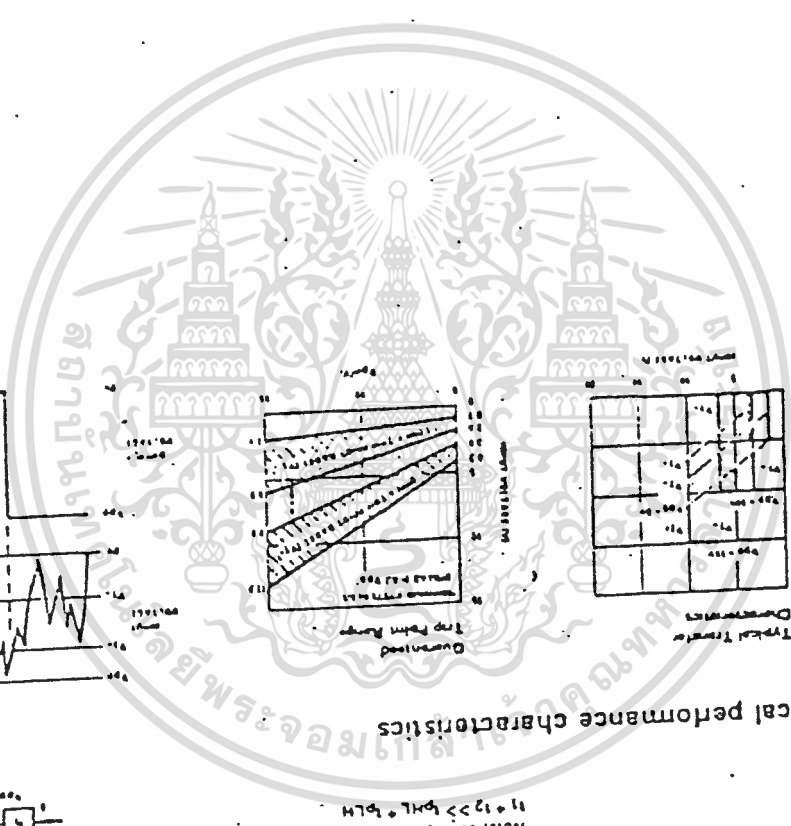


ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

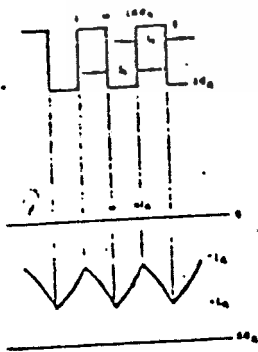
Supply Voltage	+18V
Power Dissipation	600 mW
Operating Temperature Range	0°C to +70°C
NE555	-55°C to +125°C
SE555	-65°C to +150°C
Storage Temperature Range	+30°C
Lead Temperature (Soldering 60 seconds)	+300°C

BLOCK DIAGRAM





Typical performance characteristics

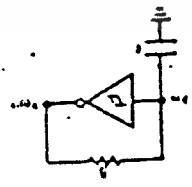


Notes: The equations assume  $f_{in} \gg f_{NL} + f_{LM}$

$$f_{in} = \frac{V_{Tn} (V_{DD} - V_{Tn})}{R_{eq} (V_{DD} - V_{Tn})}$$

$$f_{in} = \frac{V_{Tn}}{R_{eq} (V_{DD} - V_{Tn})}$$

$$f_{in} = \frac{V_{Tn}}{R_{eq} (V_{DD} - V_{Tn})}$$



Typical applications

dc electrical characteristics QD40106BC (Note 2)

PARAMETER	CONDITIONS	-40°C		25°C			+85°C		UNITS
		MIN	MAX	MIN	TYP	MAX	MIN	MAX	
I <sub>DD</sub>	Quiescent Device Current V <sub>DD</sub> = 5V V <sub>DD</sub> = 10V V <sub>DD</sub> = 15V		4.0			4.0		30	μA
			8.0			8.0		60	μA
			16.0			16.0		120	μA
V <sub>OL</sub>	Low Level Output Voltage  i <sub>O</sub>   < 1μA V <sub>DD</sub> = 5V V <sub>DD</sub> = 10V V <sub>DD</sub> = 15V		0.05			0.05		0.05	V
			0.05			0.05		0.05	V
			0.05			0.05		0.05	V
V <sub>OH</sub>	High Level Output Voltage  i <sub>O</sub>   < 1μA V <sub>DD</sub> = 5V V <sub>DD</sub> = 10V V <sub>DD</sub> = 15V	4.95		4.95	5		4.95		V
		9.95		9.95	10		9.95		V
		14.95		14.95	15		14.95		V
V <sub>T-</sub>	Negative-Going Threshold Voltage V <sub>DD</sub> = 5V, V <sub>O</sub> = 4.5V V <sub>DD</sub> = 10V, V <sub>O</sub> = 9V V <sub>DD</sub> = 15V, V <sub>O</sub> = 13.5V	0.7	2.0	0.7	1.4	2.0	0.7	2.0	V
		1.4	4.0	1.4	3.2	4.0	1.4	4.0	V
		2.1	6.0	2.1	5.0	6.0	2.1	6.0	V
V <sub>T+</sub>	Positive-Going Threshold Voltage V <sub>DD</sub> = 5V, V <sub>O</sub> = 0.5V V <sub>DD</sub> = 10V, V <sub>O</sub> = 1V V <sub>DD</sub> = 15V, V <sub>O</sub> = 1.5V	3.0	4.3	3.0	3.8	4.3	3.0	4.3	V
		8.0	8.6	8.0	8.8	8.6	8.0	8.6	V
		2.5	12.9	2.0	10.0	12.9	9.0	12.9	V
V <sub>H</sub>	Hysteresis (V <sub>T+</sub> - V <sub>T-</sub> ) V <sub>DD</sub> = 5V V <sub>DD</sub> = 10V V <sub>DD</sub> = 15V	1.0	3.8	1.0	2.2	3.6	1.0	3.6	V
		2.0	7.2	2.0	3.8	7.2	2.0	7.2	V
		3.0	10.8	3.0	5.0	10.8	3.0	10.8	V
I <sub>OL</sub>	Low Level Output Current V <sub>DD</sub> = 5V, V <sub>O</sub> = 0.4V V <sub>DD</sub> = 10V, V <sub>O</sub> = 0.5V V <sub>DD</sub> = 15V, V <sub>O</sub> = 1.5V	0.52		0.44	0.88		0.36		mA
		1.3		1.1	2.25		0.9		mA
		3.8		3.0	8.8		2.4		mA
I <sub>OCH</sub>	High Level Output Current V <sub>DD</sub> = 5V, V <sub>O</sub> = 4.6V V <sub>DD</sub> = 10V, V <sub>O</sub> = 9.5V V <sub>DD</sub> = 15V, V <sub>O</sub> = 13.5V	-0.52		-0.44	-0.88		-0.36		mA
		-1.3		-1.1	-2.25		-0.9		mA
		-3.8		-3.0	-8.8		-2.4		mA
I <sub>IN</sub>	Input Current V <sub>DD</sub> = 15V, V <sub>IN</sub> = 0V V <sub>DD</sub> = 15V, V <sub>IN</sub> = 15V		-0.30		-10 <sup>-5</sup>	-0.30		-1.0	μA
			0.30		10 <sup>-5</sup>	0.30		1.0	μA

ac electrical characteristics T<sub>A</sub> = 25°C, C<sub>L</sub> = 50 pF, R<sub>L</sub> = 200Ω, t<sub>r</sub> and t<sub>f</sub> = 20 ns, unless otherwise specified.

PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
t <sub>P</sub> HL or t <sub>PLH</sub>	Propagation Delay Time From Input To Output V <sub>DD</sub> = 5V V <sub>DD</sub> = 10V V <sub>DD</sub> = 15V		200	300	ns
				200	ns
			70	150	ns
t <sub>T</sub> HL or t <sub>TLH</sub>	Transition Time V <sub>DD</sub> = 5V V <sub>DD</sub> = 10V V <sub>DD</sub> = 15V		100	200	ns
			50	100	ns
			40	30	ns
C <sub>IN</sub>	Average Input Capacitance Any Input		3	7.5	pF
C <sub>PD</sub>	Power Dissipation Capacitance Any Gate (Note 3)		14		pF

absolute maximum ratings

recommended operating conditions

(Notes 1 and 2)

(Note 2)

V<sub>DD</sub> dc Supply Voltage -0.5 to +18 V<sub>DC</sub>  
 V<sub>IN</sub> Input Voltage -0.5 to V<sub>DD</sub> -0.5 V<sub>DC</sub>  
 T<sub>S</sub> Storage Temperature Range -65°C to +150°C  
 P<sub>D</sub> Package Dissipation 800 mW  
 T<sub>L</sub> Lead Temperature (soldering, 10 seconds) 300°C

V<sub>DD</sub> dc Supply Voltage 3 to 18 V<sub>DC</sub>  
 V<sub>IN</sub> Input Voltage 0 to V<sub>DD</sub> V<sub>DC</sub>  
 T<sub>A</sub> Operating Temperature Range  
 CD40106RM -65°C to +125°C  
 CD40106R\* -40°C to +85°C

dc electrical characteristics CD40106BM (Note 2)

PARAMETER	CONDITIONS	-55°C		25°C			125°C		UNITS
		MIN	MAX	MIN	TYP	MAX	MIN	MAX	
I <sub>DD</sub>	Quiescent Device Current		1.0			1.0		30	μA
	V <sub>DD</sub> = 5V		2.0			2.0		60	μA
	V <sub>DD</sub> = 10V		4.0			4.0		120	μA
V <sub>OL</sub>	Low Level Output Voltage							0.05	V
	I <sub>IO</sub> < 1μA		0.05			0.05		0.05	V
	V <sub>DD</sub> = 5V		0.05			0.05		0.05	V
V <sub>OH</sub>	High Level Output Voltage							4.95	V
	I <sub>IO</sub> < 1μA		4.95		5	4.95		4.95	V
	V <sub>DD</sub> = 5V		9.95		10	9.95		9.95	V
V <sub>T-</sub>	Negative Going Threshold Voltage							0.7	V
	V <sub>DD</sub> = 5V, V <sub>O</sub> = 4.5V	0.7	2.0	0.7	1.4	2.0	0.7	2.0	V
	V <sub>DD</sub> = 10V, V <sub>O</sub> = 9V	1.4	4.0	1.4	2.7	4.0	1.4	4.0	V
V <sub>T+</sub>	Positive-Going Threshold Voltage							6.0	V
	V <sub>DD</sub> = 5V, V <sub>O</sub> = 0.5V	3.0	4.3	3.0	3.6	4.3	3.0	4.3	V
	V <sub>DD</sub> = 10V, V <sub>O</sub> = 1V	6.0	8.6	6.0	6.8	8.6	6.0	8.6	V
V <sub>H</sub>	Hysteresis (V <sub>T+</sub> - V <sub>T-</sub> )							1.0	V
	V <sub>DD</sub> = 5V	1.0	3.6	1.0	2.7	3.6	1.0	3.6	V
	V <sub>DD</sub> = 10V	2.0	7.2	2.0	5.4	7.2	2.0	7.2	V
I <sub>OL</sub>	Low Level Output Current							0.36	mA
	V <sub>DD</sub> = 5V, V <sub>O</sub> = 0.4V	0.64		0.51	0.85	0.36		0.36	mA
	V <sub>DD</sub> = 10V, V <sub>O</sub> = 0.5V	1.6		1.3	2.25	0.9		0.9	mA
I <sub>OH</sub>	High Level Output Current							-0.9	mA
	V <sub>DD</sub> = 5V, V <sub>O</sub> = 4.6V	-0.64		-0.51	-0.85	-0.36		-0.36	mA
	V <sub>DD</sub> = 10V, V <sub>O</sub> = 9.5V	-1.6		-1.3	-2.25	-0.9		-0.9	mA
I <sub>ICC</sub>	Input Current							-1.0	μA
	V <sub>DD</sub> = 15V, V <sub>IN</sub> = 0V		-0.10		-10 <sup>-5</sup>	-0.10		-1.0	μA
								1.0	μA
								1.0	μA
								1.0	μA

Note 1: "Absolute Maximum Ratings" are those values beyond which the safety of the device cannot be guaranteed. They are not meant to imply that the device should be operated at these limits. The table of "Recommended Operating Conditions" and "Electrical Characteristics" provides conditions for actual device operation.

Note 2: V<sub>CC</sub> = 0V unless otherwise specified.

Note 3: C<sub>PD</sub> determines the no load ac power consumption of any CMOS device. For complete explanation, see 84C/74C Family Characteristic application note - AN400.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีโอกาสนำไปใช้

# CD40106BM/CD40106BC hex Schmitt trigger

## general description

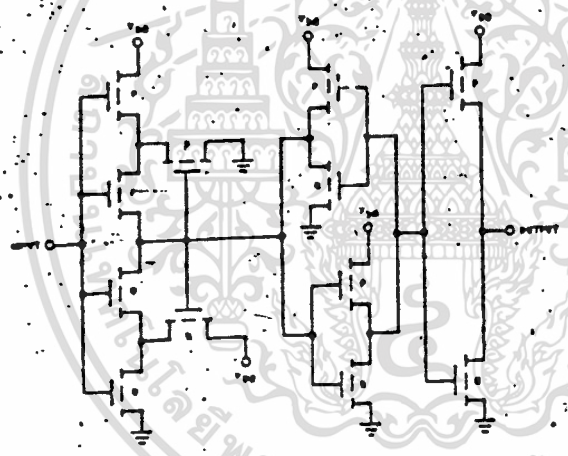
The CD40106B Hex Schmitt Trigger is a monolithic complementary MOS (CMOS) integrated circuit constructed with N and P-channel enhancement transistors. The positive and negative-going threshold voltages,  $V_{T+}$  and  $V_{T-}$ , show low variation with respect to temperature (typ 0.0005V/°C at  $V_{DD} = 10V$ ), and hysteresis,  $-V_{T+} - V_{T-} \geq 0.2 V_{DD}$  is guaranteed.

All inputs are protected from damage due to static discharge by diode clamps to  $V_{DD}$  and  $V_{SS}$ .

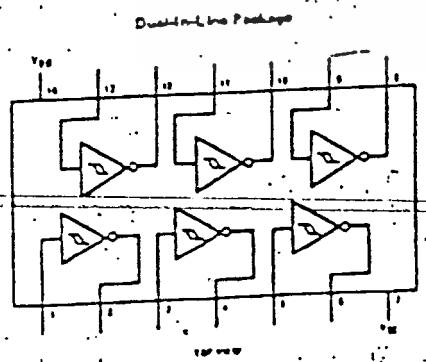
## features

- Wide supply voltage range 3V to 15V
- High noise immunity 0.7  $V_{DD}$  typ
- Low power fan out of 2 driving 74L or 1 driving 74LS
- TTL compatibility 0.4  $V_{DD}$  typ
- Hysteresis 0.2  $V_{DD}$  guaranteed
- Equivalent to MME4C14/MM74C14
- Equivalent to MC14584B

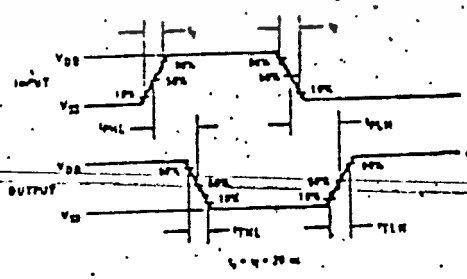
## schematic diagram



## connection diagram



## switching time waveforms



## เอกสารอ้างอิง

- 1 สว่าง ประกายรุ่งทอง, "หลักการออกแบบแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง", วารสารเคมีคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์, ฉบับที่ 81, หน้า 171-181, 2532
- 2 สว่าง ประกายรุ่งทอง, "หลักการออกแบบแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง ตอน 2", วารสารเคมีคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์, ฉบับที่ 82, หน้า 190-201, 2532
- 3 สว่าง ประกายรุ่งทอง, "หลักการออกแบบแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง ตอนจบ", วารสารเคมีคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์, ฉบับที่ 83, หน้า 189-200, 2532
- 4 ซีเอ็ดยูเคชั่น, "คู่มือทรานซิสเตอร์", หน้า 126-331, บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2531
- 5 ซีเอ็ดยูเคชั่น, "คู่มือไอซีทีโมส 4000", หน้า 207-210, บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2531
- 6 ซีเอ็ดยูเคชั่น, "คู่มือเทียบเบอร์ไอซีทีทีแอล", หน้า 78-79, บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2531

